

東京工業大学 工学院
電気電子系

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2016

Department of Electrical and Electronic Engineering

東京工業大学は電気電子工学分野において、全ての電子機器の基盤となる、温度に依らず安定した発振ができる水晶振動子、インターネットを実現した光通信用半導体レーザ、プリンターやマウスに用いられている垂直面発光レーザなどの発明により我々の生活を豊かにしてきました。今や、電気電子工学は電子機器のみならず、自動車やロボットなど、全ての産業の基礎となっています。

東京工業大学 工学院 電気電子系はこれまでの輝かしい伝統を受け継ぎ、社会に貢献できる研究と、これからの社会の発展を担う若者を育てる教育を行っています。工学院 電気電子系は、皆さんが自らの創造性を発揮して、世界を動かす一流の技術者・研究者となって、世界に羽ばたくことを応援します。



工学院 電気電子系
系主任 松澤 昭

CONTENTS

電気電子系教員リスト.....	1
電気電子系各コース紹介	
- 電気電子コース.....	3
- エネルギーコース.....	9
- ライフエンジニアリングコース.....	10
- 原子核工学コース.....	11
大学院生活.....	12
卒業後の進路.....	13
受験について.....	14
研究紹介	
- 修士・博士課程における研究活動.....	16
- 各研究室紹介.....	18
キャンパスマップ.....	116
質問があったら.....	119

電気電子系教員リスト

電気電子系には、大きく分けると「回路グループ」、「波動・光および通信グループ」、「デバイスグループ」、「材料・物性グループ」、「電力・エネルギーグループ」の5つのグループがあります。各教員はいずれかのグループに所属しています。詳細はp. 16～17の修士・博士課程における研究活動、およびp. 18以降の研究室紹介をご覧ください。

(教員の所属および職名は2016年4月での予定です。)

教員名	キャンパス	居室	内線	電子メール	主担当コース	副担当コース
回路グループ						
松澤昭	大岡山	南3-312	2508	matsu@ssc.pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
岡田健一	大岡山	南3-812	2258	okada@ssc.pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
益一哉	すずかけ台	S2-408	5010	masu.k.aa@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
伊藤浩之	すずかけ台	S2-408	5010	ito@pi.titech.ac.jp	電気電子コース	-
波動・光および通信グループ						
青柳貴洋	大岡山	西9-824	2992	aoyagi.t.aa@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
荒井滋久	大岡山	南9-704	2512	arai@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
西山伸彦	大岡山	南9-701	3593	n-nishi@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
安藤真	大岡山	南3-909	2563	mando@antenna.ee.titech.ac.jp	電気電子コース	-
阪口啓	大岡山	南3-1021	3910	sakaguchi@mobile.ee.titech.ac.jp	電気電子コース	-
西方敦博	大岡山	西9-818	3231	nishikata.a.ab@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
廣川二郎	大岡山	南3-908	2567	jiro@antenna.ee.titech.ac.jp	電気電子コース	-
水本哲弥	大岡山	南9-906	2578	tmizumot@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
庄司雄哉	大岡山	南9-904	2578	syoji.y.ad@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
渡邊文夫	大岡山	南3-614	3697	fu-watanabe@antenna.ee.titech.ac.jp	電気電子コース	-
伊藤治彦	すずかけ台	G2-1111	5459	ito@ep.titech.ac.jp	電気電子コース	-
植之原裕行	すずかけ台	R2-820	5038	uenohara.h.aa@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
黒澤実	すずかけ台	G2-614	5598	mkur@ip.titech.ac.jp	電気電子コース	-
小山二三夫	すずかけ台	R2-603	5068	koyama@pi.titech.ac.jp	電気電子コース	-
中村健太郎	すずかけ台	R2-718	5090	knakamur@sonic.pi.titech.ac.jp	ライフエンジニアリングコース	電気電子コース
田原麻梨江	すずかけ台	R2-713	5052	mtabaru@sonic.pi.titech.ac.jp	ライフエンジニアリングコース	電気電子コース
宮本智之	すずかけ台	R2-817	5059	tmiyamot@pi.titech.ac.jp	電気電子コース	-

※断りが無い限りコースは電気電子系のコースです

教員名	キャンパス	居室	内線	電子メール	主担当コース	副担当コース
デバイスグループ						
浅田雅洋	大岡山	南9-703	2564	asada@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
小田俊理	大岡山	南9-805	3048	soda@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
河野行雄	大岡山	南9-804	3811	kawano@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
鈴木左文	大岡山	南3-710	3039	suzuki.s.av@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
波多野睦子	大岡山	EEI-410	3999	hatano.m.ab@m.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
小寺哲夫	大岡山	EEI-403	3421	kodera.t.ac@m.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
久本大	大岡山	南3-815	3696	hisamoto.d.aa@m.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
福田浩一	大岡山	南9-901	2555	fukuda.k.av@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
宮本恭幸	大岡山	南9-702	2572	miya@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
石橋幸治	すずかけ台	理研		kishiba@riken.jp	電気電子コース	-
大見俊一郎	すずかけ台	J2-1204	5481	ohmi.s.aa@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
角嶋邦之	すずかけ台	S2-708	5847	kakushima@ep.titech.ac.jp	電気電子コース	-
筒井一生	すずかけ台	J2-1103	5462	ktsutsui@ep.titech.ac.jp	電気電子コース	-
若林整	すずかけ台	G2-1002	5594	wakabayashi.h.ab@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
渡辺正裕	すずかけ台	J2-1102	5454	watanabe@ep.titech.ac.jp	電気電子コース	-
材料・物性グループ						
岩本光正	大岡山	南3-719	2191	iwamoto@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
間中孝彰	大岡山	南3-715	2673	manaka@ome.pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
中川茂樹	大岡山	南3-709	3564	nakagawa@pe.titech.ac.jp	電気電子コース	-
PHAM NAM HAI	大岡山	南3-716	3934	pham.n.ab@m.titech.ac.jp	電気電子コース	-
山田明	大岡山	EEI-409	2698	yamada.a.ac@m.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
宮島晋介	大岡山	EEI-408	2807	miyajima.s.aa@m.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
飯野裕明	すずかけ台	J1-207	5181	iino@isl.titech.ac.jp	電気電子コース	電気電子コース
岡本隆之	すずかけ台	理研		okamoto@riken.jp	ライフエンジニアリングコース	電気電子コース
梶川浩太郎	すずかけ台	G2-1005	5596	kajikawa.k.aa@m.titech.ac.jp	ライフエンジニアリングコース	電気電子コース
加藤隆志	すずかけ台	J1-209	5188	takashi.a.kato@fujifilm.com	電気電子コース	-
菅原聡	すずかけ台	J3-1216	5184	sugahara@isl.titech.ac.jp	電気電子コース	-
中本高道	すずかけ台	R2-516	5017	nakamoto@nt.pi.titech.ac.jp	情報通信系 情報通信コース	電気電子コース
電力・エネルギーグループ						
赤木泰文	大岡山	EEI-405	3549	akagi@ee.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
萩原誠	大岡山	EEI-402	2852	mhagi@akg.ee.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
赤塚洋	大岡山	北1-413	3379	akatsuka.h.aa@m.titech.ac.jp	原子核工学コース	-
小栗慶之	大岡山	北1-626	3071	yoguri@nr.titech.ac.jp	原子核工学コース	-
葛本昌樹	大岡山	EEI-210	3796	kuzumoto@ee.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
堀口剛司	大岡山	EEI-210	3796	horiguchi@ee.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
千葉明	大岡山	南3-607	2697	chiba@ee.titech.ac.jp	電気電子コース	エネルギーコース
中出雅彦	大岡山	南3-614	3697	nakade@ee.titech.ac.jp	電気電子コース	エネルギーコース
七原俊也	大岡山	南3-619	2819	nanahara@ee.titech.ac.jp	電気電子コース	エネルギーコース
藤田英明	大岡山	EEI-404	2696	fujita@ee.titech.ac.jp	エネルギーコース	電気電子コース
安岡康一	大岡山	南3-616	2185	yasuoka@ee.titech.ac.jp	電気電子コース	エネルギーコース
竹内希	大岡山	南3-615	2566	takeuchi@ee.titech.ac.jp	電気電子コース	エネルギーコース
沖野晃俊	すずかけ台	J2-1306	5688	aokino@es.titech.ac.jp	ライフエンジニアリングコース	電気電子コース

※断りがない限りコースは電気電子系のコースです

電気電子コースの概要

平成28年度から発足する本学の新たな教育システムの発足に伴い、学部・大学院の一体教育を図るために、それまでの電気電子工学専攻、電子物理工学専攻、物理電子システム創造専攻の電気電子系3専攻を中心とする大学院教育に、学部教育を担う電気電子工学科を加え「電気電子系」が編成されました。「電気電子コース」はその大学院教育を担うコースになります。

電気電子コースは「回路分野」、「波動・光および通信分野」、「デバイス分野」、「材料・物性分野」、「電力・エネルギー分野」などの多くの研究分野を擁し、世界最先端の研究を行っております。

電気電子コースでは体系化されたカリキュラムの履修により幅広く電気電子の専門知識を獲得できるだけでなく、修士論文研究および博士論文研究を行うことで卓越した研究力を生かし、基礎理解力と応用発展力および独創性を備え、国際的に活躍できる人材の育成を目指しております。

このため、大学院科目は殆どの科目が英語で開講され、留学生向けの国際大学院コースの学生も多く受講しているほか、精華大学や台湾交通大学との大学院合同プログラムを完備しています。また国内会議はもとより国際会議での発表も頻繁に行われているなど、国際的に活躍できる機会が数多く用意されております。

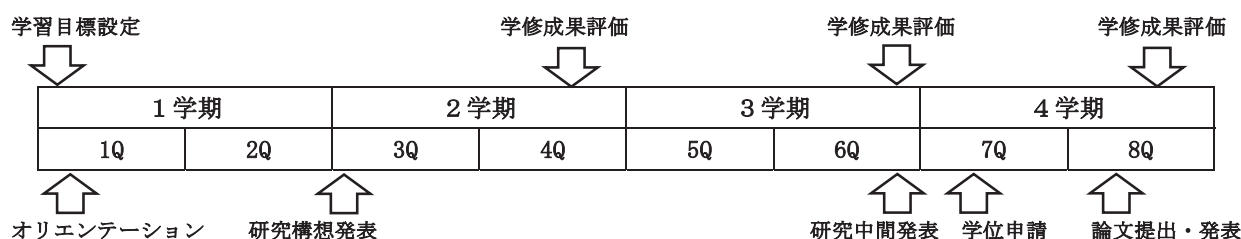
また、リサーチアシスタント(RA)制度やティーチングアシスタント(TA)制度はほぼ全員の学生が利用しており、資金的な支援を受けながら、より実践的かつ高度な研究・教育経験を積むことができます。

なお、電気電子系の教員は大岡山キャンパスおよびすずかけ台キャンパスにまたがっており、各科目も両キャンパスで開講されます。

電気電子コース（修士課程）教育カリキュラム

電気電子コースでは電気電子工学分野における新たな領域を切り開き、グローバルに活躍できる高度な研究者およびリーダーとなる人材を養成するため教育プログラムを設定しています。次ページの表は修士課程に相当する400番台ならびに500番台の講義科目を示します。これらは科目体系図に示されるように、専門分野に応じて体系づけられており、各自の専門性や必要とする分野を考慮して取得することができます。この中から修士課程修了時まで13単位以上を取得することが必要です。時間割上で科目が重複しないよう配慮しており、幅広い科目の受講が可能です。またそれぞれの講義は原則として英語で開講され、国際大学院コースの学生も多く受講するなど、大学院教育の国際化が進められています。また、専門以外の周辺領域への適応力や社会性を涵養するために、文系教養科目やキャリア科目の取得やコース以外の専門科目群からの受講が推奨されている修了要件になっています。各講義科目の情報は、東京工業大学オープンコースウェア(OCW)上でシラバスを確認できるほか、授業内容を見ることができる科目も多数あります。また、国内外の著名な講師による特論科目なども充実しており、専門基礎から先端応用まで幅広く履修できるカリキュラム体系になっています。この他、電気電子工学講究は、修士課程、博士課程の各クオータで全て必修です。講究は所属する研究室で行われる輪講(ゼミ)等を中心に進められます。

修士論文研究では研究を通じた高度専門知識や先端技術の修得だけでなく、発表や教員や研究室メンバーとの議論を通じて思考力、判断力、交渉力、プレゼンテーション力、コミュニケーション力など社会で必須な能力を向上させることができます。また、研究構想発表会、中間発表会、修士論文発表会では、所属する研究グループ教員全員から研究内容や発表能力について評価を受け、学修に活かす仕組みがあります。また、ほぼ多くの学生がリサーチアシスタント(RA)やティーチングアシスタント(TA)を経験し、研究者や指導者としての視点を養います。なお、修士課程修了までには、国内会議はもとより国際会議で発表する経験を積み、学外研究者と活発に交流する機会に恵まれます。このように、修士課程教育は、体系化された授業科目群と修士論文研究を両輪として、学生の能力が最大限活かされる極めて質の高い教育体系となっています。



電気電子工学コース修士課程における修士論文研究の標準的な流れ

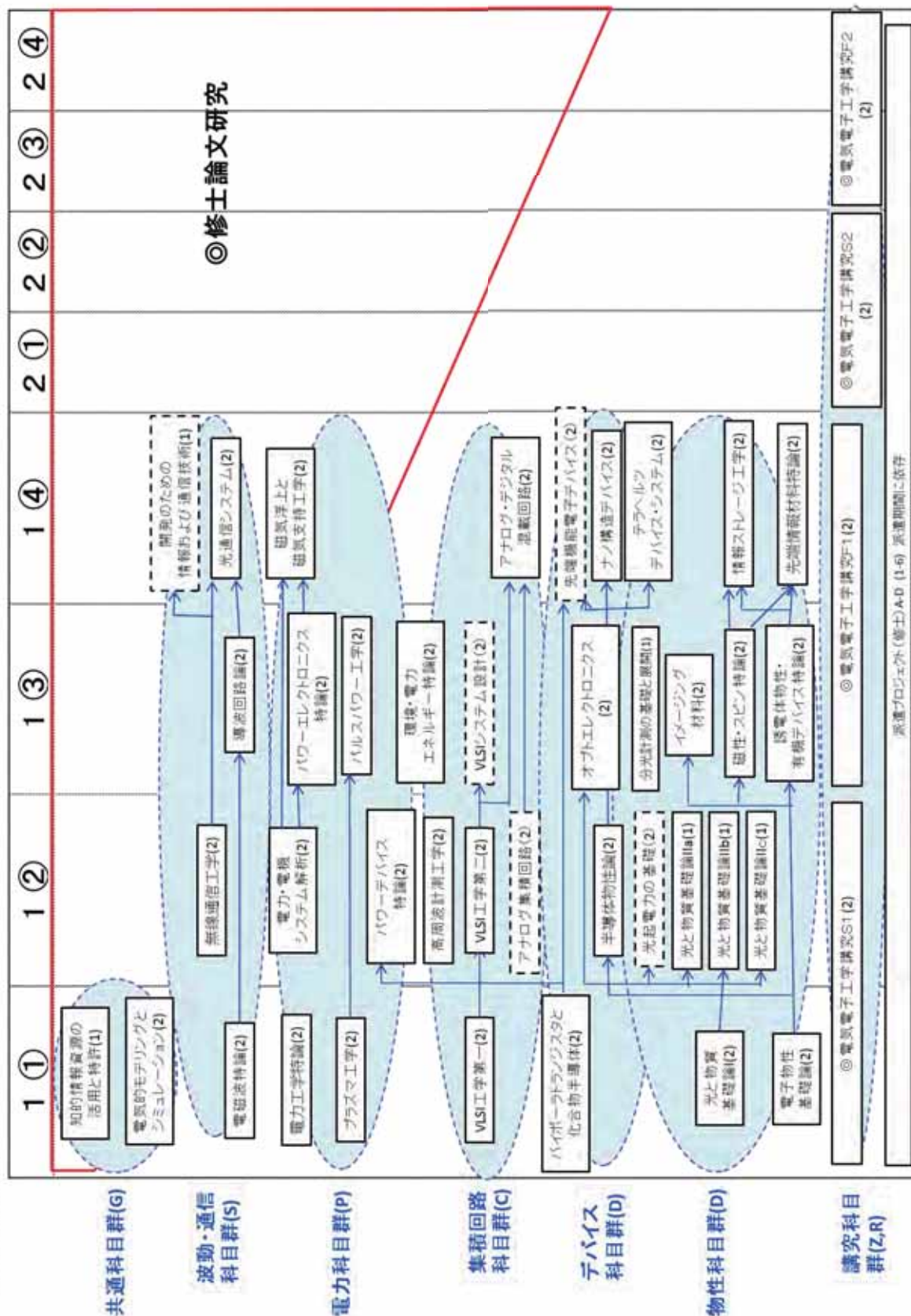
電気電子コース(修士課程)の講義科目

授業科目名	単位*	担当教員
Mixed Signal Circuits (アナログ・デジタル混載回路)	2-0-0	松澤 昭
VLSI Technology I (VLSI工学第一)	2-0-0	益 一哉, 若林 整, 角嶋 邦之
VLSI Technology II (VLSI工学第二)	2-0-0	益 一哉, 若林 整, 石原 昇, 道正 志郎
RF Measurement Engineering (高周波計測工学)	2-0-0	益 一哉, 伊藤 浩之, 非常勤講師
Fundamentals of Electronic Materials (電子物性基礎論)	2-0-0	中川 茂樹, 菅原 聡
Semiconductor Physics (半導体物性論)	2-0-0	山田 明
Imaging Materials (イメージング材料)	2-0-0	飯野 裕明
Fundamentals of Light and Matter I (光と物質基礎論 I)	2-0-0	梶川 浩太郎, 宗片 比呂夫, 伊藤 治彦
Information Storage Engineering (情報ストレージ工学)	2-0-0	非常勤講師
Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices (バイポーラトランジスタと化合物半導体)	2-0-0	宮本 恭幸
Optoelectronics (オプトエレクトロニクス)	2-0-0	宮本 智之
Advanced Power Semiconductor Devices (パワーデバイス特論)	2-0-0	非常勤講師
Utilization of Intelligent Information Resources and Patents (知的情報資源の活用と特許)	1-0-0	非常勤講師
Electrical Modeling and Simulation (電気的モデリングとシミュレーション)	2-0-0	松澤 昭, 山田 明, 非常勤講師
Electric Power and Motor Drive System Analysis (電力・電機システム解析)	2-0-0	藤田 英明
Advanced Course of Power Electronics (パワーエレクトロニクス特論)	2-0-0	藤田 英明, 萩原 誠
Advanced Electric Power Engineering (電力工学特論)	2-0-0	七原 俊也
Plasma Engineering (プラズマ工学)	2-0-0	赤塚 洋, 沖野 晃俊
Pulsed Power Technology (パルスパワー工学)	2-0-0	安岡 康一, 竹内 希
Advanced Electromagnetic Waves (電磁波特論)	2-0-0	廣川 二郎
Guided Wave Circuit Theory (導波回路論)	2-0-0	水本 哲弥
Wireless Communication Engineering (無線通信工学)	2-0-0	阪口 啓
Optical Communication Systems (光通信システム)	2-0-0	植之原 裕行, 小山 二三夫, 荒井 滋久
Dielectric Property and Organic Devices (誘電体物性・有機デバイス特論)	2-0-0	間中 孝彰
Magnetism and Spintronics (磁性・スピン工学特論)	2-0-0	中川 茂樹, Pham Nam Hai
Advanced Materials in Information Technologies (先進情報材料特論)	2-0-0	加藤 隆志
Fundamentals of Light and Matter IIa (光と物質基礎論 II a)	1-0-0	伊藤 治彦
Fundamentals of Light and Matter IIb (光と物質基礎論 II b)	1-0-0	宗片 比呂夫
Fundamentals of Light and Matter IIc (光と物質基礎論 II c)	1-0-0	梶川 浩太郎
Fundamental of spectroscopic measurements and its development (分光計測の基礎と展開)	1-0-0	宗片 比呂夫
Nano-Structure Devices (ナノ構造デバイス)	2-0-0	渡辺 正裕, 石橋 幸治
Terahertz Devices and Systems (テラヘルツデバイス・システム)	2-0-0	河野 行雄
Nano-Materials Electronics (ナノ材料電子) *「東工大ー清華大 大学院合同プログラム」により北京にて開講	2-0-0	中川 茂樹, 間中 孝彰
Magnetic Levitation and Magnetic Suspension (磁気浮上と磁気支持工学)	2-0-0	千葉 明
Environment and Electric Energy (環境・電力エネルギー特論)	2-0-0	葛本 昌樹
Study Abroad (Master Course) A-D (海外留学(修士)A-D) *	0-0-n	各指導教員
Internship (Master Course) A-D (インターンシップ(修士)A-D) *	0-0-n	各指導教員
Seminar S1, F1 on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学講究S1, F1)	0-0-2	各指導教員
Seminar S2, F2 on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学講究S2, F2)	0-0-2	各指導教員

* 単位の数字は「講義ー演習ー実験ー実習等」による単位数を表す。☆印の単位は派遣期間によりA-Dに対応し、それぞれn(1~6)単位に対応する。

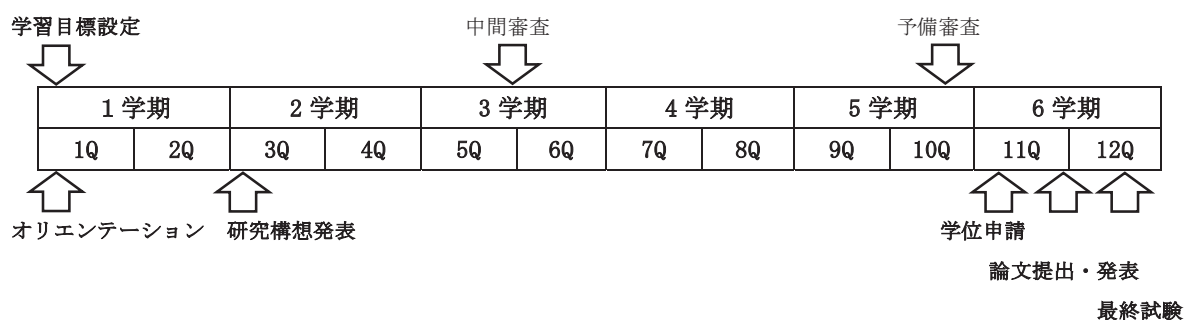
電気電子コース(修士課程)の科目体系図

学士課程で学んだ、電気・電子工学に関する基礎知識をもとに、波動・通信分野、電力分野、集積回路分野、デバイス分野、物性分野に関し、最新の研究に基づき、より先端的な知識・技術を体系的に学ぶことが出来る。更に講究および特定課題研究(修士)において自ら研究を遂行することにより、専門性を更に深めるとともに、創造力をより高めることができるように構成されている。



電気電子コース（博士課程）教育カリキュラム

博士課程では、修士課程での学修成果をベースとして、博士論文研究を中心に、数段高い専門能力、問題発掘・解決能力の開発が行われるとともに経済的・精神的自立が促されます。専門性を高度に高めるために600番台の講義科目が以下の科目表のように準備されています。これらの科目は修士課程における「研究構想発表後」、履修計画書をコースに提出し、コースが履修を許可すれば学修して取得することが可能となります。博士学位の取得に向けては、自身の研究の背景、目的等を明確化するために「研究構想発表」を行い、博士論文研究の進捗状況を確認するために「研究中間発表」を行います。学位申請を前提とした「予備審査」を経て博士論文発表ならびに最終試験を行い博士学位の審査が行われます。この博士課程の中でRA・TA活動、国際会議への参加の他に、海外研修または国内企業研修が推奨されており、研究室を越えた教育・研究の機会が提供されます。また、指導教員以外にメンターが1名配置され、複数教員による支援体制ができています。さらに、社会人博士学生や留学生が多数在籍しているほか、共同研究を通じた企業との交流など研究室構成員の多様性が確保されています。また、博士論文審査においては学外審査員制度により開かれた審査制度になっております。このように博士課程教育においては高度の専門性を身につけた独創性のある国際的リーダーの育成を図っております。



電気電子工学コース博士課程における博士論文研究の標準的な流れ

電気電子コース(博士課程)の講義科目および科目体系図

電気電子コース(博士課程)の講義科目

授業科目名	単位	担当教員
Teaching Skills in English for Doctoral Course Students (博士のための英語授業表現)	0-1-0	非常勤講師
Special Lecture I on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学特別講義第一)	1-0-0	
Special Lecture II on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学特別講義第二)	1-0-0	
Training on Teaching Technique (教授法トレーニング)	0-1-0	各指導教員
Doctor Course Colloquium (博士コロキウム)	0-1-0	各指導教員
International Presentations (国際プレゼンテーション)	0-1-0	各指導教員
Special Analysis on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学特別解析)	0-1-1	各指導教員
Practical Research on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学実践研究)	0-1-1	各指導教員
Study Abroad (Doctor Course) A-D (海外留学(博士)A-D)	0-0-n	各指導教員
Internship (Doctor Course) A-D (インターンシップ(博士)A-D)	0-0-n	各指導教員
Seminar S3, F3, S4, F4, S5, S6 on Electrical and Electronic Engineering (電気電子工学講義S3, F3, S4, F4, S5, S6)	0-0-2	各指導教員

※ 単位の数字は「講義－演習－実験・実習等」による単位数を表す。☆印の単位は派遣期間によりA-Dに対応し、それぞれn(1～6)単位に対応する。



電気電子コースの科目体系図(博士後期課程)

エネルギーコースの概要

エネルギーは、電気電子系の重要な分野の一つです。CO₂を排出せずにクリーンなエネルギーを創る。エネルギーをロスなく効率良く変換し、送る。送られたエネルギーを無駄なく有効に利用する。どれも現代社会を支え、未来の持続可能な社会を実現していくために研究すべき重要な課題です。

しかし、このエネルギーの問題は、電気電子の分野だけでは閉じていません。専門性を極めたスペシャリストが問題を的確に捉えたとともに、全体を大局的に俯瞰する力が必要とされます。エネルギーコースでは、物理、化学、材料、機械、電気の各専門の教員が、系の枠組みを超えて協力し合い、専門性と俯瞰力を兼ね備えた人材を育成することを目指しています。

1. エネルギーコースの理念

エネルギーコースでは、エネルギー分野において、物理、化学、材料、機械、電気の各ディンプリンを基礎とする高度な専門性を有し、かつ、エネルギーの諸問題を多元的エネルギー学理の視点から判断できる俯瞰力、自立的課題抽出・解決力、及び国際的リーダーシップ力を兼ね備え、社会に貢献するとの高い志を持ってイノベーションを牽引できる人材を養成します。

2. エネルギーコースの特徴

○高度な専門性と俯瞰力

地球の環境・エネルギー問題を解決するために必要とされる土台は何でしょう？それは、各人が深い基礎知識と専門性を持っていること、その知をイノベーションに繋げられる展開力、応用力にあります。エネルギーコースでは、「専門学理講義群」により深い知識と専門性が身につく、「エネルギー学理講義群」により多元的な視点から俯瞰力が身につくように講義が設計されています。人類への貢献を目指す、大学院生諸君の挑戦を期待しています。

○多様性

エネルギーコースは、理・工をまたがる様々な分野の研究室から構成されています。しかも、この多様性と幅広いバックグラウンドは、現代のエネルギー学理の伝授には不可欠なのです。エネルギー問題でわからないこと、あるいは新しいヒラメキがあったら、学院を超えて専門の先生に質問することができます。これにより、専門性と応用力について学ぶことができます。

○グローバルな視点

エネルギー研究では、基礎学力だけでなく、知識を実際に応用する力が重要となります。エネルギーコースでは、企業の研究者・経営者に講義に来てもらうなど、産(企業)と学(大学)とを繋ぐ教育に力をいれています。また、国際舞台で活躍できる人材を育成するため、活発な国際交流のエンカレッジを通して、国際的に通用する人材育成を行います。

3. 電気電子系エネルギーコースの担当教員 (2016年4月での予定です)

○主担当

赤木泰文教授、波多野睦子教授、山田明教授、萩原誠准教授、藤田英明准教授、小寺哲夫准教授、宮島晋介准教授、岩崎孝之助教、葛本昌樹特定教授※、久本大特定教授※、堀口剛司特定准教授※

※印を付してある指導教員は、主指導教員にはなれません。

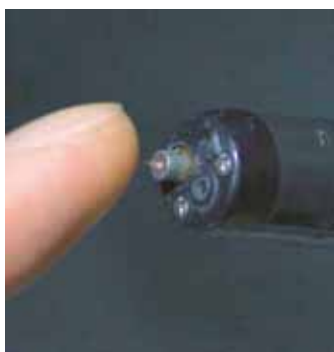
○副担当

千葉明教授、七原俊也教授、安岡康一教授、竹内希講師、中出雅彦特任教授

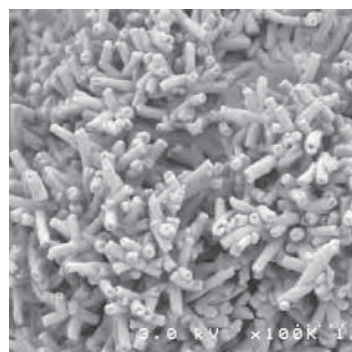
ライフエンジニアリングコースの概要

豊かな暮らしを実現するために、ひとの健康・医療・環境などに関する工学的研究開発であるライフエンジニアリングの教育と研究を行います。そのために、ヒューマンインターフェース、医療・健康科学、生命倫理、ひとが関わる環境などの基礎学問を修得して、さらに材料・応用化学系、機械系、電気・情報系・生命系などの専門学問領域を横断的に学びます。これにより、ひとの健康を守り、ひとに優しく持続的な社会を実現し、科学技術の発展に貢献できる力を育成いたします。

電気電子系ライフエンジニアリングコースのカリキュラムは、電気電子系の標準課程科目群に加えて、ライフエンジニアリングの習得ために必要な分野を横断的に学ぶ共通科目群で構成されます。これにより、ひとの健康・医療・環境などを知る電気電子系の専門家の育成をめざします。このコースに所属する教員の研究分野は、超音波技術を利用した生体測定、光学バイオセンシングや生体の構造を利用した光学材料の開発、大気圧プラズマを用いた医療機器や分析装置の開発など多岐にわたります。



大気圧プラズマ



蓮の葉を使った黒体メタマテリアル

電気電子系ライフエンジニアリングコースの担当教員 (2016年4月での予定です)

○主担当

梶川浩太郎教授、中村健太郎教授、沖野晃俊准教授、田原麻梨江准教授、岡本隆之特任教授、宮原秀一特任助教

原子核工学コースの概要

原子核工学コースでは、原子核反応・放射線・プラズマの利用、及びそれらを支える理工学分野を体系的に学修し、また研究に取り組むことで、将来エネルギー・環境・医療等の工学的分野及び関連の基礎科学分野で活躍するために必要な知識と実践力の習得を目指します。

本コースは、原子力分野で最先端の研究を行っている科学技術創成研究院先導原子力研究所との密接な連携の下に運営されています。教育カリキュラムにも研究所の最新の知見が反映され、修士・博士論文の研究では研究所での研究活動に密接に関係したテーマが用意されます。この充実した環境の下、安全・安心な社会の構築と世界の持続的発展を目指したバラエティーに富んだ研究を行うことができます。

原子核工学において、電気電子系の技術は原子力を一次エネルギーとする発電だけでなく、プラズマ・レーザー・加速器・粒子ビーム等、先端技術の基盤でもあり、将来のエネルギーである核融合をはじめ、これらを用いた先端的医療技術や材料プロセス等の様々な工業利用にも密接に関係しています。このコースに所属する教員の研究室は大岡山キャンパスにあり、研究分野としては、プラズマ内の原子分子過程、レーザー・分光学を応用したプラズマ診断、低温プラズマの基礎と応用、イオンビームを用いた核融合の基礎研究、加速器を用いた医療用診断・治療技術や高感度元素分析技術の開発等があります。



開放端磁場における
アークジェットプラズマ



メンテナンス中の1.6メガボルト
静電イオン加速器

電気電子系原子核工学コースの担当教員 (2016年4月での予定です)

○主担当

小栗慶之教授[#], 赤塚洋准教授[#]

[#]印を付してある教員は、電気電子コースを担当していません。

大学院生活

●研究室生活

学部と大学院の大きな違いは学修の場です。大学院課程では、体系的なカリキュラムに基づく教育と、研究室教育とを両輪としています。みなさんの大学における学修時間の多くは研究室で費やされると思いますが、研究室教育では世界最先端の研究に取り組みながら高度な専門知識や先端技術を修得し、修士課程在学中に成果をあげて国際会議での発表機会が得られるでしょう。また少人数教育体制を敷くことにより、教員との直接対話や先輩後輩との活発な議論が生まれ、思考力や判断力、交渉力といった社会で必須の能力が身につきます。こうした意味で研究室は皆さんのベースキャンプであり、専門学力を磨くとともに、社会性を身につける場所です。

各研究室(教員単独の研究室のほか、複数名で共同運営している研究室もある)は、電気電子系の5つの専門グループに所属します。後述する構想発表・中間発表・修了発表会などは専門グループ内の研究室が合同で開催するため、所属する研究室以外の教員からも研究指導を受けることができます。

●教員や学生との交流

研究室の枠を超えて、同じ専門グループ内、あるいは他の専門部グループとの交流の機会も多数設けられています。たとえば電気系科学技術懇話会では、電気電子系の教員が、学生や教員に科学技術の楽しさを伝え、議論を活性化させて、研究への興味を増幅させています。原則毎月1回、水曜日の夕刻に開催されるので多くの学生・教員が参加しています。このほかに、研究室合同の歓迎会、オリエンテーション、歓送会、OB会なども開かれています。また多くの学生はリサーチアシスタント(RA)やティーチングアシスタント(TA)として雇用され、教員や学生と接する過程で研究者や指導者としての視点を養います。

●発表会(構想, 中間, 学位論文発表会など)

研究活動の報告は、所属する研究グループで、構想発表会、中間発表会、論文発表会の順に行い、発表会ではグループ教員全員から研究内容や発表能力について評価を受け、学修に活かす仕組みができています。また発表会には全ての大学院生も参加が許可され、積極的に質疑に参加するよう促されており、発言力を磨く場としても活用されています。

卒業後の進路

●就職支援

電気電子系の就職支援活動は、就職支援室のスタッフと就職担当教員を中心に、大岡山、すずかけ台、双方で行われています。主な行事としては2回の就職説明会と同窓会（楽水会）主催の企業セミナーがあり、それ以外にも電気系OB/OGによる会社説明会も随時頻繁に開催されています。就職支援室からの情報提供は迅速できめ細かく、常に親身になって就職に関する相談に乗ってくれます。また楽水会主催の企業セミナーにはさまざまな分野から80社以上の参加企業があり、数多くの東工大出身者から貴重な会社情報を直接入手できる場として大変好評です。昨年は大岡山駅前の蔵前会館で開催されました。なお大学推薦の人数枠は十分用意されていますので、大いに活用してください。

●就職状況

電気・電子技術は、すべての産業に関わっています。このため電気電子系出身者への求人はあらゆる企業から集まり、求人倍率は毎年10倍以上です。業種別の就職先の割合については、平成27年度の実績で、電気機器メーカーが約半数、次いで放送・電力・鉄道分野が約1/4、その他は電気機器以外のメーカーや金融、公務員です。この中には博士課程卒の学生も含まれます。博士課程終了後の就職先は、大学や公的研究機関だけでなく、6～7割が民間企業です。大学院修了後の就職について、修士・博士ともに不安はまったくありませんが、自分のやりたいことを明確にして、自分の力を発揮できる就職先を決めることが重要です。特に、電気・電子分野以外の企業では業務上の裁量を多く任されるなど、活躍の場が多いので積極的に挑戦してみても良いでしょう。採用試験では専門学力の評価に加えて面接が重視されます。コミュニケーション力、協調性、企画力などが評価対象なので、専門学力とともに研究室での研究活動を通じて、しっかりと身につけておくことが重要です。



受験について

電気電子系の研究分野は、材料・物性分野、デバイス分野、波動分野、回路分野、電力・エネルギー分野という広範な学術・研究分野を網羅しているため、電気・情報系分野にとどまらず、幅広い研究分野の優秀な人材を国内外から広く募集し、グローバルに通用する人材として育成しています。

大学院は、修士課程と博士課程に大別されます。

修士課程では、基礎的理解力と応用発展力をもった、グローバルに活躍できる人材を育成することを目指しています。電気情報系学科はもとより、物理系学科、化学系学科、材料系学科、制御系学科などの広範な学科の卒業生を受け入れています。このため、修士課程入試においては、各分野に共通する基礎的科目である数学、電磁気学の二つの必須科目、電気回路または量子力学/物性基礎からなる選択科目および英語 (TOEIC/TOEFL等) により学力を判定します。

博士課程では、国際的に第一級の力量を持つ研究者・技術者等を育成することを目指しています。6月と1月の年2回の出願期間が設定されています。博士課程への出願は、志望する指導教員の了解が必要ですので、まずは志望分野の教員に面談の依頼をしてください。

以下では、修士課程入試について説明します。博士課程入試については、電気電子系ホームページをご覧ください。すべての情報は募集要項に記載されています。ここには概要のみを記載していますので、必ず募集要項を確認してください。

1. 募集要項

募集要項は、4月上旬にweb(入試課ホームページ)で公表され、5月上旬より以下の場所で配布しています。また、募集要項の郵送をご希望の方は以下のURLをご覧ください。

<http://www.titech.ac.jp/admission/graduate/request.html>

配布場所

＜大岡山キャンパス＞

西8号館E棟2階入試課9時00分～17時00分(平日のみ)

正門守衛所(正門入りすぐ左)7時00分～22時00分(土日祝可)

＜すずかけ台キャンパス＞

J1棟1階 学務課 ロビー 9:00～17:00 (平日のみ)

出願受付は5/26(木)を予定しています。

募集要項に関するその他の情報などは入試課のホームページをご覧ください。

http://www.titech.ac.jp/graduate_school/news/index.html

2. 入学試験

選抜は、「A日程」と「B日程」のいずれかの試験により行います。A日程では、基礎・専門学力および適正などに関する口述試験を行います(通常7月末に実施)。A日程の有資格者には、願書提出後に、その旨通知が届きます。B日程では、数学と電磁気学の二つの必須科目および電気回路または量子力学/物性基礎の選択科目という三つの専門科目とTOEIC あるいは TOEFLによ

る英語の成績の換算による筆答試験(8/16に実施)と志望分野および適正などに関する口頭試験を組み合わせて行います。A日程を欠席したり不合格となった場合でもB日程の試験を受験することができます。なお、A日程の結果は、B日程の合否判定には一切考慮されません。

B日程筆答試験の専門科目は、数学と電磁気学はそれぞれ1時間30分、電気回路または量子力学/物性基礎の選択科目は1時間です。また、英語の学力評価には、英語外部テストのスコアを利用します。英語外部テストとは、(1) TOEFL-iBT (2) TOEFL-PBT (3) TOEIC の3種類です。TOEFL-ITP及びTOEIC-IP等の団体特別受験制度のスコアは利用できません。なお、英語外部テストのスコアは、願書提出期限から2年以内のものを有効とします。

3. 系説明会

修士入試の説明会と研究室見学会を3月と5月、6月に開催する予定です。研究室の紹介や見学、入試についての説明が行われます。各研究室が二つの異なるキャンパスに属していることから、それぞれのキャンパスで説明会を開催しますが、日程は続いています。詳しくは系のホームページで報知されますので、そちらをご覧ください。

4. 国際大学院プログラム

留学生向けに国際大学院プログラムがあります。日本国内在住の留学生が出願できる種目に国際大学院プログラム(C)の国内出願があります。筆答試験と口頭試験により合否を判定します。筆答試験の出題範囲は一般試験と同様ですが英語での受験が可能です。4月に出願し、9月に入学します。

詳しくは下記ホームページおよび募集要項を参照してください。

http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/index.html

5. 清華大学(中華人民共和国)との大学院合同プログラム

東京工業大学と清華大学(中華人民共和国)が共同で大学院の学生教育を行い、日本語、中国語及び英語の素養を持ち、日中双方の文化・習慣に通暁した優れた理工系の人材を養成し、両国の科学技術及び産業経済の発展に資することを目的として大学院合同プログラムを開設しています。電気電子系では、ナノテクノロジーコースに参加しており、修士課程において、両方の大学院に同時に所属することが可能です。詳しくは下記を参照ください。

<http://ttjp.ipo.titech.ac.jp/top/>

6. 国立交通大学(台湾)とのダブルディグリープログラム

東京工業大学電気電子系と国立交通大学(台湾)国際半導体産業学院では、ダブルディグリープログラムとしての大学院修士課程教育を2016年度より開始することを予定しています。二年間で両方の修士号をとることが可能です。詳細は今後電気電子系のホームページにて掲載予定です。

7. 問合せ

受験に関するお問合せは、下記のメールアドレスにご連絡ください。

inquiry_dept@ee.titech.ac.jp

電気電子系の情報はホームページでご確認ください。

<http://www.ee.titech.ac.jp> (3月まで) <http://educ.titech.ac.jp/ee/> (4月以降)

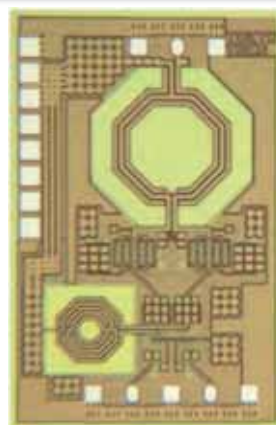
修士・博士課程における研究活動

学部と大学院の大きな違いは、みなさんの大学における勉強の多くの時間が研究活動に費やされるということにあるでしょう。電気電子系では、最先端の研究施設と各分野で活躍中の教員の直接指導により、学生でも世界に誇れる研究成果を出し、自分自身で発表することができます。

研究の基本は研究室単位(教員1名の研究室もありますし、2名で共同運営している研究室もあります)ですが、大きく分けると5つのグループがあり、中間発表・修了発表会などは合同で開催しています。

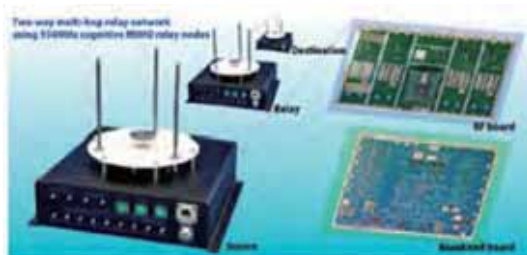
回路グループ (p.18~21)

回路グループでは、トランジスタや容量などの素子を巧みに組み合わせることにより、携帯電話、パソコン、テレビ、デジカメ、ゲーム機などのエレクトロニクス機器を作るための研究を行っています。例えば、携帯電話の中で使っている集積回路は、電波から電気信号を取り出す役割りを担っています。その取り出したアナログ信号をデジタル信号に変換し、音声や画像などのさまざまな情報として処理するのが、回路の役割りです。より大量のデータを送受信できる回路や、より低消費電力で動作する回路について研究を行っています。



波動・光および通信グループ (p.22~49)

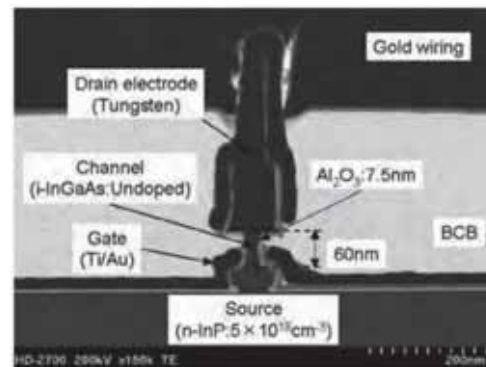
この研究分野に共通するキーワードは「波」であり、奥深い物理の理解から最先端の情報技術までを網羅し、通信は最も身近な応用と位置付けられます。基盤技術としては、光デバイスおよび集積回路、アンテナおよび高周波回路、無線通信工学および信号処理、環境電磁工学などがあります。この分野で活躍しようと思う学生の皆さんは、新材料の開拓や独自設計による



デバイス・装置の実現からシステムの実験、さらには多岐にわたるシミュレーションまで行えます。「波」を使った広い分野をカバーし、「世界で初めて」あるいは「世界で最高」の成果を常に目指した研究にチャレンジしませんか。

デバイスグループ (p.50~75)

低炭素社会に貢献する「環境」を重視した、ダイヤモンド、新規2次元材料、化合物半導体などをベースとした、低消費電力で高速動作するデバイスやパワーデバイスの研究を行っています。低消費電力で高速動作させるために、低電圧時での高電流密度や待機時低消費電力を目指します。またシリコンや化合物半導体に微細構造をつくりこむことで量子効果を積極的に用いた新規機能デバイスや、光と電波に挟まれた未開拓の周波数帯であるテラヘルツ波のデバイス開発にも取り組んでいます。



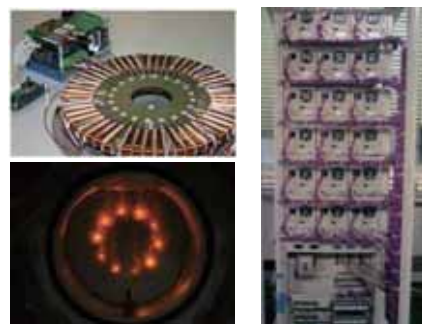
材料・物性グループ (p.76~95)

新しい電気・電子デバイスの出現は、私たちの生活に大きな変革をもたらします。そのため、革新的な材料開発と先進的なデバイス化技術の開拓に大きな期待が集まっています。集積回路や太陽電池に「半導体」、情報記録媒体に「磁性体」、表示素子に「液晶・有機分子」、バイオデバイスの実現のための「ナノ材料」など、様々です。こうした既存デバイスの特性向上のための材料開発や物性制御に留まらず、新しい機能を持つ材料の創成に挑戦し、世界初の先進的デバイスを提案し、その動作を実証します。



電力・エネルギーグループ (p.96~115)

エネルギーと環境、水と食の安全、そして地球温暖化。世界は今大きな問題に直面しています。我々のグループで開発したプラズマ技術は、難分解性有機物の無害化や新素材開発に応用されています。スマートグリッドと電力用パワーエレクトロニクスは、電力を有効利用する基盤技術として高く注目されています。さらに、太陽光や風力で発電した電力の99%以上を有効利用できる電力変換・制御技術や、レアアース磁石を使用しない高出力・高効率モータ、また、粒子ビーム応用技術など、私たちは電気エネルギーを活用し社会に役立てるための研究を行っています。



松澤・岡田研究室

先端アナログ・RF混載集積回路設計

世界最高速ミリ波トランシーバ

世界最高性能・最小電力A/D変換器



回路グループ
電気電子コース
大岡山・S3-312 / S3-812

教授 松澤 昭 准教授 岡田 健一 助教 宮原 正也

研究分野: RF・アナログ・デジタル混載集積回路設計
キーワード: ミリ波無線通信、データコンバータ、RF回路、PLL、
センサー情報処理回路、低電圧・低電力
ホームページ: <http://www.ssc.pe.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

松澤・岡田研究室では、「RF・アナログ・デジタル混載集積回路設計」に関する研究開発を行っています。微細CMOSを用いたアナログ・デジタル混載システムおよび超高速無線通信システムの可能性の追求に主眼を置き、回路からシステムまでの幅広い取り組みを通じて、世界最高性能を目指すとともに技術の体系化と実用化を図ります。

2 最近の研究成果

RF・アナログ・デジタル混載集積回路設計技術は、現在のエレクトロニクスにおいて高性能化、低消費電力化、小面積化、低コスト化を実現する上での重要な基幹技術となっております。私たちは60GHz帯を用いた超高速データ伝送用ミリ波通信システム、リコンフィギュラブルRF-CMOS回路、容量演算や補間技術を用いたデータコンバータ、ダイナミックアナログ回路、0.5V程度の超低電圧で動作する超低電圧・超低電力アナログ回路、センサ情報処理回路などに主眼を置き、エネルギー消費が少なく、環境に優しいグリーンICT社会の実現を目指した研究を行っています。

60GHz ミリ波無線通信システム

私たちは現在、ミリ波帯を用いた無線通信システムを開発しています。特に60GHz帯は世界中の多くの国で幅広い周波数が免許不要で使え、この周波数帯を用いると100Gbps超の超高速無線通信が可能になります。この高い伝送速度はHD映像を非圧縮で無線伝送するワイヤレスHDMIや映画やTVプログラムの瞬時のダウンロードなどを可能にします。

実際に、学生が自分で回路を設計し、最先端のCMOS技術による半導体チップを製作しています(図1)。ミリ波無線機は非常にホットな研究分野で、世界中の大学や企業が競って研究を行っています(図2)。そのような中、当研究室の大学院生がデザインした回路(図3)が、ミリ波帯無線機として現在の無線LANの100倍程度の速度である世界最速の28Gbpsの通信速度を達成しました。

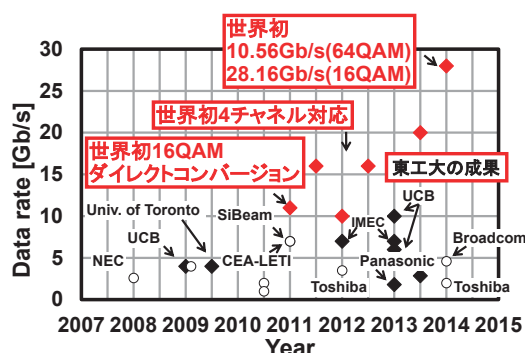


図2. ミリ波無線通信システムの研究競争

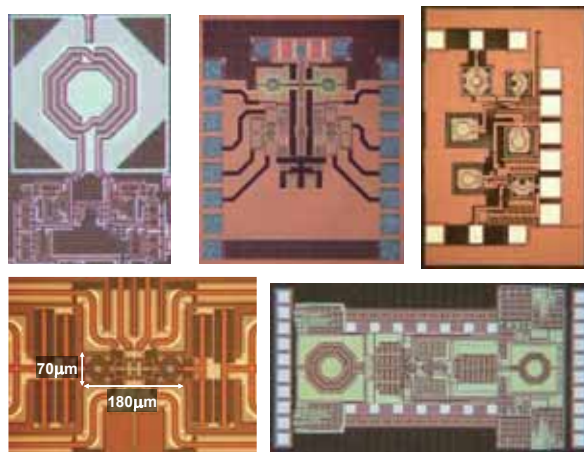


図1. 学生が設計した作品 (60GHz帯無線回路)

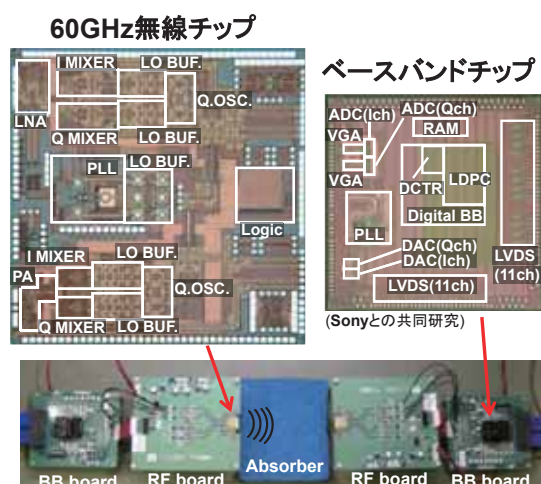


図3. 世界最速を達成したミリ波無線機

大岡山・回路グループ

リコンフィギュラブルRF回路

現在、無線通信にはWiFi、Bluetooth、WCDMA、WiMAX等数多くの規格が存在します。本研究では、全ての無線通信を可能にするマルチバンドRFフロントエンドを微細CMOSにより1チップで実現し、従来の端末より低消費電力化、小面積化が可能なリコンフィギュラブルRF回路により、究極の無線端末を実現することを目指として研究しています(図4)。

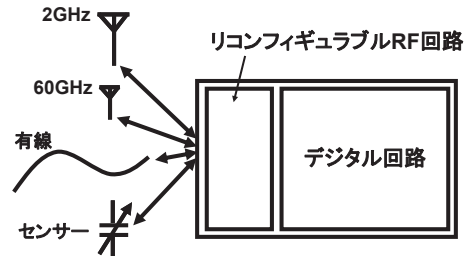


図4. リコンフィギュラブルRF回路の概念

高性能A/Dコンバータ

アナログ信号をデジタル信号に変換するA/Dコンバータは通信システムなどの電子システムの性能向上を図るための最重要技術の一つです。私たちは微細化に伴い性能が劣化する演算増幅器を用いなくても、簡単な2つの増幅器の出力電圧を補間することを提案し、7ビット400MHzの超高速A/Dコンバータを開発しました(図5)。この開発の成功により、60GHzの無線通信において7Gbpsのベースバンド処理を可能にしました。

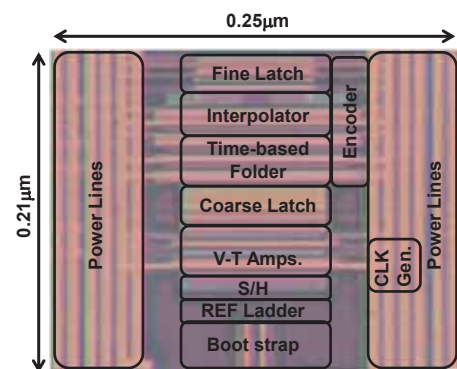


図5. 7bit 2.2GSps A/Dコンバータ

医療・環境に向けた低電力アナ・デジ混載集積回路

低電力技術は環境への負荷を低減するグリーンICT社会の実現にとって不可欠な技術です。最近ではセンサーネットワークやポータブル医療の実現のためにも強く要望されています。そこで、容量とダイナミック回路を用いることで、ナノワットで動作する超低電力A/D変換器(図6)を開発しました。また超低電力ピクセル型A/D変換器を集積し、電離電荷量を計ることができる新型粒子線検出器(図7)を世界で初めて開発し、α線などの放射線や素粒子の飛跡を捉えることに成功しました。この他、時間差をデジタル値に変換する分解能1ps以下の10bit 70MSps 時間・デジタル変換器や、設計に多くの時間が必要なアナログ・RF回路を自動的に設計する、アナログ回路自動合成技術の開発も行っております。

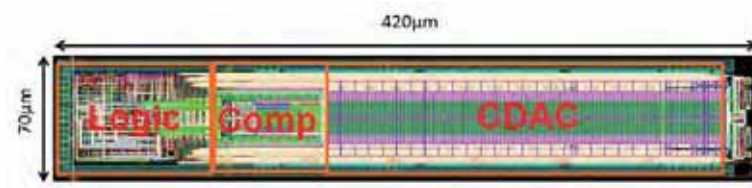


図6. 超低電力 12bit 70MSps A/Dコンバータ

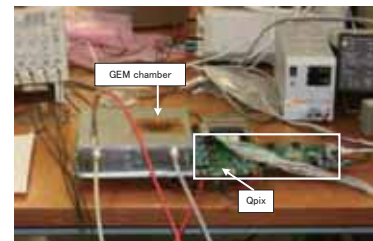


図7. 粒子線検出器と捉えられた飛跡

3 教員からのメッセージ

松澤先生より

当研究室では、みなさんのアイデアの入った集積回路や、それを用いた数mmの大きさの電子システム、ワイヤレスシステムなどを実際に作ることができます。自分のシステムを作ってみませんか。

岡田先生より

世界最速の無線チップを作ってみませんか？

益・伊藤研究室

高周波集積回路から
センサネットワーク・応用技術へ

回路グループ
電気電子コース
すずかけ台・S2棟408号室

教授 益 一哉 准教授 伊藤 浩之 助教 山根 大輔

研究分野: 集積回路, アナログ/RF回路, 集積化MEMS, 通信システム

キーワード: センサネットワーク, 無線通信システム, 高速信号伝送,
慣性センサ, Swarm Electronics, IT農業

ホームページ: <http://masu-www.pi.titech.ac.jp>

1 主な研究テーマ

我々のグループでは、これまで高速・高周波Si CMOS集積回路技術の研究開発を中心に行ってきました。集積回路の徹底的な微細化・高性能化は、本当にこれまでのやり方で良いのか、産業的に成立するのだろうかという課題に直面し、研究・開発・製造、そして応用の全てにおいて変化・変革を求めています。我々は、応用分野（ヘルスケア、農業）の研究も進めながら独自に課題を抽出し、集積回路分野・エレクトロニクスの新分野・新技術を開拓していきます。具体的には、センサネットワーク用途の極超低消費電力無線・センサ回路技術、集積化MEMS技術、超高感度なMEMS慣性センサ技術、気の検出システム、密閉型稲育成システム、獣害対策システム等の研究開発を推進しています。

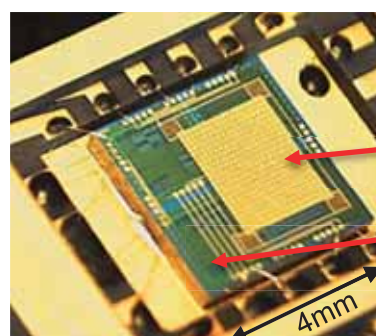
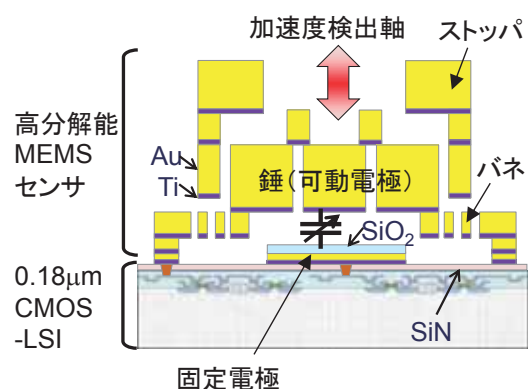
※本研究室は、未来産業技術研究所の石原昇特任教授、道正志郎特任教授、大場隆之特任教授らと密に連携しながら研究・教育を進めています。

2 最近の研究成果

■ 超高感度慣性センサ

CMOS-MEMSプロセス、CMOS-MEMS統合解析・設計環境技術による慣性センサの超高感度化と超小型化研究を核として、材料レイヤ(曾根正人准教授)と応用レイヤ(三宅美博教授)と連携して、ナノG^(注1)計測の実現と応用展開をJST CRESTプロジェクトとして目指しています。本研究室で開発中のワンチップ慣性センサシステムは、機械的雑音(ブラウンノイズ)を削減するために比重が大きい材料である金(Au)を利用しているところが特徴です。さらに、小型で雑音に強いシステムにするために、MEMS慣性センサとセンサインターフェース回路を図1のように集積化しています。また、材料面からの機械的性質制御や、慣性センサを利用した身体運動解析に基づくパーキンソン病早期発見支援システムの共同開発も進めています。

注1) 加速度 $1G = 9.8m/s^2$



D. Yamane et al.,
IEEE SENSORS
2015

図1. ワンチップ慣性センサ
(上図: 断面図, 下図: チップ写真)

すずかけ台・回路グループ

■ センサネットワークシステム・高周波回路技術

実世界から環境情報を取得するためのバッテリーレスなセンサ端末ハードウェア・RF CMOS回路技術と、それを活用したセンサネットワークシステムを中心に研究を進めています。端末ハードウェアの低コスト化・小型化・低消費電力化とセンサネットワーク全体のセンシング性能向上の両立を目指しています。集積回路技術を発展させるだけではなく、確率共鳴や群知能といった技術をセンサネットワークハードウェア・システムに展開して「量が質を生むハードウェア技術」を研究していきます。

近い将来に様々なモノに埋め込まれるセンサ端末は、バッテリーレスで環境から電力を生成(環境発電)することが強く求められます。この時、センサ端末内の無線トランシーバは、極めて低い電力・高い電力効率で通信する必要があります。本研究室では、数十マイクロワット以下の消費電力で動作するRFトランシーバフロントエンド回路や無線通信モジュールを開発しています。図2の回路では100マイクロワット程度の低消費電力動作と多値変調(32-QAM)を両立し、図3の回路は1Mb/s伝送時に2.3マイクロワットという低消費電力動作を実現しています。

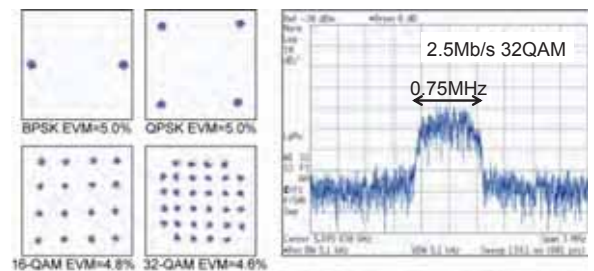
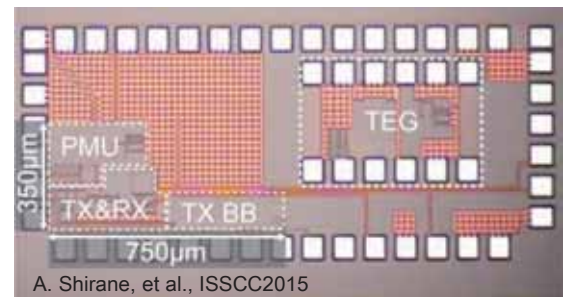


図2. 直交ボックスキャタリング回路技術

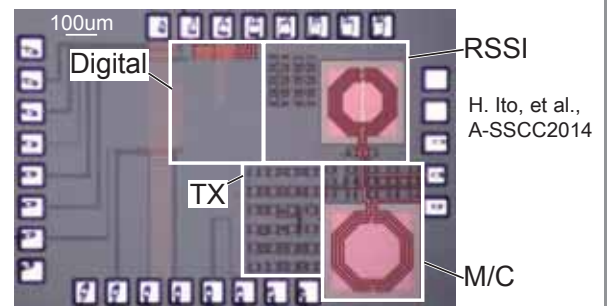


図3. 超低電力インパルス送信機

■ 応用技術研究(農業用センシング技術)

センサ・集積回路技術の応用技術として、農業用センシング技術・新システムの研究開発を進めています。稲栽培のレシピ化・365日自動播種/収穫などを目的としたSun-Rice計画(図4, 大場特任教授との共同研究), 猿などの害獣を自動撃退するシステムの研究開発(信州大などとの共同研究)などを進めています。

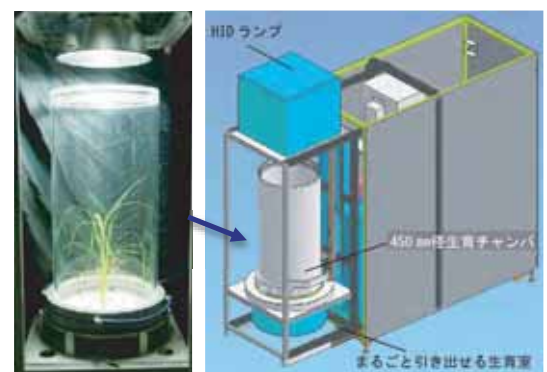


図4. 完全密閉型稲育成装置 SRP-450

3 教員からのメッセージ

【益】 何か物事に向かう時、常に前向きに考える。前向きな姿勢を失わなければ必ず道は拓けます。

【伊藤】 多少時間がかかっても自分の頭で自由に考え、チャレンジしてもらうことを重視しています。ワクワクするモノを創っていきましょう！



波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山・西9号館824/825
准教授 青柳貴洋
Assoc. Prof. Takahiro Aoyagi

Research Area: 環境電磁工学 (Electromagnetic Compatibility, EMC), ヘルスケア・医療情報通信工学 (Healthcare and Medical Information Communication Technology, MICT), 教育工学 (Educational Technology, ET)
キーワード: 電磁波工学、電波伝搬、情報通信工学
<http://www.ao.hum.titech.ac.jp/>



1 Research policy (研究ポリシー)

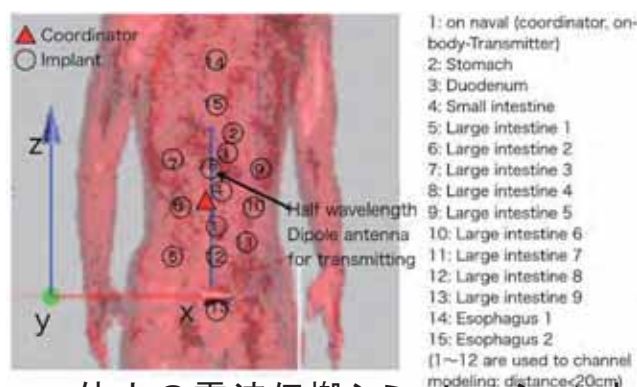
学問分野(電磁波工学、情報通信工学)の進化、発展をはかり医療、ヘルスケア、スポーツ、エンターテインメント、教育学習等の各分野における応用技術を研究するとともに、電磁環境の調和をはかっていきます。

2 最近の研究内容

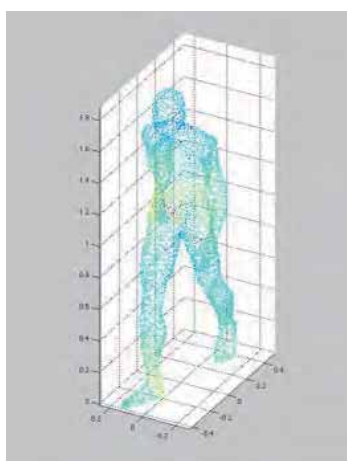
■ ボディエリアネットワーク

ボディエリアネットワークは生体(主に人間の身体)の周辺での通信の最適化を目指して設計されたセンサーネットワークです。

より高信頼性、高性能なボディエリアネットワークを構築することにより人々の健康増進、生活習慣病の予防、医療への応用、さらにはスポーツやエンターテインメントでの活用を目指します。青柳研ではボディエリアネットワークの電波伝搬や通信プロトコル、センサー情報を活用したシステムについて研究を行っています。



- 体内の電波伝搬シミュレーションとチャネルモデル
- マイクロ波による体組織の測定

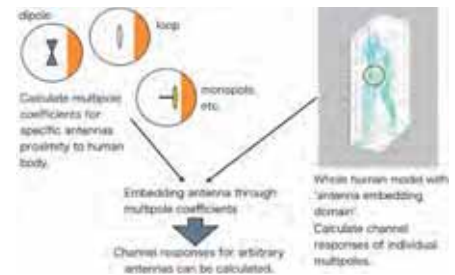


- コンピュータシミュレーションによる無線ボディエリアネットワークの電波伝搬の数値計算と伝搬モデルの作成

大岡山・波動・光および通信グループ

■ 環境電磁工学

情報通信技術が発達した現代では我々のまわりを多くの電磁波が行き交っています。安全・安心な社会生活をおくるにはこれらの電磁波と存在する全ての電子機器、生体が調和をはかることが重要です。本研究室では主に電磁ノイズの吸収、遮蔽に関する研究を行っています。



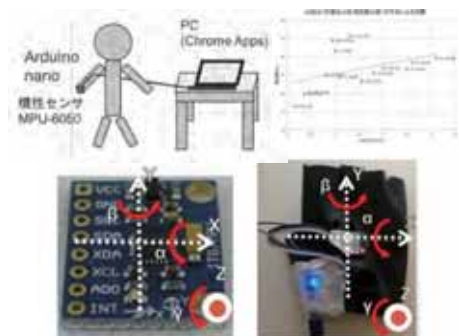
- 無線ボディアエリアネットワークの伝搬チャネルからのアンテナの分離

■ ワイヤレスセンサーネットワークを活用した生体情報の収集とヘルスケア、医療、スポーツ等への応用

各種の生体情報(心拍、体温、血圧など)や生体の動作の情報(加速度、角速度など)を取得して分析し、ヘルスケアやスポーツ学習へ応用するための研究を行っています。たとえばセンサーから取得した情報を活用し、動作分析を行うことで健康増進のための動作学習システムへの応用などが可能です。本研究室は基本的なセンサーの開発から無線ボディアエリアネットワークを利用したデータ収集、さらに収集したデータの分析と効果的な利用を行うシステムの開発まで行っています。



- 空中超音波による人体動作の測定

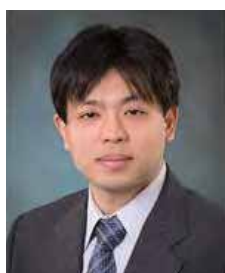


- モーションセンサ付グローブによるフライングディスク投動作解析

3 教員からのメッセージ

- 平成28年度から電気電子系の主担当となります。平成27年度は研究室に学部学生、修士学生はおらず、研究室としてはリスタートに近い形です。
- 平成27年度は、博士課程2人が在籍しています。
- 研究室では、上記の研究テーマについて、手を動かしてものをつくり実験を行う、コンピュータプログラミングにより自作のソフトウェアを開発してシミュレーション計算を行う、数式を使って理論を構築し電波伝搬のモデル化を行う、等の方法により研究をすすめていきます。
- これまでの研究成果についての詳細は東工大リーサチレポジトリ(T2R2)等を参照してください。

荒井・西山研究室

次世代光通信のための光デバイス/
光集積回路、極低電力光デバイス、
Siフォトリソ

波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山: S9-704/S9-701

教授 荒井 滋久

准教授 西山 伸彦

助教 雨宮 智宏

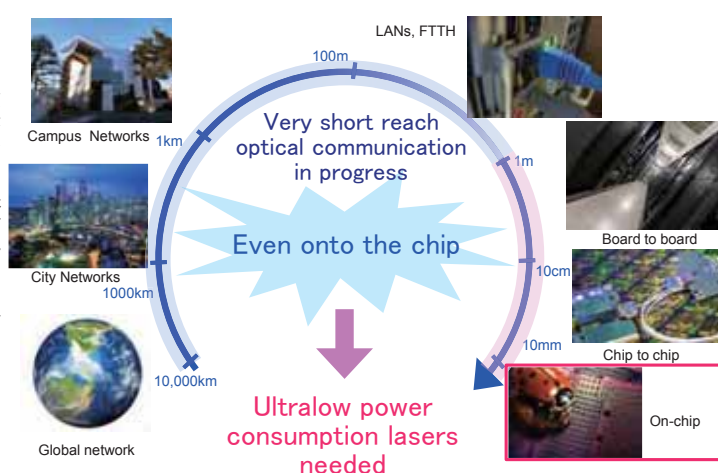
研究分野: 光エレクトロニクス、量子電子工学、
キーワード: 光通信、光インターコネクション、半導体レーザ、Siフォトリソ、
半導体材料、メタマテリアル

ホームページ: <http://www.pe.titech.ac.jp/AraiLab/>

1 主な研究テーマ

50年以上も前、私たちの生活を大きく変える一つの歴史的な出来事がありました。世界初となる半導体レーザ発振の成功です。以来、先人達は次々に技術革新を実現してきました。石英光ファイバの極低損失化と波長1.5-1.6ミクロン帯で動作する半導体レーザの実現とその高性能化に伴って、電信は光ファイバ通信へと姿を変え、インターネットやスマートフォンなどの通信を支える基幹技術となりました。

近年では、光ファイバ通信はスーパーコンピュータの中まで浸透し、高い処理能力と低消費電力化に大きく貢献しております。当研究室では、光通信の基盤となる光源を中核として、将来の光集積回路構築のための新しいアイデアの提案とそれを実現するための基盤技術の開拓を行っています。



そのような背景のもと、当研究室では、ローカルエリアネットワーク（LAN）からオンチップ光配線までを視野に入れ、光源である半導体レーザを中心とした**次世代の通信用光デバイス**の研究開発を行っています。これまでLSIの微細化・高密度化とともにムーアの法則に従って向上してきたプロセッサの処理能力は、電気配線の伝送遅延、電磁干渉ノイズ、および消費電力の急激な増大により限界に近づきつつあります。こうした電気配線による伝送限界を解消する技術として、シリコンの微細な光導波路をLSIチップ上に張り巡らせて、光によりチップ間やチップ内での信号伝送を行なう「**オンチップ光配線**」が注目を集めています。

私たちは、将来的なオンチップ・オンボード光配線への応用を念頭に、シリコン基板上極低電流動作半導体レーザ搭載集積光回路、SOI（Silicon on Insulator: 絶縁体上のSi）基板上におけるシリコン・化合物半導体混載大規模光集積回路、従来に比べて超高速変調を可能とするトランジスタレーザ、そして自然界にはありえない光特性を生み出すメタマテリアル光素子など、様々な革新的な光集積デバイスを提案し、その実現と産業応用に取り組んでおります。

研究テーマは、新規の人工材料および素子から「極めつけ」の性能を有する光デバイスと集積回路まで、“**For the first time**”あるいは“**A record Low/High**”と言えるような目標を設定できる課題を念頭に、学生諸君と決めております。研究室の先輩の成果の一例を以下に挙げます。

- ・ **世界初**の波長1.5-1.6ミクロン帯で直流動作する半導体レーザ
- ・ **世界初**の波長可変半導体レーザ
- ・ **世界最小電流**の波長1.5-1.6ミクロン通信用半導体レーザ
- ・ **世界初**の半導体メンブレンレーザ



本研究室では、自ら提案したデバイスを一から作製できます



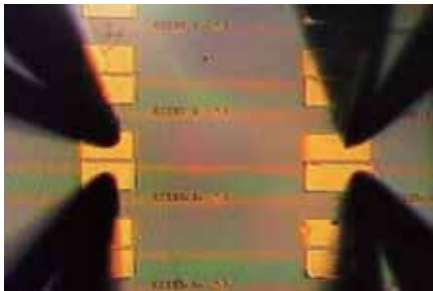
通信の伝送実験を行っているメンバー

大岡山・波動・光および通信グループ

2 最近の研究成果

毎年、多くの学生諸君が卒業しており、それぞれが、研究成果を国内学会、国際会議、英文学術誌に発表しています。詳細は下記の研究室ホームページで確認してください。

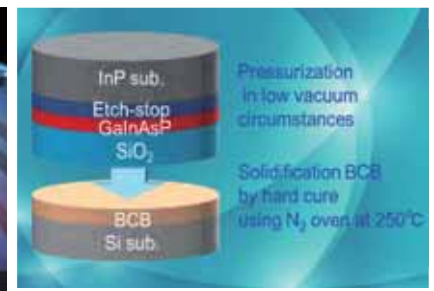
ホームページ: <http://www.pe.titech.ac.jp/AraiLab/>



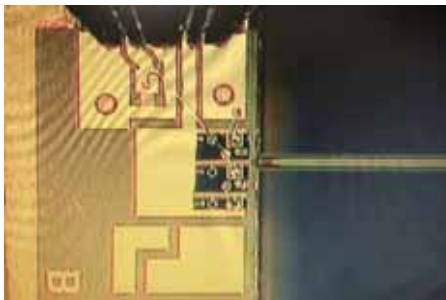
導波路集積型薄膜DFBレーザ
The 24th IEEE International Semiconductor Laser Conference (2014)



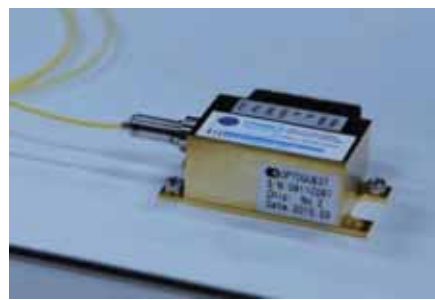
リング共振器ミラー装荷型ハイブリッドレーザ
IEICE Society Conference (2014)



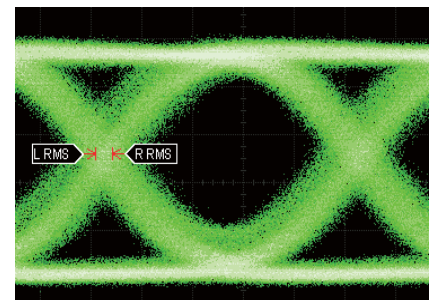
III-V半導体, SiのBCBによる貼り付け
Japanese Journal of Applied Physics 51, 042201 (2012)



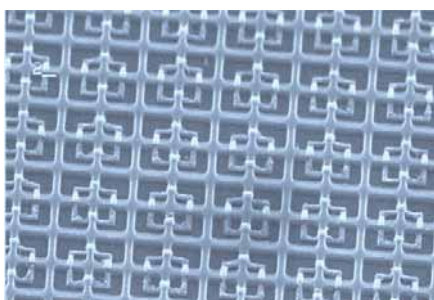
トランジスタレーザの高速変調
The 26th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials (2014)



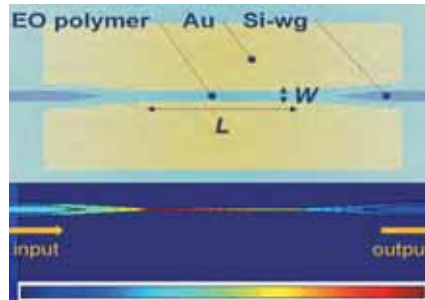
低しきい値DRレーザモジュール
Journal of Quantum Electronics, vol 48, no 5, pp. 688-695 (2012)



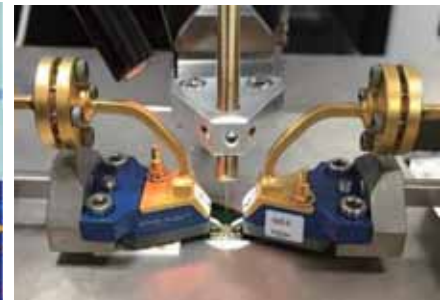
LSI上三次元超高速光伝送
APEX, vol. 7, no. 3, 032202 (2014)
日刊工業新聞、朝日新聞デジタル



III-V族半導体上メタマテリアル
CLEO 2013, QM1A.6 (2013)



EOポリマープラズモニック変調器
JSAP Spring Meeting (2016)



集積型光-THz信号直接変換素子
JSAP Spring Meeting (2016)

3 教員からのメッセージ

わたしたちも学生時代から、独自の着想やアイデアを基に達成した研究成果を国内学会および国際会議で発表したり、英文学術誌に論文掲載する機会に恵まれ、「学生でも世界初や世界一といえる研究発表ができる」ことに驚き、感激しました。修士課程学生で欧米の国際会議に参加して発表する機会も多くなっていますので、みなさんにも是非同じような経験をして頂き、大学院修了時には一回り大きくなって巣立って欲しいと願っております。

毎年4-5月の新入生歓迎旅行(1泊2日)、8月の光通信研究会(他大学を含め200名規模の夏合宿)、12月の忘年会、2-3月の卒業旅行(1泊2日)など、研究だけでなく記憶に残る時間を持ちたいと思っています。

安藤研究室

ミリ波無線通信
ネットワークの研究

波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山・南3-909

教授 安藤 真

研究分野: 電磁界解析, 無線通信ネットワーク

キーワード: 電磁界解析, 無線通信ネットワーク, ミリ波

ホームページ: <http://www-antenna.ee.titech.ac.jp>

1 主な研究テーマ

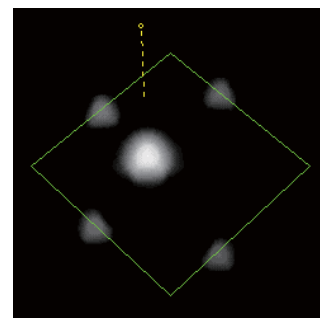
- 電磁波の回折・散乱
- 東工大ミリ波モデルネットワーク
- ミリ波高速通信システム

2 最近の研究成果

■電磁波の回折・散乱

右の図は, 黄色の点線の先にある○の位置に高周波の波源を置いたとき, 緑色で示す一辺10波長程度の方角金属板によって生じる, 紙面に対して手前方向への散乱電磁界の寄与を表わしています。高周波では位相が大きく変化するため多くの場所で寄与は打ち消し合い, 金属板の中で反射の法則を満足する点や金属板の端の光路長が極値をもつ点から主に寄与しています。

このように, 電磁界の基本現象の解明に関する研究も行っています。



■宇宙探査機用ラジアルラインスロットアンテナ

研究室で開発されたラジアルラインスロットアンテナ(RLSA)がJAXAの金星探査衛星あかつきに搭載され, 宇宙を旅しています。従来のパラボラアンテナでは太陽光まで集光してしまうことが問題であったのに対し, RLSAではそのような問題がありません。軽量化するためにダンボールのようなハニカム構造の基板を用いています。

その後、はやぶさ2にも搭載されました。

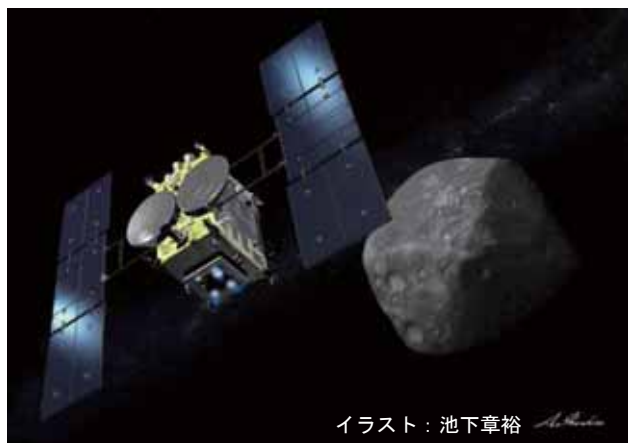
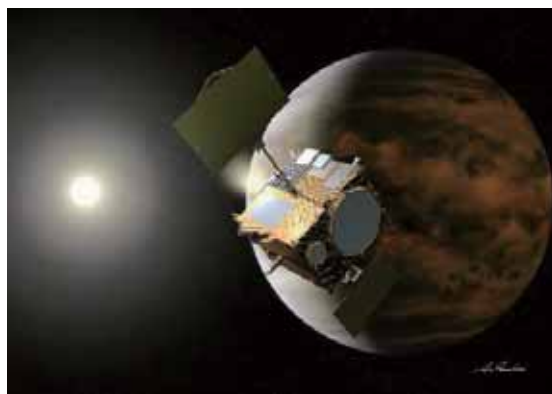
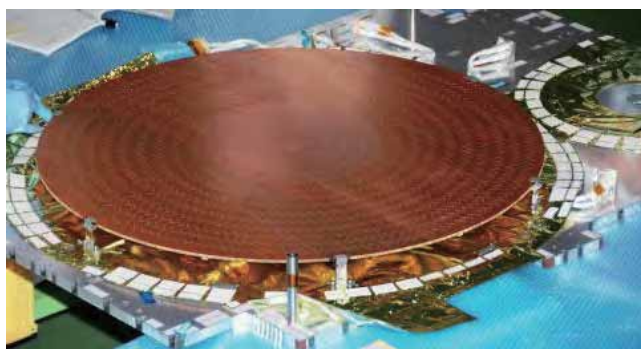


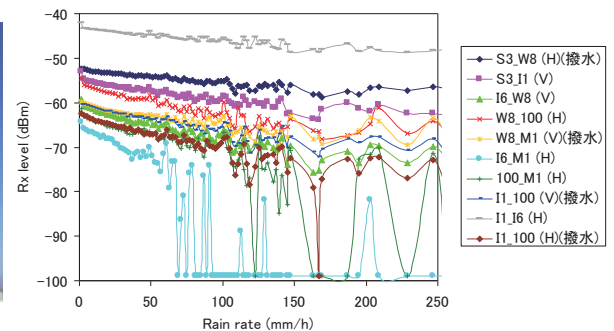
イラスト: 池下章裕



大岡山・波動・光および通信グループ

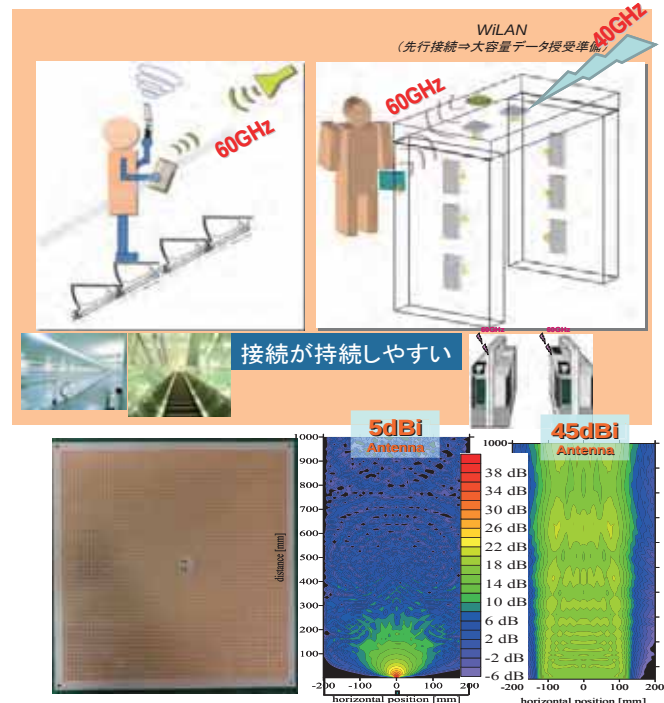
■ミリ波モデルネットワーク

学内7拠点にミリ波無線機を設置し、10経路の回線を有するミリ波モデルネットワークを学内に構築しました。本ネットワークを用いて、開発中のミリ波帯超高速無線通信装置の実証を行うとともに、ミリ波帯の屋外電波伝播特性を研究しています。降雨強度、降雨減衰、ビットエラー率(BER)、QoS (Quality of Service)とその相互関係について調べています。また、降雨の局所性を調べ、その特徴を利用した経路切り替えによる信頼性向上など高速・高信頼・安価な無線ネットワークの開発に向けて研究を行っています。



■無線アクセスゲート

スマートフォンやタブレットPC等の高性能・多機能な携帯無線通信端末の普及に伴い、データ通信を中心とする急激なトラフィックの増加が既存の移動通信システムにおける周波数ひっ迫の大きな要因となっていることを踏まえ、携帯無線通信端末からインターネット網への接続(アクセス系)で発生する大量のトラフィックの一部を周波数ひっ迫度の低いミリ波帯へ迂回させるため、ギガビット超級の伝送速度を有するミリ波帯ワイヤレスアクセスネットワークを構築するための周波数高度利用技術の研究開発を行っています。ユーザの端末へ近距離で瞬時かつ確実に大容量のデータを伝送する無線システム(無線アクセスゲート)等の近距離系ミリ波無線システム、並びに柔軟に配置される近距離系システムを結び、バックボーンとなる幹線通信網に接続するための中距離系ミリ波無線システムによる無線アクセスネットワーク構築技術を研究しています。



3 教員からのメッセージ

博士課程の学生から学部4年生まで、スタッフも合わせて、人数は約35名です。留学生も全体の約1/4と多く、国際色がとても豊かです。また、毎年、忘年会、野球大会を企画し、研究室のOB・OGとの交流も深めています。

阪口研究室

第5世代セルラネットワーク (5G) ミリ波超高速無線LAN (11ay) 無線センサネットワーク



波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山 南3号館 9階・10階

准教授 阪口 啓

助教 タン ザカン

研究分野: 無線通信工学
キーワード: 5G, 無線センサネットワーク、無線電力伝送、位置推定
ホームページ: <http://www.sakaguchi-lab.net/>

1 主な研究テーマ

携帯電話や無線LANなどの無線通信システムに関する研究・試作・標準化を行っています。



第5世代セルラネットワーク(5G)

- ・ミリ波を活用するヘテロジニアスネットワーク
- ・小セル基地局のダイナミック無線リソース制御

ミリ波超高速無線LAN(11ay)

- ・アクセスポイント連携ビームフォーミング
- ・ミリ波マルチチャ・マルチチャネル多重通信

無線センサネットワーク

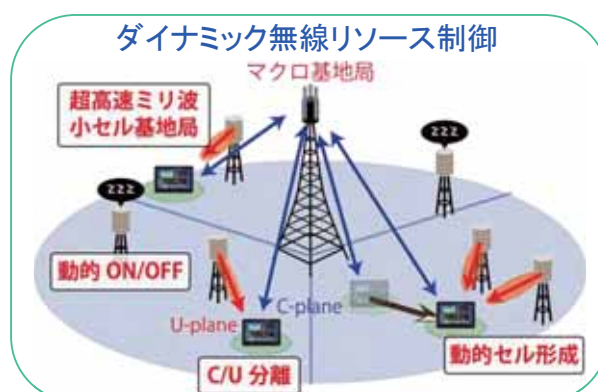
- ・フィンガープリントを用いた携帯端末の位置推定
- ・ワイヤレス給電で駆動するバッテリーレスセンサ

2 最近の研究成果

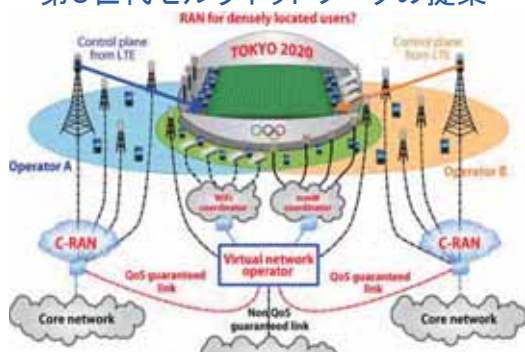
第5世代セルラネットワーク(5G)に関する研究

ミリ波を活用するヘテロジニアスネットワーク

- ・4Gの1000倍のシステム容量を実現する第5世代セルラネットワークのアーキテクチャを提案
- ・ミリ波小セル基地局をセルラネットワークに統合したヘテロジニアスネットワーク
- ・日本およびヨーロッパの各機関とMiWEBAコンソーシアムを結成し5Gの実証実験システムを構築
- ・2020年の東京オリンピックでの実用化を目指して2016年より3GPPおよびIEEEにおいて国際標準化作業に貢献中



第5世代セルラネットワークの提案



小セル基地局のダイナミック無線リソース制御

- ・ユーザの位置やデータ要求状況に応じて適応的に無線リソースを制御するアルゴリズムを考案
- ・4K動画ストリーミングなどの高速通信が必要なユーザには優先的にミリ波通信を適用することでネットワーク全体のQoSを向上
- ・ユーザの分布状況に応じて基地局の電源を適応的にON/OFF制御することでネットワーク消費電力を削減
- ・多数の基地局が適応的に協調することでユーザの過密しているエリアに快適なサービスを提供

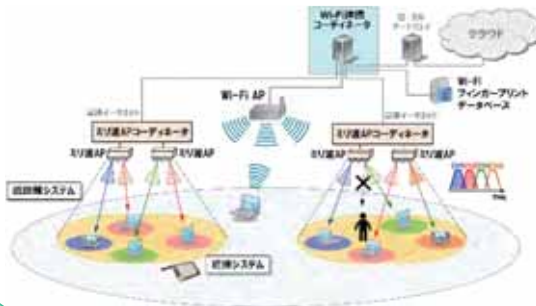
大岡山・波動・光および通信グループ

ミリ波超高速無線LAN(11ay)に関する研究

アクセスポイント連携ビームフォーミング

- WiFiコディネータが複数のミリ波APのビームフォーミングを連携制御するアーキテクチャを提案
- ミリ波AP間の干渉を自律分散的に回避しつつスループットを最大にするビーム制御プロトコルを構築
- 2015年度にはミリ波APを用いた実証実験により提案法の有効性を検証

WiFiコディネータによるミリ波APの制御



広帯域ベースバンド信号処理回路



ミリ波マルチユーザ・マルチチャネル多重通信

- 60 GHz帯は免許不要で2GHz帯域のチャネルを4つ束ねて通信できるため5Gの有力な候補
- 各チャネルでは4ユーザまでの空間多重により高い周波数利用効率を実現
- ユーザスケジューリングと組み合わせたRF帯でのビームフォーミングにより簡易な回路構成の実現
- 現在広帯域信号処理ハードウェアにマルチユーザ・マルチチャネル多重通信を実装中

無線センサネットワークに関する研究

フィンガープリントを用いた携帯端末の位置推定

- 屋内における歩行者ナビやジオフェンシングなどのアプリケーションに要求される高精度な位置情報を提供するフィンガープリントを用いたWi-Fi屋内測位システムを開発
- 提案法はフィンガープリントとして位置依存性を有する電波の特徴量を事前に学習し、推定時のデータと比較することで高精度な位置推定を実現
- 屋内実験において平均推定誤差1mを達成

携帯端末の屋内位置推定システム



LED照明一体型ワイヤレス給電システム



ワイヤレス給電で駆動するバッテリーレスセンサ

- 電波を用いたワイヤレス給電によって屋内空間でセンサを電源線・電池なしで駆動するバッテリーレスセンサネットワークを提案
- 複数ポイントから電力を供給し面的なカバーレッジを実現するマルチポイント型ワイヤレス給電
- 石川台1号館にLED照明に組込んだワイヤレス給電実証実験システムを構築
- バッテリーレスウェアラブル端末を現在開発中

3 教員からのメッセージ

本研究室は、現在第5世代セルラネットワークの国際標準化に取り組んでいるため、日本のIT企業だけでなく世界の業界団体や研究機関と協力し研究開発を進めています。よって本研究室は、語学力を活用したい学生、世界がどうなっているのかを間近に感じたい学生には最適と思われます。また本研究室には920MHz帯などの無線局免許があり、実際の電波を使って無線通信の実験を行うこともできます。無線通信システムの研究・試作・標準化に携わってみたい方は是非本研究室へお越し下さい。

西方研究室

環境電磁工学(電波吸収、電波遮蔽、
電磁波源推定、伝導雑音対策、生体
EMC)、高周波材料評価、空間音響

波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山・W9-818

准教授 西方 敦博

研究分野: 環境電磁工学(EMC)、高周波材料評価、空間音響
キーワード: 電波吸収、電波遮蔽、電磁波源推定、伝導雑音対策、
生体EMC、導波管法、音源定位
ホームページ: <http://www.ns.cradle.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

IT化やモバイル通信の発展の影で、電子機器・通信機器の正常な動作を保つための努力が払われています。不要電磁波は目に見えませんが、その対策なしに現代社会は成り立ちません。電波の安全性の確保の問題もあります。当研究室では不要電磁波を抑える・遮る・突き止めるための新しい技術を研究しています。関連して、生体に電波が及ぼす熱影響、高周波材料評価技術も研究しています。また、身近な波である可聴音波の音源推定も扱っています。

- ・ マイクロ波帯～ミリ波帯における複素誘電率・複素透磁率の導波管測定法
- ・ 人工媒質を用いた電波の吸収と遮蔽、能動的伝導雑音対策
- ・ 電磁波および音波の波源推定

★当研究室は、大岡山西9号館W棟にあります。

2 最近の研究成果

■ 導波管貫通法による材料定数測定

複素誘電率・複素透磁率の測定法として、方形導波管内部を横断方向に棒状サンプルを貫通させる導波管貫通法を提案しています。この方法が従来の方法と比べて優れている点としては固体、液体、粉体を問わず測定ができ、サンプルの着脱が容易、また比較的少量のサンプルで測定が可能です。この方法を用いて、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ という広い温度範囲での複素誘電率・複素透磁率の測定を実現しました(図1)。この測定法は、自動車の衝突防止レーダが広い温度範囲で安定に動作するための電波吸収材料の開発に応用されています。図2は、どこにでもある標準物質としての水の複素比誘電率を測定した結果(ドット)であり、報告されている周波数分散式の値(実線)と一致することを確かめたものです。



図1 導波管貫通法の温度可変測定系

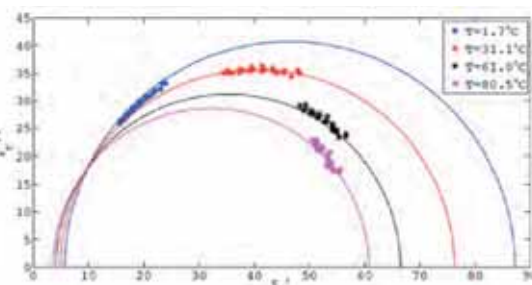


図2 水の複素比誘電率測定結果

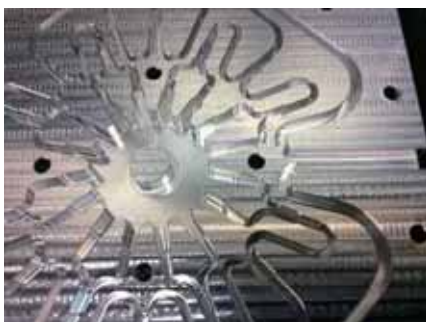


図3 円形導波管TE₀₁モード変換器の内部

■ 円形導波管TE₀₁モードを用いた複素誘電率の非破壊測定

平板状または厚い材料の複素誘電率を非破壊測定するために、円形導波管のTE₀₁モードを用いる導波管プローブ法を提案しています。この方法では、円形導波管の端部にサンプルを押し当てて反射係数を測定し、その値から複素誘電率を算出します。この方法の利点は、現在広く用いられている同軸プローブ法の弱点である隙間の影響を抑えられることです。

大岡山・波動・光および通信グループ

本方法を実現するカギは、純度の高い円形TE₀₁モードを発生させるモード変換器の設計です。図3は方形導波管から2分岐を繰り返す16分岐立体回路の内部構造です。この立体回路によって、円形導波管にモード純度の高い電磁界を発生させ、かつ装置そのものが低反射であることを実現しました。図4にモード変換器の外観を示し、図5に汎用基板材料FR4の測定結果を示します。

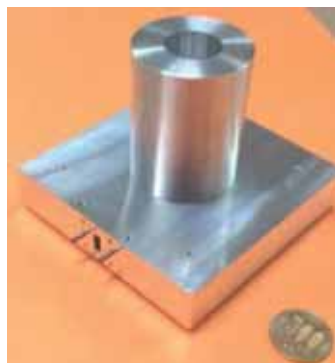
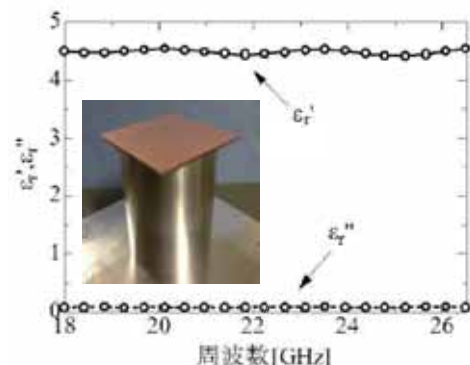
図4 円形導波管TE₀₁モード変換器

図5 FR4基板の複素比誘電率の測定結果

■ 点音源推定、双極子電磁波源推定

ヒトは2つの耳で、音を聴くだけでなく音の出所を知るといふ「音源定位」を行うことができます。これを機械に行わせるための計算アルゴリズムを研究しています。図6は、ダミーヘッドというヒトの頭部型のマイクロホンで取得した2チャンネル音声から音源位置を推定した結果を表しており、おでこの左側の赤い領域に波源があるらしいと推定されています(実際にその中央付近に音源があります)。これが実用化されれば聴覚の補助や感覚代行、ロボット用聴覚、遠隔存在感などへの応用が期待できます。一方、2つの耳を2つのアンテナに置き換えると電磁波源の推定が可能です。図7は2つのアンテナを一体化した2ポートアンテナとそれを用いた電気双極子波源の推定結果の一例です。電波の出処が目に見えるようになれば、不要電磁波対策のための強力な道具となることでしょう。

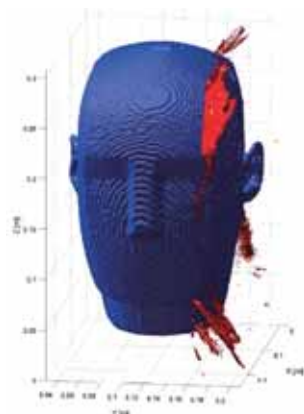


図6 ダミーヘッドによる点音源推定

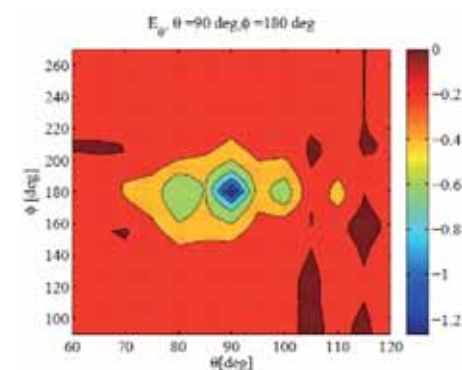


図7 2ポートアンテナ(左)とそれを用いた電気双極子波源の推定結果(右)。青い領域に波源があると正しく推定されている。

■ ミリ波帯における生体EMC実験

ミリ波は波長が短く直進性が強いので、焦点を結ぶと高い電力密度が生じます。今後ミリ波による高速通信やセンシングが普及していくうえで、生体の安全性を確保するための基礎データが求められています。図8は60GHzミリ波の集束ビームを手のひらに当てたときの閾値(気が付くレベル)をボランティア実験によって測定している様子です。人体はミリ波をよく吸収する材料でできているため、体表面から浅い領域で発熱し、比較的小さな電力でも暖かいと感じます。



図8 60GHzミリ波の掌へのばく露実験

3 教員からのメッセージ

上記の他にも人工媒質による電波吸収体などの研究も行っています。EMCはどちらかというと縁の下の技術領域ですが、課題の宝庫でもあります。この領域に新規アイデアをつぎ込んでブレークスルーを実現するために、一緒に研究しませんか。電磁波や音波などに興味がある方は、ぜひコンタクトをとって見に来てください。

廣川研究室

世界にない新しい構造の
平面アンテナの研究

波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山・南3-908

教授 廣川 二郎

研究分野: 平面アンテナ, 電磁界解析
キーワード: アンテナ, 無線通信, 電磁波
ホームページ: <http://www-antenna.ee.titech.ac.jp>

1 主な研究テーマ

- ミリ波導波管型高効率平面アンテナ
- アンテナ設計のための高速電磁界解析
- シリコンチップ厚膜誘電体上ミリ波高効率小型アンテナ

2 最近の研究成果

■ミリ波導波管型高効率平面アンテナ

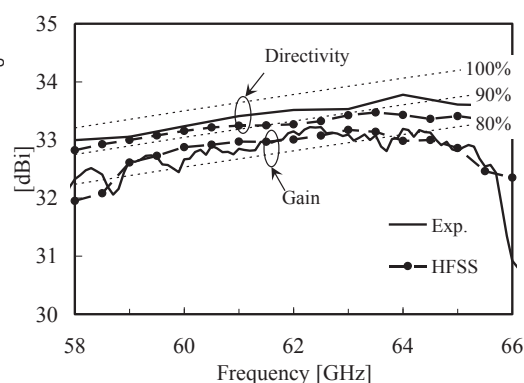
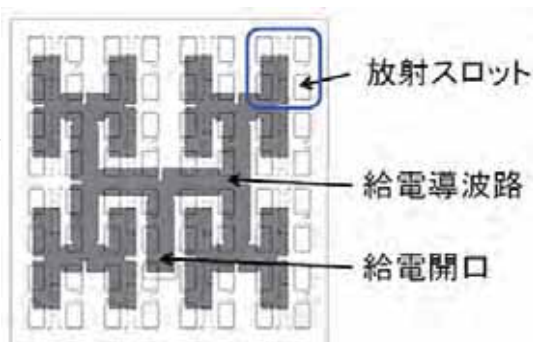
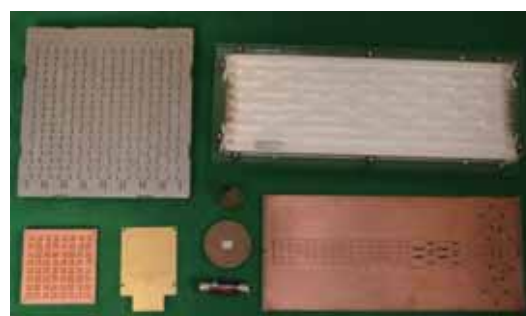
ミリ波は、周波数が30GHz～300GHzで波長がmmオーダーの波です。10Gbpsを超える高速な情報伝送をミリ波で行うためのアンテナを研究しています。

電磁波のふるまいはマクスウェルの方程式により決まり、波長で規格化した大きさが同じであれば同じふるまいをします。しかし、ミリ波帯アンテナを実際に作ろうとした場合、機械加工の限界や材料の損失などの問題が電気特性の問題とは別に出てきます。我々は右の写真に示すように、ミリ波帯での大きさで実際にアンテナを試作し、これらの問題を総合的に解決することを特長としています。

一例を示します。右上の写真の左下にある銅でできた60GHz帯の導波管アンテナの構造は右の図のようになっています。黒い四角で描かれた放射スロットを灰色で示した下層に置かれた給電導波路ですべて同振幅・同位相で励振しています。約0.02mmの寸法精度を得るために、形状をエッチングした厚さ0.3mmの薄板を10枚重ねて拡散接合して製作しています。金属成形でよく用いられる高価な型が不要なので、この積層薄板拡散接合は、安価で高精度な新しい製造法として期待しています。右下の実線の利得の実験値に示すように32dBi以上の高利得かつ80%以上の高効率が約5GHzにわたり広帯域で実現できています。

他にも、銅箔付誘電体基板に2列の金属ポストを配列して導波路を構成したポスト壁導波路を用いたアンテナなども検討しています。

多くの企業とも共同研究を行い、固定無線アクセスシステム用や衛星放送受信用として、社会で使われているものもあります。



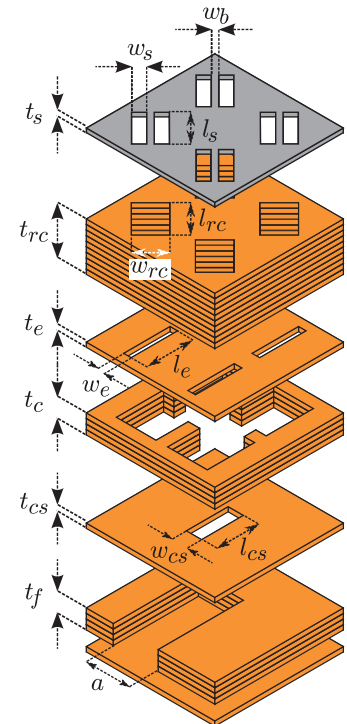
大岡山・波動・光および通信グループ

■アンテナ設計のための高速電磁界解析

右の図は、前ページ中央の図の青い線で囲まれた放射スロットの構造を表しています。任意形状を解析できる電磁界解析ソフトウェアでも1回の解析に約20分かかってしまいます。放射スロットのパラメータは17あり、それらをすべて変化させて設計するのは非常に時間がかかってしまいます。

この放射素子は、右の図に示すように、6つの領域が組み合わされています。これらの領域はすべて厚さ方向に構造が一様な2次元構造の導波管とみなせます。下から3番目の領域を除き、残り5つの領域は長方形断面ですので、断面形状で決まる電磁界固有モードは三角関数を使って解析的に表せます。しかし、下から3番目の領域はX字型の特殊な断面形状になっており、電磁界固有モードを解析的には表せません。そこで、電磁界固有モードを数値的に求めることとしました。これにより解析時間は約15秒と劇的に短くなりました。17のパラメータをすべて変化させて、約5時間で設計を終了できました。

このように、適用できる構造は限られますが、設計に使用できる高速電磁界解析法の研究もしています。



■シリコンチップ厚膜誘電体上ミリ波高効率小型アンテナ

60GHz帯において、RF回路チップと一緒に用いる小型アンテナは、RF回路と同一面内にアンテナを設けるオンチップアンテナか、RF回路チップと別体でアンテナを作るオンチップアンテナのいずれかです。オンチップアンテナはアンテナの高さが10 μm と小さいため放射効率が5%程度と低く、オフチップアンテナはRF回路とアンテナの接続が約1dBと大きいです。そこで、右の図のようにシリコンチップに穴を開け、RF回路と反対の面に厚さ200 μm の誘電体層を設けてその上にアンテナを構成することを提案しています。

また、60GHz帯小型アンテナの放射効率を測定する際に、アンテナの利得から換算する方法がほとんど用いられますが、指向性が広く、まわりの影響で指向性にリップルが生じ利得が正確に求められません。そこで、携帯電話端末内のアンテナの放射効率測定に用いられる電波攪拌金属箱により測定し、74%の放射効率を得ました。これにより0.2dBの低損失接続を確認しました。



3 教員からのメッセージ

ミリ波帯の高効率平面アンテナに特化し、この分野で世界最先端を走っています。受動素子のアンテナを高効率で実現するためには、損失低減がカギです。はやり流に流されず、基本を守って研究を行っています。また、将来の製造法の進展を見据えて、金属粉末を用いた3次元印刷などの最新技術を取り込み、ミリ波帯の平面アンテナを実現しています。

水本・庄司研究室

異種材料集積技術を用いた
光集積回路

波動・光および通信グループ
電気電子コース
大岡山・S9-905 / S9-904

教授 水本 哲弥 准教授 庄司 雄哉

研究分野: 光回路工学、電磁波回路

キーワード: 光ファイバ通信、光集積回路、オンチップ光配線デバイス

ホームページ: <http://mizumoto-www.pe.titech.ac.jp/index-j.html>

1 主な研究テーマ

高機能な光波回路の実現を目指して、光集積回路の開発をメインテーマとして研究を行っています。特に、光アイソレータと光能動素子の集積化、シリコン光回路を中心とする光デバイス集積化による高機能な光回路の開拓、およびその技術を応用したオンチップ光配線用波長選択スイッチの製作といった研究を推進しています。

2 最近の研究成果

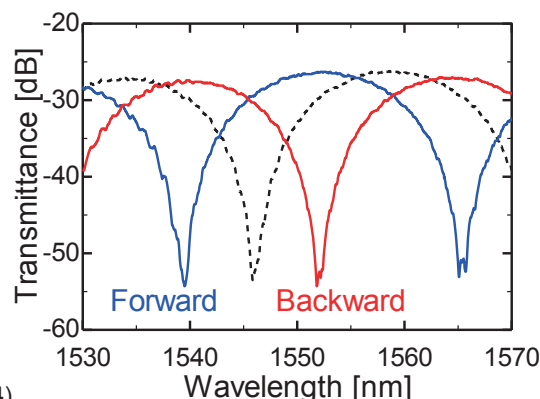
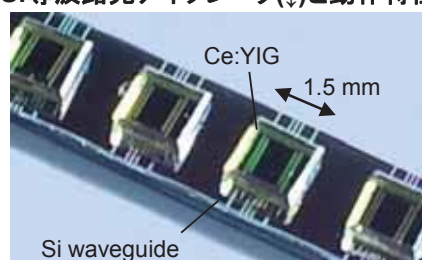
高機能な通信システム・光信号伝送システムを構築するために、光回路の高機能化が求められています。高機能な光回路の形成には、光源である半導体レーザ、光波制御用の光変調器、光スイッチ、合分波器など、多種多様な光デバイスが必要であり、多くの光回路デバイスを一体集積化した光集積回路の開発が重要な鍵を握っています。

光アイソレータは、半導体レーザや光増幅器などの光能動デバイスへの反射戻り光の再入射を防止し、能動デバイスの安定動作に必要な不可欠な光デバイスです。また、光回路中において不要な逆方向伝搬を防ぎ、光回路を所期の特性で動作させるために重要な働きをします。光集積回路の構成に必要な不可欠な導波路型光アイソレータを開発するとともに、光アイソレータを半導体レーザや他の光回路デバイスと一体集積化する技術の開発を進めています。特に、光アイソレータを実現するためには磁気光学ガーネットが必要不可欠で、半導体レーザなどの光能動デバイスと光アイソレータを一体集積化するためには、半導体上に異種結晶・磁気光学ガーネットを一体集積する技術を開発することが重要な鍵となります。本研究室では、異種結晶を直接貼り合わせるダイレクトボンディング法を開発して、これを実現しています。

■ 集積型光アイソレータ

集積化を達成するために、光アイソレータの形成に必要な不可欠な磁性ガーネットを半導体導波路に直接接合する技術(表面活性化直接接合)を開発し、光アイソレータ集積型半導体レーザの開発をすすめています。また、光回路の小型化やSi-LSIの光配線で注目されているシリコンフォトニクス用の光アイソレータの開発も進め、シリコン光回路としては世界初の光アイソレータの動作実証に成功しています[1]。その消光比や動作帯域では世界最高水準を達成し、当分野をリードする研究を行っています[2,3]。また、これを基に、シリコン光集積回路の開拓も進めています。

Si導波路光アイソレータ(↓)と動作特性(→)



- [1] Y. Shoji, T. Mizumoto, et al., APL, 92, 071117 (2008).
- [2] Y. Shirato, Y. Shoji, T. Mizumoto, OFC 2013, OTu2C.5..
- [3] Y. Shoji, Y. Shirato, T. Mizumoto, JJAP, 53, 022202 (2014).

大岡山・波動・光および通信グループ

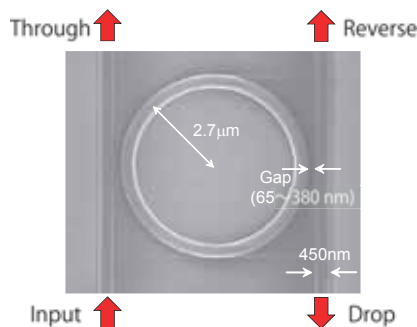
近年スーパーコンピュータやデータセンターにおける処理容量の増大のため、チップ間やボード間といった短距離の光通信応用に対する需要が高まっています。これまでは、単に電気配線をシリコンなどの光導波路へ置き換える研究が進められてきましたが、光導波路は電気配線に比べて回路の占有面積が大きいので、光信号の波長多重技術が重要となります。(波長多重技術を用いると、一本の光導波路に複数の光信号を伝送することができます。)

こうしたオンチップ光配線の次段階として考えられているのが「オンチップ光ネットワーク」の構想です。現在検討されている光配線がポイント・ポイント間の一対一の通信であるのに対し、オンチップ光ネットワークではチップ(またはボード)上にメッシュ状のネットワークノードを構築し波長単位で信号の伝送先を割り当てることで、CPUやメモリ間の通信において柔軟かつ安定な信号伝送を実現できます。このような背景をふまえて、シリコン基板上に集積可能な波長選択光スイッチを提案し製作を行っています。

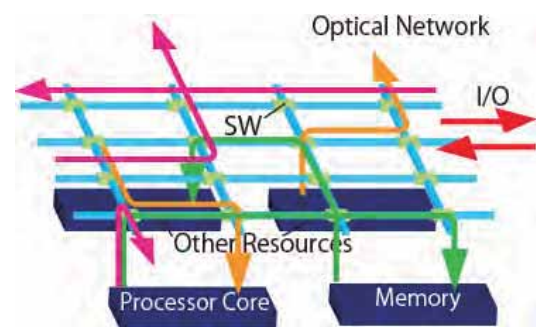
■ オンチップ光配線デバイス

シリコン基板上で波長多重された光信号を、波長ごとに経路選択し分配する機能を備えた波長選択スイッチの製作を行っています。特徴として、リング共振器による波長分波とマッハツェンダー干渉計による経路選択により、低いクロストークレベルの伝送特性が期待されます。

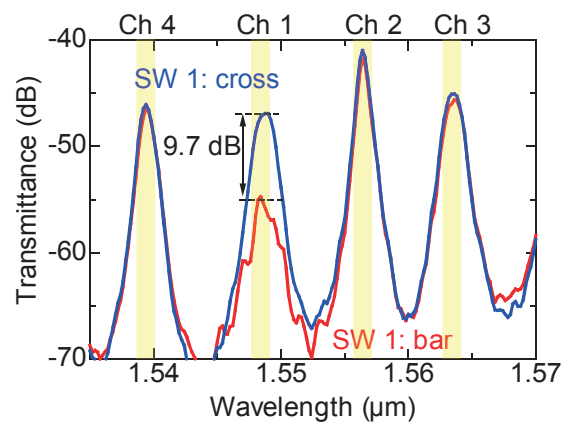
これまでの成果として、シリコン細線導波路を用いて波長選択スイッチを作製し、4チャンネル波長毎のスイッチング特性の実証に成功しています[4]。リング共振器は、リングの直径で分波する波長間隔(FSR)を設計し、バス導波路との結合の強さでフィルタとしてのシャープさが変化します。本デバイスでは、波長1550nm帯の信号に対し、8チャンネル(波長間隔:4nm)の信号分配をターゲットとしており、将来的には40チャンネル(波長間隔:0.8nm)までカバーする動作を目指しています。



シリコン細線導波路を用いた微小リング共振器のSEM像



オンチップ光ネットワークの概念図



シリコン波長選択スイッチのスイッチング特性の測定結果

[4] K. Miura, Y. Shoji, T. Mizumoto, IPC 2012, WZ3.

3 教員からのメッセージ

光技術は、光ファイバによる長距離信号伝送にとどまらず、ユーザへのアクセス系も含めた通信システムで広く使われる技術として発展を続けています。そして、コンパクトな光伝送路や光配線で、高速・大容量な信号伝送が可能であるという光信号伝送の特徴を活かして、コンピュータ間、コンピュータ内のボード間、ボード内のチップ間の信号伝送へ導入されつつあります。さらに、チップ内の信号伝送も光化するシリコンフォトリソグラフィの研究開発が加速されています。

このような背景の中で、光信号を適切に制御し、処理する光回路の機能性を高めることはますます重要になってきています。本研究室は、光デバイスの集積化によって機能集積化された光回路の開発を目標に研究を行っています。研究テーマは、これに関する内容を包含しており、最近の修士研究テーマは「シリコン導波路型光サーキュレータの研究」、「導波路型光アイソレータ製作のための異種結晶ダイレクトボンディングに関する研究」、「自己保持型光スイッチに関する研究」、「オンチップ波長選択スイッチに関する研究」です。わくわくするような研究がやりたい人、好奇心旺盛な人、大歓迎です。

渡邊研究室

第5世代移動体通信システム



波動・光および通信グループ
電気電子コース

特定教授 渡邊 文夫

研究分野: 移動体通信、通信ネットワーク、アンテナ工学

キーワード: 第5世代移動体通信、ネットワークアーキテクチャ、ミリ波通信、Internet of Things (IoT)、Sliced Network、Liquid Network

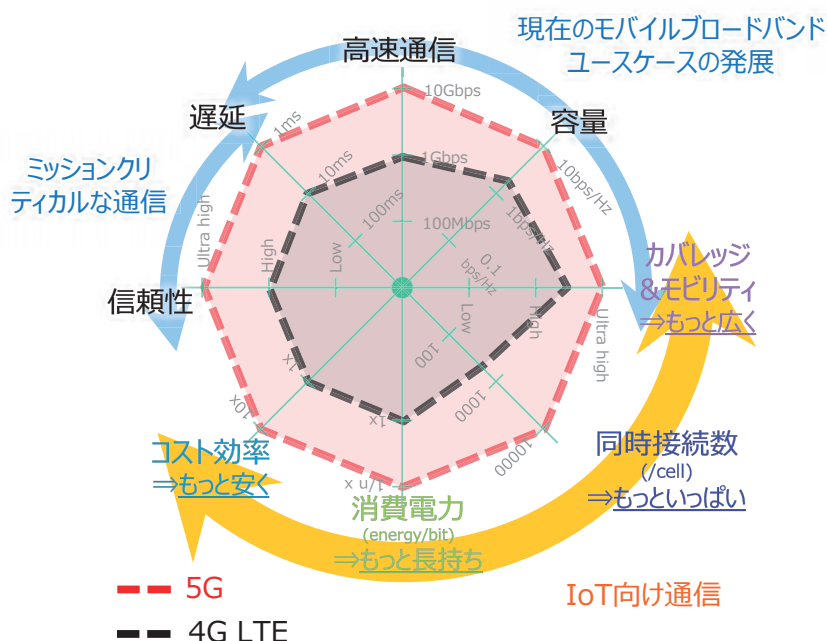
1 主な研究テーマ

- 第5世代モバイルシステム
- モバイル無線アクセス方式
- モバイルネットワークアーキテクチャ

2 研究内容

モバイル通信は、2000年ごろに数百kbps で実用された第3世代から普及が広まり、2010年ごろには数10Mbps、現在は100～200Mbps もの高速サービスを提供できる第4世代と呼ばれる方式が普及しはじめています。国内だけでも1億4千万台もの携帯電話やスマートフォンが使用されているように、社会にとって欠くことのできない重要なインフラサービスとなっています。10数年で千倍もの高速化という驚異的な技術革新がある最先端分野です。

2020年以降の実用を目指して、第5世代モバイル通信が世界中で検討開始されています。現在の光サービスをも越える数Gbps の超高速化、伝送遅延を10ms 以下にしてロボットなどの制御に使おう、爆発的に増え続けるデータトラフィックに対応できるようシステム容量を10～100倍にしよう、あらゆるものがネット接続される IoT に向けて接続可能数を100倍にしよう、バッテリーの持ち時間を10倍にしよう、など極めてチャレンジングな目標でさまざまな研究開発がスタートしています。



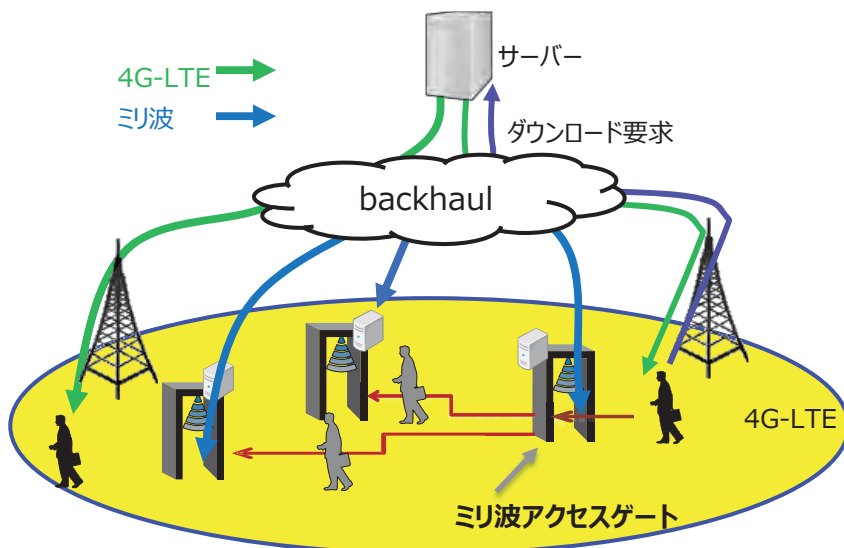
第5世代モバイル "5G" の目標と現在の第4世代 "4G LTE" の比較

大岡山・波動・光および通信グループ

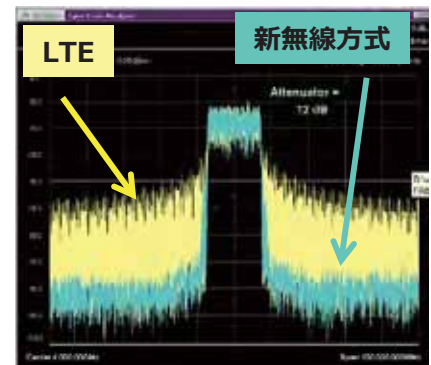
第5世代システムでは、ミリ波等の高い周波数を使った数Gbps の超高速伝送が可能になりますが、ミリ波はその伝播特性上の特徴から極めて小さなスポット的なエリア（アクセスゲート）になるので、そのスポットを端末が通過する時間はごく短時間になります。これまでのモバイルネットワークのプロトコルでは、端末の移動管理などの手続きが複雑で、データ送信を行う前に端末がスポットを通過してしまい超高速伝送を生かすことができません。

ICN（Information Centric Networking）という従来のIP ネットワークとはまったく違うアーキテクチャを応用して、超高速ミリ波スポットと 4G-LTE を併用しながら session-less でバースト伝送を行うアーキテクチャの研究を進めます。

また、超低遅延の通信を実現するため、ST-DFT-S (Suppressed Tail-DFT-Spread) と呼ぶ新しい無線方式や Liquid Network というダイナミック分散型のネットワークアーキテクチャの研究を進めます。



ミリ波超高速アクセスゲートと 4G-LTE を併用した ICN ベースのネットワーク



4G LTEと検討中の 5G 方式のスペクトラム比較



Massive MIMO 実用に向けたフィールド測定（都市内電波の可視化）



3 教員からのメッセージ

この研究室では、第5世代モバイルシステムという世界が注目する将来の通信技術を扱います。ネットワーク側の研究だけでなく、スマートフォンの次のモバイルデバイスに関する研究や、それらを利用したアプリケーションなど幅広い分野を扱います。多数の専門研究者のいるKDDI 研究所と連携した研究も行いますので、大学院修了後に実際の事業分野で活躍してみたいと考えている学生さんは大歓迎です。

（参考） KDDI 研究所： <http://www.kddilabs.jp/>

伊藤治彦研究室

ナノ量子フォトニクス



波動・光および通信グループ
電気電子コース
すずかけ台・G2棟1111号室

准教授・伊藤 治彦

研究分野: アトムフォトニクス, ナノフォトニクス, 量子エレクトロニクス
キーワード: 原子操作, ナノ光相互作用, 原子・スピン機能素子,
レーザー冷却, 近接場光

ホームページ: <http://www.ito.ep.titech.ac.jp/>

1 研究テーマ

情報処理システムの高機能集積化が進み、ナノメートルを超えて原子スケールへのダウンサイジングが必要となってきました。究極的には1個の原子で構成される素子に行き着きます。こうした極小の世界では従来の電子・光デバイスの動作原理が破綻し、量子力学や近接場光学に則った原理で動作させなければなりません。本研究室では、レーザー冷却技術とナノ寸法の局所的な光の場である近接場光を用いて原子を個別選択的に制御し、原子の量子性やスピンを機能化したデバイスおよび近接場光の特性を生かしたナノ光相互作用で動作するデバイスの開発に取り組んでいます。レーザー光に代わる次世代の光技術の担い手と期待されるナノの光で科学の未来を描きます。

2 最近の研究から

■ ナノ空間をデザインする

原子を個別的に制御する空間を、ナノの光で創りだします。例えば、図1のように、8個の格子点に配置した近接場光によって原子を力学的に閉じ込めます。これまでに、シリコン基板を微細加工して、中央に原子捕獲用のナノスペースを有する十字構造体を作製しています。図2に断面を示します。下方からレーザー光を照射すると、斜面部のAu層に沿って表面プラズモン-ポラリトン(SPP)が伝播し、境界端面で近接場光が発生する仕組みです。原子の量子性を機能化する素子の端緒として、量子ジャンプによって超高速動作する光子ゲートなどへ応用します。

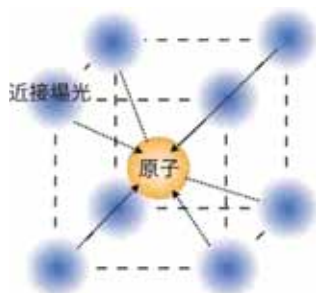


図1 近接場光光子

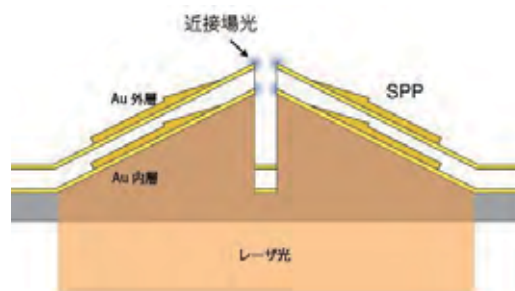


図2 単一原子トラップ

■ ド・ブロイ波の回折限界を超えて

ナノ光トラップに原子を送り込んだり、原子レベルでナノ構造をつくるのに用いる近接場光レンズの開発を行います。シリコン微細加工によって作製した中空逆ピラミッド構造の底面微小開口の周囲に近接場光を誘起し、入射原子を双極子斥力によって収束して出力します。レーザー冷却原子を用いると、数ナノメートルのスポットに集められることを数値シミュレーションによって確かめています。このデバイスでは、ド・ブロイ波のスクイージングという新しいコンセプトを用いるのが特徴です。図3にフォーカシングの様子を示します。

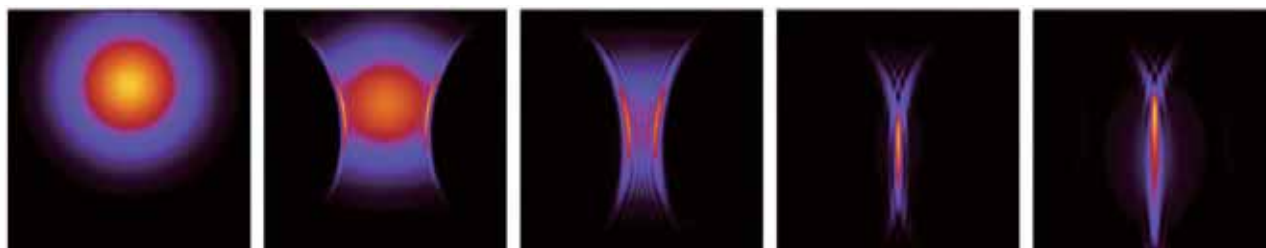


図3 原子のナノフォーカシング

すずかけ台・波動・光および通信グループ

■ スピンクラスターの実現に向けて

回折限界を超えて超高密度光記録を行うために近接場光を利用します。1nm²以上の面密度で記録できるならば、人間の脳の容量に匹敵するといわれる1Pb/in²ストレージの実現も夢ではありません。そのための記録素子として、少数個の原子で構成したスピンクラスターの形成に取り組んでいます。レーザ冷却したアルカリ金属原子を光ポンピング法によってスピン偏極し、相互作用しにくい希ガス原子をコートした基板上で自己組織化します。クラスター化に必要な多体衝突を起こさせるために、図4に示すエバネッセント光ファネルを用いて入射原子の高密度化を行います。図5は、密度汎関数理論を用いて計算した⁸⁷Rb₄クラスターのスピン1重項状態・3重項状態・5重項状態(立体)の形状です。近接場光で1重項-3重項変化を起こす方法を開発します。

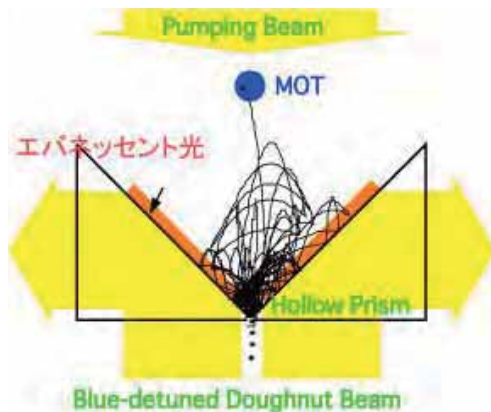


図4 エバネッセント光ファネル

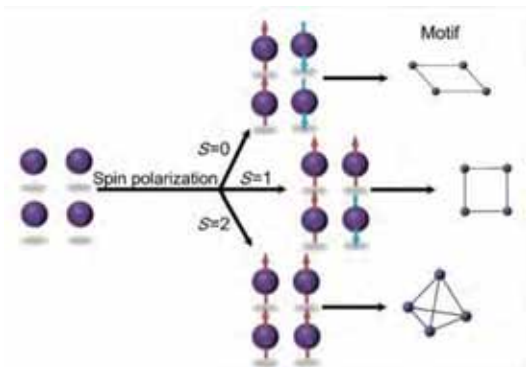


図5 スピンクラスターの形成

■ ナノの光の幾何学的特性を調べる

近接場光の発生は、物質形状に強く依存します。ナノスリットでは、端部に誘起された電気双極子モーメントによって二重ピークの強度分布が得られるはずですが、急峻でない明瞭さが失われます。このような幾何学的な性質をシミュレーションと実験の両面から調べ、近接場光に所期の機能をもたせるにはどうすればよいかを探求します。そして、ナノスリット構造に誘起した近接場光による原子の高精度偏向(図6)や高空間分解検出(図6)などへ応用します。また、ナノ光解析に適した高速シミュレーション技法を開発します。

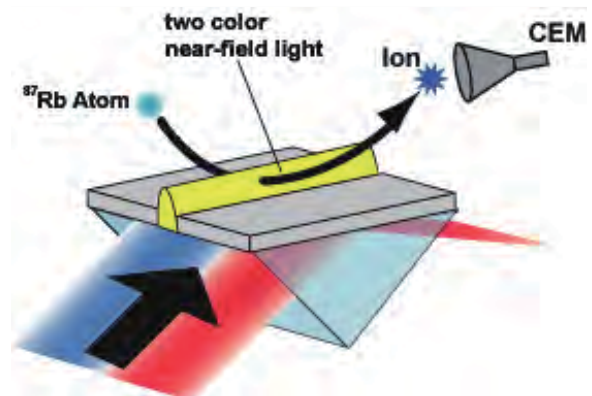


図6 ナノスリット原子センサー

3 教員からのメッセージ

本研究室で扱う多彩なテーマは、オンリーワンのキャラクターが強いものです。結果を出すのに時間がかかるし、ときには新奇なものに対する強い抵抗があります。しかし、できそうにないことを実現する、それが科学の飛躍的な発展につながります。私たちと一緒に、誰もやったことがない先進的なテーマにチャレンジしてみませんか。

4 参考図書・ビデオ

- サイエンスZERO「ナノの世界に輝く光-近接場光」NHKオンデマンド, 2010
- ナノ光工学ハンドブック, 2.8節「原子への力学的作用」, 11.1節「原子操作」, 朝倉書店, 2002
- ナノテクノロジーハンドブック, 1編創, 7.2節「近接場原子光学パターンニング」, オーム社, 2003
- 光ナノテクノロジー, 基礎編「光と原子」, 応用編「ナノの光で原子を操る」, アドスリー, 2005
- 科学立国日本を築く, 第8章「光で粒子・分子・原子の動きを操る」, 日刊工業新聞社, 2006
- 解く! 量子力学, 講談社サイエンティフィク, 2008(電子版あり)
- 解く! 先端技術の量子力学, 講談社サイエンティフィク, 2010
- 近接場光のセンシング・イメージング技術への応用, 第11章「近接場光を用いた原子の制御と検出」シーエムシー出版, 2010

植之原研究室

超高速フォトニックネットワーク用光信号
処理システムと光集積デバイスの実現

波動・光および通信グループ
電気電子コース
すずかけ台・R2棟820号室

教授 植之原 裕行

研究分野: 光エレクトロニクス、光ファイバ通信システム

キーワード: 光信号処理、光信号歪補償、符号化・復号化、光スイッチング

ホームページ: <http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

光通信システムは長距離・大容量伝送用途として世界に張り巡らされ、インターネット・モバイルネットワークのインフラとして必要不可欠です。しかしながら、信号当たり100Gbps、1本のファイバ当たり1Pbpsを超え、周波数利用効率を向上するための多値変調・マルチキャリア変調方式や、必要な帯域に応じてシステムを変更する技術、波形歪を歪量に応じて適応的に等化する技術、効率よく情報を收容する符号化・複合化技術が必須となっています。同時に、高密度集積素子の活用で低消費電力を実現することが求められています。光信号処理技術は、波長多重信号の一括処理や電気/光・光/電気変換の除去、低遅延性が期待でき、その実現を目指して取り組んでいます(図1)。

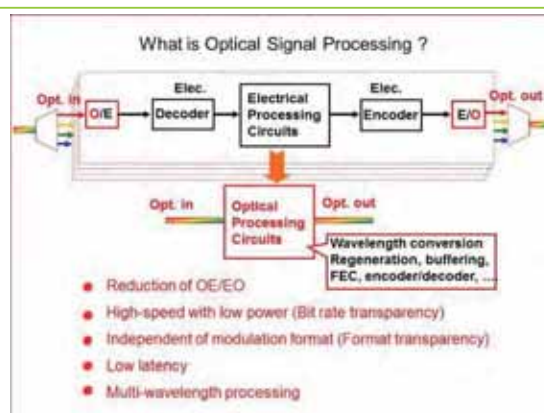


図1 光信号処理技術のコンセプト

2 最近の研究成果

■光信号処理(ラベル識別・光信号再生・誤り訂正・多次元変調)技術

先頭ビットの相対位相と遅延干渉計の位相を合わせて干渉の強め合う条件を利用した超高速光信号のシリアル/パラレル(SP)変換(図2)、高非線形ファイバ中の四光波混合(FWM)による光排他的論理和(XOR)演算技術を応用した誤り訂正符号化(図3)、並列一括符号処理による誤り訂正符号の復調回路などの光信号処理技術の実現を目指しています。光SP変換については、回路規模を縮小するためのシリコン細線導波路構造の検討を進めています(図2)。

また光PSK・QAM信号に対して光ファイバ伝送中の非線形歪を低負荷で補償する逆伝達関数処理(図4)、半導体光増幅器(SOA)のFWMを利用した位相感応型信号再生器技術についても検討を行っています。

さらに、同相・直交位相、偏波、波長、直交副搬送波への多重ビット数を適切に組み合わせることにより変調エネルギーあたりの周波数利用効率を向上する符号化・復号化(多次元変復調)技術についても取り組んでいます。

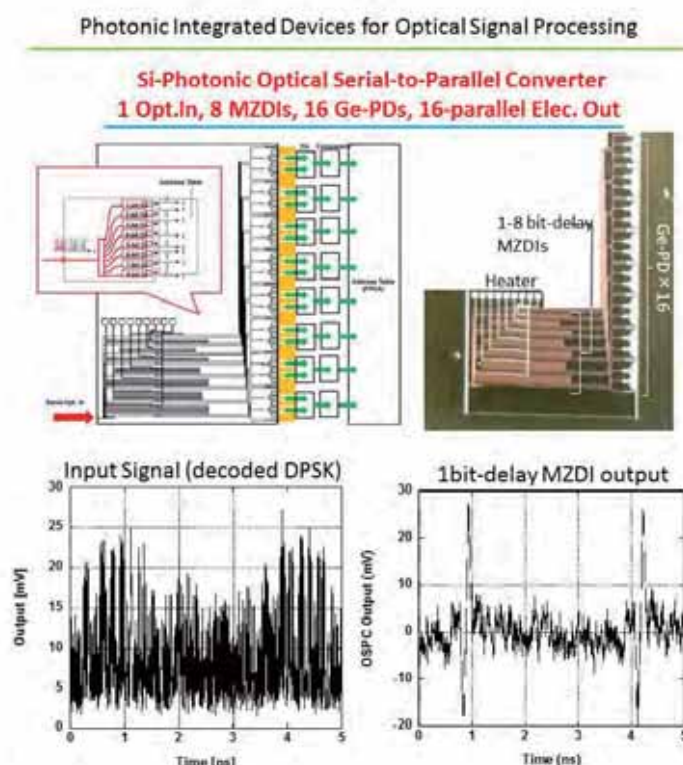


図2 シリコン細線導波路構造を用いた光シリアル/パラレル変換回路

すずかけ台・波動・光および通信グループ

符号化動作解析

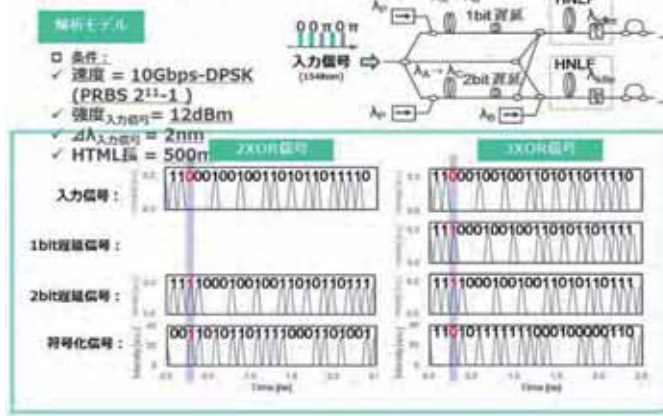


図3 全光処理畳み込み符号化回路の動作解析結果

■光信号処理用集積デバイス

高速光パケットスイッチの超高速ラベル識別回路として光SP変換器を応用する場合、処理ビット数の増加にともない構成要素数が増大するため小型・高密度に作製可能な集積技術が必須です(図2)。またデジタルコヒーレント光送受信器を実装した再構築可能な光分岐挿入装置(ROADM)においても波長分波・スイッチ・送受信回路の高密度実装が求められます。いずれも各機能をシリコンなどの半導体導波路素子で集積化することによって小型化・機能の高密度実装が可能です。現在、基本構成要素の試作と機能評価、小型実装を可能とする構成法の検討を行っています(図5)。超小型光集積素子を電気的に駆動するLSIとの2.5次元実装技術も重要です。

■超高速光ノード/パケットスイッチ応用

大容量のバースト光データを高効率かつ低遅延で転送を行う光パケットスイッチの実現が期待されています。各通信パケットの転送先情報を持つラベルを光パケットの先頭に付加し、光信号処理で識別した後に波長変換型光スイッチで転送することにより、競合確率と処理遅延の低減が期待できます。また、空間多重技術に対応した高密度・高スループットの多次元光ノードの構成法、光パスの設定・解放の繰り返しに伴う波長資源の断片化(フラグ)を光電変換を解さずに解消するデフラグ技術についても検討を進めています(図6)。

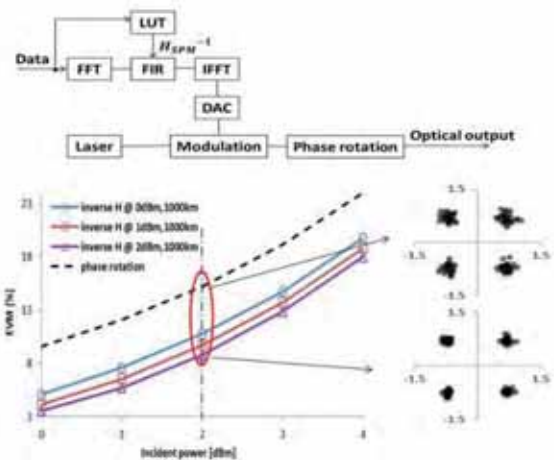


図4 非線形分散補償技術と補償前後の品質

Si Photonic Components for Ultra-compact Digital Coherent Receiver

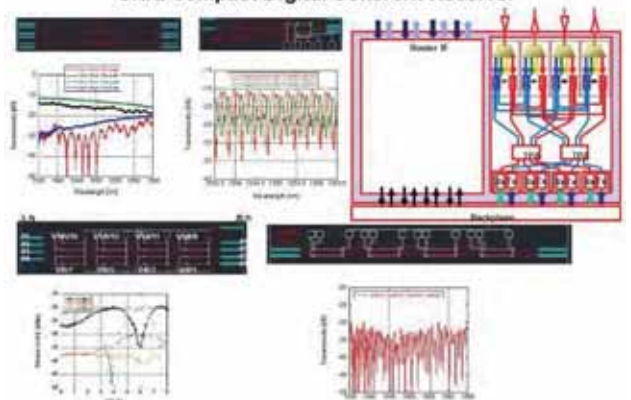


図5 シリコン細線集積素子と高密度送受信回路応用

Management of OFDM subchannels in High-Density, Highly-Integrated, and High Capacity Photonic Network

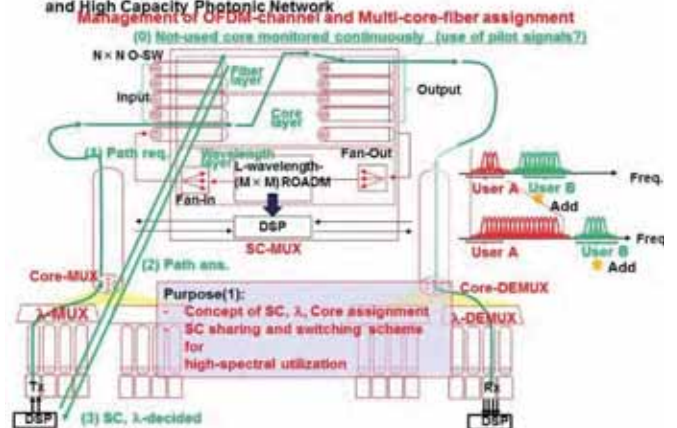


図6 高密度・大容量ROADMとデフラグ技術

3 教員からのメッセージ

楽しい研究生活を送りましょう！

黒澤研究室

弾性波動を利用したアクチュエータ
エコーロケーション、音響トランスミッタ
エネルギーハーベスティング

波動・光および通信グループ
電気電子コース
すずかけ台・G2棟614号室

准教授 黒澤 実

研究分野: メカトロニクス、電気音響変換器、音響工学
キーワード: アクチュエータ、圧電デバイス、反響位置測定、計測制御、
PZT・ニオブ酸リチウム・サファイヤ、音響デバイス
ホームページ: <http://www.kurosawa.ip.titech.ac.jp/>

1 研究の概要

電気音響変換デバイス技術を活用したアクチュエータやセンサおよびシステムに関する研究を行っている。研究内容は、電気信号を機械振動に変換するための材料技術、機械振動を効率よく励振し利用するための機械工学の知見、基本となる電気電子工学と広範である。また音響信号の実時間処理や制御システムへの応用などのために、デジタル信号処理システムの開発も行っている。

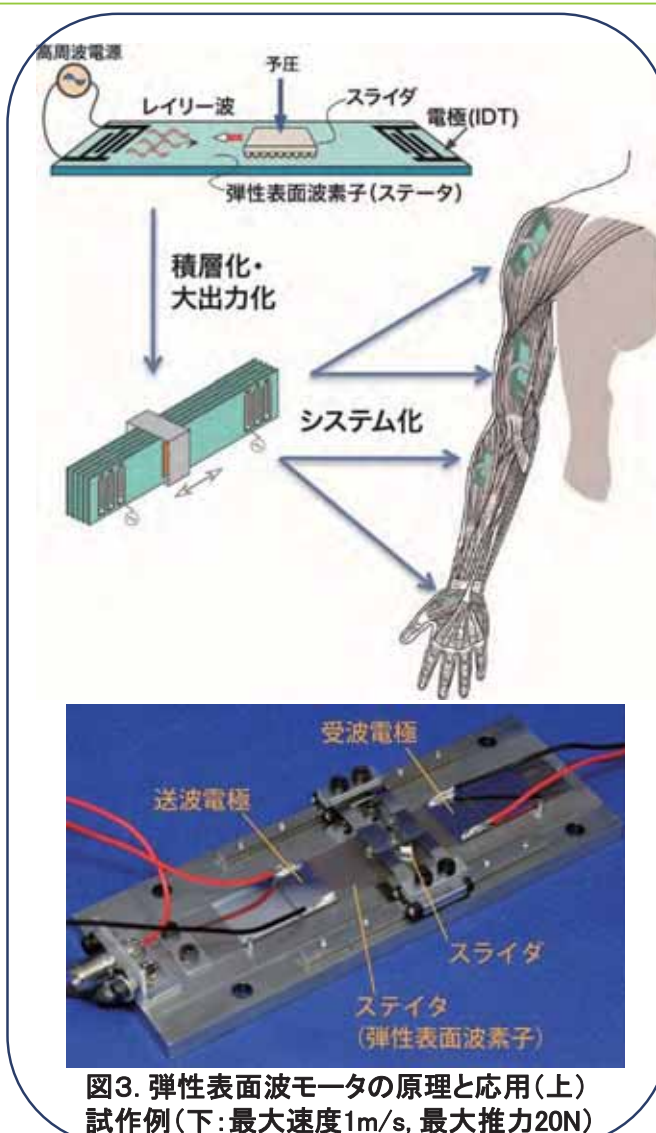
2 研究テーマ

■ 弾性表面波モータ

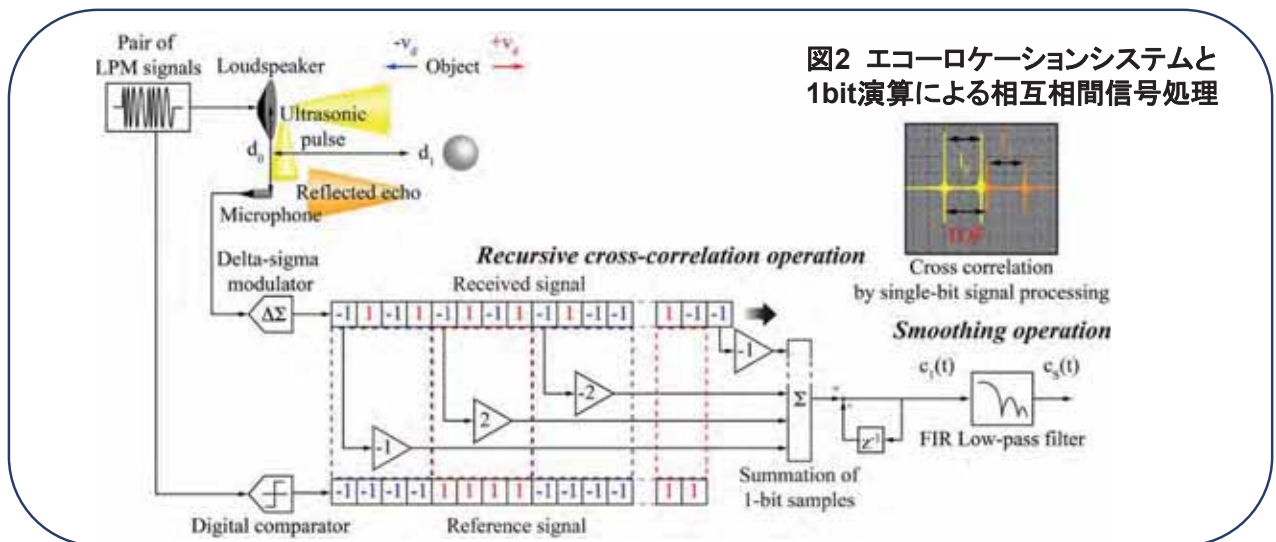
人間の手のように精緻に・自由に・力強く動作する人工の手を創出するには、これまでにない高性能なアクチュエータ技術が必要とされている。手を動かしている筋肉は、単位断面積あたり20～100N/cm²という大きな力を発生することができる。筋肉は非常に優れたアクチュエータであるため、精巧な手の動きが可能となっている。これまで、筋肉のように小型軽量で力強いアクチュエータを実現できなかったため、人間の手と同じ大きさと重量で同等の動きを実現することが不可能であった。

我々が研究・開発してきた弾性表面波モータでは、単位断面積あたり100N/cm²の力を発生することが可能となってきた。さらに1m/s以上の速度と1nmの微細な動きを実現している。弾性表面波モータは、ニオブ酸リチウムを用いた圧電トランスデューサにより励振された10MHzの音響波を駆動力源としている。音響波の励振により弾性体表面の粒子は楕円軌跡を描いて振動するので、表面に押し当てたスライダとの間で発生する摩擦力に依り、スライダには速度と推力が発生する。高周波振動による摩擦駆動を利用することで、大出力を実現している。摩擦に対する耐久性向上のため、導波路にサファイヤを用いたモータも研究している。

弾性表面波モータを発展させ、将来的には人の手を実現することも可能となるような、高性能なアクチュエータの研究を行っている。さらに60個ものアクチュエータを協調させて複雑で精緻な動作を実現するためには、新たな制御アルゴリズムも必要となるであろう。



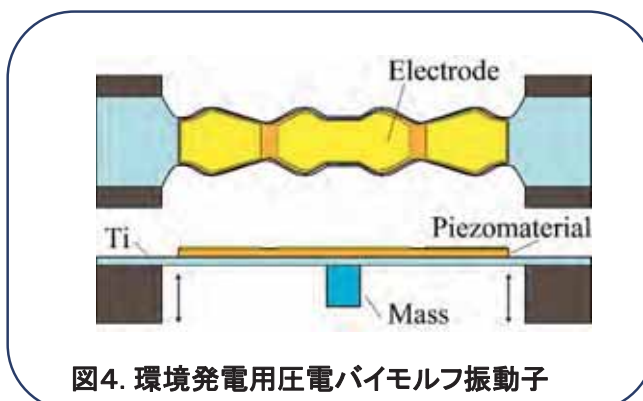
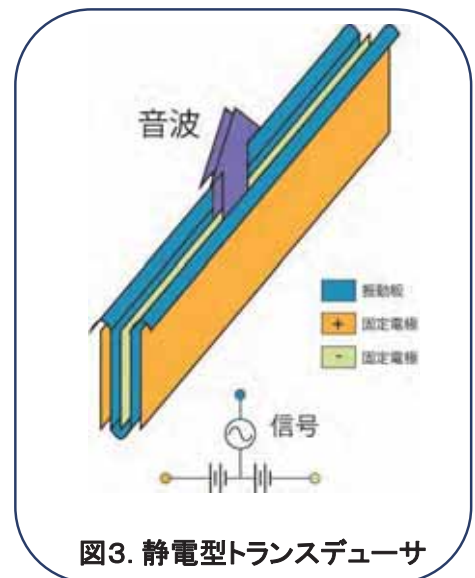
すずかけ台・波動・光および通信グループ



■ エコーロケーションシステム

コウモリのエコーロケーションは、超音波を対象物に放射し、反射波を聞き取ることで対象物の位置や動きといった空間情報を取得している。このエコーロケーションを実現するためには、音源となるデバイスと、受波した信号を簡単な仕組みで高速に処理するシステムが必要である。

高速な信号処理を実現するため、1ビット $\Delta\Sigma$ 変調信号を用いた簡便な相互相関処理方法を開発した。1ビット信号処理回路をFPGAに実装し、実時間で対象物体の3次元的位置と速度ベクトルを検知するシステムについて研究を進めている。また、空中に超音波を放射するデバイスに関しては、静電方式により音波を発生させる素子を研究している。静電トランスデューサは、20～200kHzに渡る広帯域の超音波を、100dB以上の高音圧の音波として発生することを目指している。



■ 環境振動発電

圧電デバイスを用いた環境振動発電は、分散配置したセンサシステムなどへの電力供給方法として実用化が期待されている。圧電デバイスによる振動発電は、出力や効率の観点からデバイスの最適化を進める必要がある。モデル解析を行うことで最適化の方法を研究し、新たなデバイス構造で、高出力化を実現することを目指している。

3 教員からのメッセージ

自分の手を動かして何かを作り上げる喜びと、成功したときの感動を大切に。そのために自ら考え学ぶ努力を。そして世の中に役に立つ技術とは何かを考え実践しよう。研究においてはたくさんの失敗を経験することが大事である。そしてその失敗の原因が何であったのかを突き詰めて、原因と結果の因果関係を明らかにできる能力と表現力を培ってほしい。

小山研究室

面発光レーザフォトンクス、
光ネットワークデバイス、光集積回路、
光センシング用デバイス

波動・光および通信グループ
電気電子コース
すずかけ台・R2棟603号室

教授 小山 二三夫 助教 坂口 孝浩 助教 中濱 正統

研究分野: 光エレクトロニクス、半導体レーザ、光通信、光センシング
キーワード: 光通信ネットワーク、半導体レーザ、半導体光集積回路、光マイクロマシン、フォトリソナノ構造、レーザレーダ、医療応用フォトンクス
ホームページ: <http://vcSEL-www.pi.titech.ac.jp/index-j.html>

1 主な研究テーマ

次世代光通信ネットワークや光センシングを切り拓く新しい光デバイスの開拓を目指しています。マイクロ／ナノ構造の光共振器、光マイクロナノマシン、中空光導波路、スローライト導波路、サブ波長回折格子、金属ナノ構造などの新構造を用いて、高性能半導体レーザ、波長可変光素子、光信号処理デバイス、レーザレーダ用ビーム掃引素子などの光デバイスとその集積化の研究に取り組んでいます。

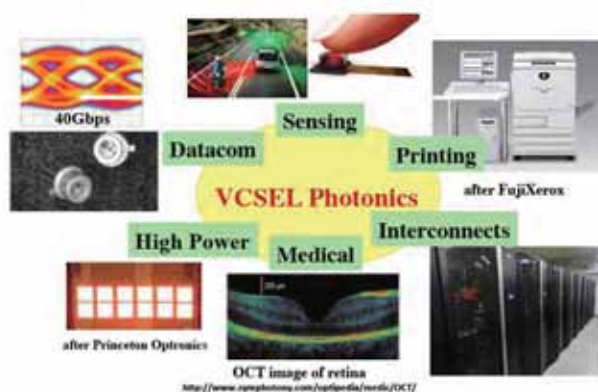


図1 面発光レーザフォトンクスと応用分野

2 最近の研究成果

■ 超高速面発光レーザフォトンクス

本学で生まれた面発光レーザの極限性能追求とその大規模集積化の研究を進めています。スパコンやデータセンターの装置間・装置内における光インターコネクトへの適用が急速に進められています。近い将来100Gbps超の高速化のニーズは大きいものの、現状技術は10Gbpsの伝送速度に留まっています。本研究室では、図2と図3に示すように、面発光レーザに微小共振器を横方向に集積することで、光学的なフィードバックにより変調帯域を数倍以上に拡大できることを見出しました。通常の半導体レーザでは、変調速度は、光と電子の相互作用による緩和振動周波数と素子の浮遊容量による帯域制限で律速されますが、本手法では、その変調特性を光学的に制御するものであり、材料などの特性で律速される速度限界を打破できます。一方、面発光レーザに光変調器を集積した変調器集積光源の開拓にも取り組んでいます。横方向に結合・伝搬する光の群速度は、通常の伝搬光に比べて、約1/50以下まで減速した光、すなわちスローライトであることがわかっています。1V以下の微小変調器電圧で10 μ m程度の超小型光変調器を実現しています。これらの研究は、100Gbps級の高速変調を可能にする超高速面発光レーザ光源を可能にします。

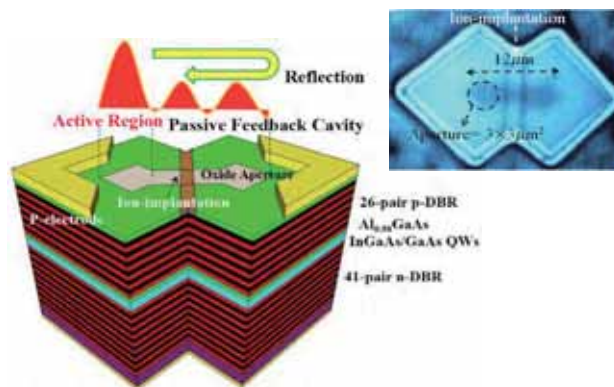


図2 結合共振器面発光レーザ

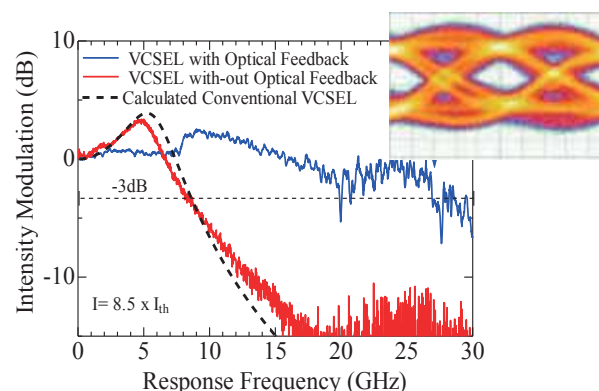


図3 結合共振器面発光レーザの高速変調

すずかけ台・波動・光および通信グループ

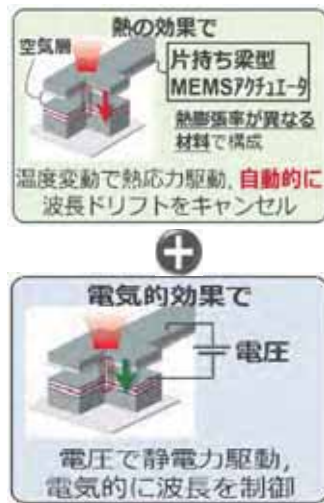


図4 波長温度無依存化と波長可変動作の原理

■ 光マイクロマシンと波長可変面発光レーザ

微小機械(マイクロマシン)を半導体レーザに集積して、連続的に波長を広範囲に掃引する機能や波長を自在に制御する新しい半導体レーザの実現に取り組んでいます。例えば、微小な反射鏡を中空に浮かせて、そこに電圧を印可することにより、静電力で鏡の位置を変化させて波長を連続的に動かすことが可能です。また、熱応力による微小アクチュエータを集積して、外部温度変化に対しても絶対波長の動かない新しい半導体レーザ“アサーマル半導体レーザ”を世界に先駆けて実現しています。この新しい光源は、波長多重化による大容量光インターコネクトや高速波長掃引による光干渉断層像などの生体イメージングを可能にします。

■ スローライト構造体と高精細ビーム掃引素子

周期構造による光導波路を用いて、光の群速度、位相、遅延時間などを制御する新技術の開拓に取り組んでいます。周期構造クラッド層を含むブラッグ反射鏡光導波路を用いることにより、光の群速度を大幅に低下することが可能です。本研究室では、巨大構造波長分散により大きなビーム掃引角を可能とする掃引デバイスを提案し、1,000を超える解像点数(非機械式では世界最高性能)を実現しています。面発光レーザとの集積化により、自動運転用の車載や、ロボット、ドローンにおける光センシング技術への展開など、これから広範な応用が期待されます。



図5 マイクロマシン面発光レーザ

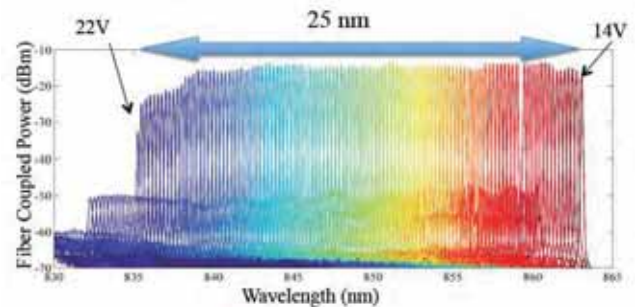


図6 広帯域波長可変動作

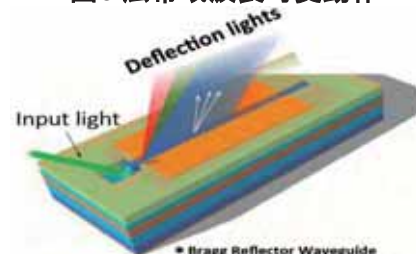


図7 スローライト構造体によるビーム掃引

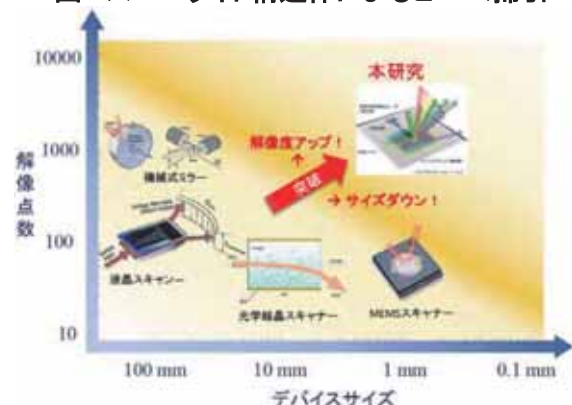


図8 小型・高速化を可能にするビーム掃引デバイス

3 教員からのメッセージ

大学院での研究を通じて、自らのポテンシャルをできるだけ高める不断の努力を！ 具体的な研究課題を通じて、“深く”研究するとともに、他の学問分野にも“広く”興味を持って、新しい分野を切り拓く気概を持って研究を進めて欲しいと思います。

中村・田原研究室

パワー超音波
光および超音波のヘルスケア応用
光ファイバセンシング

波動・光および通信グループ
ライフエンジニアリングコース・電気電子コース
すずかけ台・R2棟718号室/R2棟713号室

教授 中村健太郎 准教授 田原麻梨江 助教 水野洋輔

研究分野: パワー超音波、超音波計測、医用超音波、光応用センシング

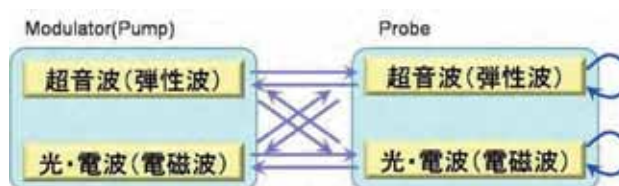
キーワード: 超音波プロセッシング、超音波浮揚、超音波モータ、
超音波診断、聴力支援技術、光ファイバセンサ

ホームページ: <http://http://www.nakamura.pi.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

超音波や光などの波動現象を用いて、人間の健康や安全に役立つ「ライフエンジニアリング」に関する研究を行っている。特に超音波のエネルギー応用・動力的応用、光と超音波の相互作用の利用、光ファイバのセンシング応用などをテーマに、他の方式では実現できない方式の開拓を行っている。

★当研究室はライフエンジニアリングコースに所属し、機械、材料、生命など他の分野の研究室とも交流しながら分野横断的な活動を行っています。試作、実験中心の研究テーマです。



2 最近の研究成果

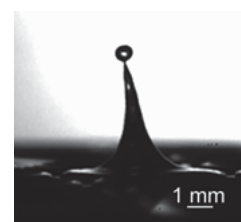
■ 超音波浮揚による薬液の非接触ハンドリング

次世代の製薬等のために、超音波の放射力を使って薬液を空中に浮揚させたまま、搬送、混合、分析、分注などの操作を完全非接触で行う技術に関する研究を行っている。非接触とすることで、不純物の混入や分析時のアーチファクトを排除する。

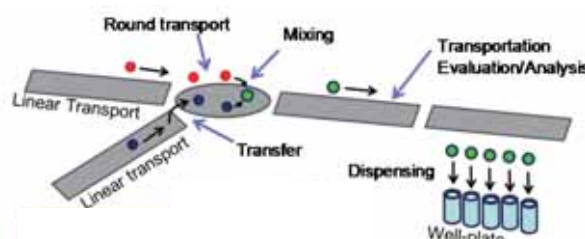
音源と反射器の間に形成される定在波の音圧の節に液滴がトラップされる現象を利用して非接触で操作する。音場モードを動的に制御したり、進行波の利用によって、搬送や混合動作に成功している。容器から必要量の薬液を打ち出すことや、浮揚したまま液量や物性を測定することにも挑戦している。今後、それぞれの動作をより高精度に行うことや、いろいろな処理工程を自由に組み替えられるような、振動系の構成方法確立したい。また、錠剤の高速搬送や検査に対応することも検討したい。



振動面と曲面反射器の間に浮揚する液滴



バースト超音波で打ち出される液滴



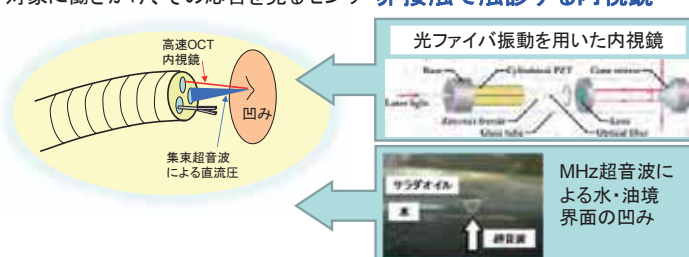
全工程を非接触で行うシステム

■ 医用・健康に役立つ超音波・光の融合

弾性波である超音波と電磁波である光波を用いることで、それぞれの特徴を生かすと同時に、超音波と光波の相互作用を利用した計測・観測技術を開発している。

右図は、超音波を集束照射することで、その放射力により組織を変形させ、光学的な手法で変形量を正確に測定する内視鏡の構成例である。

対象に働きかけ、その応答を見るセンサ 非接触で触診する内視鏡



すずかけ台・波動・光および通信グループ

現在進めている「医用・健康」に関するテーマの例：

○超音波エコー診断と光断層トモグラフィを併用した画像診断

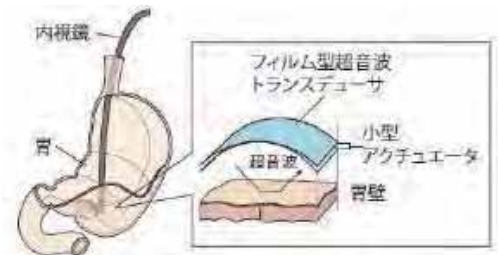
2つの画像方式を組み合わせることで、組織の音速(弾性特性)や光速(誘電率)などの物性値を知る。

○けがをしないスポーツをめざした測定技術

野球やサッカーなどの練習中に筋肉の負荷状態を遠隔モニタするシステムを構築することにより、少年スポーツの怪我を防止し、また、アスリートのトレーニング補助を実現する。

○農作物の非接触検査システム

果物等の硬さを空中強力超音波と光測定により非接触・連続的にモニタするシステムをめざす。



曲率可変のフィルム状トランスデューサにより、表面組織の弾性表面波速度を定量計測し、硬さ診断を行う。

■ 聞こえ支援システム

WHOによると、聞こえに何らかの問題がある人は人口の5%である。日本では600万人以上に相当するが、高齢化を考慮すると1000万人に達するとも考えられている。

これまでに補聴器を支援するデバイスや聞こえ支援システムを開発し、難聴者が健聴者とともに楽しめるコンサートへの協力、バスへの実装試験への協力などの活動を行ってきた。今後、スマートホンを利用したシステムの開発や、より多くの公共施設等への応用など、社会実装のための活動を行ってゆく。

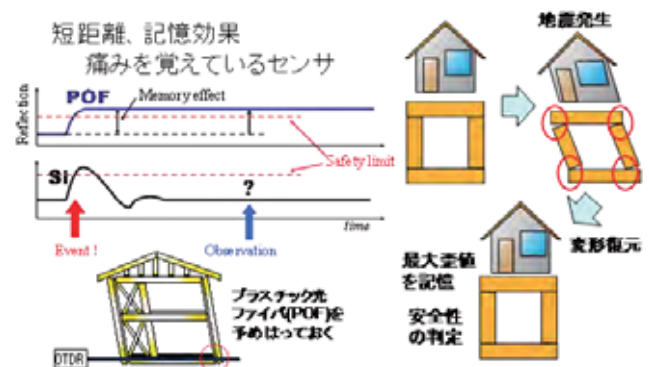


聞こえを支援するシステム

■ 光ファイバセンサによる建築物・土木構造物の保安

高度成長期に集中的にインフラ整備をしたわが国では、道路やトンネルなど多くの土木建造物で耐久性の問題が急激に起きている。また、地震や台風などの自然災害が避けられないわが国では、災害後建物のダメージの迅速な診断が必要である。光ファイバセンサは、光ファイバをセンサとして、光ファイバのどこにどのような歪が加わったのかがわかる有力な技術である。しかし、測定装置が大がかりなため、小規模構造物にはコスト等の見地から応用しにくかった。

本研究室では、ポリマーファイバを使うことで、その可塑性に着目し、変形や歪をファイバ自体が記憶することを積極的に利用している。ポリマーファイバに沿って歪や温度の分布を連続的に測定することに成功している。



ポリマー光ファイバによる「痛みを記憶する」センサ

3 教員からのメッセージ

超音波や光の技術を基盤として、これを人の健康や快適な暮らしに役立てるすべの開拓に努力しています。電気電子系のライフエンジニアリングコースとして、他の系とも積極的に交流しながら研究を進めています。実験や試作が中心の研究テーマですが、聞こえ支援の研究など、実際のユーザーと意見交換しながら進めるテーマもあります。

宮本智之研究室

次世代光エレクトロニクスに向けた
半導体光デバイス研究

波動・光および通信グループ
電気電子コース
すずかけ台・R2棟817号室

准教授 宮本智之

研究分野: 光エレクトロニクス, 光無線給電, 半導体光デバイス
キーワード: 半導体, 面発光レーザー, 量子効果, 光無線給電
ホームページ: <http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

本研究室では, 面発光レーザーを中心とした半導体光デバイスの高性能・高機能化と, その実現に必要な量子効果構造やプロセス技術の開拓, および, 光デバイスの新応用創出など, 次世代のフォトニック(光)システムに関する研究を進めています。

- ★当研究室は東工大すずかけ台キャンパス未来産業技術研究所に属し, 居室はR2棟にあります。
- ★当研究室は, 小山研究室, 植之原研究室と協力して研究活動を進めています。



2 最近の研究内容

■面発光レーザーの高性能化

光エレクトロニクス(フォトニクス)における光デバイスの中でも, 光源はシステムのカギである。本研究室では, 極低消費電力で2次元アレイレーザーが可能な面発光レーザー(東工大, 伊賀健一名誉教授の発明)の高性能化・高機能化を目指している。

面発光レーザー(VCSEL, ビクセル)は図1の構造の波長サイズの微小共振器であり, 光を基板に垂直出射することを特徴とする。これまでに, レーザマウスや光LANの主要光源, また高精度レーザープリンタなど, 広く実用されている。今後, LSI間の電気配線に代わる光配線や各種光センシング用途, また, パワー光源としてエネルギー応用や製造技術, レーザディスプレイなどに利用が進むと期待されており, その性能向上が求められている。

本研究室では, 光デバイス高性能化の新たな原理・機構の創出や設計技術・製作技術などの開拓といった基盤技術確立を進めている。VCSELの特徴を生かした高出力大規模2次元アレイ光源や, 電気光変換効率80%以上という超高効率化を進めている。また, 最近では, 従来VCSELの課題であった動作温度範囲の狭さを解決するため, 量子井戸の活性層を最適化して, 図2のように温度差269℃の動作を達成した。

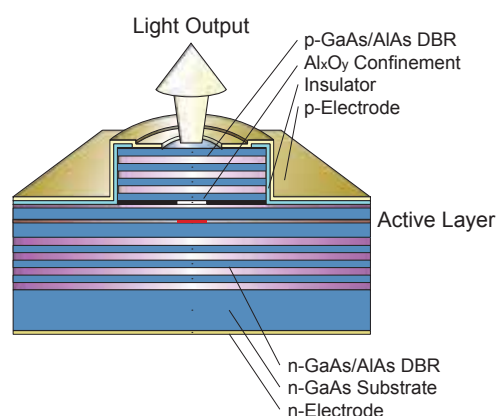


図1 面発光レーザーの断面図。

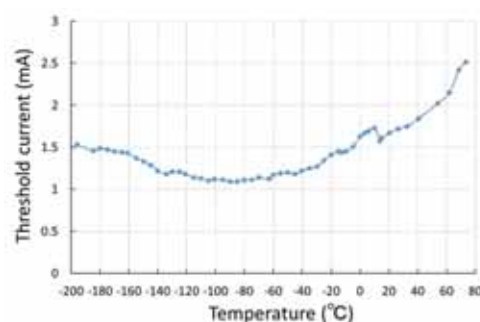


図2 温度差269℃の範囲で動作するVCSEL

すずかけ台・波動・光および通信グループ

■量子効果構造による光デバイス高性能化基盤技術

様々な半導体材料を原子1層単位で積層することで多様な量子効果構造(ポテンシャル構造)を形成可能である。単純な矩形量子井戸構造は、低消費電力化などの優れた効果から既に半導体レーザーやLEDで実用されている。

我々は、量子効果構造の高度化に向けて、キャリアの波動関数の制御による光デバイスの特性向上や、量子効果構造を結晶成長後に変形する量子構造混晶化技術の応用展開を進めている。量子構造混晶化とは、図3のように結晶成長で形成した異なる半導体材料界面を、後から原子相互拡散により変形する手法である。相互拡散する面内位置やその量を制御して、図3のようにポテンシャル構造を変形する。この手法を、従来から利用されている光吸収制御だけでなく、キャリアの閉じ込めや、光の閉じ込め、さらにトンネル接合と組み合わせた電流の閉じ込めなどに応用し、光デバイスの新規構造や特性向上手法への展開を進めている。

■高効率レーザーを用いた光無線給電システム開拓

VCSELを用いる高効率な光ワイヤレス給電システムの実現を目指している。情報伝送は無線化が大きく進んでいるが、エネルギー源の無線化では、既存の無線給電方式には電力量・伝送距離などに課題が多い。レーザー光を用いる光無線給電は移動体のような大電力を要するシステムにも有効なため、デバイスとシステムの開発を始めている。

実際のデバイス研究では、VCSELへの量子構造混晶化導入による、電流、キャリア、光閉じ込めと、その最適化による高効率化により、光無線給電システムの効率向上を進めている。また、高出力給電に向けて数万デバイスという2次元アレイ構造が必要になるが、相互の温度上昇が出力を抑制するため、効率向上とともに放熱性向上手法なども検討している。さらに、アレイ構造VCSELのビーム特性の制御に向けて、通常は独立動作する個々のVCSELを協調動作させるために、相互注入同期によるコヒーレント結合VCSELアレイの実現に取り組んでいる。

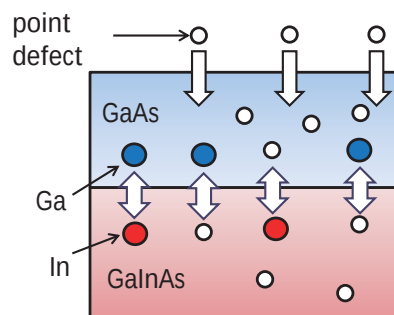


図3 量子構造混晶化手法の原理。結晶欠陥を導入して加熱することで、原子相互拡散させる。

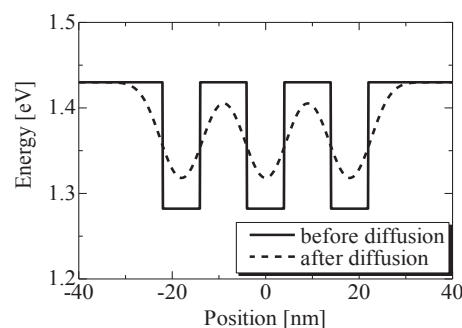


図4 量子構造混晶化による量子井戸ポテンシャルの変形。結晶成長時(実線)と混晶化後(点線)。

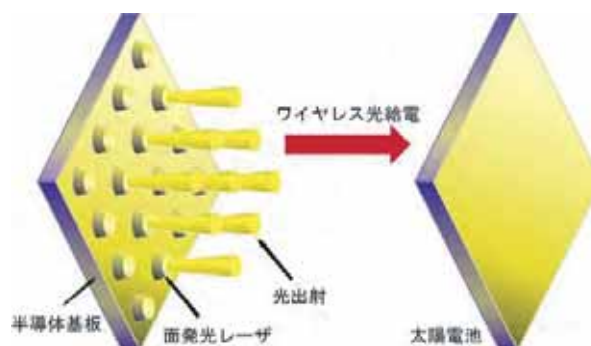


図5 面発光レーザーアレイと太陽電池を用いた光無線給電の概念図

3 教員からのメッセージ

フォトニクス(光)システムには多様な光デバイスが必要です。光デバイスの高性能化・新機能創出には、様々な原理を応用したデバイス機能のアイデアの創出とその高精度設計(シミュレーション)、および、多様な製作プロセス開拓が必要です。本研究室では、実際のデバイスの製作・評価から新規システム構築まで行うなど、最新技術を活用してものを「創る」研究を進めています。

浅田研究室

半導体ナノ構造による
テラヘルツデバイスの実現と
それを用いた未踏周波数の開拓

デバイスグループ
電気電子コース
大岡山・S9棟703号室

教授 浅田雅洋

研究分野: 電子デバイス、テラヘルツエレクトロニクス、半導体物理

キーワード: テラヘルツ波、テラヘルツデバイス、半導体ナノ構造、量子効果

ホームページ: <http://www.pe.titech.ac.jp/AsadaLab/>

1 主な研究テーマ: テラヘルツデバイス

電波と光の中間にある約0.1~10THzの周波数はテラヘルツ帯とよばれ、これまで未開拓の領域でした。最近この領域は、超高速無線通信、イメージング、分光分析など非常に幅広い応用への可能性が明らかになり、盛んに研究が行われるようになってきました。しかし、テラヘルツ波を発生できる光源や、それを検出する受信器はまだ十分に開発されているとはいえない状況にあります。特に、室温で動作するコンパクトな高出力・高効率の半導体光源や高感度・低雑音の半導体検出器は未だに実現していません。

本研究室では、半導体ナノ構造の中で生じる新しい現象を使って、テラヘルツ波を発生・検出する微細デバイスやその集積回路の実現、さらにはそれらの応用展開を目指しています。これまでに半導体電子デバイスで初めての室温テラヘルツ発振の達成や、それを使った無線伝送実験などを行ってきました。

2 最近の研究成果

■電子デバイスで初めて1THzを超える 室温発振を実現

周波数が1THz前後のテラヘルツ帯(以下、略してTHz帯。サブミリ波帯、遠赤外ともよばれる)は、光と電波の中間の未開拓領域で、半導体による光源で満足なものはまだ存在しません(図1)。

ところが、この周波数帯が開拓されれば、超高速通信やイメージング、分光分析、計測など非常に広い分野で種々の新しい応用が期待されており、光源や検出器などのキーデバイスの開発は必要不可欠となっています。

THz帯の高性能光源や検出器を実現するには、ナノメートルオーダーの極微細構造を形成し、電子の走行時間を大幅に短縮するとともに、ナノ構造に生じる新たな電子物性を用いることが有力な方法の一つと考えられます。

本研究室では、THz波に対する半導体ナノ構造の新しい現象や、ナノ構造によるテラヘルツ発生デバイスの実現を目指した研究を行っています。最近、ナノ構造の一つである共鳴トンネルダイオードを用いたTHz光源を作製し、電子デバイスで初めての室温THz発振に成功しました。さらに、周波数を制限していた電子遅延時間の短縮などを行い、最高発振周波数を更新しました(図2)。

現在、室温で1THzを超える周波数を単独で発生できるのは共鳴トンネルダイオードしかなく、THzギャップを埋める素子として期待されています。

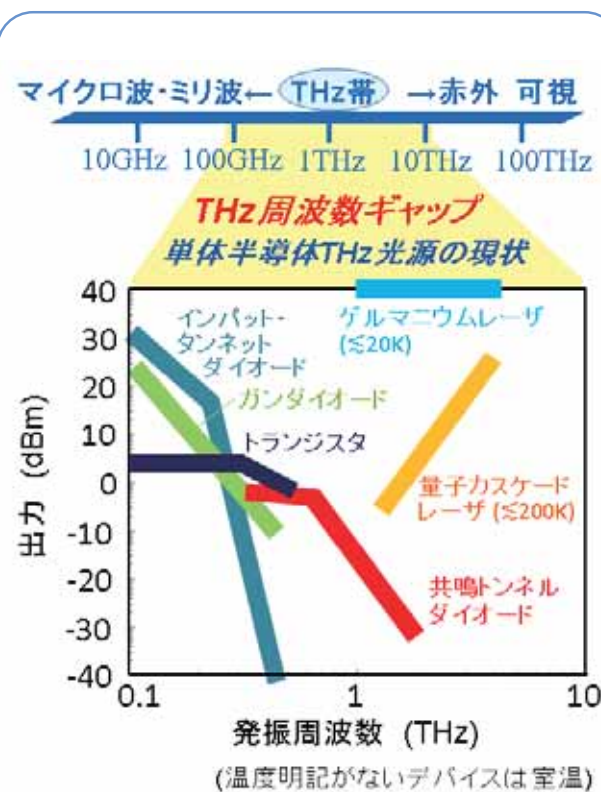


図1 半導体単体のテラヘルツ光源の現状。現在、周波数1THz周辺には満足な光源がなく谷間になっており、テラヘルツギャップと呼ばれています。

大岡山・デバイスグループ

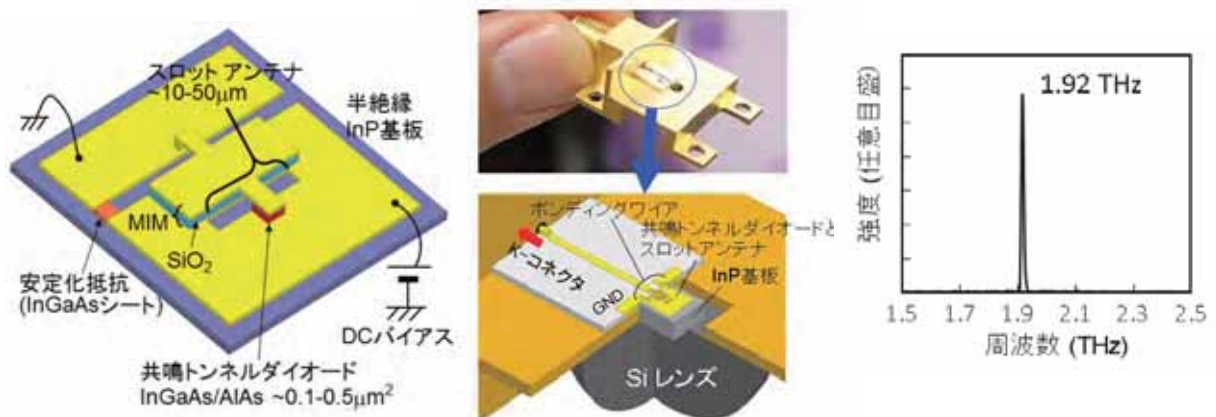


図2 共鳴トンネルダイオードによる、電子デバイスで唯一の1THzを超える室温発振器。素子構造(左)、モジュール化した素子(中央)、現在の最高発振周波数1.92THzの発振スペクトル(右)。

このような共鳴トンネルダイオードによるTHz光源をさらに高周波化・高出力化するための素子構造や、放射する出力ビームを鋭くするための微細アンテナ集積など、高性能化に向けた研究を進めています。

■半導体THz光源の高性能化と応用 (超高速無線通信、分光分析)

THz帯を用いることにより、簡易なシステムで数十～百Gビット/秒の超高速無線通信が可能となります。本研究室では、このような無線通信応用を目指して、共鳴トンネルダイオードのTHz出力に信号を乗せる高速直接変調や、これを用いたTHz送受信系(図3)の研究を行っています。

最近、共鳴トンネルダイオードの高速直接変調に成功し、これによる初期実験として、30Gビット/秒の高速THz無線通信のデモンストレーションを行いました。

THz帯では、超高速無線通信だけでなく、他の周波数では不可能な物質の分光分析が可能です。これには、周波数が連続的に変えられる光源が必要不可欠です。本研究室では、共鳴トンネルダイオードとバラクタダイオードを集積した周波数可変THz光源を実現しました。この素子の周波数範囲拡大や物質分析への応用の研究を行っています。



図3 共鳴トンネルダイオード送信器を用いた高速テラヘルツ無線通信系。

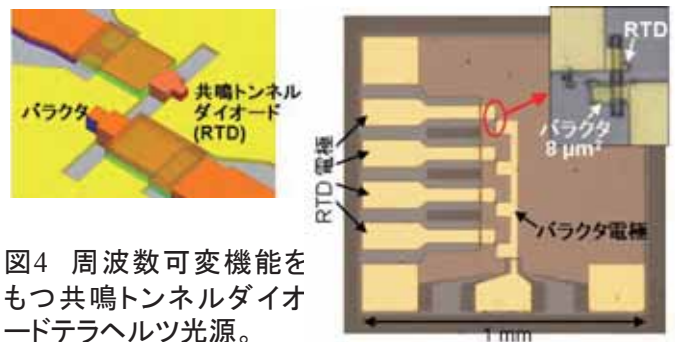


図4 周波数可変機能をもつ共鳴トンネルダイオードテラヘルツ光源。

3 教員からのメッセージ

研究はテラヘルツという未知の分野で、物理現象の探索からデバイス作製・応用にまで及んでおり、それぞれ実験あり理論あり。簡単ではないけれど、一歩先には今までになかった最高周波数のデバイスや新しい現象がある。メンバーが協力しあって新しい発見やデバイス実現を目指していきたいと思っています。

研究室メンバーから一言:世界初のデバイスを作れるかも?!(教員:作れます)ノ電子の気持ちかわかるようになるかもノ研究するには最高の環境ですノ動作時間"0"の超高速デバイスを目指せ(教員:これは…無理です)ノメンバーは個性派ぞろいノ

小田・河野研究室

低次元半導体材料、半導体量子構造を用いたナノデバイス、量子効果デバイス、テラヘルツデバイス



デバイスグループ

小田・河野研究室

教授 小田俊理

准教授 河野行雄

助教 川那子高暢

研究分野: ナノエレクトロニクス、半導体デバイス、量子効果デバイス

キーワード: シリコンナノデバイス、量子ドット、量子情報、テラヘルツデバイス

ホームページ: <http://diana.pe.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

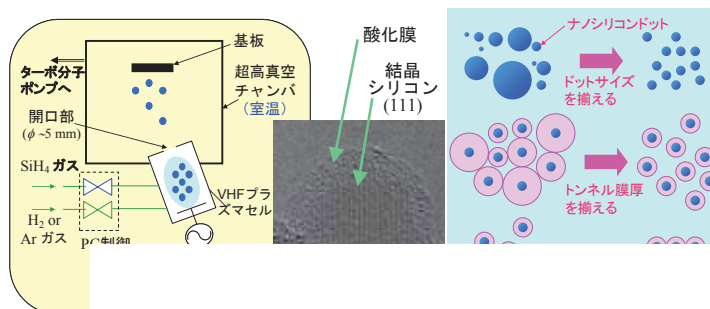
小田・河野研究室では、シリコン量子ドットの粒径、表面状態、位置を精密制御して作製し、量子ドット相互間の電子トンネル過程、発光、電子放出などの新しい機能デバイスに基づいた、革新的な情報処理技術を展開しています。シリコン量子ドットやナノワイヤの集積構造を用いて、ボトムアップ型アプローチと微細加工によるトップダウン型アプローチの融合を図ることで、エレクトロ&メカニカル量子特性の精密エンジニアリングを行い、任意の基板上に新原理素子・回路を構築する「ナノメカ・情報エレクトロニクス」の実現を目指しています。更に、究極の情報処理技術として期待されている量子情報処理技術や光と電波に挟まれた未開拓電磁波テラヘルツ波のデバイス開発にも取り組んでいます。

2 最近の研究成果

◆ネオシリコン創製に向けた構造制御

室温で量子効果を顕在化するためには10nm以下の加工寸法が要求されます。本研究では、パルスプラズマ法による直径 8 ± 1 nmの均一粒径ナノ結晶シリコン形成技術と、電子線描画による極微細電極形成技術を組み合わせて、超微細シリコンデバイスを作製し、単電子トンネルや無衝突伝導などの量子効果を観測しています。

この技術を基に、ナノ粒子間の相関制御に着目した新材料「ネオシリコン」のコンセプトを提案し、研究を推進しています。ナノ結晶シリコンドットの集積化技術として、溶液を用いる方法や、ナノテンプレートの使用などを検討しており、ネオシリコンの構造制御技術の確立を目指しています。

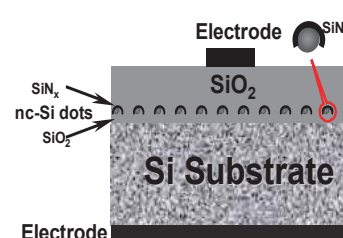
図1
(中央)

◆ネオシリコンを利用した機能デバイス

ネオシリコン作製技術と電子線描画によるナノ構造作製技術を駆使し、新しい機能デバイスの開発を推進しています。例えば、ナノ結晶シリコンを伝導層として用いる低電圧低真空中で動作可能な平面型バリスティック電子放出素子や、ナノ結晶シリコンをメモリのノードとして用いるナノドットフラッシュメモリの研究を行っています。また、電荷を保持したナノ結晶シリコンを含むフローティングゲートの機械的動作を利用した、全く新しい原理のNEMSメモリ素子の研究を推進しています。



図2



大岡山・デバイスグループ

◆テラヘルツデバイス・システムの研究

テラヘルツ波の計測技術は産業から医療に至る広範囲な分野での活用が期待されています。ところがテラヘルツ帯は電波領域と光領域の間に位置することから、新しい材料やデバイス構造を考案・開発することが求められる、挑戦的な研究分野です。本研究では、半導体量子構造やグラフェンを微細加工することにより、ワンチップ構造でテラヘルツ波を分光したり撮像したりするデバイスの開発を目指しています。これまで半導体デバイスの微細化・高性能化がトランジスタやレーザーを生み出し、私たちの生活を劇的に変えたのと同様に、ナノ構造による新しいテラヘルツ技術の創出が産業や生活の質の向上に大きく貢献すると期待できます。

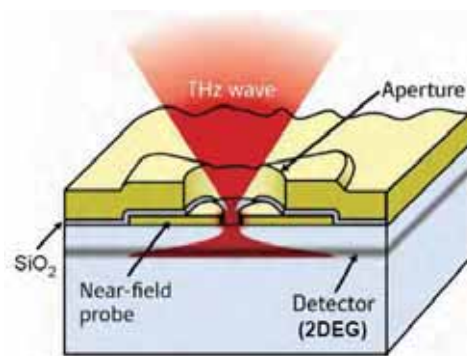


図3 ワンチップ型テラヘルツ波撮像デバイス

◆量子情報エレクトロニクス研究

量子情報処理は量子力学的物性を論理演算に利用しており、現存する情報処理の速度をはるかに上回る性能を持つことが期待されています。本研究では、シリコン量子ドット中の電子スピン状態を情報の1単位(量子ビット)として用いることを試んでいます。このシリコン量子ビットは、量子状態のコヒーレンス時間が長いこと、また多重量子ビットの集積化が可能という利点があります。最近、2つの量子ドットが結合したデバイスを用いて、電子スピン状態の観測に成功しました(米国ハーバード大学との共同研究)。また集積化を目指し多重量子ドット構造の作製も行い、電気伝導特性を詳しく調べました。これらの結果は世界的にも注目を集めています。この技術をさらに発展させ、高周波操作や時間分解測定を行うことで、電子スピンの回転操作や高速読み出しを目指し、量子情報エレクトロニクスの開拓を行います。

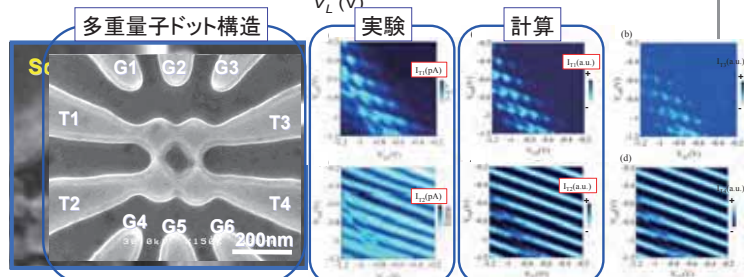
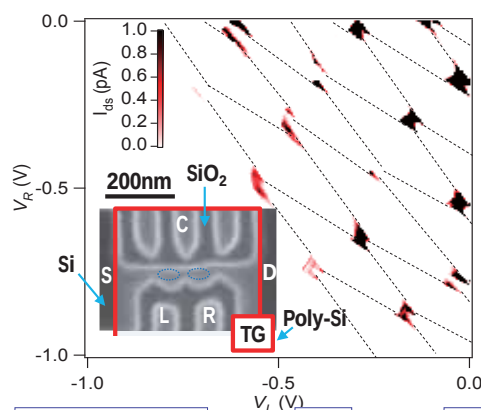
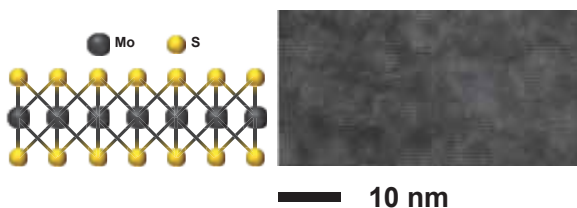


図4 多重量子ドットの静電的・量子力学的結合状態の観測

◆2次元層状材料の界面に関する研究

グラフェンに代表される2次元層状材料は、非常に興味深い性質を持つため、基礎および応用面から大変注目されています。本研究では、遷移金属ダイカルコゲナイドと呼ばれる化合物層状半導体を用いた電界効果トランジスタの作製プロセス、デバイス構造および材料技術に関する実験を行っています。特に、素子の性能や機能は単体の材料ではなく、異種材料で構成される界面の現象によって決定されるため、界面構造と電気特性の関係を明らかにすることを目的としています。

図5 遷移金属ダイカルコゲナイドの1つである二硫化モリブデン(MoS₂)の構造と断面透過電子顕微鏡による層状構造の観察

3 教員からのメッセージ

小田・河野研究室は海外にも広く研究ネットワークを広げ国際共同研究を進めています。毎年、大学院生がケンブリッジ大学やハーバード大学、デルフト工科大学、サザンプトン大学などに短期留学をしています。現在、小田・河野研究室では、欧米アジア諸国から10名の留学生が滞在しており(2016年1月現在)、自然に国際感覚が身に付く環境です。もっと、詳しいことを知りたい人は、いつでも気軽に研究室を訪ねてください。

鈴木研究室

電子デバイスを用いたテラヘルツ帯
受信素子/テラヘルツデバイスを用
いた超高速無線通信

デバイスグループ
電気電子コース
大岡山・S3-710

准教授 鈴木 左文

研究分野: テラヘルツ帯電子デバイス、テラヘルツ応用

キーワード: テラヘルツ、高電子移動度トランジスタ、共鳴トンネルダイオード
平面型アンテナ、無線通信

ホームページ: www.pe.titech.ac.jp/SuzukiLab/

1 主な研究テーマ

およそ100ギガヘルツから10テラヘルツの超高周波領域はテラヘルツ帯と呼ばれ、従来の光・電子デバイスは動作できなかったため開発がほとんどされてきませんでした。しかしながら、近年の精力的な研究開発によりテラヘルツ帯で動作するデバイスが徐々に産まれてきており、これらを用いた、超高速無線通信、イメージング、分光分析、物性・天文・生体などいろいろな分野にわたる計測などがデモンストレーションされ始めています。このように少しずつ現実味を帯びてきたテラヘルツアプリケーションですが、皆さんが日常的に意識せずに使うような存在となるにはまだまだ技術的に高い壁がいくつも存在します。本研究室では、それら障壁を打ち破り実際にテラヘルツアプリケーションを身近な存在にすべく、ナノ構造を用いることにより半導体の極限的な性能を引き出しテラヘルツで動作する電子デバイス、および、それらを用いたテラヘルツ大容量無線通信の研究を行っています。

- ・ 高電子移動度トランジスタを用いたテラヘルツ高感度受信器
- ・ 平面・小型・高指向性テラヘルツアンテナ
- ・ テラヘルツ大容量無線通信

2 最近の研究成果

■ 高電子移動度トランジスタを用いたテラヘルツ高感度受信器

テラヘルツ帯は非常に単純なことです。周波数が高いことから帯域が大変広く確保することができ、この超広帯域を用いれば簡単な変調方式（例えば0と1のオンオフ）でも100Gbpsを超えるような無線通信が可能です。ところが、デバイスの開発が進んでいるとはいえ、テラヘルツの送信出力は微弱なため、感度の高い検出器が必要となっています。本研究室では高電子移動度トランジスタ（HEMT）に微細なゲートを集積すれば、極短チャネルにおいて電子が無散乱に走行するため高い電流が流れることを利用し、これにテラヘルツ帯の平面構造アンテナを集積した高電流感度の受信器を研究しています。従来はショットキーバリアダイオードなどを用いた受信器が一般的に使われていましたが、高い周波数で動作させるためにはダイオードの面積を小さくしなければならず電流感度は低下してしまう問題がありました。HEMTを用いた受信器ではゲートを短くすることで電流を保ちつつ高周波で動作することが可能になり、従来受信器に比べ10倍以上の感度が期待できます。

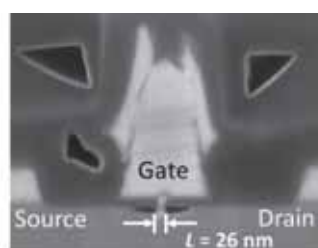
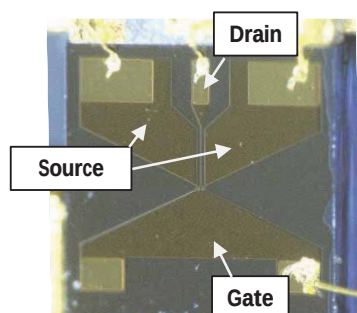


図1 作製したHEMTテラヘルツ受信器とデバイス真性部

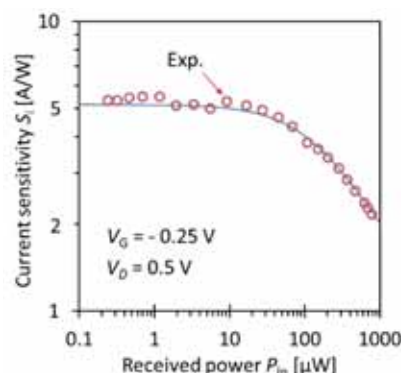


図2 HEMT受信器の受信感度特性

大岡山・デバイスグループ

大容量の無線通信に広い帯域を用いるため、受信器は広帯域性が要求されます。開発した受信器の帯域幅を調べるため、周波数可変光源であるUTC-PDと周波数通倍器の2つのテラヘルツ光源によるヘテロダイニングを用いた測定を行っています。測定から受信器の帯域幅が外部回路によって制限されていることが明らかとなり、外部回路を電磁界シミュレータにより精密に設計することにより100GHzを超える帯域幅が得られることも見積もっています。

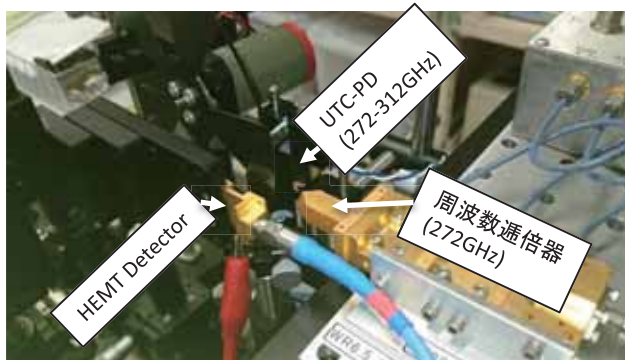


図3 ヘテロダインによる帯域幅測定系

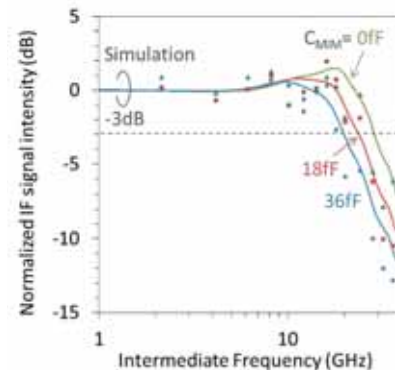


図4 受信器の周波数応答特性

■ 平面・小型・高指向性テラヘルツアンテナ

従来のテラヘルツデバイスでは放射や集光のため光学的なレンズもしくは導波管が用いられてきましたがこれらはサイズが大きく携帯機器に搭載することは不可能でした。そこで、基板上に平面アンテナを集積することによってレンズ等を用いない新たな構造を模索しています。初期的な検討として平面型パッチアンテナを集積したHEMT受信器を作製しパッチアンテナにより受信動作が行われていることを示しました。また、姿勢無依存で無線通信が可能となる円偏波放射型の小型平面アンテナについても研究を進めています。

■ テラヘルツ大容量無線通信

開発したHEMT受信器や共鳴トンネルダイオード(RTD)発振器を送信器として利用したテラヘルツ無線通信にチャレンジしています。RTDは現在電子デバイスで世界最高の発振周波数を持ち様々な周波数でキャリア信号を生成することが可能です。キャリア信号を多数使う周波数多重伝送が出来ればテラヘルツの広大な帯域をさらに有効活用することができ、大容量化が加速されます。



図5 HEMT受信器を用いた無線通信測定系

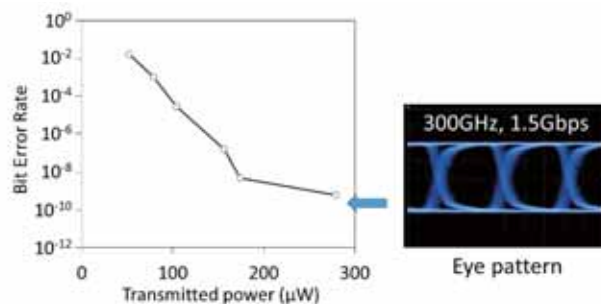


図6 300GHz無線通信の品質評価

3 教員からのメッセージ

- ・世界最速の電子デバイスとそれを用いた回路を作製し、世界最速の無線通信にチャレンジしてみませんか。
- ・クリーンルームや測定室に篋ったり研究はタフです。その分デバイスが動作したときの達成感は大いです。
- ・君の作ったデバイスで世界最速の通信ができるかも！（学生）

波多野・小寺研究室

IV族半導体(ダイヤモンド, SiC, Si)を用いたパワー/エネルギーデバイス、量子センサ、スピン量子デバイス



デバイスグループ
エネルギーコース・電気電子コース
大岡山・EEI-410/ EEI-403

教授 波多野 睦子 准教授 小寺 哲夫 助教 岩崎 孝之
研究分野: 電子デバイス、電子材料、応用物性、量子技術、固体物理
キーワード: パワーデバイス、センサデバイス、スピン量子情報デバイス、
人工光合成デバイス、ダイヤモンド・SiC・シリコン
ホームページ: <http://www.dia.pe.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

低炭素社会に貢献する「環境・エネルギー」を重視したデバイスの技術革新を創出していきます。主に優れた物性値を活かしたダイヤモンド、SiC、シリコンなどをベースとした、材料・物性・デバイスのブレークスルーとなる基礎研究、さらにパワー、センサ、スピン量子情報、人工光合成のデバイスをターゲットとした応用研究を進めていきます。

★当研究室は東工大の分野横断組織「環境エネルギー機構」にも属しており、居室は環境エネルギーイノベーション棟（EEI棟）にあります。



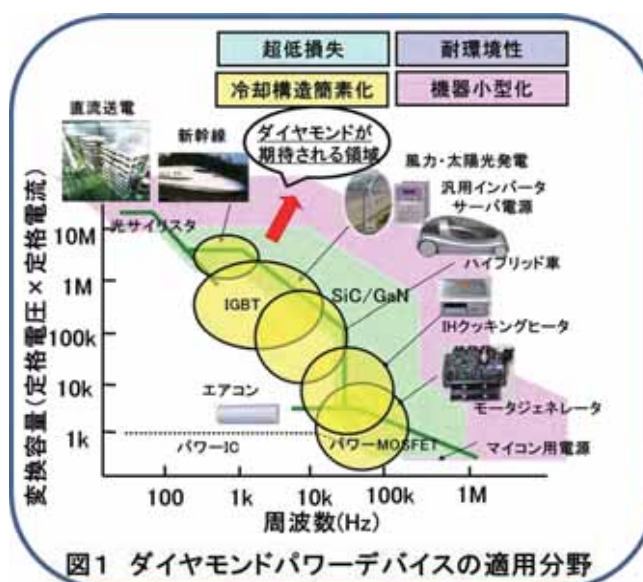
2 最近の研究成果

■ パワーデバイス

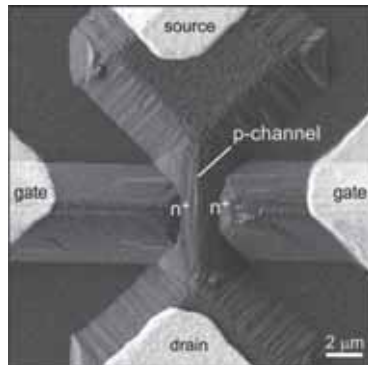
パワーデバイスは、送電、自動車、鉄道、太陽光発電、風力発電、家電などへの応用のニーズが高い電子素子であり、スマートグリッド化のキーデバイスです。高効率の電力変換が可能で超低損失なパワーデバイスの開発により、省エネルギーを推進し、二酸化炭素ガスの排出を大幅に削減することができるようになります(図1)。現在、主流であるシリコンを用いたパワーデバイスは電力変換の損失も多いなど性能の限界が近づいています。このような課題を解決するために、新しい材料として炭化珪素や窒化ガリウムによるデバイスが一部実用化されつつあります。

当研究室では、実用化されつつも未解決の課題である界面欠陥の影響について独自の測定手法により解明を目指して研究を進めています。

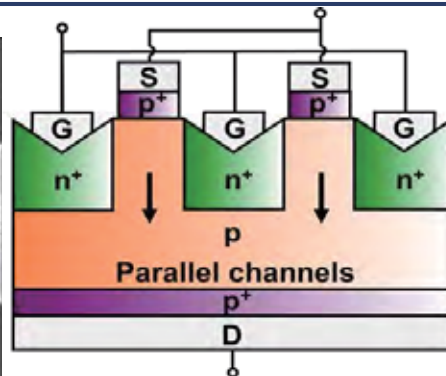
さらに、ダイヤモンドはこれらの材料よりもさらに高い絶縁破壊電界(Siの100倍)や熱の逃しやすさ(熱伝導率がSiの14倍)など究極の物性値を持つために、高電圧をかけても壊れず、また大電流を流したときに発生するジュール熱を効率的に逃がすことができます。しかしこれまで、トランジスタの基本構造の形成や基板の大面積化が困難であり、デバイス化に課題がありました。当研究室では、2020年の目標を電力損失を一桁以上低減できる、「オン抵抗 $0.05\text{ m}\Omega\text{ cm}^2$ 以下、耐圧 2 kV 以上」と定め、トランジスタや大面積基板化という、ダイヤモンドのデバイス化への本質的な課題を解決していきます。これまでに世界で初めてダイヤモンドによる接合電界効果トランジスタの開発に成功しています(図2)。



大岡山・デバイスグループ



横型接合電界効果トランジスタ



縦型接合電界効果トランジスタ

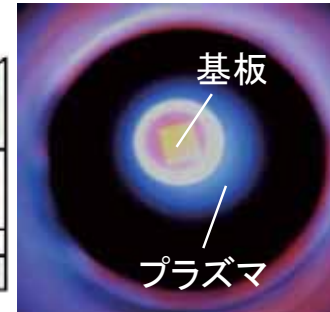
大面積化を目指した
ダイヤモンド
ヘテロエピタキシャル成長

図2 ダイヤモンドデバイス

■ 磁気センサ、スピン量子情報デバイス

細胞計測から、MRI・脳磁・心磁等の生体計測まで、高感度磁気センサのニーズがあります。当研究室では、常温で動作し、高い空間分解能を有し、2次元イメージングが可能である磁気センサの開発を目標としています。特に常温固体中で優れたスピン特性を持つことが知られているダイヤモンド中の窒素-空孔(NV)センタを用いています(図3)。他のセンサと比較して表1に示すような優位性が期待できます。スピンコヒーレンスが重要な物理量であり、これを制御することは磁気センサの高度化のみならず、量子情報デバイスへの応用にもつながります。将来的な集積化に向けて、シリコンテクノロジーを活かした研究にも取り組んでいます。



←図3. ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)センタ

↓表1. ダイヤモンド磁気センサデバイスの特徴

センサ	SQUID	MRセンサ	ダイヤモンドセンサ (本研究)
性能			
感度	◎	△	○
常温大気中動作	×	○	○
空間分解能	×	○	○
2次元検出 (磁場ベクトル可視化)	×	△	○

■ 人工光合成デバイス

太陽光を用いてCO₂の還元、貯蔵・輸送可能なエネルギーに変換を行う技術を実用化を目標としています。本研究室では、バンドギャップが2.2eVであり、可視光を吸収するとともに、酸化・還元に必要な電位を有する3C-SiC半導体に着目し、人工光合成デバイスを試作し、太陽光による水分解を実現しています。さらなる高効率・高寿命化、CO₂の還元実証に向けて、ナノ粒子の助触媒、グラフェン層パッシベーション、微細ナノ構造化によるナノ反応場での反応促進に取り組んでいます。

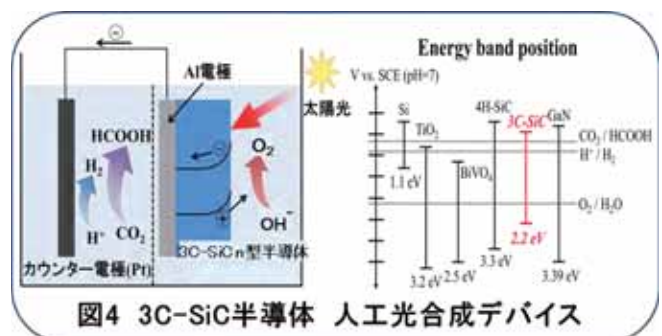


図4 3C-SiC半導体 人工光合成デバイス

3 教員からのメッセージ

電子デバイスのさらなる進化を実現するために、一緒に研究してくださる元気な方、いつでも訪ねて来てください。デバイスの新機能の創製や飛躍的な性能向上には、新材料や物性のナノスケールのサイエンスと、それを効果的に利用するブレークスルーテクノロジーが重要です。実用化を目指した工学研究と数十年先を見据えた基礎研究の両方を推進しています。一緒にチャレンジしませんか？

久本研究室

半導体プロセス・デバイスの研究
(パワーデバイス、超低電力集積
デバイス)

デバイスグループ
エネルギーコース・電気電子コース
大岡山・南3-815

特定教授 久本 大

研究分野: 半導体プロセス、半導体デバイス

キーワード: パワーデバイス、低電力デバイス、FinFET、Steep Slope
デバイス、SiC・シリコン、デバイス信頼性

1 主な研究テーマ

環境・エネルギーを重視した持続可能な社会に貢献するため、半導体デバイス技術を基に社会イノベーションを創出していきます。今日の社会で基幹となっているエネルギー分野を支えるパワーエレクトロニクスを担う「ワイドギャップ半導体デバイス」と、ICT分野を支えるULSIの将来を担う「低電力集積デバイス」の基礎研究を通して、新たなエレクトロニクスの応用分野の開拓を目指します。

★当研究室は、東工大と日立製作所の産学連携の一環として開設しています。大岡山デバイスグループのなかで、波多野・小寺研究室と連携して研究を進めています。

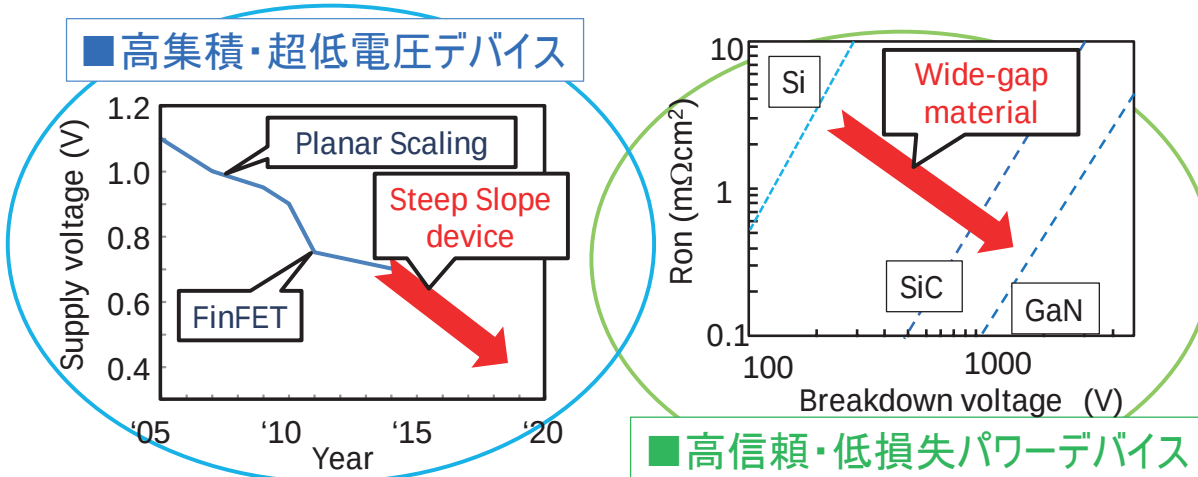


図1 本研究室のスコープ分野

2 最近の研究成果

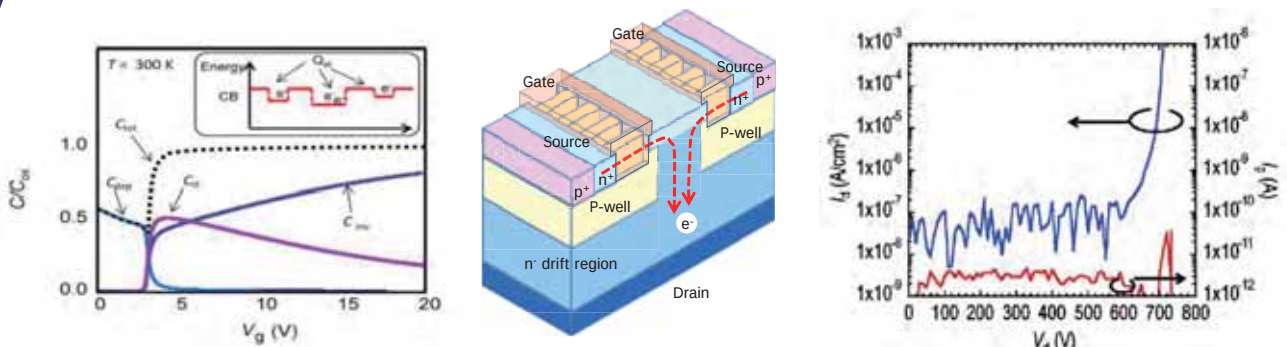
本研究室では、産学の連携のもと、デバイス信頼性の解析を基に、新たなデバイスの創造を目指しています。日立製作所研究開発グループにおける関係する研究成果について紹介いたします。

■ パワーデバイス

パワーデバイスは、発電・送電、鉄道、データセンタの電源などの社会インフラをはじめ、自動車や家電など、幅広い分野で使われている低消費電力化のためのキーデバイスです。多くの応用製品において、超低損失なデバイスの開発やインバータ化などで、高効率の電力変換が行われ、省エネルギーを推進し、二酸化炭素ガスの排出を大幅に削減できるようになってきています。現在、主流であるシリコン(Si)を用いたパワーデバイスの効率をさらに向上するため、ワイドギャップ半導体である炭化珪素(SiC)を用いたパワーデバイスの実用化を目指し研究開発を進めています。(図2)

出典: D. Hisamoto, et al., IEEE Electron Device Letters, vol. 36, no. 5, pp. 490–492, 2015.
N. Tega, et al., in Proc. ISPSD, pp. 81–84, 2015.
久本 大、電子デバイス界面テクノロジー研究会予稿集, pp. 55–58, 2016.

大岡山・デバイスグループ



4H-SiC MOSのSiC-酸化膜界面に形成される伝導帯下端の揺らぎによる電荷トラップモデルと電荷容量特性。チャネルキャリアが減少し、特性が大幅に劣化している。

高信頼性と高性能化を両立する新たなトレンチ型SiC MOSFETと耐圧を示す電流電圧特性。ゲートリーク電流が、測定限界以下に抑制されている。

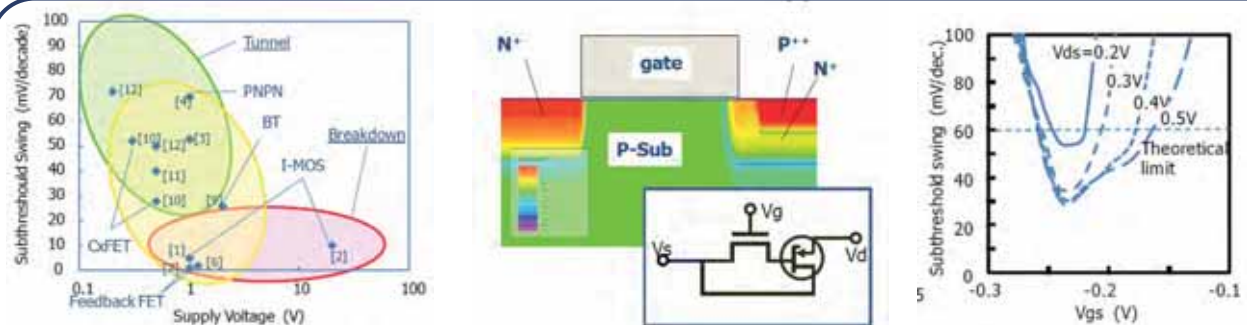
(TED-MOS: Trench-etched double-diffused MOSFET)

図2 SiC パワーデバイス

■ 超低電力集積デバイス

高集積デバイスの性能向上は、MOSFETの微細化によって支えられてきました。しかし、MOSFETのスイッチング特性(Subthreshold Swing)には、60mV/桁という理論限界があるため、電源電圧の低減の大きな制約になってきています。そのため、MOSFETに代わる動作原理を導入することで、より急峻なスイッチング特性(Steep Slope)が求められています。Steep Slopeを実現するトンネル現象を利用したデバイスの実用化を目指し、研究開発を進めています。(図3)

出典: 久本 大., 電子情報通信学会総合大会講演論文集, pp. SS-98-99, CI-4, 2015.
D. Hisamoto, et al., in IEEE Silicon Nanoelectronics Workshop, pp. 5-6, 2012.



これまで発表されている Steep Slope デバイス(実験)と印加電圧の関係。Swing と電圧の間にトレードオフが表れている。

トンネル注入型素子を用いた新たな Steep Slope デバイス構造と Swing 特性の印加電圧依存性。低電圧(~0.2V)においても60mV/桁(理論限界)以下が達成されている。

(CxSET: Complex CMOS)

図3 シリコン Steep Slope デバイス

3 教員からのメッセージ

半導体デバイスの面白いところは、基礎研究と産業である実製品との距離が非常に近いところにあります。信頼性の物理メカニズムを解析しているとき、新しいデバイスを生み出すことにつながっています。何かを見出したとき、何かを考え出したとき、そのデバイスがダイレクトに世の中に広がり、世界を席巻することができる、魅力的な分野の一つです。

福田研究室

半導体のシミュレーションとモデリング



デバイスグループ
電気電子コース
大岡山・南9-901、産総研つくば中央事業所

特定教授 福田 浩一

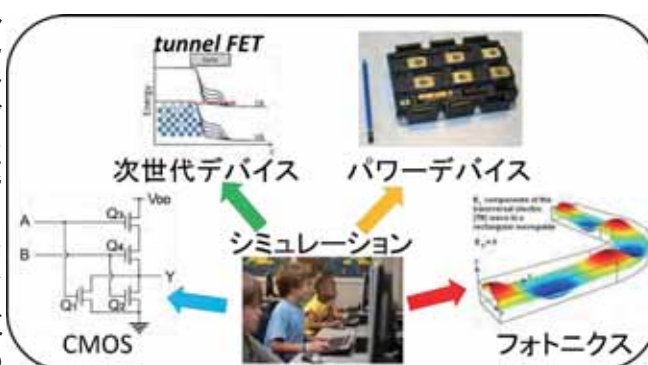
研究分野: 半導体デバイスシミュレーション、半導体デバイスモデリング

キーワード: デバイスシミュレーション、半導体デバイス
トンネルFET

ホームページ:

1 主な研究テーマ

日常にInternetが浸透し(IoT)、そこで必要とされる半導体デバイスの研究は激化しています。皆さんはすべての半導体デバイスの研究開発にコンピュータ・シミュレーションが使われていることをご存知ですか? 半導体デバイスの物理動作は複雑かつデリケートで、研究から量産まであらゆる段階でシミュレーションが必要です。本研究室ではその半導体デバイスのシミュレーションを研究しています。シミュレーションを用いたデバイスのモデリングはもちろん、シミュレーションそのものの理論や技術まで全ての側面が研究対象となります。あなたもこの分野の研究を志してみませんか?



★当研究室は国立研究開発法人産業技術総合研究所との連携大学院制度によるものです。

2 最近の研究成果

■ トンネルFETのモデリング

トンネルFETは、トンネル電流をゲートでコントロールする新原理トランジスタです。現在LSIで主流であるMOSFETより急峻なスイッチングが可能で、次世代デバイスの候補として多くの研究機関が注目しています。図1はトンネルFETの構造例と動作原理を説明したものです。

産総研でのトンネルFETの研究を元に立ち上げたトンネルFETのデバイスシミュレーションは、新デバイスのアイデア検証から実験結果の解釈まで、様々な場面でキーとなる役割を果たしています。東工大のデバイスグループでもトンネルFETを研究しており、実験と連携したモデリングの成果が期待できます。

新しい動作をするトランジスタを回路でどう応用していくのか、その検討を可能にするために、回路シミュレーション用のモデルも新たに開発しました。デバイスシミュレーションで得られた知見を、回路用の動作モデルの研究に結び付けます。このモデルは東工大を始めとする様々な大学で、回路の研究に活用されています。(Fukuda et al. JAP 2013, Fukuda et al. IWCE 2015など)

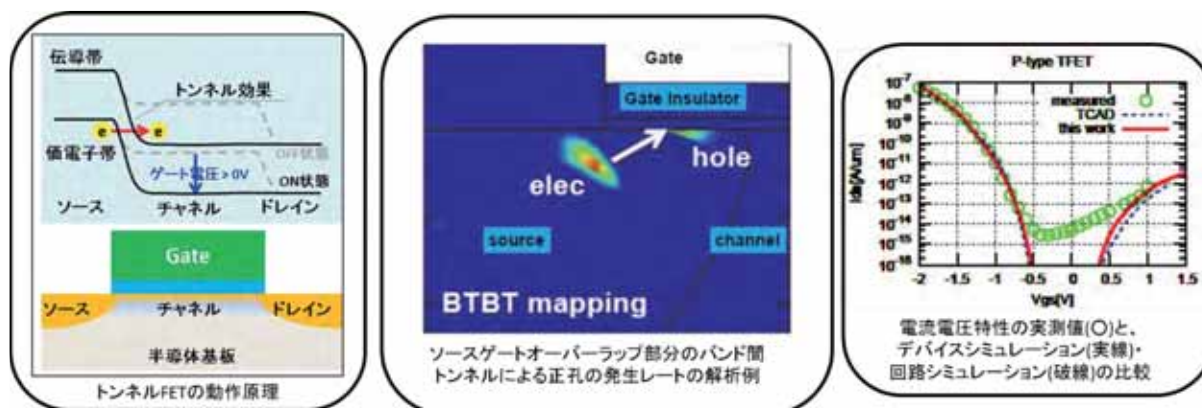
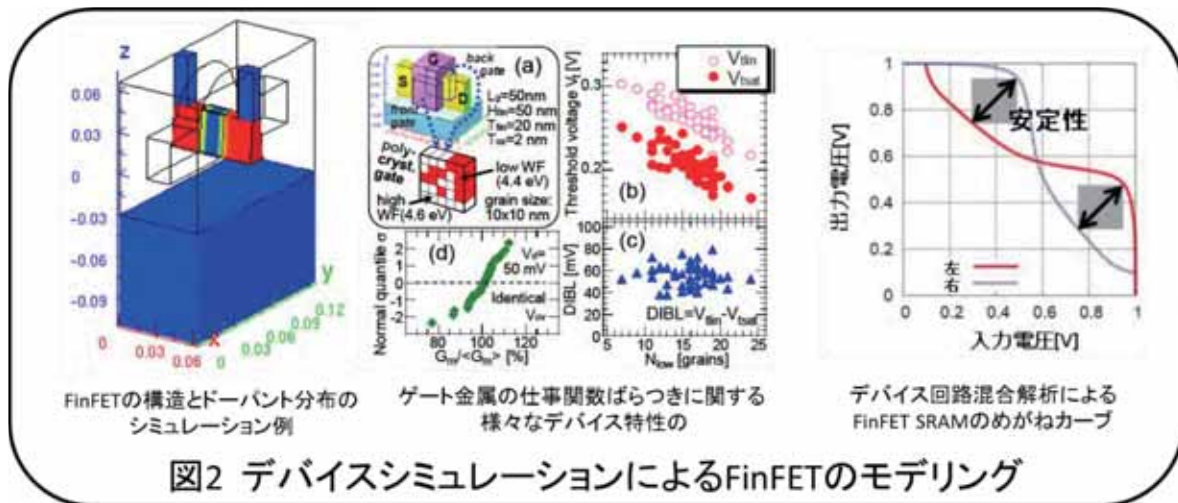


図1 デバイスシミュレーションによるトンネルFETのモデリング

大岡山・デバイスグループ

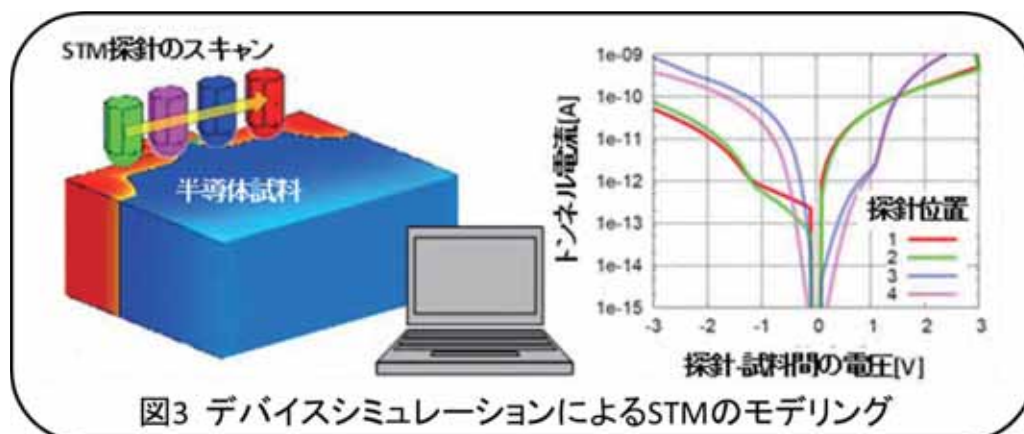


■ 新構造デバイスのモデリング

CMOSの微細化限界を延命するための新構造のMOSFETにFinFETがあります。FinFETはこれまでシリコン基板に水平に作られてきたMOSFETを、垂直に立てた立体型トランジスタとも呼ばれています。FinFETはチャネルの不純物を薄く出来るので、不純物の個数ばらつきによる素子特性バラツキを抑制できることが知られています。しかし金属ゲートの仕事関数が、面方位などでばらつく影響が次の課題となることが明らかになりました。デバイスシミュレーションはこのようなデバイスバラツキの解析にも用いられています(図2)。(Matsukawa et al., VLSI Technology Sympo. 2014 など)

■ 走査型トンネル顕微鏡(STM)のモデリング

走査型トンネル顕微鏡(STM)は試料と探針間に流れるトンネル電流を測定することで、試料の界面付近の状態を測定することが出来る強力な物理計測手法です。半導体デバイス内の微細な不純物分布の測定にも用いられています。しかしSTMは探針が試料に近づくと、探針自体のポテンシャルが試料表面の状態を変えてしまうため、正確な情報の抽出の妨げになっていました。そこでデバイスシミュレーションを、STMの探針まで含めて実施することで、探針の静電ポテンシャルが試料に与える影響や、トンネル電流が試料内部のキャリア分布に変化を与える効果を計算できるようにしました。半導体デバイスにとどまらず、その計測技術にも役立ったよい例となりました。(Fukuda et al., JAP 2014など)



3 教員からのメッセージ

半導体デバイスのシミュレーションは研究機関から産業界まで、幅広く必要とされるキー技術であり、それに特化した国際学会もあるほどの分野である一方で、案外プレイヤーの少ない分野でもあります。コンピュータの好きな方、プログラムを書いてみたい方にはうってつけの研究分野ではないでしょうか。あなたのアイデアを自分のプログラムで実現し、学会に発表していく、そんな研究者としての実力を、本研究室で身につけませんか。

宮本(恭)研究室

III-V族半導体等を用いた
高速・低消費電力電子デバイス

デバイスグループ
電気電子コース
大岡山・S9-702

教授 宮本恭幸

助教 金沢 徹

研究分野: 化合物半導体電子デバイス 微細加工プロセス

キーワード: InGaAs MOSFET、低消費電力デバイス、トンネルFET

ホームページ: <http://www.pe.titech.ac.jp/Furuya-MiyamotoLab/index.htm>

1 主な研究テーマ

高度情報化社会では、情報処理量の増大によりIT機器の消費電力が増え続けています。この消費電力の削減には、電子回路をつくる電子デバイスにおいて、高性能を保ちつつ、消費電力をさげる構造を導入する必要があります。

当研究室では、低消費電力で動作する高速電子デバイス実現の為に、移動度に優れ、半導体ヘテロ構造の導入が可能なIII-V族半導体を中心として、低電圧時での高電流密度や低電圧での待機時低消費電力の研究を行っています。また、耐圧の点で優れたデバイスについての研究も行っています。

2 最近の研究成果

InGaAs MOSFET

電源電圧=ドレイン電圧を小さくして、大きな電流を流す為には、まずチャンネル長を短くすることと移動度を上げることが必要になります。

大学研究室においてチャンネル長を短くするのに最も有力なのは、電子ビーム露光法(EBL)による方法であり、当研究室は、数十nmという微細な構造形成が可能になっています。

また移動度を上げる材料としてシリコンに代わるInGaAsが有望視されており、この構造も当研究室では有機金属気相成長装置という装置で望む薄膜構造をエピタキシャル成長できます。

さらに高い電流密度を保つ為にはソースから充分な電子が供給される必要があります。そこで、エピタキシャル成長による高濃度ソースを持ったInGaAs MOSFETを提案・作製しています。チャンネル長50nmのFETでは、ドレイン電圧0.5Vにおいて2.4A/mmという高電流密度を示せました。これは国際半導体技術ロードマップ(ITRS)において2018年以降に予定されているInGaAs MOSFETの目標値(2.2A/mm@0.63V)を世界で始めて上回ったものです。

またさらなる微細化(現在最小値13nm)や三次元構造デバイスの研究も行っています。

原子層状半導体HfS₂によるFET

FETにおいて短チャンネル効果抑制のためのチャンネルの究極の薄層化として、積層構造型半導体材料の導入が考えられ、代表的な層状物質であるグラフェンは単純な周期構造ではバンドギャップを持たない欠点があることから、バンドギャップを有する層状半導体が期待されています。

当研究室では、単分子層で高い電子移動度(1,800 cm²/Vs)とSiと同等の禁制帯幅(1.2 eV)が予測されている遷移金属カルコゲナイドHfS₂において世界で初めてトランジスタ動作を実現しています。

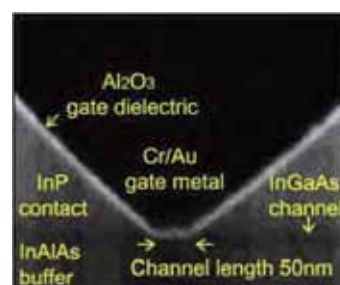


図1 チャンネル長50nm素子の電子顕微鏡断面写真

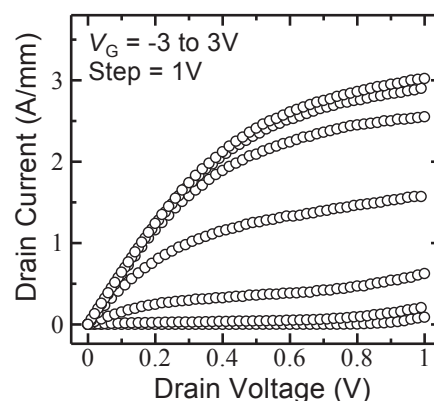


図2 チャンネル長50nmの素子のI-V特性

大岡山・デバイスグループ

ヘテロ構造を持った縦型InGaAsFET

縦型トランジスタ構造では、異種の材料組合せ(ヘテロ接合)を導入することにより、電子の走行する位置によってもっとも適した特性を持つ構造を実現することができます。例えば、ヘテロ接合によるバンド不連続での電子を加速するランチャを導入した縦型InGaAs FETでは、チャンネル長60nm、チャンネルメサ幅15nmの素子を作製し、7MA/cm²の電流密度を確認しています。

現在当研究室では、この素子作製プロセスを低電圧においても待機電力を下げるトンネルFET構造に応用しています。InGaAsをチャンネルとすることはゲートオーバードライブ電圧(有効ゲート電圧・実効ゲート電圧とも呼ばれます)やドレイン電圧を低くして高い電流を得るには有用ですが、電圧を下げるためにもう一つ必要なのは、しきい値自身を小さくことです。その為には、オフ状態でのリーク電流(待機時電流)に注意を払う必要があります。通常しきい値以下でのリーク電流の変化は、サブスレッショルドスロープと呼ばれるチャンネル/ソース間電位の60mV変化で一桁以下しか減少しないという熱限界があり、低電源電圧でオフすべき電流量を下げるには、この熱限界を打ち破ることが必要です。バンド間トンネリングによりキャリアを注入するトンネルFETはこの熱限界を打ち破れると期待されていますが、一般的なシリコンはトンネル抵抗が高く、高電流密度を実現することが困難です。

そこで当研究室では、GaAsSb/InGaAsによるタイプIIと呼ばれる価電子帯と伝導帯があらかじめ近づいたヘテロ接合を導入しています。現時点で得られた最小のサブスレッショルドスロープは71mV/decであり、熱限界はまだ破れていませんが、タイプII型ヘテロ接合を用いた縦型FETとしては世界最小の値を得ています。今後、絶縁膜の改善をおこなうことで、さらに急峻な変化を目指します。

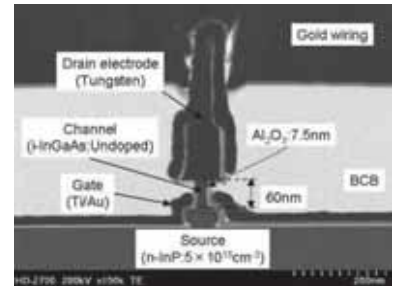


図3 15nm幅のメサを持つ縦型InGaAsFETの透過電子顕微鏡断面像

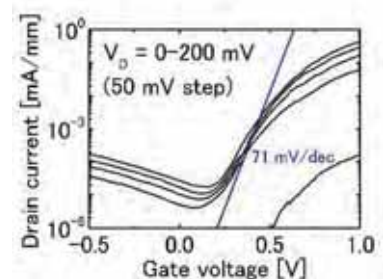


図4 GaAsSb/InGaAsチャネル縦型トンネルFETのサブスレッショルド特性

超格子構造によるスティープスロープFET

急峻なサブスレッショルド特性と高オン電流を両立させるための構造として、超格子をソースに導入したFETについて、理論的計算を行うとともに、超格子構造を導入したダイオードを作製し、その実験的な検証も行っています。

GaN系HEMTの高性能化

電源電圧などの高電圧の領域においては、耐圧の点でSiよりもバンドギャップが広い化合物半導体であるGaNを用いたデバイスが有望です。

当研究室では、GaN HEMTについてしきい値を作製時に制御する為の新たなプロセスの開発を行っています。

またGaN HEMTの高周波応用に向けた研究も行っています。(本研究は三菱電機との共同研究です。)

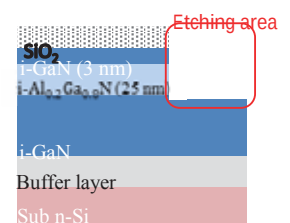


図5 デジタルエッチングされたAlGaIn層の断面TEM像とその模式図

3 教員からのメッセージ

自分で思いついた新しい素子を、自分で設計し、自分の手で作製し、自分でその素子の測定・評価をするということは、技術者・研究者としての楽しみの一つです。我々の研究室においては、他ではなかなか使えない世界最高水準の電子ビーム露光装置や結晶成長装置などを目一杯使って、その楽しみを味わって貰いたいと思っています。

石橋研究室

ハイブリッドナノ構造の形成と量子
ナノデバイスへの応用

和光キャンパス南地区 研究交流棟前にて

理化学研究所・石橋極微デバイス工学研究室
(埼玉県和光市広沢2-1)

主任研究員 石橋幸治

研究分野: ナノ物理、ナノデバイス、量子情報デバイス、量子技術
キーワード: 量子操作、量子ドット、人工原子、単電子デバイス、
コヒーレント制御、トポロジカル超伝導、カーボンナノ
チューブ、半導体ナノワイヤホームページ: http://www.riken.jp/research/labs/chief/adv_device/

1 主な研究テーマ

ナノスケールの構造を作製する技術を開発するとともに、そこに現れる量子効果を探査し、量子物理学の原理に基づいた新しいデバイスや量子技術を研究しています。その典型例は量子コンピュータの基本デバイスである量子ビットです。量子ビットは人工的な2準位系であり2準位を持つ人工原子です。それを実現するために量子ドットに閉じ込めた1個の電子のスピンの励起子を使い、光や電磁波との相互作用を利用してコヒーレントに量子ビットを操作する技術を開発します。これらの量子ビットと共振器を強く相互作用させる技術を開発し、将来は超伝導型量子ビットなどと組み合わせたハイブリッド量子プロセッサの実現を目指しています。また、量子技術を電荷、テラヘルツ波、磁束などの極限計測へ応用することも目指しています。量子技術に必須な高いコヒーレンスを求め、より小さな構造を実現する原子操作技術やトポロジカル超伝導接合の研究なども行っています。



試料作製のためのナノ加工はナノサイエンス実験棟で行います。



100mK以下の極低温を発生する希釈冷凍機(最低温部)

2 最近の研究成果

■ 量子ドットとマイクロ波共振器の相互作用

ハイブリッド量子プロセッサのイメージを図1に示します。ここでは、ロジック動作を行う超伝導型量子ビット、量子メモリとして働くスピン型量子ビット、さらに、プロセッサ内の量子情報と光子を変換し外部との通信を可能にするインターフェース、そしてこれらを制御する古典的なトランジスタ回路からなります。これを実現するためには様々な物理機能を利用しますが、その一つが量子ビットと共振器の量子的な相互作用です。スピン型の量子ビットでは大きな相互作用を得るために単一スピンと電界の相互作用が必要です。普通、スピンは電界で制御できませんが、そのためにスピン軌道相互作用や2電子系の一重項・3重項状態を使うことを検討しています。図2はコプレーナ導波路型マイクロ波共振器をチップ上に作製し、電界強度が大きくなるところにスピン軌道相互作用が大きなInSb半導体ナノワイヤで作った2重結合量子ドットを設置し、量子ドットと共振器の相互作用に関して予備的な実験を行うための試料構造です。測定では極低温に置かれた共振器を透過してくるマイクロ波の強度と位相を測定します。1個の電子が片方のドットに局在した場合(Aの場合)とドット間をトンネルにより行ったり来たりできる場合(Bの場合)で共振周波数が異なることが分かりました。量子的な相互作用を実現できているのかどうかはまだわかりませんが、このような共振特性の測定から量子ドットの状態を調べる手法は量子ビットの非破壊読出しの観点からも重要です。

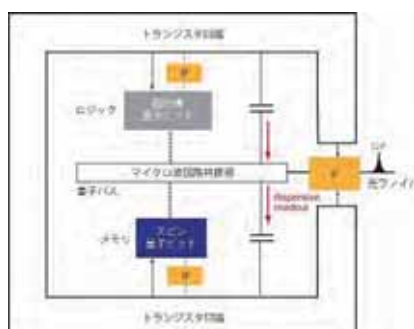


図1: ハイブリッド量子プロセッサのイメージ

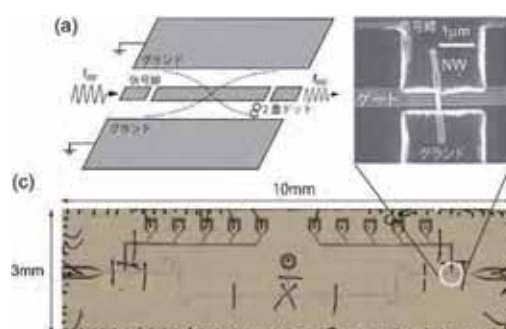


図2: マイクロ波コプレーナ導波路共振器中に置かれた2重結合量子ドット

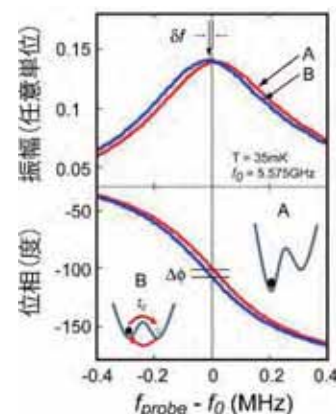


図3: 電荷状態に依存した共振特性

理化学研究所・デバイスグループ

■カーボンナノチューブ/分子ヘテロ接合とその応用

単層カーボンナノチューブ(SWCNT)は1ナノメートル程度の直径を持つことから、これをBuilding Blockとすればリソグラフィでは実現できないくらい小さな分子スケールのナノ構造を作製することができます。SWCNTに対してトンネル障壁となるような構造を分子で作ることができれば、半導体ヘテロ構造と同じように1次元的なバンドエンジニアリングが可能です。このような構造は極めて微細であるので大きな量子効果をより高温で発現させることができます。図4はこのような構造の基本ユニットとなる分子でSWCNTをつないだ構造です。ここで分子はトンネル障壁の役割を果たします。図5は3つのSWCNTを分子でつないだ構造です。分子がトンネル障壁として働くことからこの構造は1次元量子ドットとして動作することが期待できます。1本のSWCNTの両端を分子で修飾した構造は分子と結合している化学結合を選ぶことにより単一量子ドットや2重量子ドットを作ることができます。図6は1次元量子ドット内の状態密度を走査トンネル分光(STS)法によって測定した結果です。カルボキシル基を用いて分子を結合した場合には調和振動子のような閉じ込めポテンシャルを持つ単一量子ドットが形成できます。また、この量子ドットからは励起子発光が観測されています。この発光は光通信波長帯でおこり、量子通信に必要な単一光子発生への応用が期待できます。また、1次元量子ドットで生成される励起子の物性や制御にも興味があります。

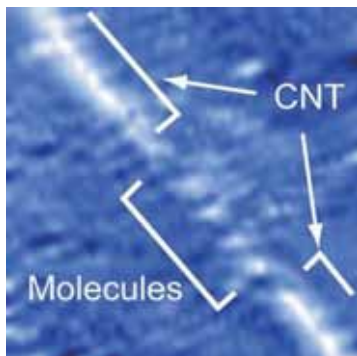


図4: 分子との化学結合をもちいて2つのカーボンナノチューブをつないだ構造の走査トンネル顕微鏡像

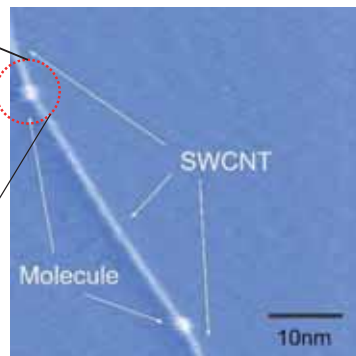


図5: 3つのカーボンナノチューブを分子でつないだ1次元量子構造

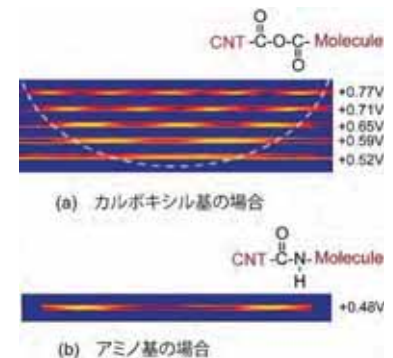


図6: 両端を分子で修飾したカーボンナノチューブ量子ドットの状態密度分布(STS測定による実測結果)

■ 極限量子計測への応用 -THz波の量子検出の例-

ここでは量子効果を使った極限量子計測の例として、テラヘルツ(THz)波を光子として検出する量子応答メカニズムとその応用について紹介します。カーボンナノチューブで作った量子ドットでは人工原子としてのエネルギースケールがTHzの周波数になるため、THz波を光子として吸収したり放出したりする量子的な応答が可能です。実際、図7に示すようにTHz波を量子ドットに照射するとTHz光子の吸収を伴うピークが観測されます(矢印)。このメカニズムは光アシストトンネルと呼ばれ、超伝導/絶縁体トンネル接合においてマイクロ波の量子検出に使われています。量子ドットではインピーダンス整合の問題があるためそのまま高感度検出に応用することはできませんが、量子ドットを複数個組み合わせたデバイスを作製することによりこの課題を克服することを検討しています。そこで、カーボンナノチューブで量子ドットを複数集積化したデバイスや簡単な回路を作製するための方法として、イオンビームを局所的に照射することによりトンネル障壁を形成する技術の開発を行っています(図8)。

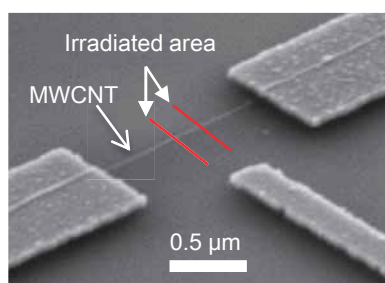
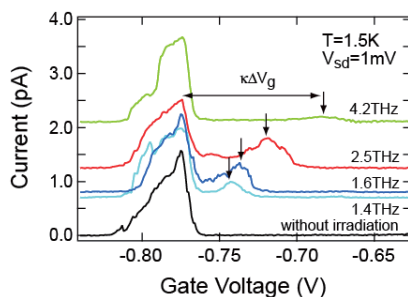


図7(左): 単層カーボンナノチューブ量子ドットにTHz波を照射した時の電流応答

図8(右): 多層カーボンナノチューブの一部に集束イオンビームなどを用いて局所的にトンネル障壁を形成して量子ドットを形成します。この方法を使えば好きな場所にトンネル障壁を作ることができるので、デバイスや回路へ向けた自由度が広がります。

3 教員からのメッセージ

1電子レベルで量子状態を操作する研究ですから、量子物理学に興味があり、単に本を読んでいるだけではなくそれを体験し、実際にそれを使ってデバイスを作りたいと思う人にはとても面白い研究だと思います。ただ、日々の研究はうまくいかないことの連続です。めったに思った通りの結果は得られない、というのが実感でしょう。それだけに、うまくいった時の感動は大きいものです。

大見研究室

新機能集積化デバイスの創製 - 高・強誘電体を用いた新構造デバイス



デバイスグループ
電気電子コース
すずかけ台・J2棟1204号室

准教授 大見俊一郎

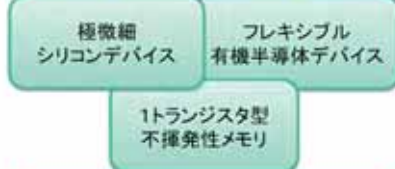
研究分野: 集積化電子デバイス、半導体デバイス・プロセス
キーワード: シリコンデバイス、有機半導体デバイス、不揮発性メモリ、
高誘電率薄膜、強誘電体、シリサイド、原子レベル平坦化
ホームページ: <http://www.lsi.ip.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

集積化により高性能化する新機能デバイスの創製を目的とした、新しいデバイス構造と作製技術に関する研究を推進する。特に、シリコン酸化膜(SiO_2)よりも高い誘電率を持つ高誘電率薄膜や、分極特性によるメモリ機能を有する強誘電体薄膜などの高機能誘電体薄膜を用いて、学問に基づく新構造デバイスの実現を目指す。

相補型MOSFET(CMOS)を高性能化する極微細シリコンデバイス、シリコンにはない特徴を持つフレキシブル有機半導体デバイス、ユニバーサルメモリを目指した1トランジスタ型不揮発性メモリを主要な研究テーマとして、本学すずかけ台キャンパスに構築されたクリーンルーム(CR)設備、超純水装置、高純度ガス供給設備などの、恵まれた実験環境を有効に利用して研究を進める。

高・強誘電体を用いた新構造デバイス



学問に基づく新しいデバイスの創製



2 最近の研究成果

■ 極微細シリコンデバイス

MOSFETのシリコン(Si)チャネル構造を立体化した3次元ゲートMOSTランジスタへの高誘電率窒化ハフニウム(HfN)ゲート絶縁膜の形成に関する研究を進めている(図1)。電子サイクロトロン共鳴(ECR)スパッタ法を用いて HfN_x 薄膜の窒素組成を制御することにより、ゲート電極($x < 1$)とゲート絶縁膜($x > 1$)をin-situプロセスで形成し、 SiO_2 換算膜厚0.5 nmでリーク電流を劇的に低減したゲートスタック構造を実現している(図2)。

また、Si表面を原子レベルで平坦化することにより、高誘電率ゲート絶縁膜を用いたMOSFETのデバイス特性が向上することを明らかにしている。このSi表面平坦化プロセスを用いて、表面ラフネスを低減した100 nm以下の3次元Siチャネルの形成を進めている(図3)。

さらに、トランジスタの直列抵抗を低減するために、耐熱性に優れたプラチナシリサイド(PtSi)と、低仕事関数を有するハフニウムシリサイド(HfSi)を混晶化したPtHfSiを形成し、n-Siに対するコンタクト抵抗を $10^{-8} \Omega\text{cm}^2$ に低減することに成功している(図4)。

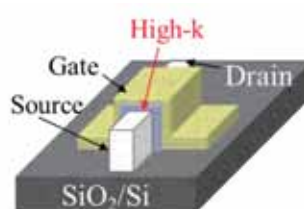


図1 3次元ゲートMOSFET

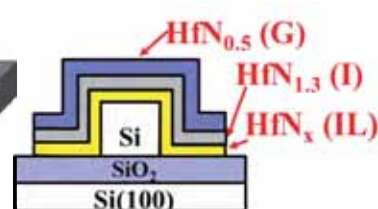


図2 HfNゲート積層構造のin-situプロセスによる形成

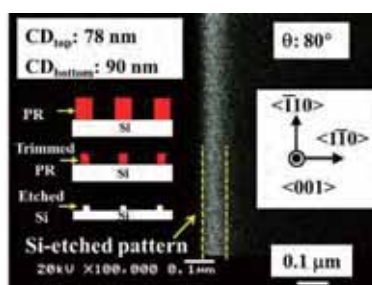


図3 3次元Siチャネル構造のレジストリミングによる形成

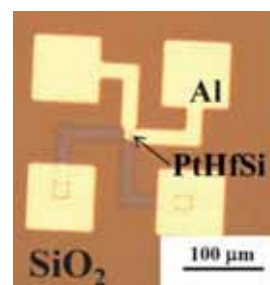


図4 PtHfSiのコンタクト抵抗測定素子

すずかけ台・デバイスグループ

■ フレキシブル有機半導体デバイス

有機半導体は、フレキシブルで軽く、低温形成が可能などの、Siにはない様々な特徴を有しており、新しいエレクトロニクス分野の創製が期待されている。しかし、その材料物性に起因してSiデバイスで用いられるリソグラフィプロセスが適用できないため、有機半導体トランジスタ(OFET)の微細化、高集積化が困難であるという課題がある。この課題を克服するために、図5に示すトップゲート構造を有する有機半導体CMOSの実現に向けた研究を進めている。

また、集積化に向けた単一有機半導体CMOSに関する研究を行っている。代表的な有機半導体であるペンタセン($C_{22}H_{14}$)やルブレン($C_{42}H_{28}$)は、ホール移動度に対して電子移動度が著しく低いため、N-OFETにはフラーレン(C_{60})などの別の材料を用いる必要があり、高集積化が困難となっている。そこで、図6に示すように低い仕事関数(2.4 eV)を有し、大気中で安定な窒素添加 LaB_6 を、ペンタセンの電子供給層として用いることで、光照射下において大気中でのペンタセンの電子電流の測定に初めて成功している。

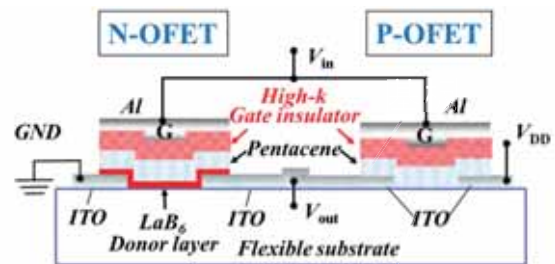


図5 トップゲート型単一有機半導体CMOS

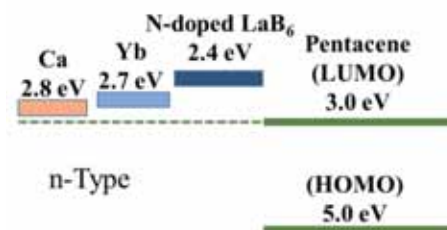


図6 ペンタセンと低仕事関数金属のバンド構造

■ 1トランジスタ型不揮発性メモリ

高速かつ低電圧動作が可能なユニバーサルメモリの創製を目的として、1トランジスタ型不揮発性メモリに関する研究を進めている。まず、フラッシュメモリの高性能化に向けた、Hf系多層構造によるMONOS型多値メモリに関する研究を行っている(図7(a))。また、MOSFETのゲート絶縁膜に強誘電体を用いたMFSFETによる1トランジスタ型強誘電体メモリの研究を進めており、Hf系強誘電体薄膜のSi基板上への形成と、低分子有機強誘電体クロコン酸($C_6H_2O_5$)の蒸着法による薄膜形成および有機MFSFETの低電圧動作化に関する研究を行っている(図7(b))。

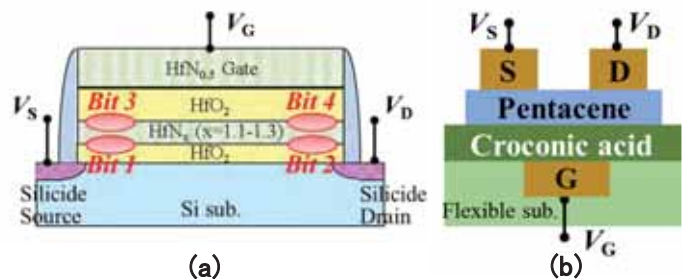


図7 1トランジスタ型不揮発性メモリ

(a) Hf系MONOS型多値メモリ、
(b) 有機強誘電体クロコン酸を用いた有機MFSFET

3 教員からのメッセージ

自分で考えたデバイスを自分で試作できる。本学の恵まれた実験環境を活かして、思いっきり研究を楽しもう。夢にみるくらい考え抜けば、君のアイデアが世界を変えるかもしれない。

4 参考文献

- (1) Shun-ichiro Ohmi, Sohya Kudoh, and Nithi Atthi, "Variability Improvement of Electrical Characteristics of MOSFET with High-k HfON Gate Insulator by Si Surface Flattening", IEEE Trans. on Semicond. Manuf., **28**, pp. 266-271 (2015).
- (2) Sohya Kudoh and Shun-ichiro Ohmi, "A Study on Si(100) Surface Flattening Utilizing Sacrificial Oxidation Process and Its Effect on MIS Diode Characteristics", IEICE Trans. Electron., **E98-C**, pp. 402-405 (2015).
- (3) Yasutaka Maeda, Shun-ichiro Ohmi, Tetsuya Goto and Tadahiro Ohmi, "High quality pentacene film formation on nitrogen-doped LaB_6 donor Layer", 2015 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2015), pp. 225-229 (2015).

角嶋研究室

機能性界面の制御による
次世代電子デバイスの創出

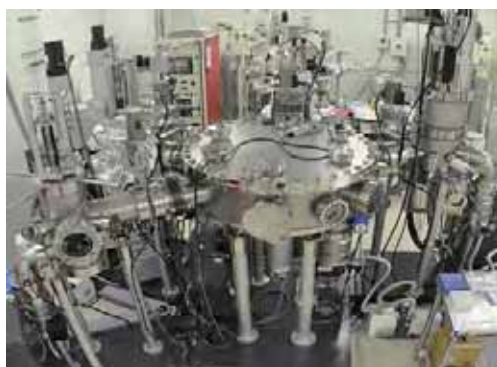
デバイスグループ
電気電子コース
すずかけ台・S2棟708号室

准教授 角嶋 邦之

研究分野: 電子デバイス、異種材料界面制御、プロセス
キーワード: パワーデバイス、太陽電池
ホームページ: <http://www.iwailab.ep.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

今後の省エネ社会を実現するためには大規模集積回路を利用した高効率なエネルギー制御が必須になります。そのためには高性能な半導体デバイスが必要になりますが、同時にデバイス自身の消費電力を抑制する必要があります。高性能・低消費電力の半導体デバイスを実現するためには新しいデバイス構造や新しい材料を導入することが必要です。半導体デバイスは異種材料の界面の性質を利用して動作してきました。そのため、新構造や新材料の異種材料界面の潜在的に有する機能を最大限に引き出すことが高い性能を持つデバイスの実現に繋がります。本研究室では理想的な異種材料界面を実現するプロセスを考案し、デバイス試作を通じて実証する研究を行っています。



2 最近の研究成果

■ GaN/パワーデバイス

AlGaN/GaN HEMTは高効率な電力変換が期待されるデバイスです。基板の品質やデバイスの信頼性を含めて様々な課題が山積している状況ですが、界面制御技術を用いて一つずつ研究を進めています。最近はいき値の制御が可能なゲート絶縁膜材料として酸化ランタン膜の検討や高い信頼性が得られるポリシリコン電極材料を検討しています。

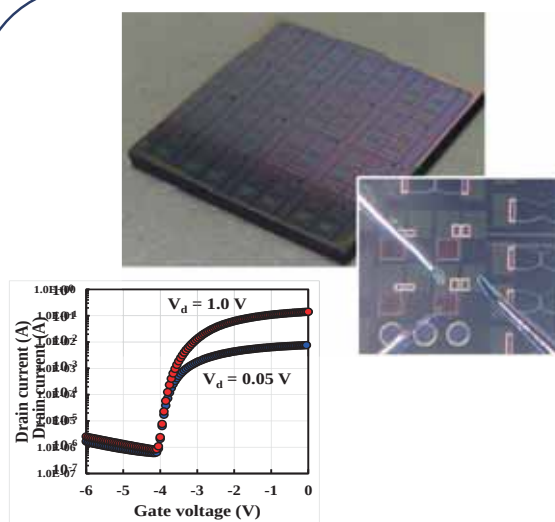


図1 試作したAlGaN/GaN HEMTの写真と特性

すずかけ台・デバイスグループ

■ SiCパワーデバイス

シリコンカーバイド(SiC)は社会インフラの高電圧を用いる領域で高い効率で電力変換を行うデバイスです。更なる高効率化と安定性を得るためにゲート絶縁膜、ショットキー電極材料など界面制御技術に基づいて検討を進めています。

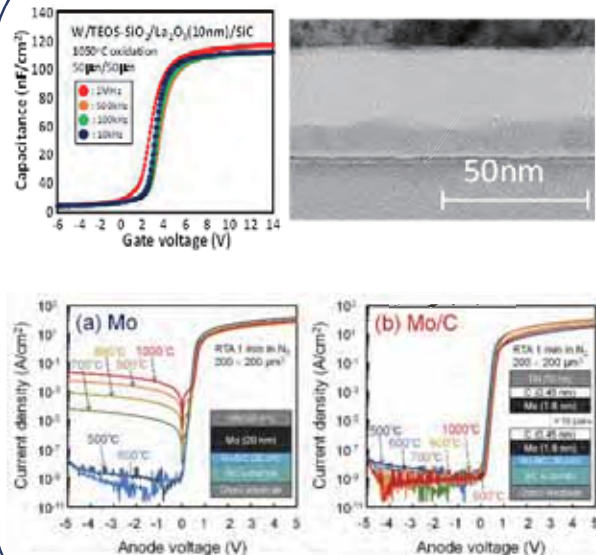


図2 SiCのMOSキャパシタとSchottky diode

■ ナノワイヤ太陽電池

シリコンを10nm以下のサイズに小さくすると量子効果によってバンドギャップが大きくなります。この特性を利用して太陽電池の開放電圧を大きくし、変換効率を高くすることが期待されています。本研究室ではナノワイヤ太陽電池を実現するために解決すべき課題の抽出を行っています。

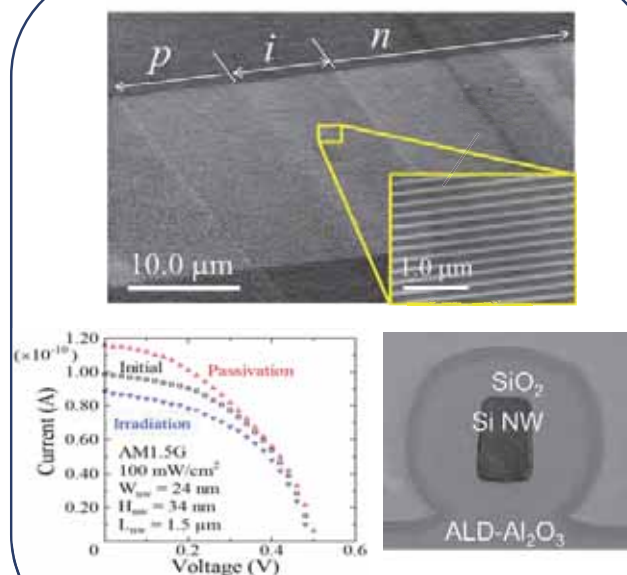


図3 試作したナノワイヤ太陽電池と特性

3 教員からのメッセージ

本研究室ではウェハレベルからスタートして加工プロセスを進めてデバイス試作を行い、電気測定に物理分析、解析ソフトウェア開発に至るまで一貫して行います。探求的要素の強い研究内容になりますが、自由な発想をもって世界トップのデータを出したいと考えております。

筒井研究室

新材料・新機能素子技術による電子デバイス：
ナノデバイスからパワーデバイスまで

デバイスグループ
電気電子コース
すずかけ台・J2棟1103号室

教授 筒井 一生 助教 星井 拓也

研究分野： 電子デバイス、電子材料・プロセス、結晶成長
キーワード： パワーデバイス (Si, AlGa_N/Ga_N)、立体チャネルトランジスタ、
半導体中不純物の原子レベル3D解析
ホームページ: <http://www.tsutsui.ep.titech.ac.jp/>

1 主な研究分野とめざすもの

シリコン大規模集積回路 (LSI) からパワーデバイスまで、半導体電子デバイスは大きな進歩を遂げ、それは将来にわたり我々の社会を支える高度な基盤技術です。本研究室では、新しい材料技術、デバイス技術、プロセス技術によるブレークスルーの提案、ひいては技術のパラダイムシフトの誘導をめざして研究を進めています。研究テーマとしては、ロングレンジの独自の研究から、近い将来の明確なターゲットを産学連携で推進するものまで、同時に取り組んでいます。また、これらの研究テーマの多くは、角嶋研究室、若林研究室等との連携で進めています。

2 最近の研究テーマ

■ 半導体パワーデバイスの高性能化技術

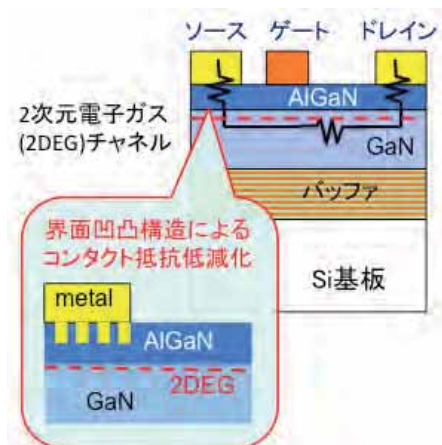
電力の制御に使われるパワーデバイスは、エネルギー・地球環境問題の克服につながる大きな役割を担っています。当研究室では種々の半導体によるデバイスの新技術の研究に取り組んでいます。

(1) AlGa_N/Ga_N系パワーデバイス

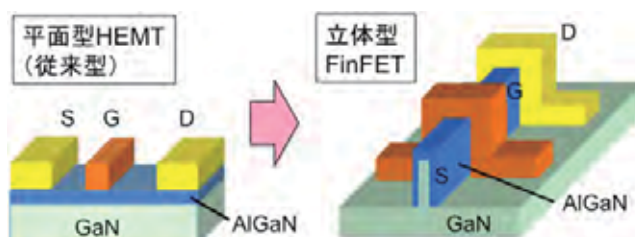
高性能パワーデバイス用半導体として窒化ガリウム系材料があり、AlGa_N/Ga_Nのヘテロ界面に発生する二次元電子ガスをチャネルに使う高電子移動度トランジスタ (HEMT) は高速パワーデバイスとして有望です。パワーデバイスでは、オン状態での素子抵抗を徹底的に下げて低損失化を図ることと同時にオフ状態では高い耐圧と低い漏れ電流を維持することが必要です。

オン状態の素子抵抗低減には、ソース、ドレインのオーミックコンタクト電極の接触抵抗を下げる技術の開発が重要であり、コンタクト形成のメカニズムに立ち戻る観点からの研究を進めています。例えば、AlGa_N層への凹凸構造導入などの新技術も提案し、有用性を明らかにしています。

さらに、将来技術として、トランジスタを従来の平面構造から立体構造にして、AlGa_N/Ga_N系パワーデバイスの特性を飛躍的に高めることを目指した研究も行っています。



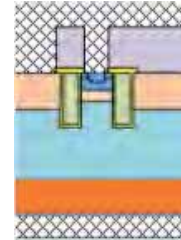
HEMT構造とコンタクト技術

Ga_Nによる立体型トランジスタ: FinFET

すずかけ台・デバイスグループ

(2) シリコンパワーデバイス (IGBT)

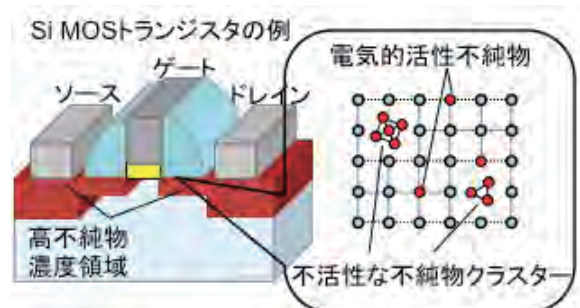
現在最も広く使われているパワーデバイスの一つは、半導体シリコンの絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)です。そのため、IGBTの低損失化の追求は、インバータ等の電力変換システムの高効率化を通して世界の省エネルギーに大きく貢献できます。当研究室では、IGBTのゲート部分を微細化することによって格段に低損失な高性能IGBTを目指す研究にシミュレーションと実験の両面から取り組んでいます。



トレンチIGBT

■原子ホログラフィー技術による半導体中の不純物の3次元構造の解明

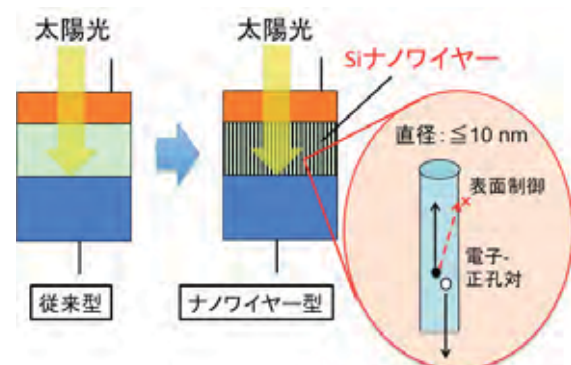
半導体に不純物をドーピングしてp形、n形の導電性を制御するのは半導体デバイスの重要な基礎技術ですが、デバイスの高性能化を果たすためには、この不純物ドーピングにも極限的な特性が求められます。デバイスの低損失化のために非常に高濃度の不純物ドーピングを行うと、不純物原子が半導体結晶の格子構造にきちんと取り込まれず原子クラスター等を作り電気的特性が劣化します。しかしこのメカニズムは十分に解明されていません。この課題解決を目指し、大型放射光施設(Spring-8)での光電子ホログラフィーなどの新しい手法を使い、不純物の3次元的な原子配列構造を解明する研究を行っています。



半導体中不純物の結晶中での配置構造

■シリコンナノ構造を用いた太陽電池

シリコンを直系ナノメートルのオーダーまで細くしたシリコンナノワイヤーは、電子から光まで多くのデバイス技術として関心が高まっています。当研究室では太陽電池への応用を目指した研究を行っています。最も広く普及しているシリコンを用いながら従来の層構造から高密度のナノワイヤー構造にすると発電効率の顕著な向上が期待されます。しかし、ナノワイヤーの表面制御技術や、ナノ構造への不純物ドーピングなど、実用化に向けて課題も多くあります。微細トランジスタでの研究蓄積も基礎としてその克服に向けて研究を進めています。



シリコンナノワイヤー太陽電池

3 教員からのメッセージ

新しい物を作り出す研究は思い通りには行かないことの方がずっと多いものです。常に自分の頭でよく考え、ねばり強くとり組んでみてください。あるときそこから小さな、しかしわくわくさせるような輝きが見えるときが来ます。研究はそういう非常に個人的体験である一方で、他の研究者との関わりのなかで自分の活動と存在を形にしてゆく社会的な面があります。国内、海外の学会で自分の研究成果を発表する機会も多くあります。これも自分の世界がひろがるエキサイティングな体験になるはずです。そしてそれらは、皆さんが将来社会で活躍できる大きな糧になります。

若林研究室

シリコン・トランジスタ技術を基礎
とした低電力・高性能な
知的システムデバイスの先行研究

すずかけ台・デバイスグループ
電気電子コース
すずかけ台G2棟1002号室

教授 若林 整

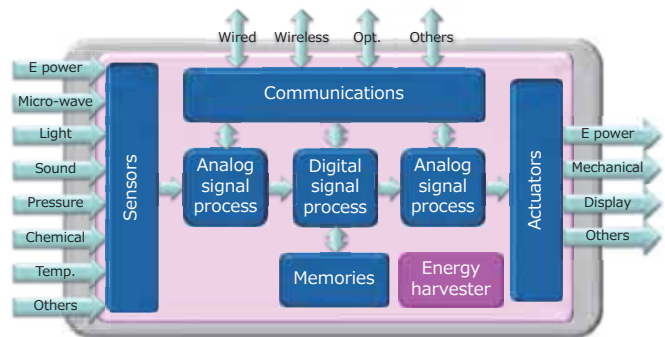
研究分野：電子デバイス

キーワード：Advanced 3D MISFET (Silicon),
2D FET (MoS₂, WS₂, HfS₂, Black Phosphorous, etc.)

ホームページ：<http://search.star.titech.ac.jp>

1 背景および主な研究テーマ

皆さんの生活に溶け込んだ電子機器に用いられているシリコン・トランジスタからなる集積回路(Integrated Circuits: IC)は、Moore's lawの通りScaling conceptに支えられてLSI (Large Scale Integration)からVLSI (Very LSI), ULSI (Ultra LSI)へと進化しています。さらにSmartphone等に搭載されている様に、高周波通信素子や撮像素子(Image sensor), Motion sensor等のインターフェースを機能モジュールとして混載するMore than Moore領域へ応用範囲が急速に拡大しています。当研究室では、シリコン・トランジスタ技術[10-18]を基礎として、アプリケーションを意識した高集積・低消費電力・高性能を目指した知的システムデバイスの先行研究を行っています。

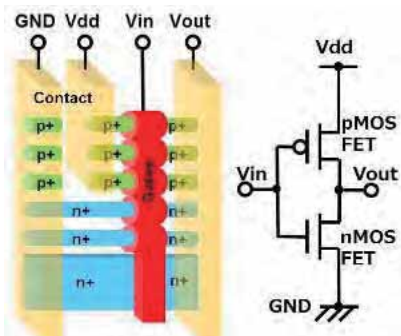


図：知的システムデバイスの信号処理フローと発電システムのブロック図。

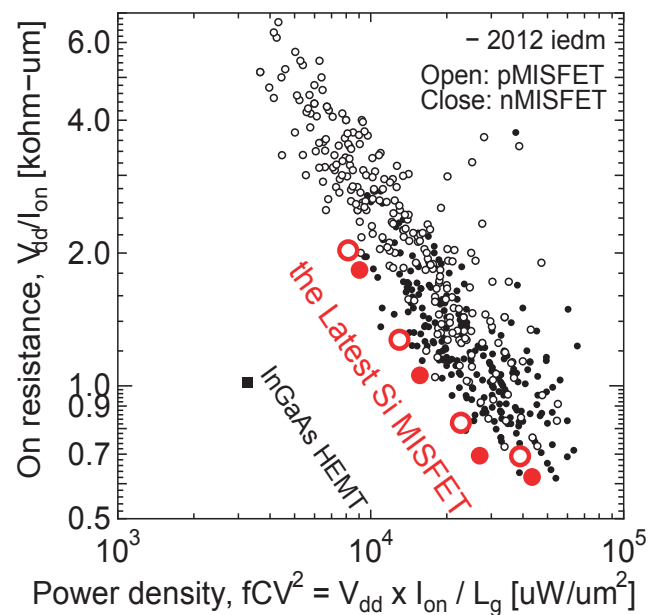
2 最近の研究成果

■ LSI用高度3D高集積化MISFET技術先行研究

現在でも世界最小のトランジスタの部類にあるゲート電極長が5 nmのシリコンCMOS [15-17]を含む様々な高性能CMOSデバイス動作を実証した経験に基づに、さらなる高集積化・低消費電力化[18]・高性能化に加え、多機能化を目指した先行研究を行います[1,3,6,8]。例えば右図Benchmark等も用いて研究の意義を明確にしながらデバイス・シミュレーション等を駆使して、効率的にデバイス動作を実証して行きます。特に、高度に3次元高集積化した構造を持つMISFETの性能向上を実現する技術について、公開論文や独自の技術開発だけでなく特許情報等も活用して研究を推進します。



図：高度3次元高集積化シリコンMISFETの例。

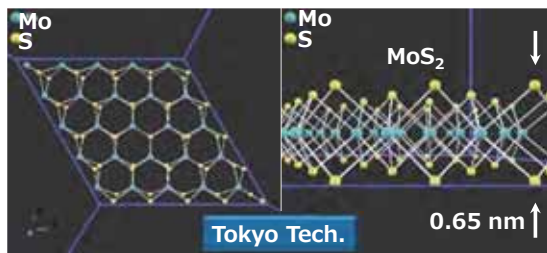


図：シリコンMISFETの性能推移。駆動時抵抗の駆動時消費電力面密度依存性。駆動エネルギー効率を向上させるには左下の方向へ研究を進める必要がある。

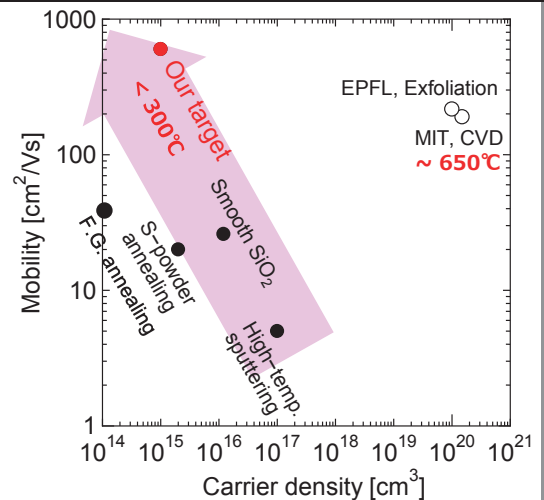
すずかけ台・デバイスグループ

■ 2D FETの応用に関する先行研究

バンドギャップが0 eVであるグラフェンに代わる原子層状半導体である遷移金属ダイカルコゲナイド(MoS_2 , WS_2 , HfS_2 等)を用いた電子デバイスの研究を行っています[2,4,5,7,9]。新材料による新たなデバイス物理を実証・構築し、LSIやディスプレイなどへ応用することを目指して、研究を拡大・加速します。



図：2D層状半導体の例。

図：スパッタ多結晶 MoS_2 膜高品質化。

■ 参考文献

1. 若林整、「SoC向け先端デバイスの研究開発動向」、SEMICON Japan 2015, 2015/12/18, Invited.
2. H. Wakabayashi, "Advanced CMOS Device Technologies Discussed Also with Transition-Metal Di-Chalcogenide (TMDC) Channel," 228th ECS meeting 2015, MA2015-02 1098, Invited.
3. 若林整、「先端Si-LSIデバイスの現状と今後の展望」、(公社)精密工学会『プランリゼーションCMPとその応用技術専門委員会』第142回研究会, Invited.
4. T. Ohashi, H. Wakabayashi, et.al. "Multi-layered MoS_2 film formed by high-temperature sputtering for enhancement-mode nMOSFETs," 2015 JJAP, 54 04DN08, doi:10.7567/JJAP.54.04DN08.
5. H. Wakabayashi, "Two dimensional material device technologies," IEEE, EDS, WIMNACT45, Feb.2015, Invited.
6. H. Wakabayashi, "Advanced Scaling and Wiring Technology," Tutorials, ADMETAplus2014, Invited.
7. T. Ohashi, H. Wakabayashi, et. al., "Multi-Layered MoS_2 Thin Film Formed by High-Temperature Sputtering for Enhancement-Mode nMOSFETs," SSDM 2014, pp. 1074-1075.
8. H. Wakabayashi, "Progress&Benchmarking of CMOS-Device Technologies," ICEP2014, FA2-1, Invited.
9. H. Wakabayashi, "Progress and prospects of silicon transistors based on junction technologies," IWJT 2013, pp. 98-103, Invited.
10. 若林整：「V.19.3.1: 論理素子」、「化学便覧応用化学編第7版」、招待寄稿, 2013.
11. 若林整：「シリコントランジスタのあゆみと将来」、総合報告(招待解説論文), 応用物理, 82巻、4号、292頁、2013.
12. H. Wakabayashi, "More-than-Moore Devices based on Advanced CMOS Technologies" (Keynote Address), 2012 AWAD, June 2012, Invited.
13. H. Wakabayashi, "CMOS-Device Technology Benchmarks for Low-Power Logic LSIs", G-COE PICE Int'l Symp. and IEEE EDS Mini-Colloquium on Advanced Hybrid Nano Devices: Prospects by World's Leading Scientists, October 2011, Invited.
14. H. Wakabayashi, "SONY's outstanding work involving HK-MG on Silicon," 7th International Symposium on Advanced Gate Stack Technology, SEMATECH, 2010, Invited.
15. H. Wakabayashi, et al., "Characteristics and Modeling of Sub-10-nm Planar Bulk CMOS Devices Fabricated by Lateral Source/Drain Junction Control," IEEE T-ED, Vol. 53, Issue 9, 2006, pp. 1961-1970, Invited.
16. 朝日新聞朝刊一面Top「トランジスタ最小化に成功」外、「Sub-10-nm CMOSデバイス」、2003年12月8,9日.
17. 「電子ビームリソグラフィーで作られた世界最小5 nmトランジスタ」、集英社イミダス2006, p. 859.
18. H. Wakabayashi, D.A. Antoniadis, et. al., "Supply-Voltage Optimization for Below-70-nm Technology-Node MOSFETs," IEEE T-SM, Vol.15, No.2, 2002, p. 151-156, Invited.

3 教員からのメッセージ

日々指数関数的に増える情報資源を自然に活用する人に優しく豊かな社会の実現に向けて、集積回路技術への期待が高まっています。その一助となることを目指して、実用研究と将来を見据えた探索研究について領域を柔軟に設定して研究を進めます。他方、筒井研究室及び角嶋研究室と強く連携して研究を進めます。すずかけ台の明るく清々しい環境での自由闊達な活動を好む学部/修士/博士学生および研究員を募集しています！共同/委託研究も広く募集していますので、お気軽に御連絡下さい！ (wakabayashi.h.ab@m.titech.ac.jp, 226-8502 横浜市緑区長津田町4259-G2-22, G2棟10階1003号室、Tel/Fax: 045-924-5594)

渡辺研究室

ヘテロ・ナノ結晶の創製と
量子ナノ構造光・電子機能デバイス

デバイスグループ
電気電子コース
すずかけ台・J2棟1102号室

准教授 渡辺 正裕

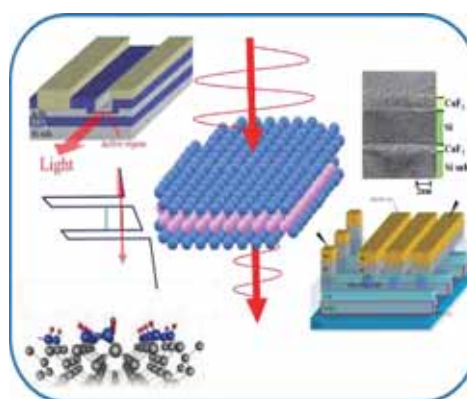
研究分野: 光・電子機能デバイス、量子効果デバイス、ヘテロ結晶成長
ナノプロセス工学、ナノ構造の光・電子機能

キーワード: ナノ構造、ヘテロ接合、量子効果、集積回路、二次元薄膜、機能設計学、
金属/絶縁体ヘテロ接合、シリコン光・電子集積

ホームページ: <http://www.pe.titech.ac.jp/watanabelab/>

1 研究目的

革新的機能創出を志向する、新しい集積デバイスのコンセプト提案と設計論の構築、その実験的検証を主軸として研究教育活動を進めています。金属・絶縁体・半導体など、性質が異なる複数の材料を接合したナノメートル厚の二次元積層薄膜、あるいは微結晶を形成する技術を創り出すとともに、その新しく創り出された人工結晶(≡ヘテロ・ナノ結晶)の中で生じる光及び電子の相互作用を支配する量子物性を利用して、高度な情報処理やエネルギー変換の極限機能を引き出す固体デバイス設計論の構築及び原理実証を行います。これらの研究活動を通じて、未来社会を支えるエレクトロニクス・システム構築へ向けたデバイス設計学理の構築と基盤技術の開拓に資するとともに、多様な人々と協力して問題解決を主導するリーダーの育成に貢献します。

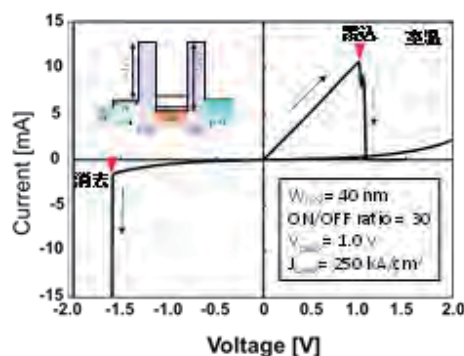


2 研究テーマ

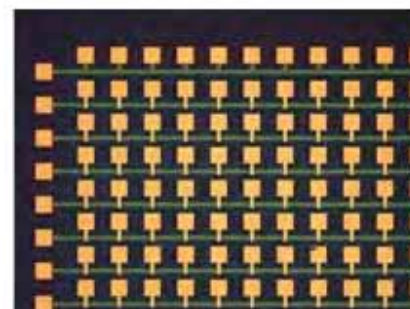
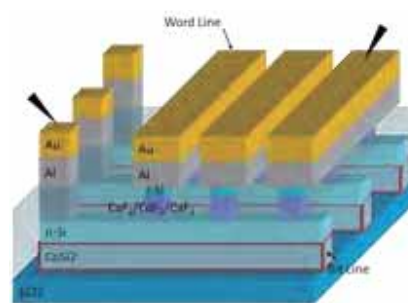
■ 超高集積・高速メモリ・スイッチングデバイス

本研究で提案する人工結晶を用いた共鳴トンネル素子は、異種材料の組み合わせと、ナノサイズの構造に特有の強い量子閉じ込め効果によって、室温においても顕著な電流スイッチング特性を示すことが本研究室よりはじめて見いだされました。この共鳴トンネル構造に、量子井戸への電荷蓄積/放出現象を適切に組み合わせると、電源を切っても記憶が消えない不揮発型メモリ素子可以实现できます。この素子は、極限的な低消費電力性と、微細化・集積化に適した原理的優位性を併せ持っており、将来の極限集積メモリや高速三端子素子実現への基本要素になると考えています。本研究テーマでは、集積回路に適合する異種

材料で構成された共鳴トンネル抵抗変化スイッチング素子を提案・作製し、特性の理論解析及び実験的な特性説明等を通して、未来の集積デバイス実現への基礎的課題を明らかにします。



室温でメモリサイクル動作を示す提案素子のI-V特性(実測)
(グラフ中左上の図は単体素子のバンドプロフィール)



クロスポイント型集積構造 (概略図: 上, 実際に作製した構造の顕微鏡写真: 下)

すずかけ台・デバイスグループ

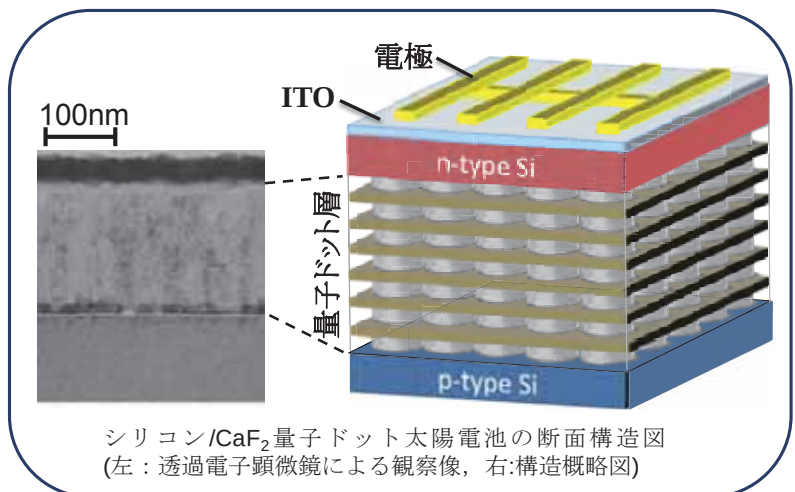
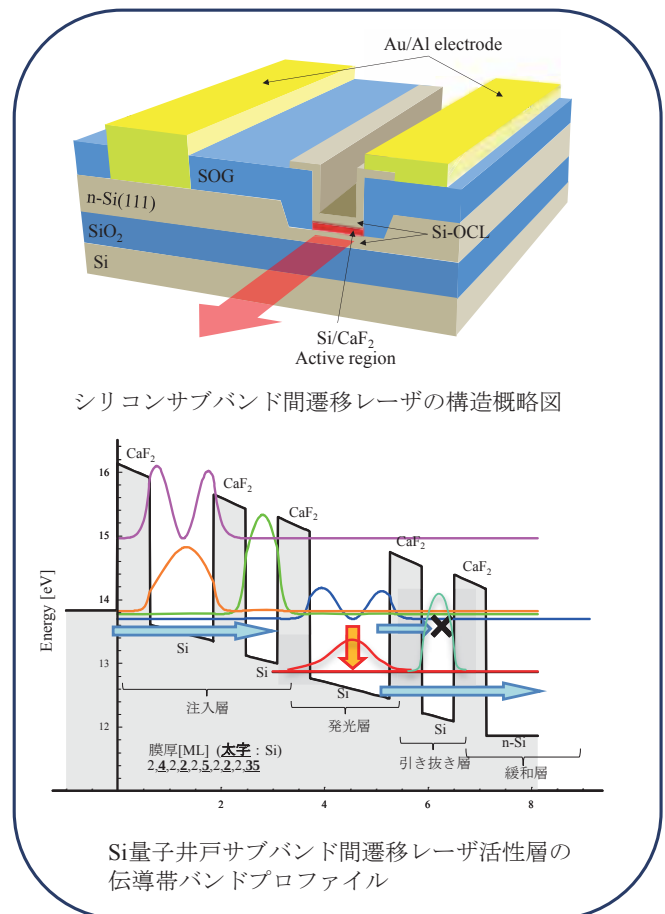
■ シリコン集積サブバンド間遷移レーザ

量子井戸中に形成されたエネルギー準位間の光遷移(ミサブバンド間遷移)の原理を利用すると、「光らない」半導体の代表格であるシリコンにおいても発光遷移が期待でき、しかもバンド内の電子・ホールへの応答速度は高速であるため、シリコンLSIと集積可能な高速応答レーザを実現できる可能性があります。本研究では、シリコンと積層結晶形成可能な異種材料群を組み合わせた量子井戸の構造設計により、可視～赤外をはじめとする広範な波長での発光遷移を設計可能な量子井戸構造を提案し、そのレーザ発振の可能性に関する理論予測や、結晶成長・素子形成技術に関する研究を行っています。近年、電流注入と、光導波路を両立できる素子構造を形成する技術の開発に成功したことから、シリコン量子薄膜の電流注入発光特性の解明へと研究の段階は着実に進展しています。

■ 量子ドット太陽電池

量子ドット構造は、量子閉じ込めによる禁制帯幅制御や、フォノン散乱制御など、太陽電池の変換効率を根本的に増大させる可能性のある基本原理を内蔵しています。

このミクロな視点に基づく基本原理を、実用的な太陽電池の変換効率向上につなげるためには、材料や結晶構造、ナノ構造の設計などを個別に検討することに加え、変換効率を最大化するためのデバイス構造や形成プロセスを見出す研究が必要とされています。本研究では、単結晶で構成可能なシリコン量子ドット超格子を用いて、変換効率増大に資すると期待される現象の原理実証、および、高効率なセル構造の提案や素子構造形成技術等に関する研究を行います。



3 教員からのメッセージ

人々の夢や社会の要請が科学技術、中でもエレクトロニクスの方で現実になっていく様を私たちは目の当たりにしてきました。まさに、これからが本番です！新らしい機能を設計し、形あるものとして実現することに興味のある方はぜひいらっしゃってください。根本原理から自然現象を理解し、その知識を使って、目的の電子機能を、もろもろの制約条件を克服しつつ、現実の物質を駆使して構成的に組み立てていく方法論は、デバイス工学の醍醐味です。一緒に学び、チャレンジしましょう。

岩本・間中研究室

有機半導体を用いた各種デバイス
(トランジスタ、EL、太陽電池)、
単分子膜、新規計測技術

材料・物性グループ
電気電子コース
大岡山・S3-719/ S3-715

教授 岩本 光正 准教授 間中 孝彰 助教 田口 大

研究分野: 有機エレクトロニクス、誘電体物性

・キーワード: 有機トランジスタ、有機EL、有機太陽電池、LB膜、キラリ
ティ、新規計測技術

ホームページ: <http://www.pe.titech.ac.jp/lwamotoLab/>

1 主な研究テーマ

現在、有機材料のもつ「柔らかい・軽い」といった性質を背景として、ユビキタス社会を支える新規な有機デバイスに関する研究が世界中で行われています。絶縁体というイメージが強い有機物ですが、ホール・電子輸送性材料や電極材料などが実用化されており、半導体や電気伝導体としての機能を持っていることも事実です。とはいえ、有機物の基本は誘電性であり、この誘電性を軸に多くの現象を捉えることが、有機材料の本質を活かしたデバイス設計には重要であると考えています。

岩本・間中研究室では、誘電体の持つ重要な性質である「分極」と「電気伝導」というコンセプトを柱に、誘電体工学の立場から有機材料の電子物性の基礎と応用、すなわち有機エレクトロニクスに関する研究を展開しています。



2 最近の研究成果

■SHG分光法による有機デバイスの特性評価とそのモデル化

材料中を流れる電流(伝導電流)は、電荷(電子やホール)の流れですが、電荷は小さく直接観測することは不可能です。有機材料を用いたデバイスでは、動作機構が解明されていない点も多く、キャリアの流れを可視化することは、動作機構の解明や特性向上の鍵となります。我々は、光第2次高調波発生(SHG)が材料中の分極から発生することに着目し、この分極を可視化することでデバイス中の電荷を観測するという新しい手法を開発しました。有機材料は誘電体のように振舞うため、外部からの印加電界や注入されたキャリアによって分極されやすく、SHGは有機デバイス进行评估する技術として、非常に適していると言えます。右図は、実際にペンタセンFETにおいて観測されたキャリア挙動の様子です。ソース電極から注入されたキャリアがチャンネル中を拡がり、ドレイン電極に近づいていく様子が確認できます。このように、デバイス中における分極の伝播を通して、キャリアの動きを光学的手法によって可視化するシステムを世界で初めて実現しました。我々が開発した新規計測手法は、有機FETの動作に関して、電極依存性や絶縁膜依存性、トラップの影響など、様々な情報を得ることができ、動作機構解明やデバイス動作を最適化する上で非常に有効な手法として期待されています。また、有機FETの動作を記述するモデルとして、異なる誘電体の界面における電荷蓄積を表現するMaxwell-Wagner効果を

基礎とした動作機構を提案し、実際に有機FETの動作を再現することに成功しました。このような技術は有機FETにとどまらず、現在開発が行われている、有機EL、有機太陽電池といった有機デバイスへ応用が可能であり、現在そのようなデバイスの評価にも用いています。

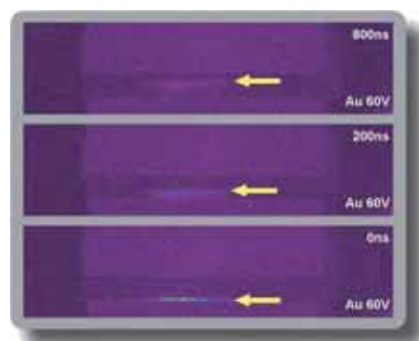


図1. 時間分解顕微SHG測定によって観測される、デバイス中におけるキャリアの流れ。

大岡山・材料・物性グループ

■ MDC-SHGスペクトロスコピーの開発

有機分子を用いて素子を作製する場合、素子特性は分子の向き(配向)に大きく依存します。そのため、分子の配向を制御する技術とともに、その「配向を評価する技術」も重要となります。我々は、分子の配向を表す指標として配向オーダーパラメータに着目して、分子膜のオーダーパラメータを、変位電流(MDC)と光第2次高調波(SHG)測定から決定するという研究を進めています。

界面に置かれた分子は方向をそろえて並ぶため、単分子膜は非対称な構造となります。その結果として、界面膜は自発分極を持ち、またレーザー光照射下において、構造の非

対称性に由来する非線形分極が誘起されます。MDC-SHG法は、このような単分子膜レベルにおける分極を検出し、界面の構造を評価を可能にするものです。この評価手法は、単純な棒状分子だけでなく、キラル分子やバナナ型分子などにも適用することができます。例えばバナナ型分子では、拡張過程における特徴的な変位電流、表面圧波形が得られ、ピエゾ効果、フレクソエレクトリック効果の観点からの理論解析により説明できています。ここで得られた分極計測に基づく知見は、以降の分極の観測や制御する技術を開発する上での基本となっています。

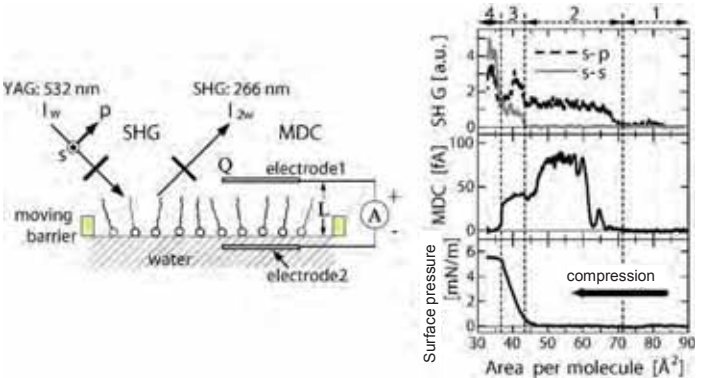


図2. SHG-MDC システムと MDC-SHG特性

■ 単分子膜の量子形状評価と量子形状効果素子の検討

有機材料の特徴は柔軟性にあります。このような柔軟性を反映して、水面上に展開された単分子膜では、膜の圧縮に伴って様々な形状をもつ分子膜ドメインが成長します。このようなドメインは、通常の顕微鏡では観察することはできませんが、ブリュースター角顕微鏡(BAM)という特殊な顕微鏡を用いることで観測することができます。実際に研究室で構築したBAM-MDC評価装置により観測を行うと、膜の圧縮に伴って、ドメイン形状が円形→双葉→三つ葉型へと離散的に変化するという結果を得ることができました。ドメインパターンには、分子自身の性質も強く反映されることが明らかになってきています。たとえば、キラルな性質の分子では、図3に示すようなドメインにおいて、「巻き」の方向がある特定方向に決まります。また、ラセミ体(左右キラル分子の等量混合物)においては、ドメインごとに左右のキラル分子が自発的に分離し、逆の「巻き」を持ったドメインが均等に成長することもわかりました。このような離散的(量子的)なドメイン形成は、外部刺激によってドメイン形状を制御できることを意味しており、純粋な科学的な興味に留まらず工学的な応用も期待されています。我々は、キラル構造から発する電気・光、電気・電気変換は21世紀の有機エレクトロニクスの鍵であると確信しています。

現在、これまで誰も観測したことがない、ドメイン内部の分極構造を可視化するシステムを構築中であり、これにより分極構造の重要性が実験的にも確かめられると考えています。

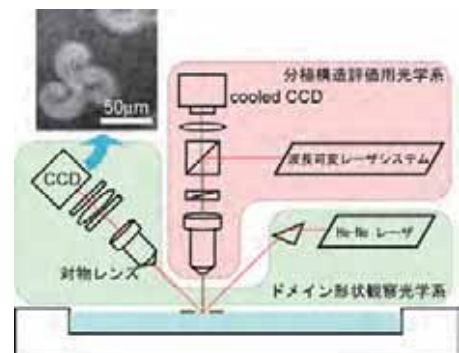


図3. BAM-MDC システムと観測される水面上単分子膜におけるドメイン構造

3 教員からのメッセージ

「世界で初めての課題を見つけこれに挑戦する。」これが研究の方針です。誘電体物性の考え方を基礎にこれを実践しています。そうすると、トランジスタや太陽電池、液晶、絶縁体、…と呼ばれるものがどのように見えてくるでしょうか。上に掲げているテーマはこうして追求して得た世界初の結果ばかりです。ここには新しいエレクトロニクスの飛躍の鍵が隠されています。その扉を開くのは、君たちです。そして挑戦する君を大きく育つよう手助けするのが我々の研究室です。

スピントロニクスと磁性応用素子

中川研究室



材料・物性グループ
電気電子コース
大岡山・S3-709

教授 中川 茂樹 助教 高村 陽太

研究分野: スピントロニクス, 磁性デバイス, 磁気記録・記憶

キーワード: スピントロニクス, 大容量垂直磁気記録

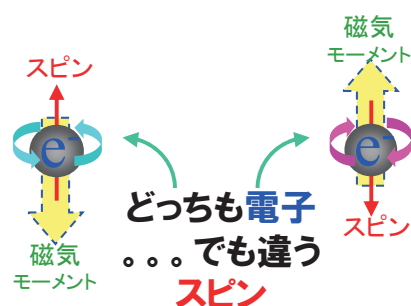
磁気抵抗ランダムアクセスメモリ

ホームページ: <http://www.spin.pe.titech.ac.jp/index-j.html>

1 主な研究テーマ

当研究室では「電子スピンに着目した次世代材料・デバイスの開発」を目的に、伝統的な永久磁石材料から、最新のスピントロニクス材料・デバイスまで幅広い分野の研究を行っています。

電子スピンは磁気モーメントと密接な関係を持っていますから、スピンの制御は物質の磁化の制御を行うことを意味します。ナノメータサイズの薄膜や人工構造を作製することにより、既存の材料に垂直磁気異方性などの新たな機能を付加することで、磁気抵抗メモリ等の不揮発性低消費電力デバイスを実現することができます。



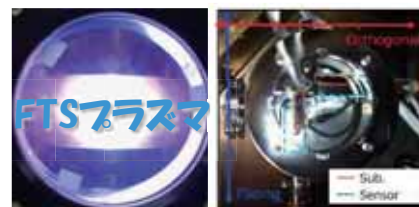
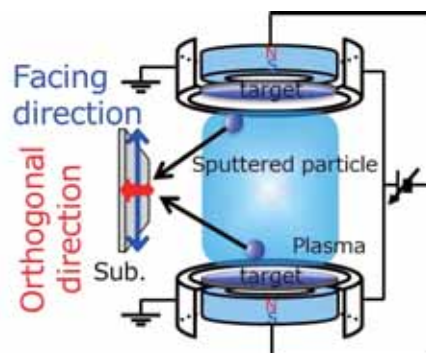
2 最近の研究成果

■ 薄膜作製技術

スパッタリングはターゲット物質に加速したイオンや原子を照射すると、ターゲット表面の原子が運動量交換を経て飛び出してくる現象です。この現象は熱蒸発とは異なり、物質の昇華点の違いにあまり影響を受けません。また、飛び出してくる原子(スパッタ粒子)は数eV程度のエネルギーを持っていて、蒸発の熱エネルギー(0.1eV程度)よりも大きなエネルギーを持っています。このような特徴を利用して、スパッタ粒子を基板に堆積させれば、様々な機能的な薄膜を作製できます。

【対向ターゲット式スパッタ(FTS)法】

磁性薄膜を薄い領域でも高品質に作製する技術として対向ターゲット式スパッタ法を、本研究室のオリジナルな技術として開発してきました。これは2枚のターゲットを向かい合わせて同時に陰極として動作させ、ターゲット面に垂直に加えた磁場と2枚のターゲットの陰極降下部で高密度プラズマを閉じ込める方法です。これを利用して種々の磁性薄膜や機能性酸化物膜などを作製しています。



【高異方性磁界を有する磁性薄膜】

対向ターゲット式スパッタでは、条件を整えて成膜すると、薄膜内部に異方的な応力を形成することができます。内部に応力があると、逆磁歪効果によって、大きな異方性磁界を有する薄膜が実現できています。この現象を利用して、従来の10倍以上の高い異方性磁界をもつCoFeB薄膜を実現しました。この値は共鳴周波数換算で、10GHzに相当する大変大きなものです。

【超高感度応力観測システムの開発】

応力形成が機能的な薄膜の形成に重要であることがわかりましたので、これをさらに推し進め、薄膜の厚みが数原子層の非常に薄い領域の内部応力を、スパッタ成膜中にリアルタイムで観測できるシステムを開発しました。現在、このシステムを用いて、薄膜の成長初期過程の解析を行っています。

55

PHAM研究室

電子スピンを用いた次世代エレクトロニクスの材料とデバイスの研究開発



大岡山・材料・物性グループ

PHAM研究室
准教授 PHAM NAM HAI

研究分野: 半導体スピントロニクス

キーワード: 強磁性半導体、スピントランジスタ、単電子スピントランジスタ

ホームページ: <http://magn.pe.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

半導体と強磁性体は情報化社会を支える材料としてそれぞれ大きな役割を果たしています。半導体は集積回路や光通信素子などの様々なデバイスに応用されている。これらの半導体デバイスにおいては機能が高速な電子の電荷によって支えられているため、動作が大変高速である。一方、強磁性体はハードディスクなどの情報記録媒体に広く利用されており、これらの磁性体デバイスには電子のスピンの持つ「不揮発性」という特徴が生かされている。もし半導体と磁性体の特徴を融合することができれば、磁性体の不揮発性を持ち併せたようなエネルギー使用効率が極めて高い半導体デバイスが実現できると期待される。当研究室では、強磁性体と半導体の長を両方持ち合わせる新しい材料の創製およびそれを利用する新しいデバイス構造の提案と実証を行う。例えば以下のよう研究テーマを遂行している。



- ✓ 新型強磁性半導体の創製とそのスピン依存伝導特性の評価
- ✓ 半導体: 強磁性ナノ微粒子のグラニュー構造の作製とそのスピン依存伝導特性の評価
- ✓ n型強磁性半導体 / p型強磁性半導体のスピンドायオードの作製とスピン依存伝導特性の評価
- ✓ 強磁性半導体を用いたバイポーラスピントランジスタ、電界効果スピンとランジスタの作製と評価
- ✓ 単電子スピントランジスタの作製と評価

2 最近の研究成果

次世代強磁性半導体: Fe系強磁性半導体の創製

当研究室では、従来の強磁性半導体の問題点を全て解決できる次世代強磁性半導体、Fe系強磁性半導体の研究開発を行っている。Fe強磁性半導体はMn系強磁性半導体よりも、次の点で優れている。

- ◆ p型だけではなくn型強磁性半導体も作製できる
- ◆ 室温で動作可能な強磁性半導体を作製できる
- ◆ バンド構造と強磁性の発生メカニズムの解明が容易である

当研究室は世界で初めてn型電子誘起強磁性半導体(In,Fe)Asの開発に成功した。当時はn型電子誘起強磁性半導体は実現不可能だと言われたため、この開発の意義が大きい。n型強磁性半導体ができただけで、初めて強磁性p-n接合など、強磁性半導体デバイスが作製できるようになった。

[参考文献: Appl. Phys. Lett. 101, 182403 (2012)]

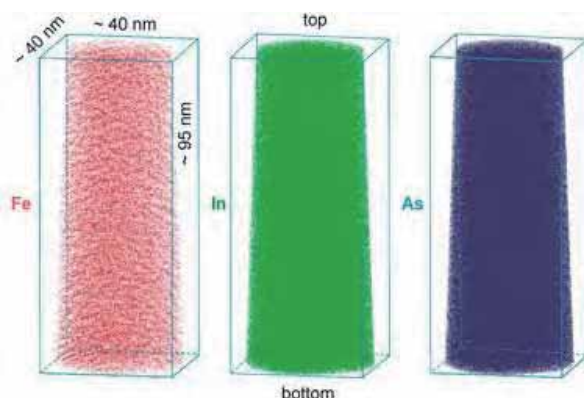


図1. 開発した(In,Fe)As結晶の原子分布。

GaAs:MnAs強磁性ナノ微粒子の作製とスピン依存電気伝導特性の評価

GaAs半導体中にMnを添付して、高温で(580°C)で熱処理することによって、半導体結晶中に六方晶のMnAsナノ微粒子を形成できる。当研究室はこのGaAs:MnAs強磁性ナノ微粒子を含むヘテロ構造の作製、そのスピン依存電気伝導特性の評価およびデバイス応用の研究開発を行っている。具体的には、GaAs:MnAsナノ微粒子 / AlAs / MnAs強磁性薄膜からなる半導体ベースの磁気トンネル接合を作製したところ、明瞭なトンネル磁気抵抗効果 (TMR)を観測した。この成果により、半導体中に埋め込まれたMnAsナノ微粒子はスピン注入源・検出器として利用できることを実証した。

[参考文献: Appl. Phys. Lett. 89, 021104 (2006)]

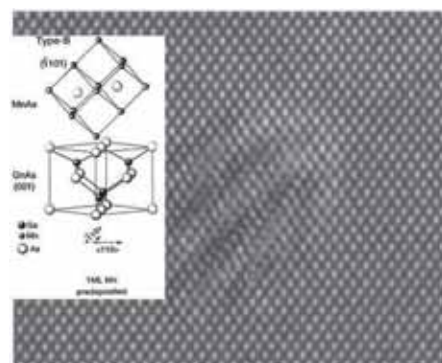


図2. GaAs半導体とMnAsナノ微粒子の結晶方位の関係。

大岡山・材料・物性グループ

単電子スピントランジスタの作製と評価

MnAsナノ微粒子のサイズがナノレベルと小さいことから、様々な量子サイズ効果が出現している。たとえば、同じ微粒子に2個の電子を閉じ込めると、2個の電子の間にクーロン反発力が発生するため、静電エネルギーが余計にU分だけ高くなる。従って、先に1個の電子を微粒子に注入しておいた場合、バイアス電圧が $\sim U/e$ と比べて十分小さければ、2個目の電子が微粒子にトンネルできない「クーロンブロック」(Coulomb Blockade)現象が発生する。つまり、同じ微粒子に2個以上の電子が存在できない。従って、微粒子をチャンネルとするトランジスタを作製できれば、電子1個ずつ伝導させる「単電子トランジスタ」を作製できる。当研究室では、さらに強磁性の特長を生かして、トンネル電流の大きさを強磁性微粒子の磁化の向きで変化させられる「単電子スピントランジスタ」(Single Electron Spin Transistor; SEST)を提案、作製および評価を行っている。図3に実際に作製したSESTの走査型電子顕微鏡による平面像を示す。

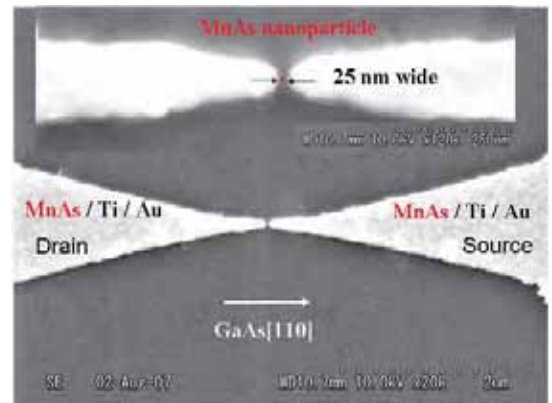


図3. 作製したSESTの走査型電子顕微鏡による平面像

このように、本研究室では、ナノプロセス技術を駆使し、ナノレベルのSESTが作製できる。さらに、SEST素子において、単電子効果に起因する微分電流電圧特性のクーロン階段およびTMRの振動現象を観測した(図4)。また理論との比較から微粒子中の電子スピンの緩和時間を割り出した。その結果、MnAs微粒子が低温において10 μ sと極めて長いスピン緩和時間(現時点では世界記録)を持つことを見出した。[参考文献:Nature Nanotech. 5, 593-596 (2010)]

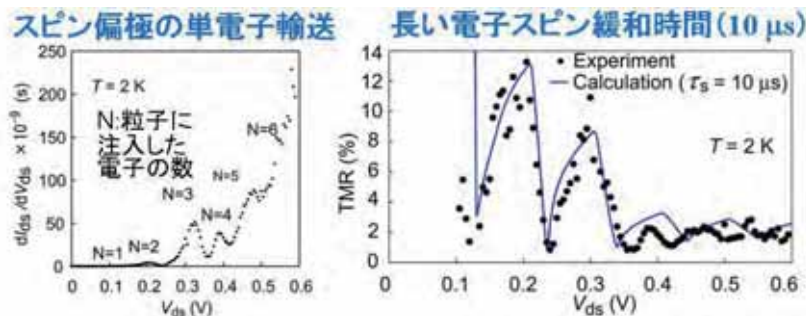


図4. SESTにおける微分電流電圧特性のクーロン階段(左)およびTMRの振動現象(右)の観測。TMR振動の実験を理論でフィッティングした結果、10 μ sと強磁性金属ナノ微粒子において世界最長のスピン緩和時間を実現した。

強磁性ナノ微粒子による巨大磁気抵抗効果およびスピン起電力の発生

MnドーピングしたGaAsの熱処理温度を約480°Cに減らせば、閃亜鉛鉱型構造のMnAs微粒子(サイズが2nm以下)が作製できる。この微粒子を含むMTJ構造において巨大な磁気抵抗効果およびスピン起電力を観測した[Nature 458, 489 (2009)]。スピン起電力とは磁化反転によって生じた起電力のことで、磁気エネルギーを電気エネルギーに直接変換する現象であるため、静磁場下でも起こりうる。この現象は最近にMITのグループによって再現されている[Nature Communication 5, 3682 (2014)]。今後にさらなる実験および理論的な発展が期待できる。

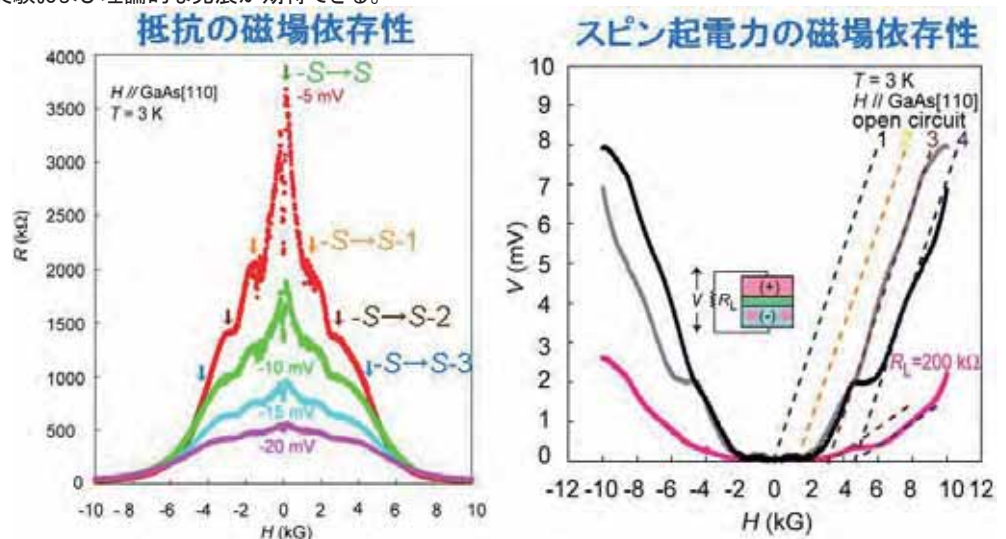


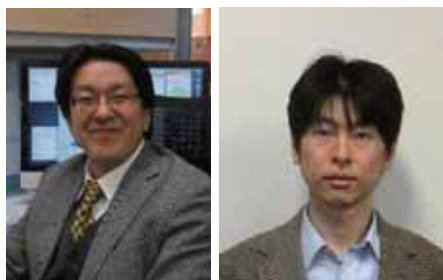
図5.閃亜鉛鉱型MnAsナノ微粒子を含むMTJにおける巨大磁気抵抗効果(左)およびスピン起電力の発生(右)。Nature 458, 489 (2009)から出典。

3 教員からのメッセージ

当研究室では、上記の研究テーマ以外に未公開の先端的な研究課題は多数あります。PHAM研究室では若い学生の想像力が最大限に活用でき、未踏の研究にチャレンジできます。

山田・宮島研究室

様々な半導体材料の太陽電池応用



材料・物性グループ
エネルギーコース・電気電子コース
大岡山・EEI-409/ EEI-408

教授 山田明 准教授 宮島晋介

研究分野: 半導体物性、太陽電池、
キーワード: 薄膜太陽電池、結晶Si太陽電池、酸化物材料
有機無機ハイブリッド材料

ホームページ: <http://solid.pe.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

クリーンなエネルギー源として太陽光発電に寄せられる期待が高まっています。日本では、2013年度末でおよそ1430万kW程度の太陽光発電システムが導入され、2014年には第3四半期までで約600万kW分のモジュールが国内向けに出荷されたと報告されています。しかし、いっそうの加速度的普及を目指すには、さらなる低コスト化、高効率化が必要となります。本研究室では、第1世代のシリコン太陽電池に加えて、第2世代の高効率化合物薄膜太陽電池、さらには有機無機ハイブリッド材料を用いた太陽電池の開発を進めています。また、デバイス研究と共に材料物性に関する研究も進めています。

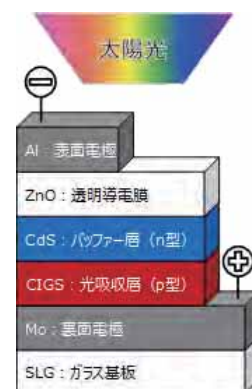
1. 高効率カルコパイライト化合物薄膜太陽電池 (CIGS, AIGS)
2. レアメタルフリー化合物薄膜太陽電池 (CZTSSe)
3. シリコン系太陽電池 (ヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池)
4. 新材料太陽電池 (有機無機ハイブリッドペロブスカイト、銅酸化物)

2 最近の研究成果

◆ 高効率カルコパイライト化合物薄膜太陽電池 (CIGS, AIGS)

Cu(In,Ga)Se_2 (CIGS)はカルコパイライト構造を有する半導体材料です。この材料のバンドギャップはIn/Ga比を変化させることで1.0 eVから1.4 eVの範囲で制御可能です。現在は太陽光と相性の良い1.4 eV程度のバンドギャップを有するCIGS太陽電池の高効率化に取り組んでいます。これまでに新たなデバイス構造を提案し、世界最高レベルの変換効率を実現しています。

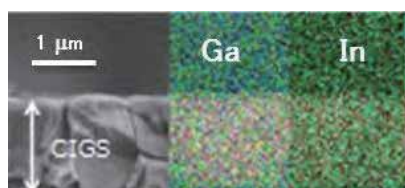
また、変換効率30%を超えるような超高効率太陽電池を目指して、多接合型太陽電池の開発にも取り組んでいます。この材料系を用いる場合、バンドギャップ1.0 eV程度のCIGSとバンドギャップ1.8 eV程度の Ag(In,Ga)Se_2 (AIGS)の組み合わせが、最適なバンドギャップの組み合わせに極めて近いことがわかっています。まだ未知の部分が多いAIGS膜の電気的特性を徐々に明らかにしつつ、デバイスにおいてもこの材料系ではトップクラスの10%を超える値を実現しています。



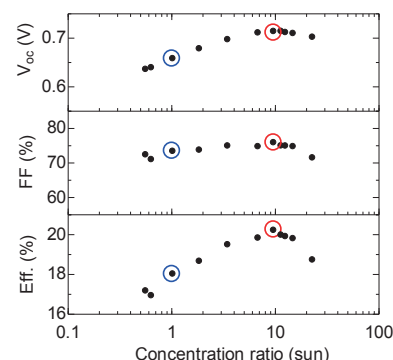
CIGS太陽電池



CIGS製膜用MBE装置



CIGS薄膜の断面電子顕微鏡像とEDSによる組成分布解析

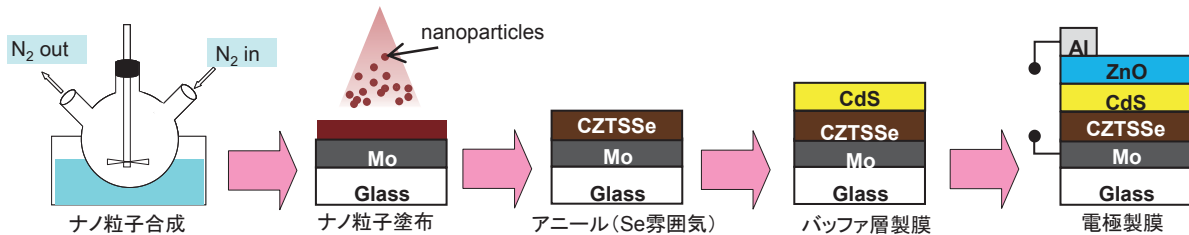


高効率CIGS太陽電池の集光特性

大岡山・材料・物性グループ

◆ レアメタルフリー化合物薄膜太陽電池 (CZTSSe)

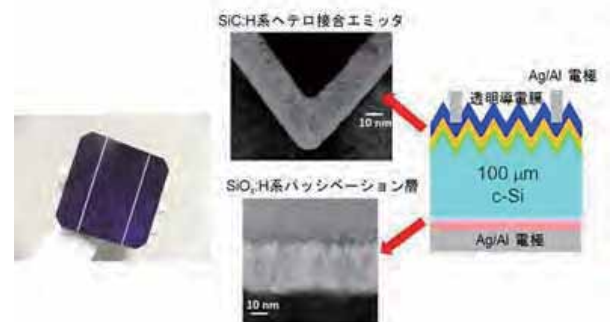
CuZnSn(S, Se)_4 (CZTSSe) はCIGSと類似の構造を有する化合物です。レアメタルであるInを使用しないという利点を有しています。本研究室では低コスト化を見据え、非真空プロセスでCZTSSe膜の作製を行い、太陽特性の向上を目指しています。効率10%超を目指して研究を進めています。また、CZTSSeへの表面処理は特性に大きな影響を与えるため、その最適化およびその特性向上メカニズムの解明を目指しています。

CZTSSe系膜作製用
超音波スプレー塗布装置

CZTSSe系太陽電池の作製プロセス (CZTS系膜は非真空製膜)

◆ ヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池

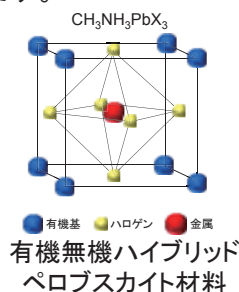
Siは無毒かつ地球上に豊富にある材料であるため、太陽電池材料の主流となっています。本研究室では主にヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池の高効率化を行い、20%を超える変換効率を実現しています。さらに、新しいヘテロ接合材料の開発に注力しており、良質なヘテロ接合を用いた結晶シリコンの評価にも取り組んでいます。また、多接合化による高効率化をめざし、有機無機ハイブリッド型太陽電池との積層構造についても検討を行っています。



結晶Siヘテロ接合太陽電池

◆ 新材料太陽電池 (有機無機ハイブリッドペロブスカイト、銅酸化物)

新しい太陽電池材料の開発にも取り組んでいます。近年、注目を集めている有機無機ハイブリッドペロブスカイト材料や銅酸化物(Cu_2O)を用いた太陽電池の開発を進めています。すでに、良質な特性を有するペロブスカイト膜および Cu_2O 膜の形成に成功しており、今後はデバイス開発及び、物性の詳細な研究を進める予定です。



ペロブスカイト膜作製装置

電気化学製膜した Cu_2O 膜の表面構造

3 教員からのメッセージ

山田・宮島研究室は、国内で実際に太陽電池を試作できる数少ない研究室の一つです。自分で考案した太陽電池を、自分の装置で試作、評価できます。太陽電池の製作、評価に必要な設備はすべて整っております。さらに、海外研究機関との連携を活発に行っています。ドイツ、オランダなどの欧州諸国のほか、タイ、韓国、中国、インド、インドネシア、マレーシアなどのアジア諸国とも連携を密にしています。

飯野研究室

大面積イメージングデバイスを目指した有機半導体材料・有機デバイスの研究



物性・材料グループ
電気電子コース
すずかけ台・J1棟207号室

准教授 飯野裕明

研究分野: 有機エレクトロニクス、イメージングデバイス

キーワード: 液晶性有機半導体、有機薄膜トランジスタ、有機EL素子、有機光電変換素子

ホームページ: <http://www.isl.titech.ac.jp/~iino>

1 研究目的

情報の入出力に用いられるイメージングデバイスの実現を目指して、大面積の半導体薄膜を簡易な製膜プロセスで作製可能な有機半導体材料の開発とデバイス応用の研究を行なっています。材料としては新しい有機半導体である『液晶性有機半導体』に注目しています。液晶性有機半導体の材料開発、物性・電気特性評価からプロセス開発、デバイス応用までを検討し、印刷プロセスを利用して、安価なプラスチック基板上にフレキシブルで軽量なディスプレイや発光素子、光電変換素子等のイメージングデバイスの開発に取り組みます。

本研究室では材料の開発から基礎物性の評価、デバイス応用までを研究グループ内で一貫して進めています。

2 主な研究テーマと最近の研究成果

■液晶性有機半導体材料の開発

液晶性有機半導体とは、液晶性を示す有機半導体のことです。液晶性とは液体のような流動性と結晶のように分子が自発的に並ぶ特徴を有します(図1)。液晶ディスプレイにはこの性質から導かれる光学的な特徴である複屈折が利用されています。一方、半導体の性質を持つ有機物質に液晶性を持たせた材料では分子が自発的に並ぶため、配向性と秩序性をもった高品質の有機半導体薄膜を容易に作製することができることになります。また、液晶性有機半導体は結晶薄膜としても利用可能です。この研究では有機トランジスタ、有機光センサ、有機EL素子、有機薄膜太陽電池等への応用を目指した新規材料の開発を行ないます。

■材料の基礎物性の評価

開発した液晶性有機半導体をデバイスに応用するためには図2のように材料の電荷輸送特性や電極との界面特性を電気的な測定を通じて明らかにする必要があります。また、材料開発を進める上でも合成した物質の基礎特性を調べることは、材料設計の指針を得る上でも重要となります。この研究では、移動度の評価や界面特性の評価ばかりでなく、その物理的理解を深めることを目指します。

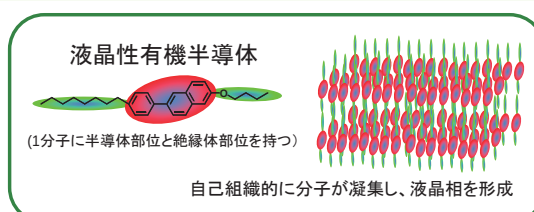


図1 代表的な液晶物質の分子構造と液晶相の凝集状態(スメクチック相)。自己組織的に分子が凝集し層構造の凝集構造を形成する。

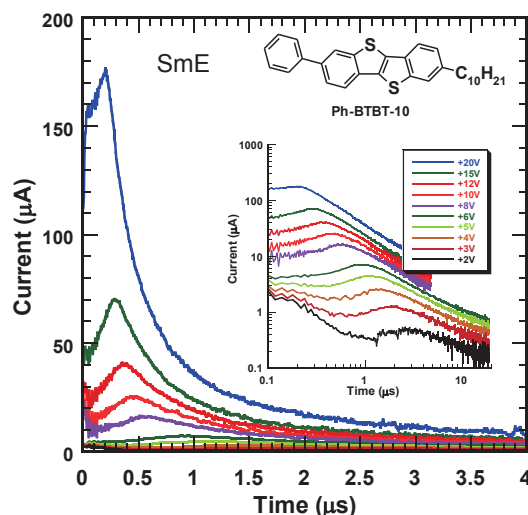


図2 Time-of-Flight法による液晶物質の移動度の評価例。Ph-BTBT-10は液晶物質の中で現在最も高い移動度を示す。
ITO/ITO, $d=15.84\mu\text{m}$, $S=16\text{mm}^2$, $\lambda=337\text{nm}$

すずかけ台・材料・物性グループ

■プロセス技術の開発

材料をデバイスへ応用するためには、材料の薄膜形成やパターニングが必要となります。液晶性有機半導体は容易に有機溶媒に溶かして溶液にすることができるため、種々の塗布技術やインクジェット法を含む種々の印刷法を適用することが可能となります。さらに、液晶物質は適度な流動性と分子配向した均一な液晶薄膜を結晶薄膜の前駆状態として利用することも可能で、分子レベルで均一な結晶性の高い多結晶薄膜を溶液プロセスであるスピコート法により作製する技術の開発に成功しています(図3)¹⁾。今後は、インクジェット法や印刷法を利用したプラスチック基板上への薄膜作製技術の確立を目指します。

■デバイス応用

液晶性有機半導体は、従来の非液晶性の有機半導体材料と同様、有機トランジスタ、有機EL素子、有機光センサ、太陽電池へなどの種々のデバイスへ応用することが可能です。最も、手短な応用は有機トランジスタです。液晶薄膜を前駆状態に用いた結晶薄膜は均一性、表面平坦性に優れ、素子ごとのばらつきの少ないトランジスタを容易に作製することができます。図4は、有機トランジスタ用に当研究グループで開発した液晶性有機半導体(Ph-BTBT-10)を用いて作製した、FET(電界効果トランジスタ)の伝達特性の一例です。多結晶薄膜にもかかわらず、ボトムゲート・ボトムコンタクト構造で移動度 $10\text{cm}^2/\text{Vs}$ を超すFETの作製に成功しています。現在、有機ダイオード、有機EL素子、有機光センサ、有機薄膜太陽電池等への応用にも取り組んでいます。

■参考文献

- 1) H. Iino and J. Hanna, "Availability of liquid crystallinity in solution process for polycrystalline thin films", *Advanced Materials*, **23**, 1748-1751 (2011).
- 2) H. Iino, T. Usui, and J. Hanna, "Liquid crystals for organic thin-film transistors", *Nature Communications*, **6**, 6828 (2015).

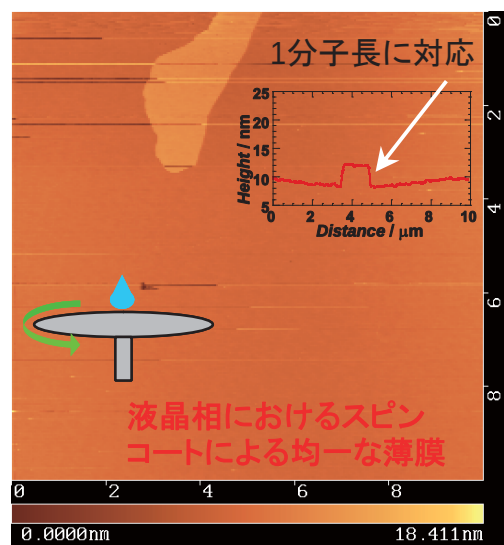


図3 溶液から液晶相を経由して作製した液晶性有機半導体の多結晶薄膜の例。表面形状を原子間力顕微鏡で観測すると分子長に対応するステップしか観測されず、非常に均一な膜であることがわかる。¹⁾

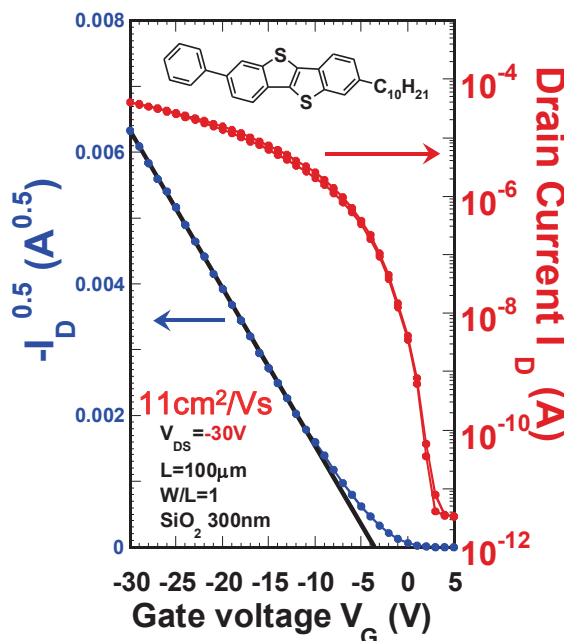


図4 液晶性有機半導体(Ph-BTBT-10)の多結晶薄膜を用いて作製した有機FETの伝達特性の例。簡易な溶液プロセスで作製した多結晶薄膜としては非常に高い移動度($>10\text{cm}^2/\text{Vs}$)を有するトランジスタが実現でき、画像表示デバイス用の薄膜トランジスタ(TFT)の材料として期待されている。²⁾

3

教員からのメッセージ

本研究室で研究している有機エレクトロニクスは物理、化学、電気の分野にまたがっており、様々な分野の研究者が力を合わせて研究を推進しています。様々な分野に挑戦したい皆さんの積極的な参加を期待しています。

岡本研究室

プラズモニクスを用いた高効率有機EL素子、高効率有機薄膜太陽電池、および、放射冷却フィルムの開発



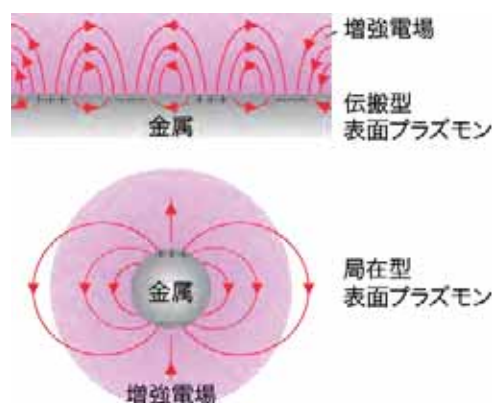
材料・物性グループ
ライフエンジニアリングコース・電気電子コース

特任教授 岡本 隆之

研究分野: ナノフォトニクス、プラズモニクス
キーワード: 光デバイス、有機EL素子、有機薄膜太陽電池、放射冷却

1 研究目的

金属が銀色をしているのはその反射率が可視域全域において高いからです。もちろん金属内部を光は伝搬しません。しかし、金属の表面に沿って光は伝搬します。この光は表面プラズモンと呼ばれており、金属中の自由電子の集団的な振動と強く結びついています。また、金属ナノ粒子中の自由電子の集団的振動は局在型表面プラズモンと呼ばれており、ナノ粒子の周囲には強い電磁場が局在しています。表面プラズモンをあつかった科学や工学は近年プラズモニクスという名前で呼ばれています。当研究室では金属表面にナノ構造を導入することで光を表面プラズモンとして蓄積したり、また、表面プラズモンから光としてエネルギーをとり出す技術を開発し、光電子デバイスへの応用を行います。



★当研究室は国立研究開発法人理化学研究所との連携の研究室であり、研究は主として埼玉県和光市にある理化学研究所で行ないます。

2 研究テーマ

■ 高効率有機EL素子の開発

有機EL素子は厚さが $1\mu\text{m}$ 以下のナノ構造なし極薄の発光デバイスであり、視野角依存性がなく、色表現の範囲が広いため液晶ディスプレイを置き換える可能性を持っています。しかし、一方で生じた光エネルギーの20%しか自由空間に取り出せていないため、エネルギー利用効率は良くありません。これは光エネルギーの大部分が金属陰極表面を伝搬する表面プラズモンに変換され、熱に変わるためです。私達は、金属表面にプラズモニック構造と呼ばれるナノ構造を導入することで表面プラズモンを効率良く光として取り出すことに取り組んでいます。

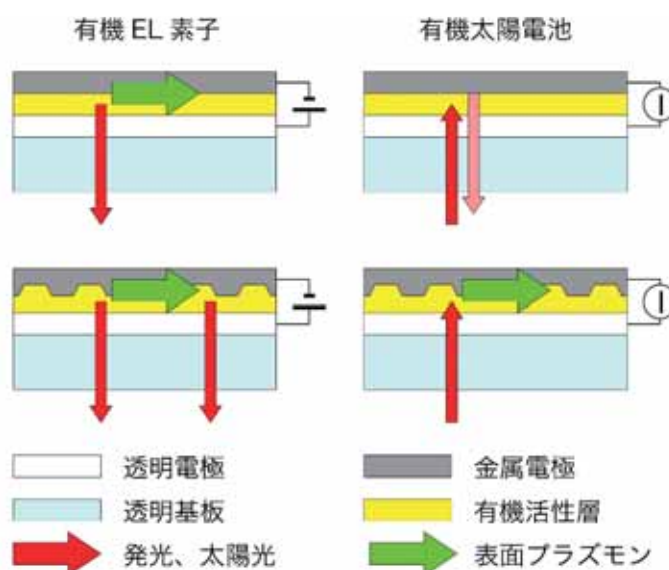


図1 有機EL素子と有機薄膜太陽電池に置ける表面プラズモンの働き

すずかけ台・材料・物性グループ

■ 高効率有機太陽電池の開発

有機太陽電池は安価に大面積の素子が簡単に作製できるという利点を持つので、次世代の太陽電池として期待されています。有機太陽電池はエネルギーの流れは有機EL素子とは逆ですが、その構造は基本的には同じです。相反則を考えると表面プラズモンを活用することで、有機太陽電池の高効率化が可能となります。有機太陽電池の活性層の厚さは数100nm以下であるため、入射光は十分吸収されずに反射され、効率の低下を招いています。私たちはプラズモニック構造を用いて活性層で吸収しきれなかった入射光を界面に沿って伝搬する表面プラズモンへ変換し、活性層での吸収を増強することで、変換効率の向上に取り組んでいます。

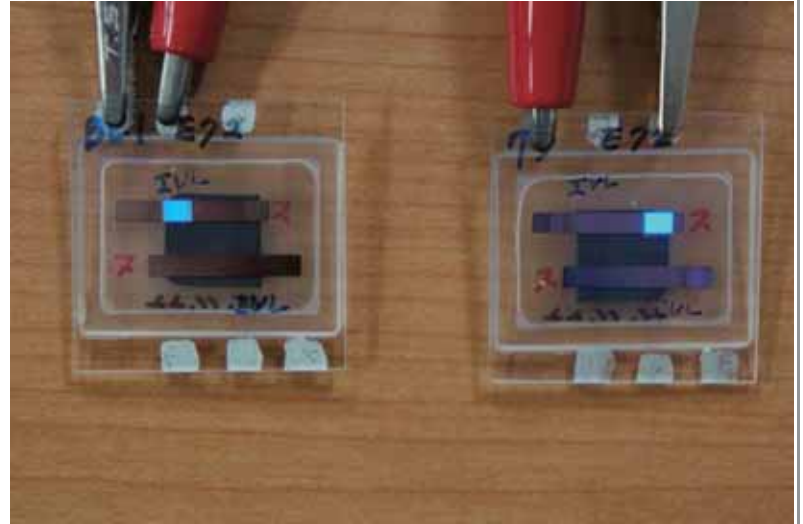


図2 作製した白色有機EL素子。左が従来の素子で右がプラズモニック構造を賦与した素子。両者は直列に接続されています

■ 放射冷却フィルムの開発

地球の大気は可視域の光を透過しますが、 $8\sim 13\mu\text{m}$ にも大気の窓と呼ばれる赤外線の透過領域があります。この波長域は地表の温度に対応する黒体放射の波長領域とも重なっています。また、宇宙の背景放射から、宇宙背景の温度は約3Kであることが知られています。そのため、太陽からの光を反射し、その一方で黒体放射により地表の熱を赤外光として宇宙背景へ捨てるようなフィルムを実現することにより、日中においても地表温度以下への冷却が可能です。冷却を高効率で行うためには、フィルムは太陽光波長領域で高い反射率を持つとともに、大気の窓領域の波長で高い放射率(キルヒホッフの法則により吸収率と等しい)を持つ必要があります。私たちはこのような光学特性を持つフィルムをプラズモニクスを用いて実現しようとしています。このようなフィルムが実現すると、エネルギー問題や地球温暖化問題の解決に大きく貢献すると考えています。

3 教員からのメッセージ

プラズモニクスという言葉ができてからまだ20年を経過していません。しかし、今では光でナノ、あるいはナノで光を扱うときに欠かすことの出来ない科学・技術になっています。また、プラズモニクスはそこから派生したメタマテリアルの母体ともなっています。粘土細工のように金属の幾何学的形状を様々な形に加工することにより、実に様々な興味ある光学的特性を示します。学生諸君の若い新しい頭がいろいろな形にこれから柔軟に変化して行くように、金属の形を様々な形に加工して、この新しい分野を切り開いて下さい。

梶川研究室

表面プラズモンとメタマテリアルをつかったナノフォトニクス



材料・物性グループ
ライフエンジニアリングコース・電気電子コース
すずかけ台・G2棟1005号室

教授 梶川浩太郎

研究分野: ナノフォトニクス、プラズモニクス、非線形光学
キーワード: 表面プラズモン、メタマテリアル、ランダムレーザー
バイオセンシング、物体の透明化・不可視化、黒体
ホームページ: <http://www.opt.ip.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

光が持つエネルギーを貯めたり、加工したり、好きなように伝搬させたり放出させたりする技術が注目を集めています。これらは、表面プラズモンという金属中の電子波を使えば可能となります。私たちは表面プラズモンを巧みに操った光学技術、プラズモニクスやメタマテリアル技術の開発を行っています。

具体的なテーマは以下の通りです。

1. 表面プラズモンを使った電磁誘起透明化
2. 物質を透明にする手法の理論と実験
3. 生物が持つ微細な構造を使ったバイオ・メタマテリアル
4. DNAやタンパク質、ウイルスを検出するデバイス
5. ランダムレーザー

2 最近の研究成果

■ 表面プラズモン、メタマテリアルとは？

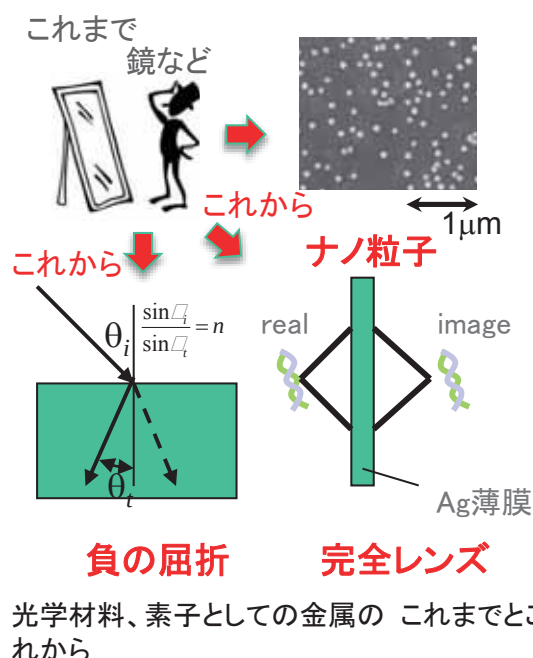
金属中の自由電子は電気を流すことでよく知られています。でも、電気を流す自由電子は通常光とは相性がよくないので、光は金属中に入らずに反射されています。鏡がそうですね。

金属でも、表面に特殊な構造を施したり、ナノメートルサイズの小さい金属の粒では、光と相性がよくなります。これを用いた光の技術を**プラズモニクス**と呼びます。**プラズモニクス**では、半導体や誘電体で実現できない様々な光学的な性質を実現することができます。

たとえば、ナノメートルの微小領域に光を閉じ込め伝搬させたり、高感度なDNAや蛋白質の検出を行ったりできます。

また、微細な人工構造により、自然界の物質が持つことができない光学的な性質を持たせた物質があります。これを**メタマテリアル**と呼びます。メタとは「超」という意味なので、「超物質」ということです。

メタマテリアルでは負の屈折率を持つ物質、光が進む速度がとても遅い物質、包むと中の物を見えなくしてしまう薄い構造（クローキングと呼びます）、逆に非常に薄いのに光をほとんど吸収する黒体構造等、がメタマテリアルによって実現できます。また、右からへは光を伝搬させられるけど左から右へは伝搬させられない不思議な物質などもあります。



光学材料、素子としての金属の これまでとこれから

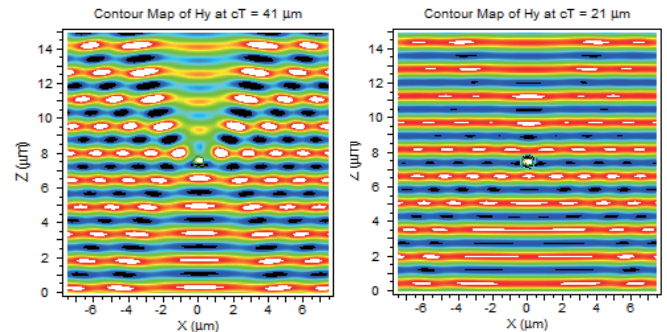
すずかけ台・材料・物性グループ

■ モノを見えなくする技術の開発(透明化・不可視化)

光を通さない、普通の金属の細線や薄膜をメタマテリアルで塗布してあげる透けて向こうが見えるようになる... 私たちの研究室では、メタマテリアルを使って**透明ではないモノを透明にする「クローキング」**の研究をしています。

光のクローキングの研究は世界中の研究者が一生懸命研究していますが、ほとんどは理論の研究です。私たちの研究室では、理論だけでなく**実験でクローキングを実証**する研究を行っています。

また、光を吸収する構造のそばに、別の構造を近づけるだけで、全体が透明になる「**電磁誘起透明化**」現象の研究を行っています。これを使って、光集積デバイスや高感度なバイオ素子の研究を行っています。



クローキング(透明化)なし
強い散乱があり中央の物質が「見える」

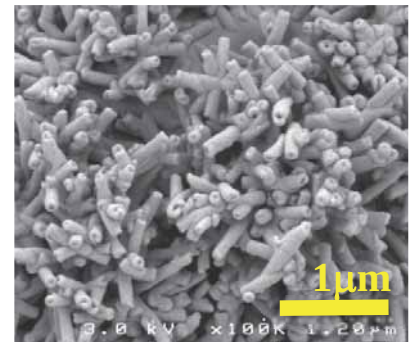
クローキング(透明化)あり
散乱無く波面が乱れない
中央の物質が「見えない」

■ バイオ・メタマテリアル (Scientific Reports 5 15992 (2015))

昨年、私たちの研究室では自然界の物質(葉や羽など)を使えば、簡単に**極薄の黒体**を作れることを発表しました。金でできている「超薄膜」を蓮の葉の表面にコートすれば、光をほとんど吸収して黒体となることがわかったのです。

黒体というと単に黒いものというイメージがありますが、実は黒体は以下の大切な性質を持ちます。

・広い波長にわたって、どのような角度で入射した光も反射せずに吸収します。光検出器や太陽電池等の光から電気や熱へのエネルギー変換の効率化に役立ちます。また、光を利用した物質生産(人工光合成や光化学反応)にも役立ちます。



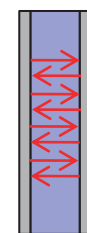
ハスの葉黒体メタマテリアルの電子顕微鏡写真。

・「光を吸収するものほどよく発光する」というキルヒホッフの法則があります。赤外光源などの発光素子に用いることができます。赤外線の利用は、今競争が激しい分野の一つです。

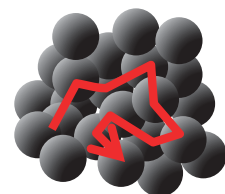
・条件によっては、モノを隠したり、見えなくしたりすることができます。映像や視覚分野での利用が期待できます。

■ ランダム・レーザー (Physical Review A 92 13824 (2015))

レーザーの教科書には、レーザーには共振器が必要と書いてあります。共振器とは向かいあわせた1対の鏡やリングのような構造のことを指します。でも、共振器が無くても、光が散乱されながらゆっくり進むランダム媒質では、レーザー発振が起こります。これをランダムレーザーといいます。私たちの研究室では、**ランダムな媒質やランダムではない媒質でおこるランダムレーザ**の研究をしています。



共振器



共振器なし

3 教員からのメッセージ

私たちは広い分野を研究対象としていますのでメンバーの専門分野は様々です。皆さんの得意なそれぞれの分野で個性を発揮してもらっています。本研究室は、電気電子系ライフエンジニアリングコースと電気電子コースのどちらのコースの学生も受け入れることができます。

加藤研究室

 π 共役分子を用いた光電子デバイス、有機半導体材料の開発

材料・物性グループ

電気電子コース

すずかけ台

特任教授 加藤 隆志

研究分野: 光デバイス、電子デバイス、 π 共役分子

キーワード: 有機半導体、光機能性材料、プリント・エレクトロニクス

1 主な研究テーマ

π 共役分子の集合状態を制御することで、従来にない革新的な光・電子デバイスの実現を目指します。特に、次世代のディスプレイ材料ならびに有機エレクトロニクス材料を目指した応用研究を進めていきます。

★当研究室は飯野研究室と密に連携して運営していきます。

 π 共役分子

次世代光・電子デバイス

集集体制御
高機能化

- ・プリント
- ・フレキシブル
- ・軽量

2 最近の研究成果

■ 光機能性材料の配列制御技術

有機分子は特定の配列に固定されることで、従来にない新しい性質を示します。これまで、色素分子を様々な配列に連結したモデル化合物を合成し、配列様式が光学および電子的性質を大きく変えることがわかりました。現在は、結晶および液晶場などの利用により色素分子の集合状態を制御して、新しい光電子材料を開発することを目指しています。

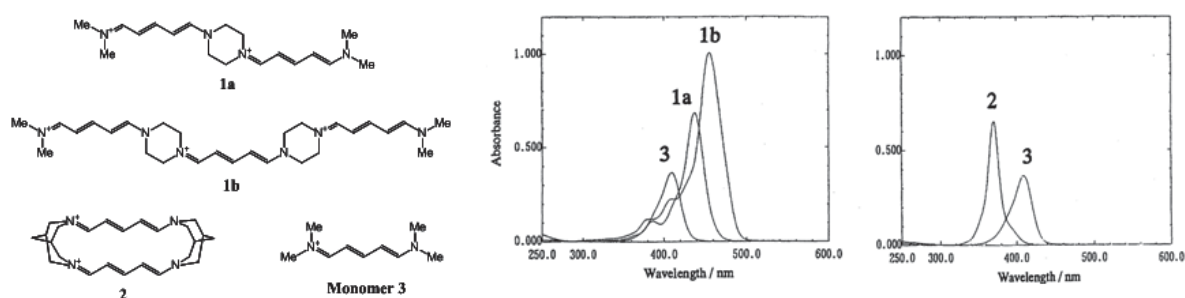


図1. 色素の配列の違いによる吸収スペクトル変化

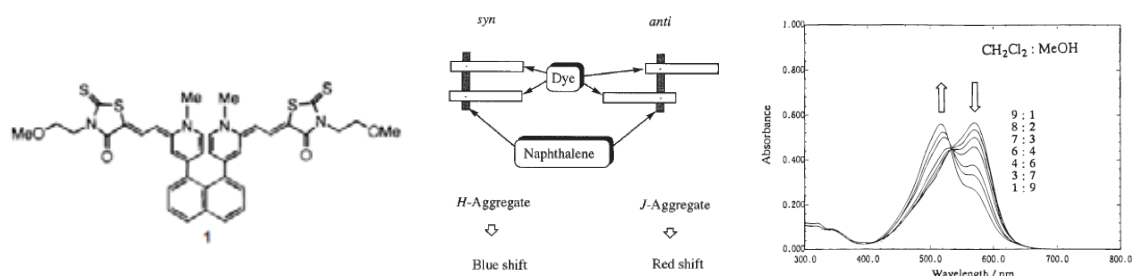


図2. 連結型メロシアン色素における吸収スペクトル変化

すずかけ台・材料・物性グループ

■ 次世代表示材料の開発

インターネットの普及により、デジタル情報を手軽に表示させる技術に注目が集まっています。これまで、次世代ディスプレイ用材料として期待される2色性色素を開発してきました。現在は、さらに次世代の表示用材料の開発にも取り組んでおり、今後の発展が期待されるプリンテッドエレクトロニクスとの融合を目指しています。

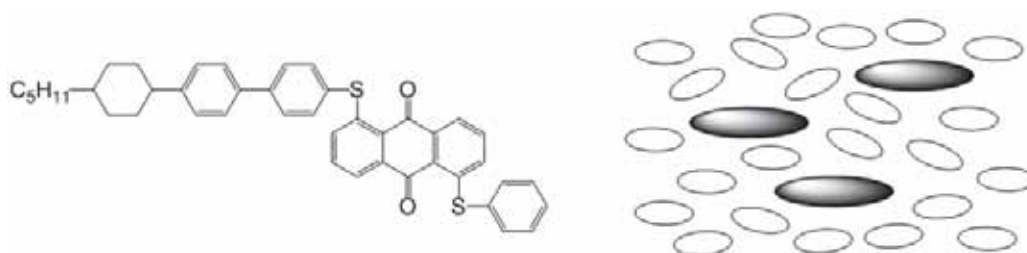


図3. 新しく開発したアントラキノン系2色性色素

■ 有機半導体材料の配列制御

プリンテッドエレクトロニクスの実現に向けて、有機半導体材料への注目が高まっております。有機半導体材料は、その配列を精密に制御することが必要です。これまで、ルブレイン誘導体について大面積の単結晶作製技術の開発に取り組んできてきました。今後は、さらに実用性を見据えた有機半導体材料の配列制御技術の開発に取り組んでいきます。

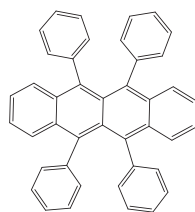


図4. ルブレインの構造式

3 教員からのメッセージ

有機化学は暗記ではなく、無限の可能性を秘めた研究分野です。 π 共役分子は、多様な光および電子との相互作用を持つ大変魅力的な機能性材料です。大発見の期待を胸に、新しい光電子材料の開発を一緒に考えていきましょう。

菅原研究室

電荷とスピンの生み出す新しい機能デバイスとその低消費電力CMOS技術への応用，集積回路技術を応用した環境発電デバイス



材料・物性グループ
電気電子コース
すずかけ台・J3棟1216号室

准教授 菅原聡

研究分野: 電子デバイス, スピンデバイス, 集積回路, 熱電発電デバイス

キーワード: CMOS、スピントランジスタ, 磁気抵抗デバイス, 不揮発性メモリ, 低消費電力アーキテクチャ, 半導体スピン物性, 高スピン分極率強磁性体, 熱電材料, 熱電発電モジュール

ホームページ: <http://www.isl.titech.ac.jp/~sugaharalab/>

1 主な研究テーマ

電子は“電荷”と“スピン”による特徴を有しますが、従来はこれらの一方のみに着目してそれぞれ半導体エレクトロニクスと強磁性体ストレージ技術として活用されてきました。本研究室では、スピントランジスタなどの“電荷”と“スピン”の融合が生み出す新しい機能デバイスを実現して、これまでにない新しいエレクトロニクスの体系を創出することを目的として研究を進めています。特に、大規模集積回路に用いられる高度に洗練されたCMOS技術に立脚して、スピン機能/CMOS融合による超低消費電力ロジックシステムのための材料・デバイス・回路技術の研究開発を行っています。さらに、CMOS技術に不揮発の機能を導入した高エネルギー効率のCMOSアーキテクチャの研究も行っています。また、環境にある微弱な温度差や、集積回路の発熱を利用した熱電発電技術の開発を行っています。特に新しい熱電材料薄膜の研究と、これにCMOS集積回路に用いられる高密度集積化技術を応用した新型の熱電発電モジュールの開発を行っています。

2 最近の研究成果

■高効率スピン注入源の開発

スピン機能/CMOS融合技術では、シリコンにスピン偏極した電子を注入して、その伝導を制御する必要があります。このスピン注入に必要となるトンネル接合型スピン注入源や、高いスピン分極率を有する強磁性体などの研究開発を進めています。ハーフメタル強磁性体は一方のスピンに対して金属的なバンドを持ち、他方のスピンに対して絶縁体(半導体)的なバンド構造を持つことから、フェルミ準位において100%のスピン分極率を有するスピン注入源材料です。本研究室ではCMOSプロセス技術を用いてフルホイスラー合金と呼ばれるハーフメタル強磁性体を実現して、トンネル接合型スピン注入源などへの応用を進めています。また、スピン注入源に重要となる各種高品質トンネル絶縁膜の開発も行っています。

■シリコンへのスピン注入とスピン伝導の評価

本研究室で提案された強磁性体によってソースとドレインを構成したスピンMOSFETと呼ばれるスピン機能/CMOS融合デバイスの研究・開発を進めています。このスピンMOSFETを実現するためにシリコンへのスピン注入と、MOS反転層におけるスピン伝導が特に重要になりますが、これらはこれまでのところ完全には理解されていません。本研究室ではこのようなスピン物性の評価のための新型デバイスを提案して、シリコン中へのスピン注入とシリコンチャンネル内でのスピンダイナミクスの評価を行い、その理解とデバイス応用を進めています。

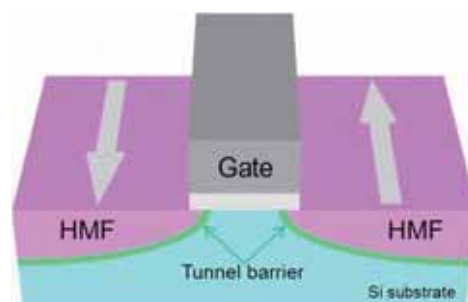


図1 スピンMOSFETのデバイス構造

すずかけ台・材料・物性グループ



図2(a) 超高真空マルチチャンバー成膜装置, (b) 作製したホイスラー合金トンネル接合, (c) 磁気伝導評価デバイス.

■ スピン機能MOSFETの開発と集積エレクトロニクスへの応用

スピンMOSFETの最大の特徴は、ソースとドレインの磁化の状態に応じた不揮発な情報保持とこの状態に応じた出力特性です。この特徴を用いれば、高性能な不揮発性メモリや待機時電力を極限まで削減したロジックシステムなどを実現することができます。また、二端子のスピンデバイスである強磁性トンネル接合 (MTJ) と通常のMOSFETを用いてスピンMOSFETと同等の動作を実現できる回路技術 (擬似スピンMOSFET) を用いても同様の回路応用が可能です。本研究室ではこのようなスピンMOSFETおよび擬似スピンMOSFETの理論解析, 試作・評価, 集積回路応用について研究を行っています。

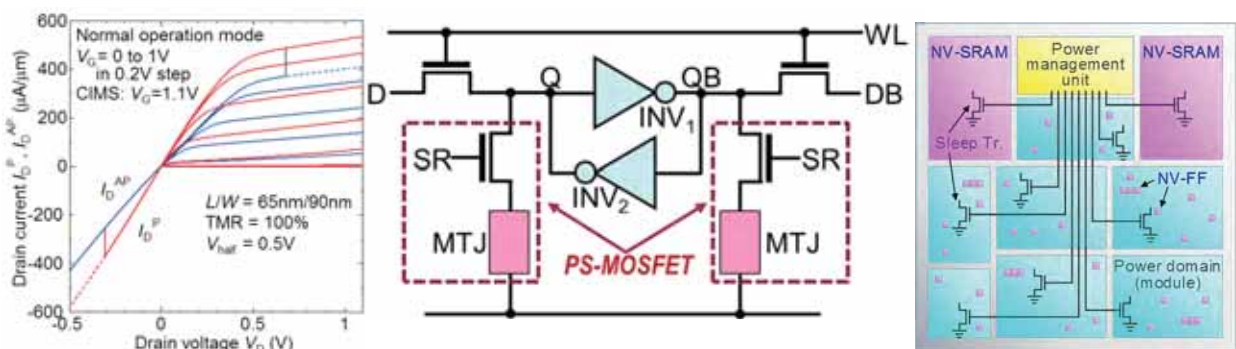


図3(a) 擬似スピンMOSFETの出力特性, (b) 擬似スピンMOSFETを用いた不揮発性SRAM, (c) 不揮発性パワーゲーティングの概念図

■ 新型熱電発電モジュール

フルホイスラー合金はその特異的なバンド構造によって高いゼーベック係数を示す熱電材料としても期待されています。本研究室では、CMOSプロセス技術を用いて高いゼーベック係数を有するフルホイスラー合金薄膜の形成を試みています。また、このような熱電材料薄膜に集積回路技術を応用して、高密度にゼーベック素子を集積化した新型高性能熱電発電モジュールの設計・プロセス技術についても開発を進めています。これらの技術を用いれば、環境にある微弱な温度差による発電や、集積回路の発熱を利用したエネルギー回生が可能となります。

3 教員からのメッセージ

本研究室では新しい研究分野を自らの手で開拓して行くというフロンティア精神を重視して研究を進めています。皆さんからのアイデアも大歓迎です。アクティブな研究活動を実践して、学生生活をエンジョイしてください。

中本研究室

ヒューマン嗅覚インタフェース



材料・物性グループ
情報通信コース(主担当)・電気電子コース(副担当)
すずかけ台・R2棟516号室

教授 中本 高道

研究分野: センサ、電子計測、組み込みシステム、ヒューマンインタフェース

キーワード: 匂いセンサ、嗅覚ディスプレイ、感性情報センシング、
バイオセンサ、嗅覚IoT

ホームページ: <http://silvia.me.ee.titech.ac.jp/>

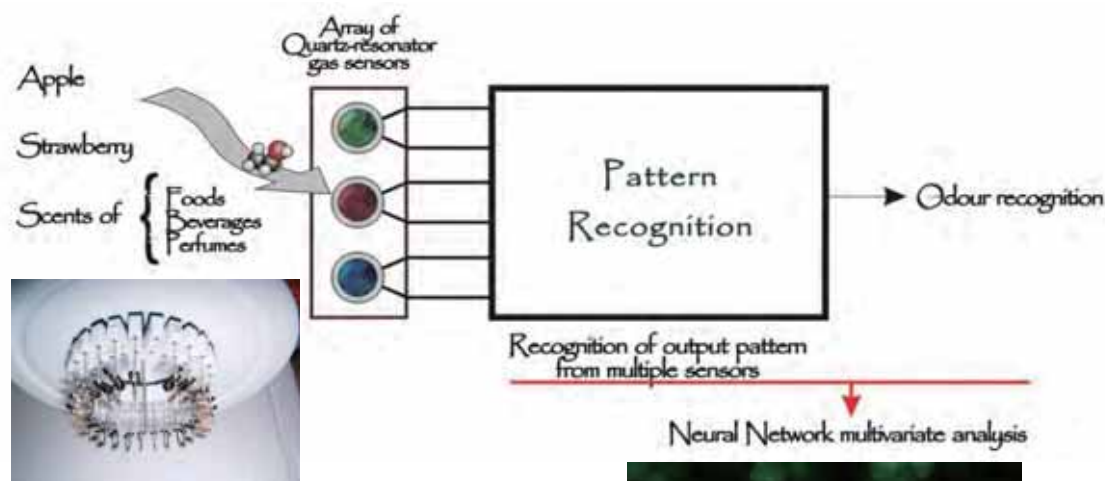
1 研究内容・目的

中本研究室では、感性情報のセンシング、情報処理、感性情報を再現するヒューマンインタフェースを目指し、その中でも嗅覚に注目して研究を行っています。視覚情報の場合ビデオカメラでキャプチャしてテレビ画面で情報再現を行うように、匂いセンサや嗅覚ディスプレイで嗅覚情報のセンシング、記録、再現を実現することを目指します。また、香る料理ゲーム等の嗅覚を利用したマルチメディアコンテンツも研究し、その実演も多く行います。さらに匂いバイオセンサやセンサ情報処理システム・アルゴリズムの研究も行っています。

2 研究テーマ

■ 匂いセンシングシステム

多数のセンサの応答パターンをパターン認識することにより、匂いの種類を識別する。センサ素子としては水晶振動子センサを多く用いるが、近年は嗅覚受容体を発現させた細胞をセンサ素子として用いる研究も行っている。嗅覚受容体を用いることにより、生物に近い性能を持つセンサを実現できる可能性がある。



水晶振動子センサアレイ

匂いバイオセンサのカビ臭
に対する応答
(細胞提供: 東大神崎研)



すずかけ台・材料・物性グループ

■ 嗅覚ディスプレイ

多成分の香りを任意の比率で調合させることにより多様な香りを提示可能。ゲーム、デジタルサイネージ用のコンテンツを作成し、国内だけでなく海外でもリサーチデモを行う。嗅覚VRはバーチャルリアリティ分野でも注目されている。テレビ・新聞取材も多い。



デスクトップ型嗅覚ディスプレイ
(既にメーカーが外販)



HMD

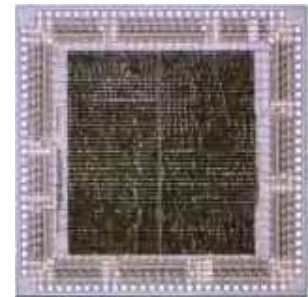
ウェアブル嗅覚
ディスプレイ



バーチャルアイスクリームショップ
(嗅覚ディスプレイコンテンツ)

■ 匂い認識チップ

小型匂いセンシングシステムに組み込むセンサ情報処理回路（デジタル回路）の設計・試作。計測回路、周波数解析等を行う前処理回路、パターン認識・学習を行う機械学習回路を設計し、ASICやFPGAに実装する。回路の全体制御にはCPUコアも使用。



匂い認識チップ写真（VDECによる試作）

■ 嗅覚IoT (Internet of Things)

匂いセンサでセンシングした匂いを遠隔地で映像と共に再現



インターネット



海外テレビでも放映

3 教員からのメッセージ

この分野は境界領域で、情報エレクトロニクスだけでなく、生物、化学、環境計測、機械、制御、医学、歯学、芸術等の分野と関連があります。これらの情報・電気以外の分野の他大学や企業との共同研究も多いです。幅広くやってみたい人は、ぜひ当研究室にきてください。当研究室ではモノづくりをする機会が多く、計測や組み込みシステム、FPGAの知識、さらに感性情報処理、ヒューマンインターフェースの素養が身につきます。また、パターン認識や機械学習に関連する研究テーマもあります。さらに、国内外の学会発表の機会も豊富にあります。国内だけでなく海外でのresearch demoやテレビ取材など自分の研究を実演を通じてアピールする機会があります。海外との交流も多く、たくさんの留学生も研究に参加しています。

赤木・萩原研究室

パワーエレクトロニクスの電力システム・スマートグリッドへの応用



電力・エネルギーグループ
エネルギーコース・電気電子コース
大岡山・EEI-405/ EEI-402

教授 赤木 泰文 准教授 萩原 誠

研究分野: パワーエレクトロニクス

キーワード: スマートグリッド, 高圧モータドライブ, 電池電力貯蔵装置,
ハイブリッド直流遮断器, 高圧・大容量DC/DCコンバータ

ホームページ: <http://www.akg.ee.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

- ・ 次世代パワーデバイスを駆使したスマートグリッド用パワーエレクトロニクス機器
- ・ 次世代マルチレベル変換器を使用した高圧モータドライブ駆動システム
- ・ 直流スマートグリッドに適用可能な高圧・大容量DC/DCコンバータ, 次世代ハイブリッド直流遮断器

2 最近の研究成果

次世代パワーデバイスを駆使したスマートグリッド用パワーエレクトロニクス機器



18台の電力変換器



18個のリチウムイオン
バッテリーモジュール

再生可能エネルギーの大量導入に対応
可能な次世代電池電力貯蔵装置

近年, 風力や太陽光に代表される自然エネルギーの大量導入が進んでいます。自然エネルギーの発電電力は時々刻々と変化するため, 電力平準化を目的とし**電池電力貯蔵装置**を導入する必要があります。しかし, 従来の電池電力貯蔵装置は大容量電池ストリングスを一括して設置・管理するため, 電池ストリングスを構成する電池モジュールの一台に故障や不具合が発生した場合, システムを運転継続できないという実用上の大きな課題がありました。

本研究室では, 次世代電池電力貯蔵装置に関する研究を行っております。これは, 電池ストリングスを一括して設置・管理するのではなく, 電池モジュールごとに管理を行う点に特長があります。具体的には最新のパワーエレクトロニクス技術, デジタル制御技術を駆使し, 世界で初めて実験検証に成功いたしました。左に示す実験装置は, 電力変換器18台とリチウムイオン電池モジュール18個から構成されており, その実験結果は世界中の関連の研究者・技術者を唖せました。これらの研究成果をまとめた学術論文は2013年にはIEEE Power Electronics Society から First Prize Transactions Paper Award を受賞しました。



スマートグリッド用電力潮流制御器

日本の配電系統は樹枝状に構成されており, 複数のフィーダから構成されています。従来, フィーダ電圧は配電変電所の負荷時タップ切替変圧器や自動電圧調整器といった機械的手法により調整されてきました。しかし, 近年の太陽光発電の大量導入により, フィーダ電圧の管理を上記の機械的な手法を用いてのみで実現することが困難になってきました。

本研究室では, 上記問題点を解決する手法として, **ダブルスター構成モジュラー・マルチレベル・カスケード変換器**を用いた電力潮流制御器に関して検討を行っております。これは, 二つのフィーダ間の電力潮流を制御することで, 太陽光発電が大量導入時においてもフィーダ電圧を適切に管理できる点に特長があります。左に示す実験装置は, パワーデバイス192個使用した世界最高レベルであり, 経済産業省の「次世代送配電系統最適制御技術事業」の一環として研究を行いました。上記の実験装置を用いた実験結果・シミュレーション結果は, 国内外の権威ある学術論文誌に掲載済みであり, 非常に高い評価を得ています。2014年にはIEEE IAS IPCC First Prize Paper Award を受賞しました。

大岡山・電力・エネルギーグループ

次世代マルチレベル変換器を使用した高圧モータドライブ駆動システム



次世代マルチレベル変換器

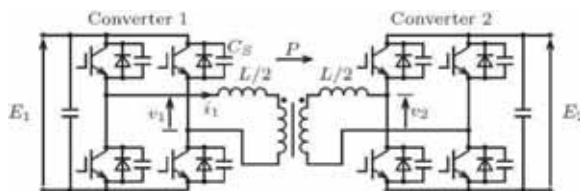


各種モータ(誘導電動機, 同期電動機)

ファン・ブローヤやポンプなどは、可変速運転を行うことによって大幅な省エネが達成できます。しかし、高圧・大容量インバータの開発・実用化は遅れています。従来、インバータの高圧化には多巻線変圧器を使用することで対応してきました。しかし、この複雑な巻線構造の変圧器は高コストで、信頼性が低いという課題がありました。

本研究室では、左図に示す次世代マルチレベル変換器を用いた誘導電動機・同期電動機駆動システムを設計・製作し、良好な特性を実証しました。2014年にはIEEE IAS IPCC Third Prize Paper Award を受賞しました。

SiC-MOSFET/SBDモジュールを使用した大容量双方向絶縁形DC/DCコンバータ



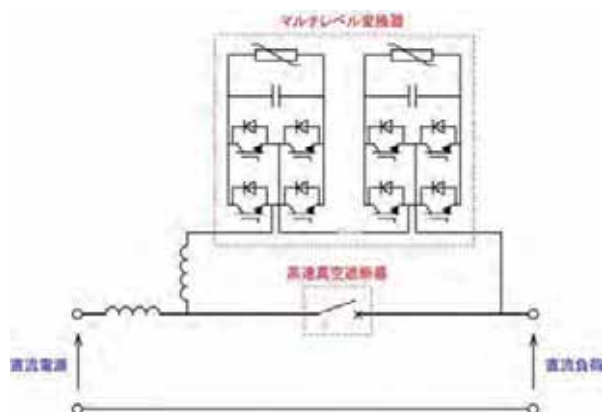
	1990 ¹⁾	2014(東工大)	2020 ²⁾
Switching Devices	Planar-Gate IGBTs	Planar-Gate SiC-MOSFETs	Trench-Gate (SJ) SiC-MOSFETs
Core Material in Transformer	Ferrite	FINEMET TM	New Magnetic Materials
Efficiency (DC to DC)	Below 90% @ 50 kW, 50 kHz	97.9% @ 100 kW, 20 kHz	Over 99% @ 100 kW, 20 kHz

双方向絶縁形DC/DCコンバータの過去、現在、未来

電気自動車の急速充電装置や、今後の普及が想定される直流スマートグリッドでは、高圧・大容量双方向絶縁形DC/DCコンバータが必要不可欠です。従来は商用周波数(50/60Hz)変圧器を使用しており、小型・軽量化を実現するための障害でした。

本研究室では、次世代パワーデバイスであるSiC-MOSFET/SBDモジュールを使用した750V, 100kW, 20 kHz双方向絶縁形DC/DCコンバータに関して実験検証を行いました。その結果、電力変換効率(DC入力からDC出力まで) **98.7%** という高効率を達成いたしました。この値は、同一回路・同一運転条件では世界最高効率です。損失分析については、世界のパワーエレクトロニクス研究者が思いもよらなかった簡便な手法を考案し、パワーデバイスのスイッチング損失と導通損失、磁気デバイスの鉄損と銅損の分離に成功しました。現在も、さらなる高効率・小型軽量化を目指して研究を継続しています。

機械式(真空)遮断器とマルチレベル変換器を併用した次世代ハイブリッド遮断器



次世代ハイブリッド直流遮断器

直流電気鉄道や実用化が期待される多端子直流送電システムでは、短絡事故が発生した場合に電流を遮断するため直流遮断器が必要不可欠です。従来の直流遮断器は、機械式遮断器(真空遮断器)とサイリスタ、コンデンサ、リアクトル、バリスタなどから構成されているため、遮断時間が長いという問題点がありました。

本研究室では、安岡・竹内研究室と共同でハイブリッド直流遮断器の研究を行っています。これは最新の半導体の高速動作と高速機械式遮断器を併用することで、直流電流の高速遮断を実現する点に特長があります。本研究室では、直流300V, 150A定格(本実験室で可能な最大容量)の実験装置を設計・製作し、左図の特性評価から直流高電圧(250kV以上)に適した次世代ハイブリッド直流遮断器の動作原理検証に至るまで幅広く研究しています。

3 教員からのメッセージ

パワーエレクトロニクス技術は、コンピュータ・OA機器から家電製品、一般産業、交通(ハイブリッド・電気自動車、鉄道、船舶、飛行機)、再生可能エネルギー、電力システムまで幅広く応用されており、電気電子工学の基幹技術になっています。今後は、現在主流のSi(シリコン)に代わり、SiC(炭化珪素)やGaN(窒化ガリウム)などのワイドバンドギャップ半導体を使用した次世代パワーデバイスの本格的な実用化に伴って、パワーエレクトロニクス技術のさらなる発展と応用技術の拡大が期待されています。

赤塚研究室

Plasma Spectroscopy and Astronautics
プラズマ分光学と原子分子、宇宙応用

電力・エネルギーグループ
原子核工学コース
大岡山・N1-413
准教授 赤塚 洋

研究分野: プラズマ理工学、プラズマ分光学、希薄流体工学
キーワード: 分光計測、原子分子過程、衝突輻射モデル、非平衡分布、
希薄超音速電磁流体、宇宙工学、電気推進機、超高層大気
ホームページ: <http://www.nr.titech.ac.jp/~hakatsuk/>

1 主な研究テーマ

1. プラズマ分光計測法の開発、その基礎となる原子分子過程の解明

分子気体放電プラズマは、電子工学や材料工学に応用されるとともに、地球環境や上層大気現象でも重要です。これらの発光分光計測から、電子温度・密度はもちろん、ラジカル温度やラジカル密度を求める方法を研究しています。分光光学や量子力学を必要とするスペクトル解析やそれに基づく非平衡プラズマの各種温度の計測法開発、各種ラジカル発光分光計測法の開発研究、励起状態生成消滅モデル計算による励起状態密度のプラズマ化学的な理論解析、電子エネルギー分布の非平衡性の起源の解明、等の研究に取り組んでいます。

2. 超音速プラズマ流と粒子シミュレーション

我々の実験室で所有する希薄気体風洞で、超音速アークプラズマジェットを定常生成可能です。人工衛星用スラスター(電気推進機)に応用の可能性があります。上手く応用するとマッハ数を上げる事が可能ですが、流体力学に電磁気的相互作用が加わり解析は大変複雑です。しかも希薄流のため、流体ではなく粒子モデルに基づくシミュレーションが必要です。実験と理論計算を組合せ、加速現象・空間電位変化の解明などのプラズマ物理学・プラズマ工学を研究します。

2 最近の研究成果

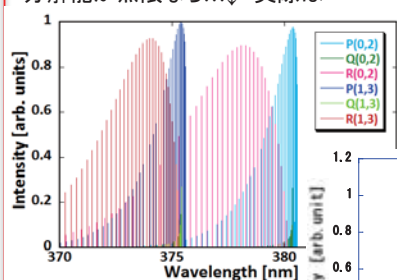
放電プラズマ中の分子スペクトルの理論計算と振動・回転温度の測定、およびその結果を利用したプラズマの熱構造解明と非平衡性の起源に関する研究

分子気体を含むプラズマは、分子の線スペクトルを多数放出しますが、一般的分光器では分解能が不足し、振動・回転励起分布の実測は困難でした。我々は上準位の振動・回転温度を仮定すれば、発光スペクトルを理論計算できることに着目し、種々の分子励起状態の振動・回転温度を測定可能としました。特に N_2 2PSの回転温度はガス温度の近似値となることを見出し、これにより多数のプロセスプラズマの熱的構造を理解できるようになりました。また同一プラズマ中でも振動・回転温度が異なる励起種を見出し、生成消滅の素過程の違いが反映されることから、励起状態生成消滅の素過程の解明にも取り組んでいます。

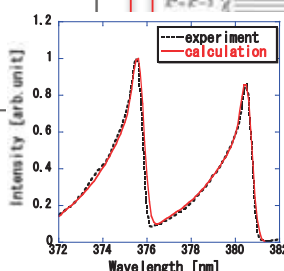
 N_2 2PSの場合

振動回転分布を温度 T_v , T_r のBoltzmann分布と仮定すれば、発光線強度が計算可能

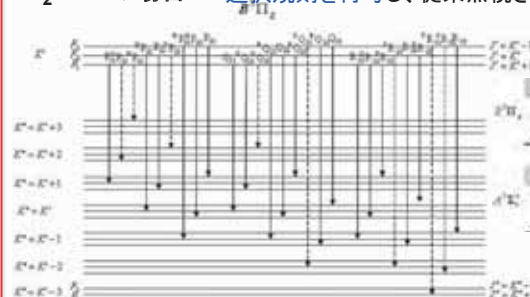
分解能が無限なら...↓ 実際は↓



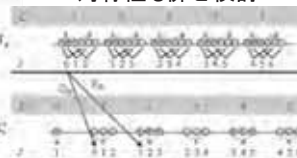
理論は非常によく実験と一致。ベストフィットにより振動・回転温度が求まる→

 N_2 1PSの場合

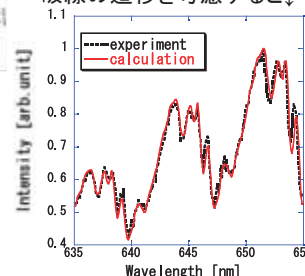
選択規則を再考し、従来無視された破線の遷移も含めた



対称性も併せ検討



破線の遷移を考慮すると↓

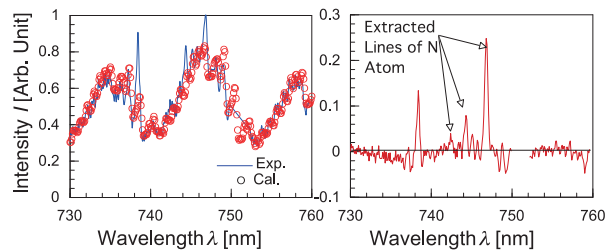
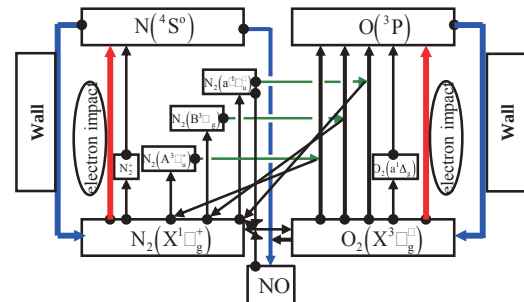


従来の拙い1PS計算例→実験に合わない

大岡山・電力・エネルギーグループ

アクチノメトリー法によるプラズマ中の非発光ラジカル密度の測定、および励起種密度に関するモデリング

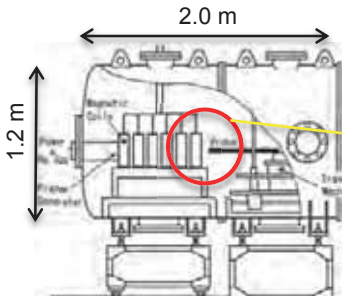
プラズマプロセスでは、化学反応性を有するラジカルの密度のモニタが重要となります。アクチノメトリー法を用いると、O原子やN原子など、自らは発光しない反応性ラジカル密度が計測できます。ただし様々な仮定を適用しており、励起状態生成消滅の理論モデリングによる数密度の放電条件への変化による考察を併せて行うことが必須で、窒素・酸素混合放電プラズマ中の励起種生成につき、化学カインエティックモデルを生成・検討しています。

N₂ 1PSに埋もれたN原子発光線抽出□ N₂ 1PS発光をフィッティングし減算N₂-O₂ 混合プラズマ中の原子種の主要な生成消滅過程

人工衛星電気推進機の基礎～希薄電離超音速プラズマへの電磁場の影響 (1) 実験研究

衛星電気推進機、磁場核融合炉周辺領域、宇宙地球科学など、基礎現象として重要な希薄超音速プラズマ流につき、実験研究を行っています。希薄気体風洞を利用してアークジェットを定常生成し、電磁場の影響を調べています。

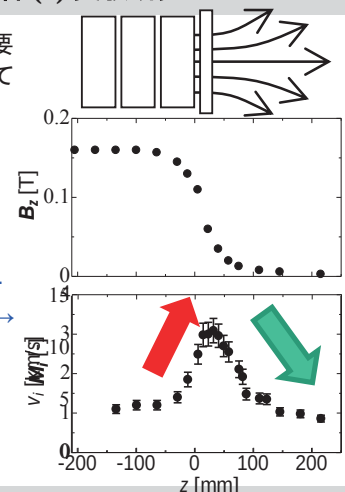
希薄気体風洞



磁気ノズルから噴出される超音速膨張アークジェット



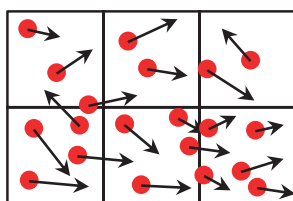
磁気ノズル近傍で測定された磁場強度とイオンマッハ数→



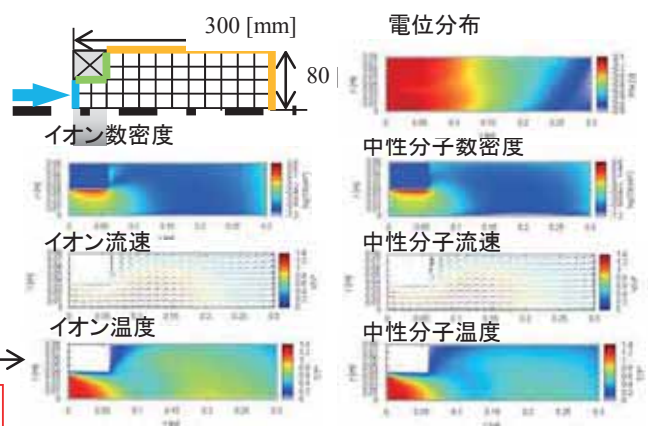
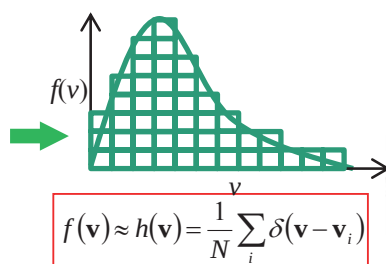
人工衛星電気推進機の基礎～希薄電離超音速プラズマへの電磁場の影響 (2) 数値計算研究

希薄電離超音速プラズマ流の数値シミュレーション研究も行っています。中性粒子とイオンは粒子法、電子は流体法によるハイブリッド法を適用します。空間電位形成に、中性粒子とイオンの速度差(イオンスリップ)が重要なことなど、興味深い結果が明らかになってきています。

計算領域分割、サンプル粒子の運動・衝突



速度分布を統計によって再現



3 教員からのメッセージ

- 赤塚研究室では、学生の方々に、プラズマ理工学の幅広い分野にわたる基礎研究を通じて、電気・電子工学や原子核工学に限られない、幅広い理工学分野で活躍できる能力と、それを発展させる能力を持って欲しいと考えています。
- 平成27年度は、博士課程2人、修士課程4人が在籍しています。
- 就職先：九州電力、三菱電機、東芝、商船三井、日立製作所、東洋エンジニアリング、三菱重工、トヨタ、JR東海など

小栗研究室

Ion beams: Technology towards the future
未来を拓くイオンビーム技術

電力・エネルギーグループ
原子核工学コース
大岡山・N1-626

教授 小栗慶之

研究分野: 核融合学、原子力学、プラズマ科学、量子ビーム科学、医用システム

キーワード: 慣性核融合、放射線工学・ビーム科学、高エネルギー密度科学、量子ビーム
医療応用、低侵襲治療システム

ホームページ: <http://www.nr.titech.ac.jp/~yoguri/>

1 主な研究テーマ

1. イオンビームを用いた核融合・高密度エネルギー状態の研究

大強度の高エネルギー重イオンビームを用いた核融合や高エネルギー密度科学の研究に関連して、高温高密度プラズマと重イオンビームの相互作用、主にプラズマへのエネルギー付与過程に注目して調べます。

2. 小型加速器を用いた医療用診断・治療技術の基礎研究

陽子ビームを金属標的に照射して発生させた単色X線を、患者に優しい透視撮影や深部ガン治療等に应用するための基礎研究を行います。

3. イオンビームを用いた高感度・精密元素分析技術の開発とその応用

イオンビームを試料に照射して精密な元素分析を行うための技術開発、及び環境・材料科学等に関連する試料を用いたその実証実験を行います。

写真: (上) メンテナンス中の1.6メガボルト静電重イオン加速器
(下) 加速器にイオンを供給するイオン源のプラズマ

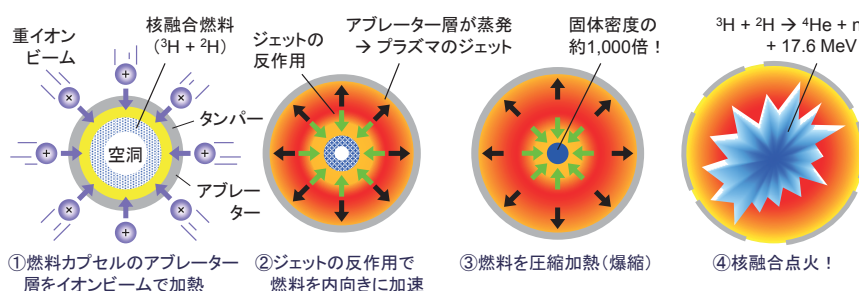
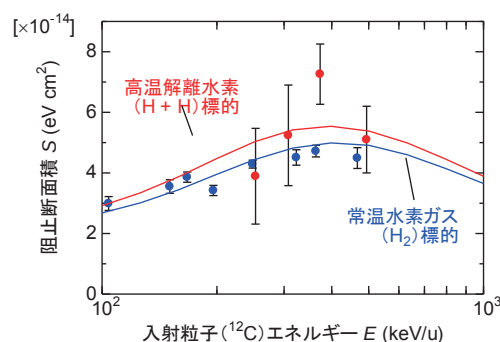


2 最近の研究成果

慣性核融合に関連した高密度プラズマへの重イオンビームのエネルギー付与

重イオンビームを用いた慣性核融合(下図)においては、燃料標的の温度上昇に伴ってその電子状態が変化(励起・解離・電離)するため、入射ビームによる標的の加熱効率(標的の[厚さ×密度]当たりのエネルギー付与≡阻止断面積)が変化します。この変化に関するデータがないと、燃料標的の詳細設計ができません。研究室の静電重イオン加速器とプラズマ発生装置(右下の図)を用いて、この基礎データを取る実験を進めています。

右上の図は電磁駆動衝撃波管で発生した解離水素(水素原子)標的中の ^{12}C イオンの阻止断面積を測定した例で、標的が常温の場合に比べ、阻止断面積が増加する傾向が見られました。

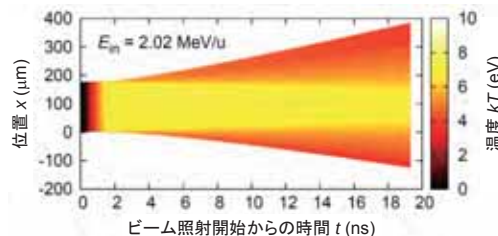


大岡山・電力・エネルギーグループ

重イオンビームを用いた高温高密度核物質の状態方程式の評価手法の開発

非常に大きな反応度を伴う高速炉の過酷事故や核テロによる被害の予測には、温度が数万度を超える超高温状態の核物質の状態方程式データが必要です。大強度パルス重イオンビームを核物質試料に照射し、その流体的挙動を測定することで、このデータを取得する方法を数値シミュレーションにより提案しました。

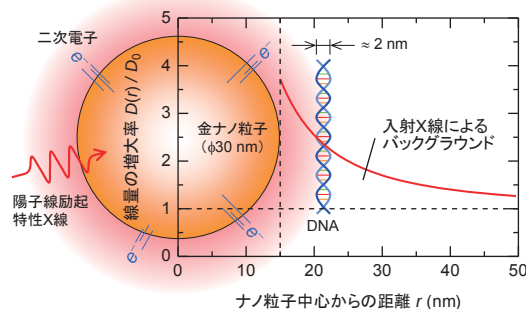
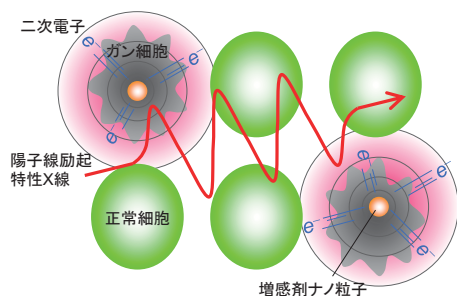
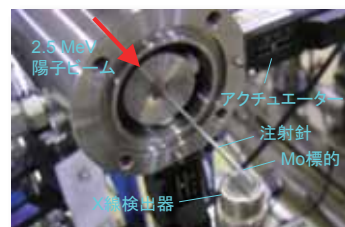
図は ^{23}Na イオンビームで加熱したウラン標的の流体的挙動の計算結果で、標的を約7万度まで一様に加熱できることが分ります。



小型加速器を用いた低侵襲深部ガン治療技術の基礎研究

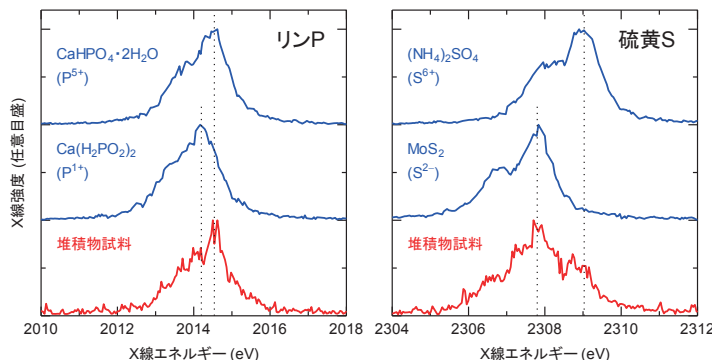
小型加速器からのMeV級陽子ビームを金属標的に照射すると、単色のX線を効率良く発生できます。ガン細胞に予め金属ナノ粒子を含む薬剤を摂り込ませておき、その金属に選択的に吸収されるエネルギーの単色X線を照射すると、粒子から飛程の短い多量の二次電子が出ます。これらを使って左下の図のようにガン細胞のみを内部から照射する技術の基礎研究を行います。

照射は右図の注射針型線源を患部に刺入して行います。ファントム実験と計算により、右下の図のようにナノ粒子の周囲のみで高線量が得られ、正常細胞への影響(副作用)が少ない治療が原理的に可能なことが分りました。



イオンビームを用いた高感度・精密元素分析技術の開発とその応用

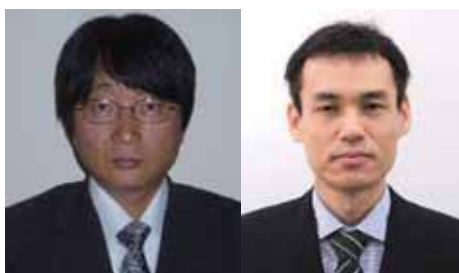
環境問題や材料科学に関連した試料にイオンビームを照射し、発生するX線・荷電粒子を測定して高感度・精密元素分析を行う手法を開発します。左図は実験装置、右図は湖沼堆積物中のリン、硫黄の電子状態を同定した例です。



3 教員からのメッセージ

- 研究室での活動には物理・化学の知識も必要です。また、放射線・高電圧・レーザー・重量物等の危険物を扱うため、安全には十分な注意を要します。よって早めに登校し、昼間のうちに実験室での作業を完了せねばなりません。
- 平成27年度は博士課程1名、修士課程6名が在籍しています。
- 就職先: 日立製作所、東芝、三菱電機、三菱重工、IHI、四国電力、東京大学、KEK、放射線医学総合研究所、他

葛本・堀口研究室

パワー半導体デバイスモデルの構築
とパワエレ機器高機能化への応用

電力・エネルギーグループ
エネルギーコース・電気電子コース
大岡山・EEI-210

特定教授 葛本 昌樹 特定准教授 堀口 剛司

研究分野: パワーエレクトロニクス、電子デバイス

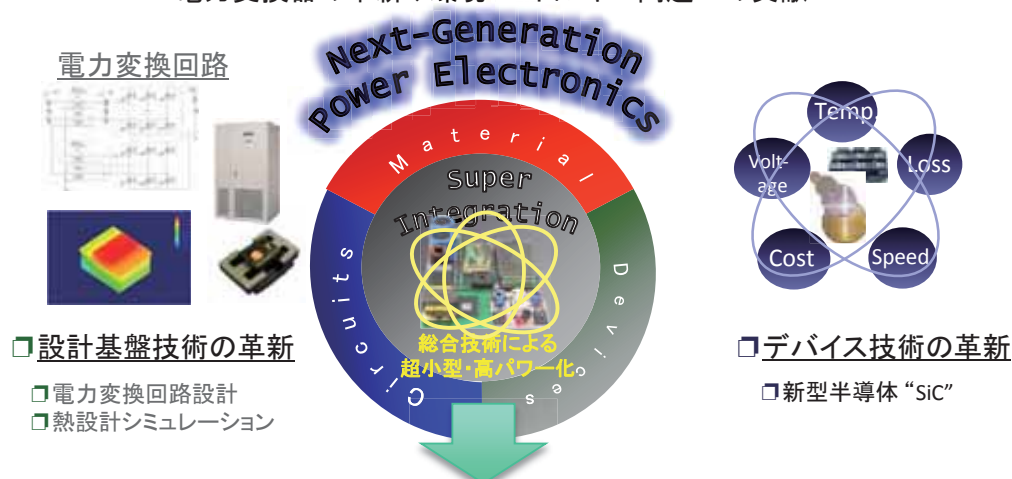
キーワード: パワーデバイス、デバイスモデル、Si・SiC、トランジスタ、ダイオード、シミュレーション

1 主な研究テーマ

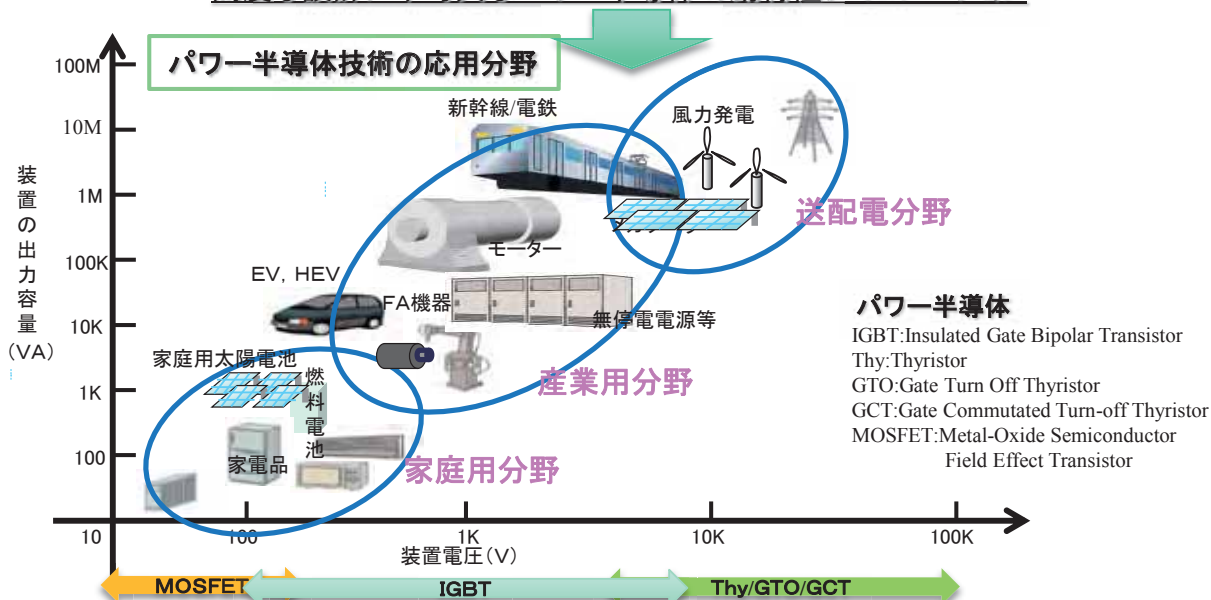
- ・パワーエレクトロニクスのキーデバイスであるパワー半導体の過渡応答を表現するデバイスモデルを構築
- ・デバイスモデルを用いたスイッチング損失、EMIノイズなどパワエレ機器の解析評価手法を開発

2 最近の研究成果

次世代パワーエレクトロニクス技術
電力変換器の革新→環境・エネルギー問題への貢献



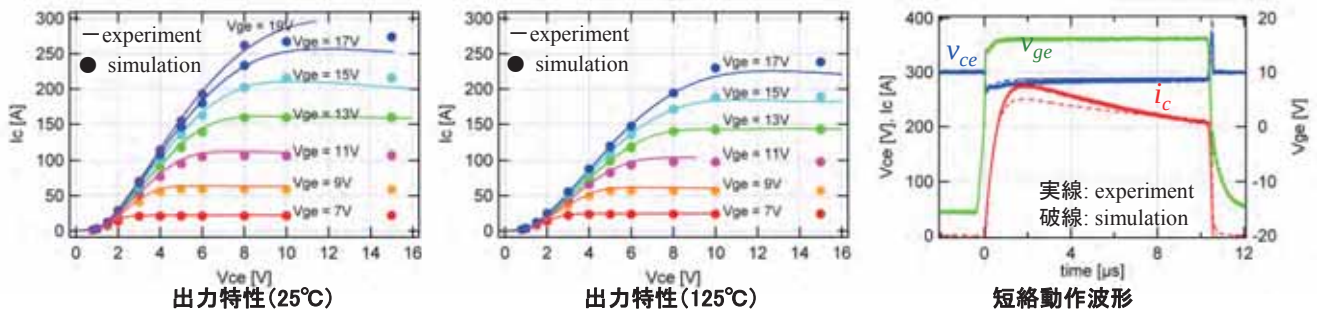
高度な設計に不可欠なパワー半導体の動特性シミュレーション



大岡山・電力・エネルギーグループ

パワーデバイスの物理モデルの構築
電気自動車、新エネルギー機器の電力変換回路を設計するためPSpice等の
回路シミュレータ上で動作するデバイスモデルを開発を開発

IGBT物理モデルを用いた静特性と短絡動作解析 (定格: 600-V, 30-A)



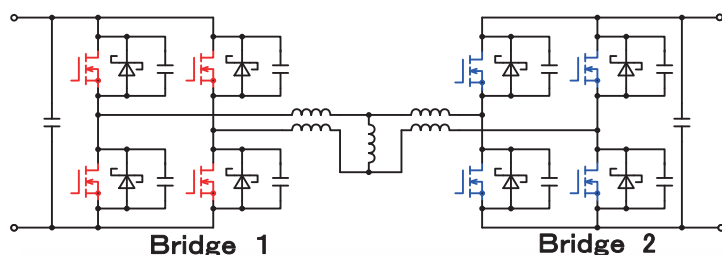
シミュレーション結果は実験結果を良好に再現

- 出力特性: 7%の誤差で再現
- アーム短絡動作: 9%の誤差で再現 (コレクタ電流ピーク値)

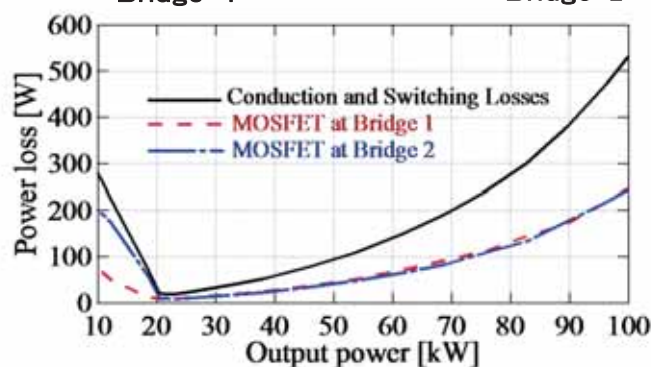
T. Horiguchi, S. Kinouchi, Y. Nakayama, T. Oi, H. Urushibata, S. Okamoto, S. Tominaga, and H. Akagi, "A High-Speed Protection Circuit for IGBTs Subjected to Hard-Switching Faults", IEEE Trans. IA., vol. 51, no. 2, pp.1774-1781, Mar./Apr., 2015

SiC-MOSFET準物理モデルを用いた応用解析事例

■ DC/DCコンバータ(100kW)の損失解析



双方向DC/DCコンバータ回路図
(SiC-MOSFET, 1200V, 400A)



DC/DCコンバータのSiC-MOSFET
損失解析結果

- 回路の動作特性を詳細に解析可能
- 解析結果を回路、熱設計に展開

小杉、中村、葛本、赤木、堀口、木ノ内、宮崎 「SiC-MOSFETモデルを用いた双方向DC/DCコンバータの損失解析」
電子デバイス/半導体電力変換合同研究会、EDD-15-092, SPC-15-174(2015)

3 教員からのメッセージ

パワーエレクトロニクスの研究室である赤木・萩原研究室、藤田研究室と連携した研究室です。居室、実験室等を含め全ての活動を赤木・萩原研究室、藤田研究室と連携して進めています。環境エネルギー分野で注目されるパワーエレクトロニクスの発展を担ってきたのがパワー半導体デバイスです。パワーデバイスを高度に活用するためには、回路設計者が容易に使うことのできるデバイスモデル構築が重要です。IGBTからSiC-MOSFET対応へと研究を進めています。

千葉研究室

ハイブリッド自動車用スイッチドリラクタンスモータ、磁気浮上ベアリングレスモータ



電力・エネルギーグループ
電気電子コース・エネルギーコース
大岡山・S3-601/607/608

教授 千葉 明 助教 杉元 紘也

研究分野: 電気機器、メカトロニクス、制御工学、磁気浮上
キーワード: レアアースフリーモータ、スイッチドリラクタンスモータ、ベアリングレスモータ、磁気軸受
ホームページ: <http://www.chiba.ee.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

省エネルギー、温室効果ガス削減に貢献する2種類の革新的モータの研究開発を行っています。電気自動車やハイブリッド自動車の主機モータへの応用を目指して、レアアース磁石を用いずに、高性能を実現するスイッチドリラクタンスモータの解析、設計、試作、実験、評価を行っています。また、次世代モータとして、機械的ベアリングを用いずに、電磁力によって回転軸を磁気支持する磁気浮上ベアリングレスモータの基礎研究を行っています。

本研究室の研究テーマは、電気、機械、情報、電子を融合した内容であり、幅広い知識と技術を身に付けることができます。また、実機を設計・試作し、実験することを大切にしています。モータの研究を通して、ものづくりの重要性を学ぶことができます。

省エネルギー

温室効果
ガス削減

次世代の革新的モータ
高効率・低消費電力

研究テーマ

1. ハイブリッド自動車用スイッチドリラクタンスモータ
2. 磁気浮上ベアリングレスモータ

2 最近の研究成果

■ EV/HEV用スイッチドリラクタンスモータ(SRM)

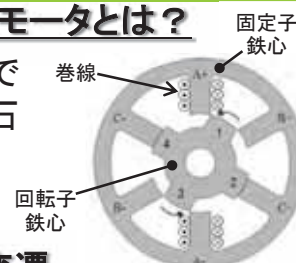
スイッチドリラクタンスモータ(SRM)は、固定子及び回転子が鉄心と巻線のみで構成され、永久磁石を使用しないため、安価で堅牢である利点があります。現状、市販のハイブリッド自動車の主機モータには、永久磁石が使用されていますが、レアアースの供給不安や価格変動の問題から、永久磁石を用いないSRMへの関心が高まっています。しかしSRMは、以下の4点の課題があり、ハイブリッド自動車用への応用は難しいとされてきました。(i) 低トルク密度、(ii) 低効率、(iii) インバータが特殊、(iv) 振動・騒音が大きい。

本研究テーマでは、これらの困難な課題に果敢にチャレンジし、これまで(i)(ii)を解決するモータ構造に関する研究開発を行いました。設計段階では、モータの3Dモデルを作成し、磁界解析ソフトを用いて、シミュレーションを行い、構造を検討します。一方、この分野は、良いシミュレーション結果が出たとしても、その結果のみでは評価されず、実験結果が重要です。そこで、ハイブリッド自動車用と同じ体格で、同じトルク、出力を発生させることが可能な、60 kWの実サイズの試作機を製作し、実験的に有効性を実証しました。

この研究成果は、SRMが永久磁石モータに匹敵する性能を出すことが可能であることが、実サイズの試作機で実験的に実証された世界初の事例であり、世界中の企業や大学から注目を集めています。

スイッチドリラクタンスモータとは？

- ✓ 鉄心と巻線のみで構成され、永久磁石を用いない
- ✓ 堅牢、安価



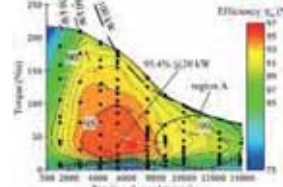
SRMの効率向上の変遷

鉄心材料や巻線の工夫により、SRMの効率向上を図ってきた。



ハイブリッド自動車用主機モータへの応用

トルク、出力、効率目標を達成



大岡山・電力・エネルギーグループ

■ スイッチドリラクタンスモータの振動・騒音低減

SRMの振動・騒音は20年以上前からの課題であり、低減方法に関する論文は多数存在しますが、顕著な低減効果はありませんでした。

本研究室では、2012年頃から本研究テーマに取り組んでいましたが、最初の2年間は成果が出ませんでした。2014年頃に、固定子ヨーク部のラジアル力の和の脈動を低減するように電流を流すことで、振動・騒音が低減可能となる革新的方法を提案し、実験的に有効性を実証しました。

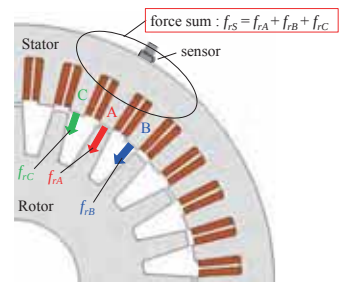
本研究テーマでは、SRMの振動・騒音が大幅に低減可能となるメカニズムを数式による基礎理論の構築、磁界解析を用いた数値シミュレーションによる検証、試作機を用いた実験的検証により明らかにすることができました。この研究成果は、学術的な価値だけでなく、産業応用においても多大な貢献となっています。

画期的な制御方法を提案し、
大幅な振動・騒音の低減に成功

スイッチドリラクタンス
モータの試作機



固定子ヨークの
ラジアル力の和
の脈動を低減



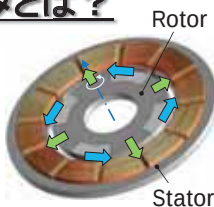
■ 磁気浮上ベアリングレスモータ

近年、モータの小型化・高速化・高効率化が進み、今後もその要求が高まると見られています。しかし、現状の機械的ベアリングでは、一般的に、高速回転時に機械損が増加するため、回転速度が制限されています。そこで、本研究室では、機械的ベアリングが不要で、電磁力により回転軸を非接触で磁気支持可能なベアリングレスモータの研究開発を行っています。

ベアリングレスモータは、長寿命・メンテナンスフリーという利点があるため、高速回転用途に限らず、ベアリングの故障が多い用途、長時間の連続運転が要求される用途やメンテナンスが困難な場所に設置される場合にも大変有効です。したがって、冷却ファンや風力発電機などへの応用を目指して、研究開発を行っています。

ベアリングレスモータとは？

機械的なベアリングが
不要で、電磁力により
回転軸を磁気支持



ベアリングレスモータの利点

長寿命

メンテナ
スフリー

無摩擦・
無摩耗

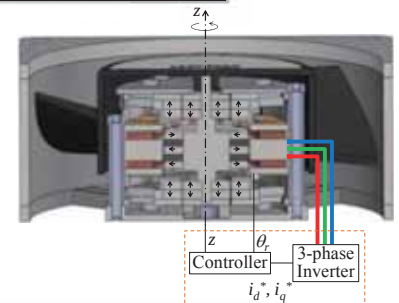
潤滑油レス

高付加価値の創出で、次世代の高効率
・高性能モータとして期待されている

冷却ファンへの応用



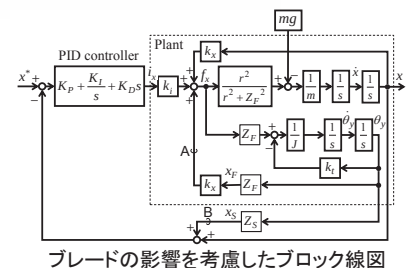
試作した固定子



風力発電機への応用



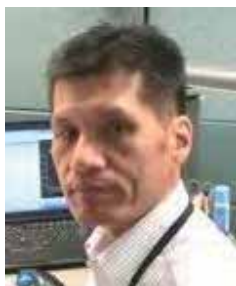
直径1mのブレードを
取付けた試作機



3 教員からのメッセージ

千葉研究室では、ものづくりを重視した次世代の革新的モータの研究開発を通じて、設計から解析、試作、実験、評価まで幅広く携わることができます。スイッチドリラクタンスモータの研究では、困難な課題にチャレンジし、独創的なアイデアを実際に形にできる点が面白いと思います。ベアリングレスモータの研究では、なかなか磁気浮上せず、何度も失敗と改良を続けて、最後に磁気浮上に成功した時の感動は計り知れないものです。世界で活躍する一流のモータ技術者になるために、千葉研究室で共に貴重な時間を過ごしましょう！

中出研究室（関係講座）

電力ケーブルの劣化
メカニズム・診断法開発

電力・エネルギーグループ
電気電子コース・エネルギーコース
大岡山・S3-614

特任教授 中出 雅彦

研究分野：電力ケーブル、劣化診断
キーワード：絶縁設計、劣化診断

1 主な研究テーマ

発電所で作った電気を送る送配電設備は、過去に建設したものが現在も大量に使われ、時に経年に伴う故障が発生します。都心ではケーブルを地下に布設し電気を送電しますが、故障は絶縁体内部で発生するため外からは見えません。経年に伴い故障の増加も予想されます。そこで、課電劣化や熱劣化など様々な故障モードを予想して整理し、必要なものについては診断手法を開発し、故障を起こす前に対処し、大量に存在する経年設備を長く大切に使う研究を実施します。

2 研究内容

電力を送電するケーブルには大きく分けて、油浸絶縁紙電力ケーブルと架橋ポリエチレン電力ケーブルがあります。油浸絶縁紙電力ケーブルはOFケーブルといわれ、導体の中心に絶縁油の通り道を作り、絶縁油に圧力をかけ、導体に巻き付けた絶縁紙にしみ込ませて絶縁するケーブルです。架橋ポリエチレン電力ケーブルは一般にCVケーブルと言われ、架橋したポリエチレンを絶縁体を使用します。

OFケーブルは比較的古くから使われてきたケーブルで信頼性が高く、高い電圧階級で使われています。しかし、絶縁油に圧力をかける必要があります、それに伴う加圧装置が必要で、油漏れに対するメンテナンスが必要です。

これに対し、CVケーブルは比較的新しいケーブルで、低圧から500kVまで、広範囲の電圧のケーブルに使用されています。OFケーブルに比較し加圧装置などの付帯設備を必要とせず、油漏れなどに対するメンテナンスも必要ないため、近年は新設ケーブルのほとんどがCVケーブルです。

CVケーブル絶縁体の経年劣化として以下が考えられています。

- ・課電劣化
- ・熱劣化
- ・水トリー劣化

課電劣化と熱劣化に関しては、運転電圧、使用温度範囲内の使用で、絶縁破壊を起こした事例はありません。水トリー劣化は課電電圧と水の影響によりプラスチックの高分子構造が破壊され、そこに水がたまり高分子構造が破壊されということを繰り返し、木のような形（トリー）に成長する劣化です。時に絶縁破壊事故を起こすことがあります。

これに対して、いろいろな診断手法が開発され、適用されています。特に66kV以上の高圧ケーブルは絶縁厚が厚く、測定信号が弱いので診断が困難でしたが、損失電流法という非破壊診断法が実用化され使用されています。



OFケーブル



CVケーブル

各種水トリー



青色水トリー

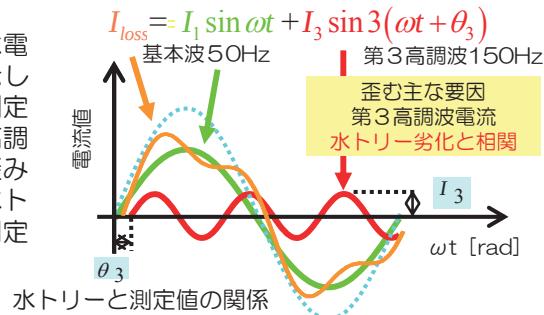


ボウタイトリー

大岡山・電力・エネルギーグループ

損失電流法

水トリーを流れる電流は電圧に対し非線形な特性を示します。絶縁体の漏れ電流測定時、損失電流成分の第3高調波に上記の非線形による歪みが測定できます。微細な水トリー信号を処理し、良否判定をします。



診断車

一方、OFケーブル絶縁体の経年劣化として以下が考えられています。

- ・課電劣化
- ・熱劣化

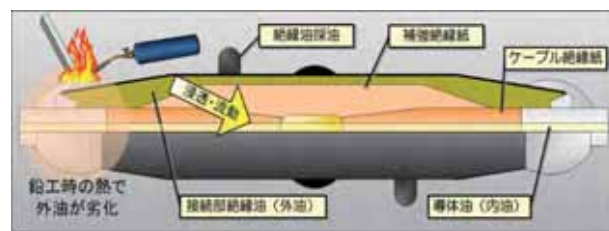
これまでOFケーブルは運転電圧、使用温度範囲内の使用で、課電劣化と熱劣化を起因とした絶縁破壊事例はありません。しかし、経年が50年を超える設備も出始め、経年劣化に対する備えの必要性が強く求められています。

熱劣化に対しは接続部で採油された絶縁油の誘電正接が高い事象に対し、各種実験データをシミュレーションに組み込み、長期亘り異常発熱しないことを確認した研究があります。

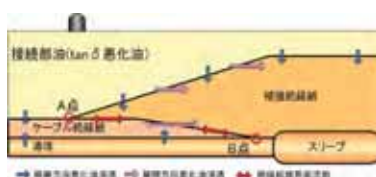
当研究室では上記の研究等を参考にしながら、OFケーブルの経年劣化に関する研究を実施しております。

OFケーブル接続部の誘電正接による発熱

OFケーブルの接続部絶縁油が建設時のバーナー加熱で劣化し、誘電正接の大きなものがあります。経年により内部に浸透し発熱する恐れがあります。劣化油の浸透や熱劣化のデータを実験により採取し、長期劣化シミュレーションに組み込み、長期に亘り異常発熱しないことを確認しました。



OFケーブル接続部カットモデル



油拡散1/4モデル



熱劣化後の温度分布 (誘電正接300%、1/4モデル)

3 教員からのメッセージ

既存設備を如何に長生きさせるかを考える、話題に上ることの少ない研究分野です。人間も寿命が延び医療コストが増大し、その対策が必要ですが、社会インフラも大量の経年設備を抱え、効率的なメンテナンスニーズは強く存在します。華々しい分野ではありませんが、良い成果はすぐに還元される、ある意味やりがいのある研究です。

七原研究室

風力・太陽光発電などの
再生可能エネルギーと電力システム
の協調を目指して

電力・エネルギーグループ
電気電子コース・エネルギーコース
大岡山・S3-609

教授 七原 俊也 助教 河辺 賢一

研究分野: 電力システム工学, 電力工学, 発電工学(再生可能エネルギー発電)

キーワード: 電力システム, 風力発電, 太陽光発電, スマートグリッド, 需給運用・制御, 発電出力変動, 電力品質, 安定性解析, 安定化制御, パワーエレクトロニクス応用機器

ホームページ: <http://www.pwrsys.ee.titech.ac.jp>

1 主な研究テーマ

2015年4月に開設された当研究室では、太陽光・風力発電が大量に導入された電力システムの安定性を確保する研究、新しい時代に適した電力システムの計画・運用手法の開発や安定性・信頼性の評価などに関する以下の研究を行っています(図1)。

- ・ 電力システムの解析技術
- ・ 太陽光・風力発電の電力系統への影響
- ・ 分散形電源の系統連系技術
- ・ 蓄電池などスマートグリッド技術の適用

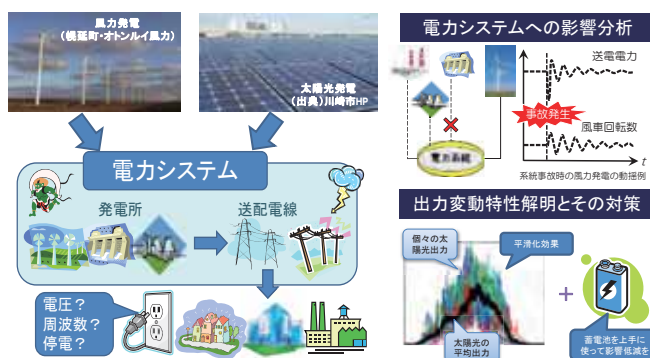


図1 研究の概要

2 最近の研究成果

■ 大量導入時の再エネ電源の電力系統影響評価

風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー発電(以下、再エネ電源)は地球温暖化などの面で地球環境に優しいエネルギー源として大きな期待を集めています。一方、再エネ電源は、天気によって発電出力が大きく変動するとともに、発電機として誘導発電機やインバータを用いているため落雷時などにおける挙動が火力発電などの在来型電源とは異なっています。このためこれら再エネ電源が大量に導入された場合に電力系統にどのような影響を及ぼすかを的確に評価することが重要です。

当研究室では、下記のように、再エネ電源が電力システムの安定性や電力品質(周波数, 電圧など), 経済性等に及ぼす影響についての解析手法の開発と分析に取り組んでいます

- ・ 再エネ電源の出力変動が周波数・電圧におよぼす影響の評価(図2: 周波数への影響の評価例)
- ・ 電力系統事故時における再エネ電源の応動特性の分析
- ・ 再エネ電源が電源の運用に及ぼす影響の評価

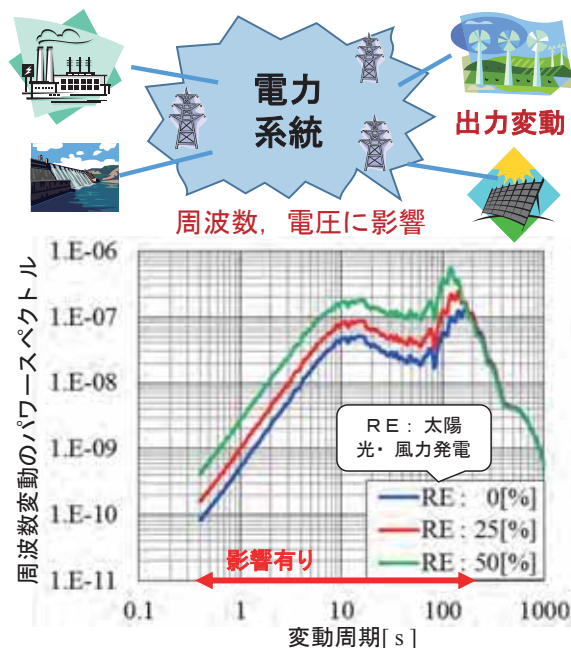


図2 再エネ電源の出力変動が系統周波数に及ぼす影響の評価例

大岡山・電力・エネルギーグループ

■ 再エネ電源大量導入時の広域系統安定化システムの開発

電力系統における事故(送電線への雷撃等)後の過渡領域で進展する各種不安定現象(同期発電機の脱調, 負荷供給系統の電圧低下等)に対する安定性を維持することは, 安定的な電力供給のために必要不可欠です。太陽光発電(PV)等のインバータ連系電源は, 同期発電機を利用した在来型電源と事故時の出力特性が異なり, 大量導入により安定性を損ねる恐れがあります。

当研究室では, 再エネ電源連系時における電力系統の安定性維持を目的として, 以下の課題に取り組んでいます(図3: 制御システムの概要)。

- ・ 再エネ電源がもつインバータの高速制御性を利用した電圧安定性の安定化システムの開発
- ・ 広域情報計測システムや系統設置型二次電池を利用した同期安定性の安定化システムの開発
- ・ 各種制御システムの統合(複数台・複数種類の電力制御機器の協調)

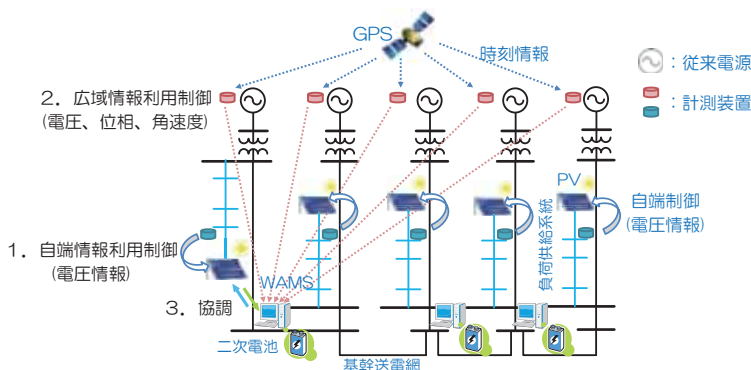


図3 再エネ大量連系時における広域安定化制御システムの概念図

■ 太陽光・風力発電の出力変動特性の分析と変動補償法の開発

太陽光や風力発電の出力は風速や日射強度など天気により大きく変動し, しかもその出力変動を正確に予測することは容易ではありません。また太陽光や風力発電については地域的に分散して設置された場合の出力変動は個々の設備の出力変動よりも小さくなることも知られています(平滑化効果)。一方, 近年は蓄電池を用いてその変動補償を行うことが注目されています。

当研究室では太陽光・風力発電の出力変動特性について以下の手法開発や分析とともに, 蓄電システムを用いてその変動補償を行うための制御法の開発などに取り組んでいます。

- ・ 太陽光・風力発電出力の平滑化効果の分析(図4: 太陽光発電の平滑化効果の分析例)
- ・ 大量導入時における太陽光・風力発電の出力変動の大きさの想定手法の開発
- ・ 出力補償用蓄電池の所要容量の評価と蓄電池の運用上の制約を考慮した蓄電池制御手法の開発

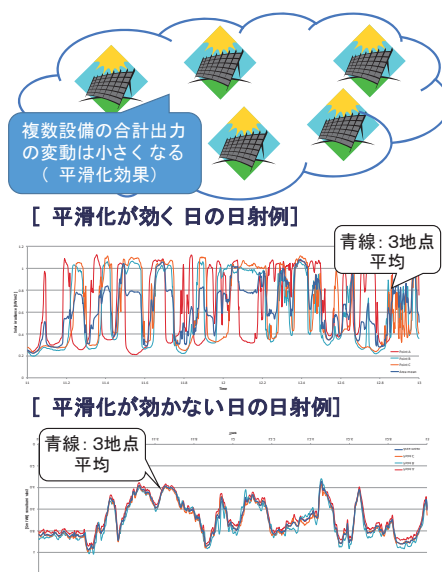


図4 太陽光発電での平滑化効果例

(注)教員2人は, これまで電力中央研究所, 東北大学, 富山大学などで研究に携わってきました。上記の研究成果はそこでの研究成果を含んでいます。

3 教員からのメッセージ

電力システムは現代社会の基盤をなす重要なインフラであり, これまでに長い年月をかけて構築されてきました。一方, 近年の電力システムを取り巻く状況は, 太陽光発電や風力発電の大量導入, 発送電分離等の電力自由化の進展など, 大きく変わりつつあります。当研究室では, このような状況下での新しい電力システム工学を確立すべく, 太陽光発電や風力発電の大量導入の影響とその対策説明を中心課題に据え, 研究を進めています。新たな分野の開拓に興味を持つ意欲的な学生が仲間に加わってくれることを期待しています。

藤田研究室

パワーエレクトロニクス モータドライブ応用 電力エネルギーシステム



電力・エネルギーグループ
エネルギーコース・電気電子コース
大岡山・EEI-404

准教授 藤田 英明

研究分野: パワーエレクトロニクス, 電気機器, 電力システム
キーワード: 太陽光発電, モータドライブ応用, 高効率電力変換器
ホームページ: <http://www.akg.ee.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

- 最新の半導体デバイスと新しい回路方式を活用した高効率・小型電力変換装置の開発
- 新しい回路トポロジーを用いた太陽光・風力・小規模水力発電用高効率・低コスト電力変換器
- インダクタやコンデンサ容量を低減した新しい電力変換器の回路方式と制御方式

2 最近の研究成果

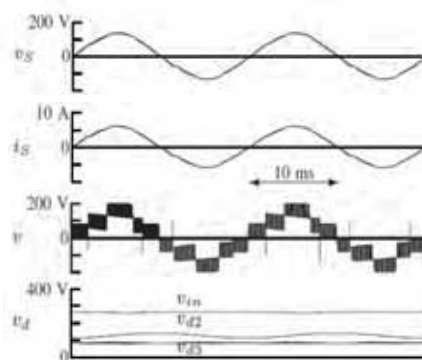
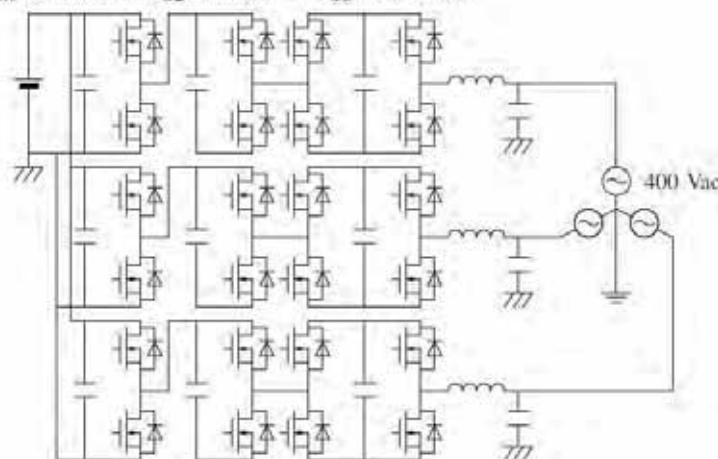
■太陽光発電用高効率 Zig-Zag Connected Copper Converter

太陽光発電では、太陽電池が発電した直流電力を種々の機器でできるように、交流電力に変換するインバータが必要です。インバータには、日の出や雨天の弱い日射から、日中の強い日差しまで、広い動作状態で電力を高効率に変換する能力が求められます。また、太陽電池からの漏れ電流は、太陽電池の寿命を短くすることが知られており、トランスなどを用いて漏れ電流を抑制する対策が取られていますが、電力変換効率の低下を引き起こします。

当研究室では、チョップ回路を組み合わせた新しい回路トポロジー Zig-Zag Connected Chopper (ZCC) 変換器を開発しました。このZCC変換器は、トランスを用いることなく、漏れ電流を抑制できるだけでなく、比較的低周波のスイッチングでも、交流電流を正弦波に制御できる特長があります。その結果、研究室での試作装置では、98.2%の最高効率を実現しました。既に、この回路方式は、ヨーロッパ向けの太陽光発電用インバータに適用されています。



v_{in} : 520-800 V v_{d2} : 260-400 V v_{d3} : 130-250 V



大岡山・電力・エネルギーグループ

■完全光絶縁共振形ゲートドライブ回路

パワーエレクトロニクス回路では、パワーMOSFETやIGBTなどの半導体スイッチングデバイスを高速にターンオン・ターンオフすることが重要です。このためには、ゲートドライブ回路が用いられます。最近の高速かつ高耐圧な半導体スイッチングデバイスを駆動する場合、制御回路や電源回路との間に高周波成分に対しても高い絶縁能力が求められます。制御信号については、これまでも光ファイバーなどを用いた絶縁方式がありましたが、電源回路との絶縁に課題がありました。

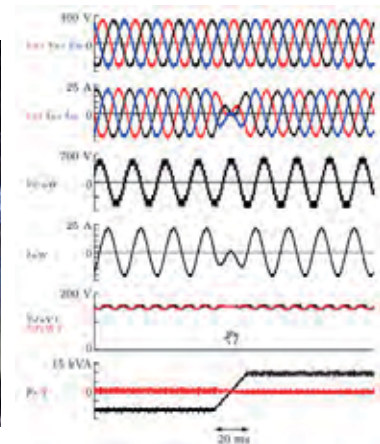
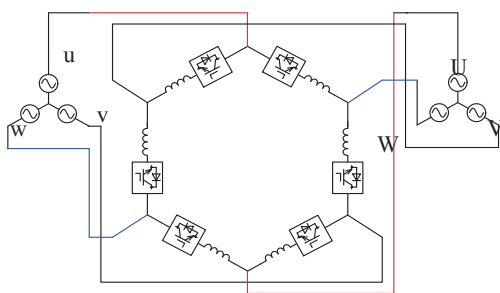
当研究室では、共振形ゲートドライブ回路の技術を研究してきました。これは、ゲート容量(キャパシタンス)の共振現象を活用して、理論的な損失なしに、半導体スイッチングデバイスをオン・オフする新しい回路方式です。その結果、新しいゲートドライブ回路は、わずかな電力だけで動作することができ、レーザーダイオード(発光素子)とフォトダイオード(受光素子)で必要な電力を伝達することができます。新型スイッチング素子のゲートドライブ回路への適用が期待されています。



■カスケード電力変換器を用いたパワーフローコントローラ

送電・配電システムには、高い安全性と信頼性が要求されます。このためには、電力の需要と供給が一致している必要がありますが、現在の電力システムでは、電力潮流(パワーフロー)を積極的に制御することが重要な課題の一つです。

新しいシステム構成として、6台のカスケード変換器を用いたパワーフローコントローラを提案しています。これは、変換器を六角形に接続した回路トポロジーに特長があり、高速な電力潮流の制御と同時に、各カスケード変換器の直流コンデンサ電圧を安定に制御することができます。その結果、20msで電力潮流を反転する高速な制御特性を可能にしました。



3 教員からのメッセージ

当研究室では、回路解析から回路の設計、試作、制御アルゴリズムの開発までを行います。これらのすべてが得意な人は少ないと思いますが、むしろ「新しいものを創り出してみたい」という気持ちが重要だと考えています。どうせ研究するのなら、ここでしかできない、他の大学には真似のできない創造的な研究を行いたいと考えています。

しかし、研究の成果は、実用化されてはじめて意味を持ちます。当研究室の研究課題の多くは、共同研究等のテーマであり、場合によっては、研究室で開発した新しい技術は、数年後には、実用化される場合もある。自分たちで開発した技術や機器が実際に使われるのはとても嬉しいものです。



電力・エネルギーグループ
電気電子コース・エネルギーコース
大岡山・S3-616/S3-615

教授 安岡 康一 講師 竹内 希

研究分野: プラズマ工学、高電圧工学、電力工学、静電気工学

キーワード: 気液界面プラズマ、高度水処理、ハイブリッド直流遮断器、
材料改質、プラズマ液体界面反応制御

ホームページ: <http://www.plasma.ee.titech.ac.jp/>

1 主な研究テーマ

1. 気液界面プラズマを用いた高度水処理

気液界面プラズマの基礎反応過程の追求と、実用化研究を進めています。現在世界的な水不足と環境保護の高まりに対応して、水再生はエネルギー確保に並ぶ最重要課題です。自動車産業、半導体産業、シェールオイルなどの新エネルギー産業、どれをとっても難分解有機物を含む水を排出し、環境汚染の原因となります。気液界面プラズマは、OHラジカルといった反応性の極めて高い活性種を生成し、難分解有機物の無機化・無害化が可能です。水問題に関する社会の要求を理解し、課題を抽出して実験を行い、解決していきます。

2. ハイブリッド直流遮断器

大規模太陽光発電や洋上風力発電といった分散型電源の普及や、直流送配電の増加に伴い、直流遮断器の需要が高まっています。事故発生時には遮断器により電流を直ちに遮断する必要がありますが、直流は電流零点をもたないため、電流遮断が困難です。そこで、通常時の電力損失が小さく、かつ事故電流の高速遮断が可能な、電気接点と並列に半導体素子を挿入したハイブリッド直流遮断器の研究を進めています。

3. プラズマによる炭素系材料改質

グラフェンなどの炭素系材料は、優れた電気・熱的特徴を有するため、燃料電池の触媒担持体や導電インクなどへの応用が期待されています。しかし、炭素系材料は一般的に疎水性を示し、溶液中での使用が困難です。そこで、気液界面プラズマにより生成されるOHラジカルを利用して親水性を付与するといった、炭素系材料の改質を行っています。

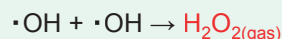
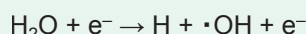
2 最近の研究成果

プラズマ・オゾン法による水中難分解性有機物の高速・高効率分解

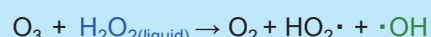
気液界面プラズマで生成されるOHラジカル($\cdot\text{OH}$)は、水中難分解性有機物の分解が可能ですが、OHラジカル同士が結合して生成される過酸化水素(H_2O_2)が有機物分解反応を阻害することが問題でした。そこで、オゾン(O_3)を処理液に供給し、過酸化水素とオゾンの反応によりOHラジカルを再生するプラズマ・オゾン法により、水中難分解性有機物の高速・高効率処理を実現しました。

プラズマ・オゾン法

プラズマによる $\cdot\text{OH}$ および H_2O_2 生成



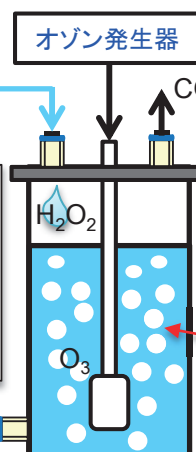
液相への H_2O_2 吸収と $\cdot\text{OH}$ 生成



処理液内の微細孔で、ジュール熱により発生した気泡内でプラズマを形成し、 $\cdot\text{OH}$ および H_2O_2 を生成



ダイアフラム放電プラズマリアクタ



水中有機物は $\cdot\text{OH}$ との反応で無機化され、 CO_2 として排出

ダイアフラム放電プラズマで生成した H_2O_2 と、微細気泡として供給した O_3 の反応で $\cdot\text{OH}$ を生成し、水中の有機物を分解・無機化

大岡山・電力・エネルギーグループ

直流ハイブリッド遮断器による直流電流の高速遮断

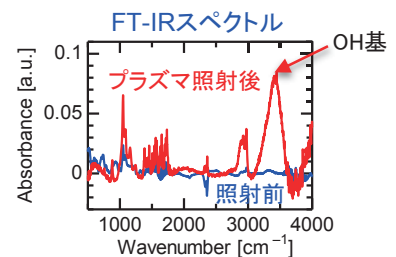
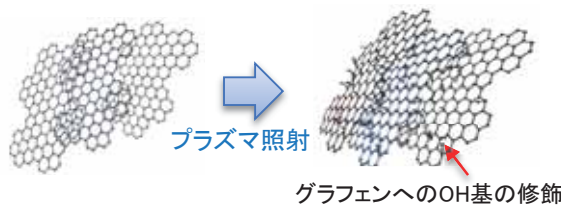
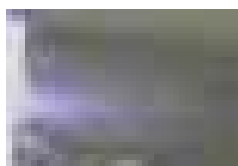
直流ハイブリッド遮断器は、電気接点と半導体素子、およびバリスタと呼ばれる素子が並列に並んだ構成です。通常時は電気接点を電流が流れますが、接点を機械的に開極することで、接点間にアーク放電プラズマが発生し、このときに発生するアーク電圧で半導体素子がオンします。すると、電気接点を流れていた電流が半導体素子に転流し、半導体素子をオフすることで**直流電流の高速遮断**が可能です。バリスタは、半導体素子オフ時に発生するサージを吸収します。



水面上プラズマによるグラフェンの改質

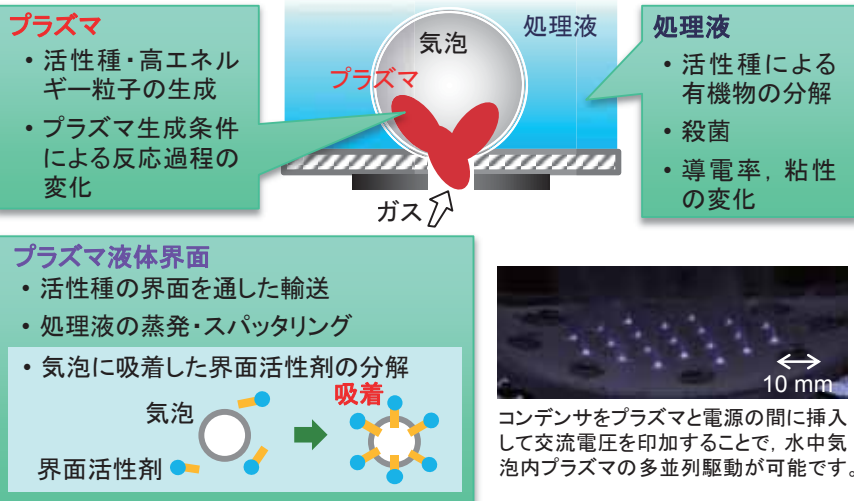
グラフェンは疎水性を示すため、水中に分散させることができません。しかし、グラフェンを含んだ溶液にプラズマを照射すると、グラフェンにOH基と呼ばれる官能基がついて親水性をもち、水中に分散させることができます。

溶液へのプラズマ照射



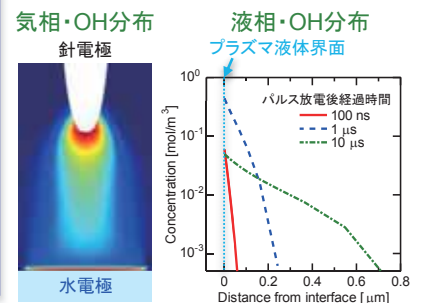
気液界面プラズマにおける反応過程

水中気泡内プラズマなどの**気液界面プラズマ**において、プラズマ、処理液、およびそれらの界面での**基礎反応過程**と、それぞれの相互作用の理解を目標としています。



水面上パルスプラズマの反応シミュレーション

気液界面を通しての活性種の輸送を考慮した**反応シミュレーション**により、OHラジカルの生成・損失反応を精査するとともに、プラズマ液体界面現象の理解を進めています。

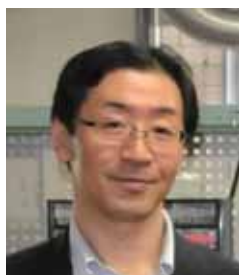


3 教員からのメッセージ

- 安岡・竹内研究室では、各学生がそれぞれの研究テーマを進めながら専門知識や技術を身につけ、思考力や判断力、交渉力、国際性などを養います。楽しく、厳しく、下克上が伝統の研究室です。
- 平成27年度は、博士課程3人、修士課程11人、学部生4人が在籍しています。
- 就職先： 新日鉄住金、東芝、日立、三菱、東京電力、東京ガス、経済産業省、JR東日本、オリンパス、デンソー、など

沖野研究室

新しい大気圧プラズマ装置の開発と 医療・環境・材料分野への応用



電力・エネルギーグループ
ライフエンジニアリングコース・電気電子コース
すずかけ台・J2棟1306号室

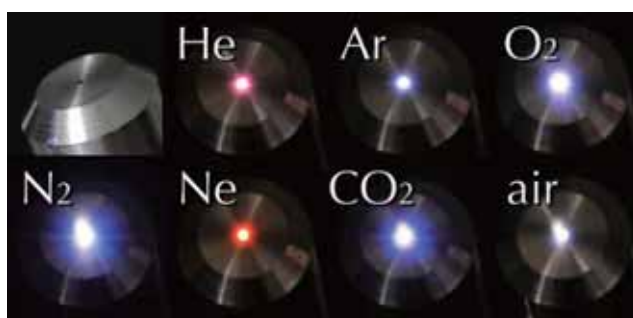
准教授 沖野 晃俊 特任助教 宮原 秀一

研究分野: 零下から高温までの新しい大気圧プラズマ装置の開発と
医療・環境・材料分野への応用

キーワード: 大気圧プラズマ, プラズマ医療, 環境分析, 表面処理
ホームページ: <http://www2.es.titech.ac.jp/okino/>

1 新しい大気圧プラズマ装置

大気圧下で生成されるプラズマは、連続的で高速なプラズマ処理を実現できるため、産業応用に有利なツールになります。しかし、大気圧下での安定なプラズマ生成は容易ではないため、従来の装置にはいくつかの制限がありました。沖野研究室では、酸素、窒素、空気、二酸化炭素など、様々なガスを安定にプラズマ化できる「マルチガスプラズマ」、人体にも安全にプラズマ照射できる「ダメージフリープラズマ」、零下から高温まで精密にガス温度を制御できる「温度制御プラズマ」などの新しい大気圧プラズマ装置を開発してきました。これらの技術により、従来の半導体やセラミックス等だけでなく、プラスチック、紙、繊維、液体、生体等のあらゆる物質へのプラズマ照射が可能となり、大気圧プラズマ応用の範囲が飛躍的に広がっています。



左上: 様々なガスのプラズマを生成できる
マルチガスプラズマジェット

上: 温度制御プラズマでは零下90℃から
250℃までのプラズマを生成可能

左: 人体や様々な素材に高密度プラズマ
を照射可能

2 大気圧プラズマの応用研究

沖野研究室では、上記のような様々な大気圧プラズマを開発しており、それぞれの特性に適した様々な分野に応用する研究を行っています。

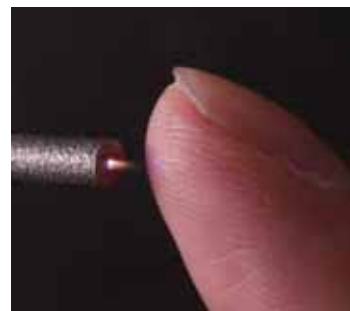
■ 医療関連分野への応用

プラズマ中にはラジカルやイオンなどの様々な活性粒子が存在します。この粒子により、プラズマは殺菌、止血、細胞活性化、創傷治療などの効果を持つことが明らかになってきました。そこで我々は、神戸大学医学部等と共同で、上記のプラズマ装置を駆使した医療関連機器や新技術の開発を行っています。

殺菌では、様々なガスと温度のプラズマを使用して、ドライ、もしくは水中の殺菌を行っています。ターゲットは、医療機器のほか、食品や農業への応用も検討しています。

すずかけ台・電力・エネルギーグループ

大気圧プラズマを照射すると止血効果が得られますが、従来の熱焼灼とは違って照射部に熱損傷を与えないため、短期間での創傷回復が期待できます。この長所を活かした、プラズマ内視鏡治療装置を開発するプロジェクトを進めています。内視鏡の鉗子口は内径わずか4mmなので、写真のような小型の温度制御マルチガスプラズマジェットを金属の3Dプリンタを使用して作成し、内視鏡用の止血・治療装置としての実用化をめざしています。



■ 環境分野への応用

沖野研では、プラズマを用いた新しい分析装置の開発を行っています。右図のように直径30ミクロン程度の微小な液滴に一つの細胞を封入して高温プラズマに導入することで、特定の細胞中の超微量元素を測定する装置を開発しています。これまでに、 $55\text{zg}(10^{-21}\text{g})$ というSPring-8を超える検出下限を実現しています。

プラズマを物質に照射すると、表面に付着した物質が脱離されます。この物質をイオン化して質量分析する装置を開発しています。低温プラズマでソフトにイオン化することで、付着物を分解することなく質量分析することが可能になります。これにより、皮膚などに付着した化学物質を超高感度かつ非接触で分析する事が可能になりました。右写真のようなプラズマ脱離・イオン化プローブを作成する事で、汗による疾病の診断や化粧品分析、さらには大気粉塵等の分析が可能になります。



左：微小な液滴に細胞やナノ粒子を包含させてプラズマ中に射出して分析

上：低温プラズマを皮膚に照射して付着物を脱離・イオン化

環境浄化に関連する取り組みとしては、警察庁科学警察研究所(科警研)と共同で、2020年の東京オリンピックのテロ対策に向けた化学兵器分解処理装置を開発しています。大気中の化学兵器を放電処理で分解して、短時間で無害化処理します。また、自動車メーカーと共同で新しい自動車排ガス浄化システムの研究も行っています。

■ 材料分野への応用

プラズマを物質の表面に照射すると、プラズマ中の活性種によって、表面付着物が除去されます。さらに、活性種は物質表面と相互作用して表面の官能基を変化させます。また、プラズマ中に物質を混合すると、表面をコーティングすることも可能です。これらの手法で材料の表面を改質し、接着性や塗装性を向上させたり、防汚性や撥水性を付与する研究を行っています。

現在は、自動車や航空機に使用する、高強度接着手法の開発などを実施しています。



表面処理用に開発した、リニア型プラズマ装置

3 教員からのメッセージ

沖野研究室では、学内生のほか、全国の大学や高専等の全ての学部、学科、専攻の皆さんを歓迎しています。プラズマに興味を持つ人なら、これまでの専門は問いません。各自の得意分野を活かしてプラズマの研究を行って下さい。大気圧プラズマや各種の装置開発に興味があり、いろいろな事にチャレンジしてみたい人はぜひ見学にお越し下さい。

キャンパスマップ (大岡山)

大岡山キャンパスで電気電子系に所属する研究室は、南3号館、南9号館、西8号館、EEI棟、および北1号館にあります。



キャンパスマップ (すずかけ台)

すずかけ台キャンパスで電気電子系に所属する研究室は、G2棟、J1棟、J2棟、J3棟、S1棟、S2棟、およびR2棟にあります。



質問があったら

何か疑問・質問があるとき、さらに詳細な情報を知りたいときは、下記ホームページを参照するかメールで質問してください。

東京工業大学 大学院で学びたい方

http://www.titech.ac.jp/graduate_school/index.html

電気電子系入試について

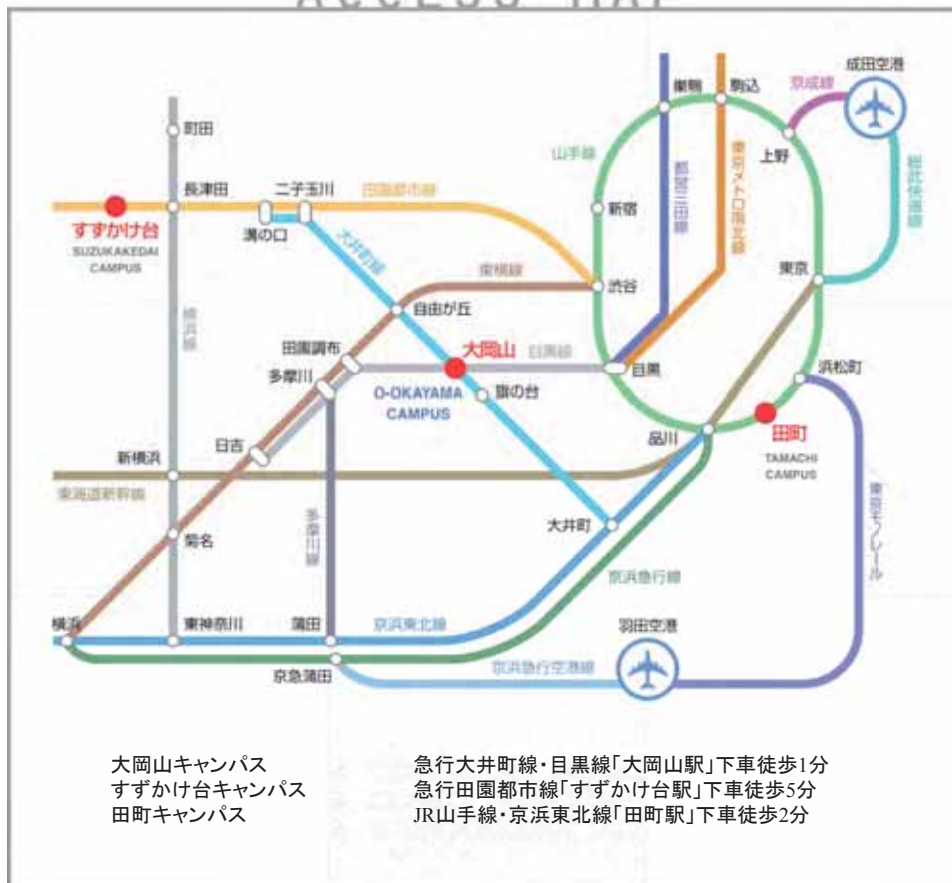
http://www.ee.titech.ac.jp/admissions/detail_59.html

<http://www.ep.titech.ac.jp/setsumeikai-j.html>

質問用メールアドレス

inquiry-dept@ee.titech.ac.jp

ACCESS MAP



東京工業大学

工学院 電気電子系 事務室

〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1-S3-39 TEL. 03-5734-2853

電子メール: inquiry-dept@ee.titech.ac.jp